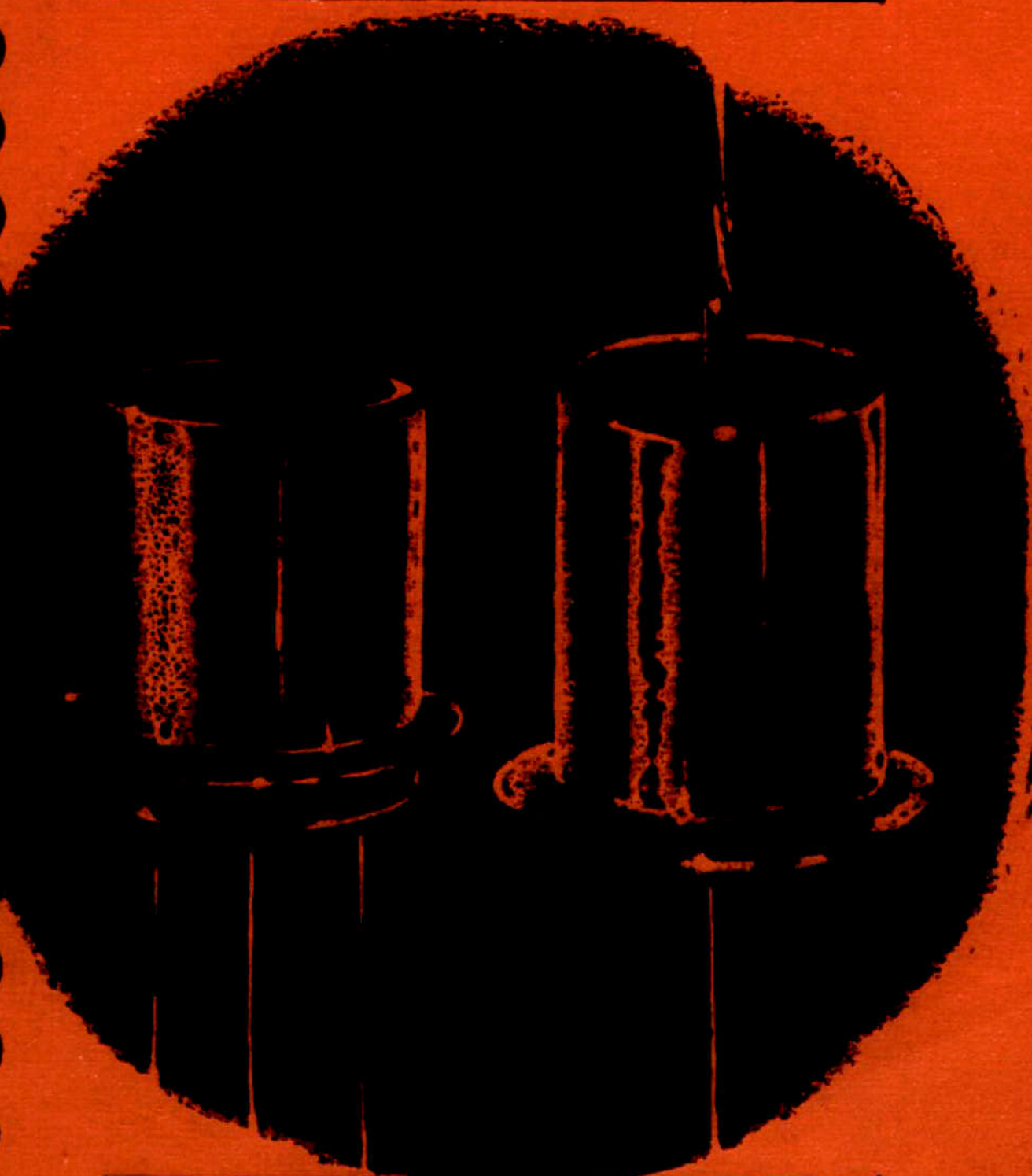


АТАНАС ШИШКОВ
ТРАНЗИСТОРЫ
И ДИОДЫ



ТЕХНИКА

КРАТКІ СІЛРОВОЧНИК

К. Т. Н. ИИИ. АТАНАС ИВАНОВ ШИШКОВ

ТРАНЗИСТОРИ И ДИОДИ

КРАТЪК СПРАВОЧНИК

ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

СОФИЯ, 1981
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“

СЪДЪРЖАНИЕ

Указания за ползуване на справочника	5
Проверка годността на транзистори, диоди и тиристори	14
Замяна на транзистори и диоди	18
Таблицы: БИПОЛЯРНИ ТРАНЗИСТОРИ	20
ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ	126
MOS ТЕТРОДИ	136
ЕДНОПРЕХОДНИ ТРАНЗИСТОРИ	137
МАЛОМОЩНИ И ИЗПРАВИТЕЛНИ ДИОДИ	138
ЦЕНЕРОВИ ДИОДИ	167
ВАРИКАПИ	175
ТУНЕЛНИ ДИОДИ	177
СВЕТОДИОДИ	179
ТИРИСТОРИ	180
Приложение	184

1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА СПРАВОЧНИКА

1.1. Биполярни транзистори

В първата колона са дадени означенията на транзисторите, подредени по реда на латинската азбука. Транзисторите, чиито означения са на кирилица, са подредени по същия признак след съответния буквен еквивалент от латиницата — напр. Г е след G, Д е след D и т. н. Транзисторите, чиито означения започват с цифра, са поместени след буквата Z.

Във втората колона са дадени някои данни за транзисторите, като са използвани следните съкращения:

Ge — германиев;

Si — силициев;

p — транзистор от типа PNP;

n — транзистор от типа NPN;

Dp — два PNP транзистора в един корпус, свързани по схема „Дарлингтон“ (съставен транзистор);

Dn — два NPN транзистора в един корпус, свързани по схема „Дарлингтон“ (съставен транзистор);

dp — два отделни еднакви PNP транзистора в един корпус;

dn — два отделни еднакви NPN транзистора в един корпус;

lp — лавинен PNP транзистор;

lp — два отделни еднакви PNP и NPN транзистора в един корпус;

Ep — двуемитерен PNP транзистор.

Във втората колона е означена и страната-производител, както следва:

A — Австрия;	DDR — ГДР;	NL — Холандия;
AUS — Австралия;	F — Франция;	PL — Полша;
BG — България;	GB — Англия;	R — Румъния;
CH — Швейцария;	H — Унгария;	SU — СССР;
CS — ЧССР;	I — Италия;	USA — САЩ;
D — ФРГ;	JP — Япония;	YU — Югославия.

Във връзка с горното искаме да припомним, че понастоящем редица транзистори с едно и също означение се произвеждат едно-

времето в няколко държави. Например транзисторът BC107 се произвежда в Унгария, Полша и ФРГ; транзисторът BF506 — в Полша и ФРГ и т. н. Ето защо в справочника като производител е посочена онази държава, чиито каталожни материали са използвани.

В останалите клонони са дадени стойности за следните основни параметри:

$U_{CB\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение колектор-база при $I_E = 0$. При PNP транзисторите то е положително, а при PNP — отрицателно.

$U_{CE\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение колектор-емитер при определено постоянно постоянно съпротивление (напр. 1—10 kΩ), включено между базата и емитера. При PNP транзисторите то е положително, а при PNP — отрицателно. Означено е със звездичка.

$I_{C\max}$ — максимално допустим колекторен ток. Когато е означен със звездичка, се отнася за импулсен режим;

f_T — гранична (транзитна, преходна) честота при схема ОЕ, при която $\beta = 1$, в МHz. Ако стойността е заградена в скоби, е дадена в kHz;

f_{α} — гранична честота при схема ОБ в МHz, при която коефициентът на усилване по ток α намалява с 30% (3 dB) спрямо стойността си при ниски честоти. Означена е със звездичка. Ако е заградена в скоби, е дадена в kHz;

h_{21E} или β — коефициент на усилване по ток при схема ОЕ. Поради производствени толеранси са дадени или средната му стойност за даден тип, или границите, между които варира;

$P_{C\max}$ — максимална мощност, разсейвана от колектора, в mW. Ако е заградена в скоби, тя е дадена във W. Отнася се за температура $+25^\circ\text{C}$. При средномощните и мощните транзистори се отнася за случая, когато е използван подходящ радиатор. (Напомниме, че на маломощните транзистори с метален корпус също може да се поставят радиатори, с което мощността им се увеличава до 3 пъти.)

Цокъл — означен е с цифра, на която съответствува ед-

на от рисунките, дадени най-долу. Показано е разположението на електродите, като буквите имат следното значение: E — емитер, B — база, C — колектор, M — метален корпус. Със стрелка е означена цветната точка (ако има такава). Нека споменем, че в някои каталози корпусите на транзисторите не се чертаят, а се дават съкратените им означения — напр. TO-5, TO-18, SOT-32 и т. н. Този начин за определяне изводите на транзисторите понякога може да заблуди читателя, тъй като някои корпуси се произвеждат от различните фирми в няколко варианта (вж. напр. корпусите TO-72, TO-92, SOT-23, SOT-25, SOT-32 и SOT-89 в приложението, дадено в края на настоящата книга).

Забележка — В този каталог са посочени някои данни за предназначението на транзисторите, като са използвани следните съкращения:

ун — универсален;
нч — нискофrequentен предусилвател;
мч — мощен нискофrequentен;
вч — високофrequentен предусилвател;
мвч — мощен високофrequentен;
имп — импулсен маломощен;
мм — мощен импулсен;
мш — маломощен;
вв — високофrequentен;
свч — свръхвисокофrequentен.

В някои случаи в колоната „Забележка“ е посочен транзистор с противоположна симетрия, подходящ за комплементарна двойка.

1.2. Полеви транзистори

В първата колона са дадени означенията на транзисторите, подредени по реда на латинската азбука.

Във втората колона са дадени някои данни за транзисторите, като са използвани следните съкращения:

PN — полеви транзистори с PN преход между управляващия електрод и канала (накратко — PN транзистор);
MOS — полеви транзистор с изолиран управляващ електрод (накратко — MOS транзистор);
dPN — два еднакви PN транзистора в общ корпус;
dMOS — два еднакви MOS транзистора в общ корпус;
P — каналът има проводимост P;

п — каналът има проводимост N;

p-соб — транзисторът е със собствен P-канал;

n-соб — транзисторът е със собствен N-канал;

p-инд — транзисторът е с индуциран P-канал;

n-инд — транзисторът е с индуциран N-канал.

Тук не е указан полупроводниковият материал, тъй като настоящем всички полеви транзистори са силициеви. Във втората колона е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1).

В *останалите колони* са дадени стойностите за следните параметри:

$U_{DS\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение дрейн-сорс при $U_{GS}=0$. При транзисторите с N-канал то е положително, а при P-канал — отрицателно;

I_{DSS} — при PN транзисторите и MOS транзисторите със собствен канал това е дрейновият ток при $U_{GS}=0$ и $U_{DS}=|U_p|$. При MOS транзисторите с индуциран канал това е дрейновият ток при $U_{GS}=2U_p$ и $U_{DS}=U_p$. Даден е в mA, а ако е заграден в скоби, той е в A;

$I_{D\max}$ — максимално допустим постоянен дрейнов ток, в mA. (Ако стойността е заградена в скоби, тя е дадена в A.) Неговите стойности са означени със звездичка;

$U_{GS\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение гейт-сорс при $I_D=0$;

S_n или y_{21S} — струмност на транзистора при схема общ сорс. При PN транзисторите и MOS транзисторите със собствен канал тя съответствува на работната точка $U_{GS}=0$ и $|U_{DS}|=|U_p|$. При MOS транзисторите с индуциран канал тя се отнася за работна точка $U_{GS}=2U_p$ и $U_{DS}=U_p$;

U_p — прагово напрежение (напрежение на отсечка, напрежение на запущване). Измерва се при $|U_{DS}|=|U_p|$ и $I_D=10 \mu A$;

$P_{D\max}$ — максимална мощност, разсейвана от дрейна, в mW. Ако е заградена в скоби, е във W. Отнася се за температура $+25^\circ C$. При мощните полеви транзистори е валидна при използване на съответен радиатор, препоръчан от завода-производител;

Цокъл — означен е с цифра, на която съответствува една от рисунките, дадени най-долу. Показано е разположението на електродите, като буквите имат следното значение: S — сорс (исток), G — гейт (затвор), D — дрейн (сток), M — метален корпус, Sub — подложка.

1.3. MOS тетроди (двугейтови полеви транзистори)

В *първата колона* са дадени означенията на тетродите, подредени по реда на латинската азбука.

Във *втората колона* са дадени някои данни за тетрода и стратипроизводител (вж. т. 1.1). Всички MOS тетроди, дадени в справочника, са с N-собствен канал (понастоящем те са най-разпространени) и се изготвят от силиций. Значението на останалите параметри е следното:

$U_{DS\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение дрейн-сорс при $U_{GS}=U_{GS0}$;

$I_{D\max}$ — максимално допустим постоянен дрейнов ток; $U_{GS0\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение първи гейт-сорс;

$U_{GS\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение втори гейт-сорс;

y_{21S} — най-голяма струмност на тетрода при схема общ сорс;

U_p — прагово напрежение на тетрода (напрежение на отсечка, напрежение на запущване). Измерва се при $|U_{DS}|=|U_p|$, $U_{GS}=4 V$ и $I_D=10 \mu A$;

$P_{D\max}$ — максимална мощност, разсейвана от дрейна. Давана се за температура $+25^\circ C$;

Цокъл — означен е с цифра, на която съответствува една от рисунките, дадени най-долу. Показано е разположението на електродите, като буквите имат следното значение: S — сорс (исток), G₁ — първи гейт (първи затвор), G₂ — втори гейт (втори затвор), D — дрейн (сток).

1.4. Еднопреходни транзистори (двубазови диоди)

В първата колона са дадени означенията на транзисторите, подредени по реда на латинската азбука.

Във втората колона са дадени някои данни за транзистора, както следва:

Si — силиций;

P — полупроводникът има P-проводимост;

N — полупроводникът има N-проводимост.

Във втората колона е посочена и страната-производителка (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

R_{BB} — съпротивление между двете бази при $I_E=0$;

η — коефициент на пропорционалност (отношение на R_{EB} към R_{BB} при $I_B=0$);

I_o — ток на падина (съответствува на минимума на входното напрежение). Това е най-малкият емитерен ток, при който транзисторът е все още отпуснен;

I_p — пиков ток (съответствува на максимума на входното напрежение). Това е минималният емитерен ток, необходим за включване на транзистора;

P_{max} — максимална мощност, разсейвана от транзистора, валидна при температура $+25^\circ\text{C}$;

Цокъл — означен е с цифра, на която съответствува една от рисунките, дадени най-долу. Показано е разположението на електродите, като буквите имат следното значение: E — емитер, B_1 — първа база (която най-често се заземява), B_2 — втора база.

1.5. Маломощни и изправителни диоди

В първата колона са дадени означенията на диодите, подредени по реда на латинската азбука.

Във втората колона са дадени някои данни за диодите, както следва:

Ge — германиев;

Si — силициев;

ун — маломощен диод с универсално предназначение;

дет — маломощен детекторен диод;

изпр — средномощен или мощен изправителен диод;

имп — импулсен диод;

свч — маломощен диод за СВЧ обхват;

ч.дет — маломощен диод за ЧМ детектори;

стълб — определен брой последователно свързани диоди;

дв. стълб — два отделни (несвързани) стълба;

мост — определен брой диоди, свързани по схема Грец;

дв. мост — два отделни (несвързани) моста.

Във втората колона е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

U_{RMmax} — максимално допустимо обратно напрежение (импулсно или амплитудна стойност);

U_{RM} — максимално допустимо постоянно напрежение в обрратна посока;

I_{OMax} — максимално допустима средна стойност на изправения ток, в пА. Ако стойността е заградена в скоби, тя е в А. При мощните изправителни диоди е валидна за случая, когато е употребен съответен радиатор, препоръчан от завода-производител;

I_{Fmax} — максимално допустим постоянен ток в права посока, в пА. Ако стойността е заградена в скоби, тя е в А;

I_{FMmax} — максимално допустима импулсна (или амплитудна) стойност на тока в права посока, в пА. Ако стойността е заградена в скоби, тя е в А. Стойността на тока е означена със звездичка;

I_R — постоянен ток в обратна посока (обратен ток на диода);

I_{RM} — най-голяма импулсна (или амплитудна) стойност на тока в обратна посока. Неговата стойност е означена със звездичка;

U_F — пад на напрежението в права посока при протичане на ток в права посока с големина I_{Fmax} .

1.6. Ценерови диоди (силициеви стабилитрони)

В първата колона са дадени означенията на ценеровите диоди подредени по реда на латинската азбука.

Във втората колона са дадени някои данни за диодите, както следва:

Si — силициев;

цен — ценеров диод;

стаб — стабилитрон.

Във втората колона е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

U_Z — напрежение на стабилизация при ток I_{Zmin} ;

I_{Zmin} — минимален ток на стабилизация;

I_{Zmax} — максимален ток на стабилизация;

r_d — диференциално (динамично, променливотоково) съпротивление на диода, съответстващо на определен ток (най-често в средата на работния участък на волт-

амперната характеристика);

TKU — температурен коефициент на напрежението на стабилизация;

R_D — максимална мощност, разсейвана от диода при температура $+25^\circ\text{C}$. При средномощните и мощните целерови диоди е валидна при употреба на съответен радиатор, препоръчан от завода-производител.

1.7. Варикапи (варактори, вариконди)

В *първата колона* са дадени означенията на варикапите, подредени по реда на латинската азбука.

Във *втората колона* са дадени някои данни за варикапите, както следва:

Si — силиций;

d — два еднакви варикапа в един корпус.

Във *втората колона* е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

C_1 — максимален капацитет на варикапа при обратно напрежение U_1 , дадено след наклонената черта;

C_2 — минимален капацитет на варикапа при обратно напрежение U_2 , дадено след наклонената черта;

$\frac{C_1}{C_2}$ — отношение между максималния и минималния капацитет;

Q — качествен фактор на варикапа;

U_R — максимално допустимо постоянно обратно напрежение;

I_R — обратен ток на варикапа при напрежение U_R .

1.8. Тунелни диоди

В *първата колона* са дадени означенията на тунелните диоди, подредени по реда на латинската азбука.

Във *втората колона* са дадени някои данни за тунелните диоди, както следва:

Ge — германий;

GaAs — галиево-арсенидов.

Във *втората колона* е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

I_{\max} — максимален ток през диода (ток в максимума);

U_1 — напрежение в права посока, съответстващо на I_{\max} ;

I_{\min} — отношение между максималния и минималния ток;

U_2-U_1 — отвор на волт-амперната характеристика, съответстващ на падания участък;

C_D — собствен капацитет на диода;

$U_{D\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение в права посока.

1.9. Светодиоди

В *първата колона* са дадени означенията на светодиодите, подредени по реда на латинската азбука.

Във *втората колона* са дадени някои данни за светодиодите, както следва:

GaP — галиево-фосфидов;

GaAs — галиево-арсенидов;

SiC — силициево-карбидов.

Във *втората колона* е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

Цвят — това е цветът на светене. Съкращението ин. черв. означава, че диодът излъчва в инфрачервената област;

Яркост — тя е дадена в нитове (nt). Нека напомним, че $1 \text{ нит} =$

$$= \frac{1 \text{ кандела}}{1 \text{ м}^2} \approx \frac{1 \text{ свещ}}{1 \text{ м}^2};$$

$I_{F\max}$ — максимално допустим постоянен ток в права посока, пораждащ най-силно светене на диода;

$U_{F\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение в права посока, съответстващо на $I_{F\max}$;

$U_{R\max}$ — максимално допустимо постоянно напрежение в обратна посока;

P_{\max} — излъчвана мощност при определен ток I в права посока, даден след наклонената черта.

1.10. Тиристори

В *първата колона* са дадени означенията на тиристорите, подредени по реда на латинската азбука.

Във *втората колона* са дадени някои данни за тиристорите, както следва:

Si — силиций;

дин — динистор (неуправляем тиристор);

тир — тиристор.

Във *втората колона* е посочена и страната-производител (вж. т. 1.1). По-нататък са дадени следните параметри:

$U_{DM \max}$ — максимално допустимо обратно напрежение (импулс-на или амплитудна стойност);

$U_{FM \max}$ — максимално допустимо право напрежение (импулсна или амплитудна стойност) при $I_d = 0$, при което тиристорът е все още запущен;

U_A — напрежение на включване (отпушване) на диностора в права посока. Отбелязано е със звездичка;

$I_{0 \max}$ — максимално допустима средна стойност на тока в права посока, в mA. Ако стойността е в скоби, тя е в A.

При средномощните и мощните тиристори се отнася за случая, когато е употребен съответен радиатор, препоръчан от завода-производител;

$I_{FM \max}$ — максимално допустима импулсна (амплитудна) стойност на тока в права посока, в mA. Ако стойността е в скоби, тя е в A;

I_{0T} — необходим ток в управляващия електрод за отпушване на тиристора;

P_{\max} — максимална мощност, разсейвана от тиристора, в mW. Ако е заградена в скоби, тя е във W. Отнася се за определена температура и при употреба на съответен радиатор, препоръчан от завода-производител.

2. ПРОВЕРКА ГОДНОСТТА НА ТРАНЗИСТОРИ, ДИОДИ И ТИРИСТОРИ

2.1. Проверка годността на биполарните транзистори

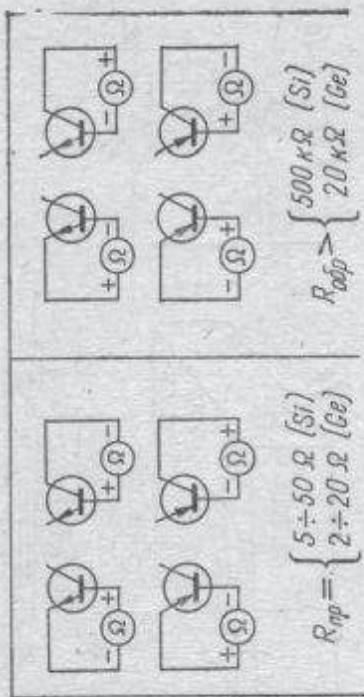
Биполарният транзистор е годин тогава, когато са изправни двата му прехода и между електродите му няма късо съединение.

Годността на биполарните транзистори се проверява най-лесно с омметър. За целта се прави проверка на всеки един от преходите съгласно фиг. 1, където с „+“ сме означили онази клемма на омметъра, която е свързана с положителния полюс на вграденния токоизточник. (При някои комбинирани ампер-волт-омметри това е клемата, маркирана с „+“, а при други — клемата, маркирана с „—“). Следователно трябва да сме напълно наясно с какъв омметър работим.) Тук трябва да се подчертае и това, че използваният от нас омметър трябва да има скала „x1Ω“, за да може *свояси сигурно* да се отчита кога измерваното съпротивление е 0 Ω (късо съединение) и кога 5—10Ω.

На фиг. 1 са дадени съпротивленията, които следва да се получат, ако транзисторът (маломощен или мощен) е в изправност. (Нека споменем, че някои високоволтови транзистори правят изключение,

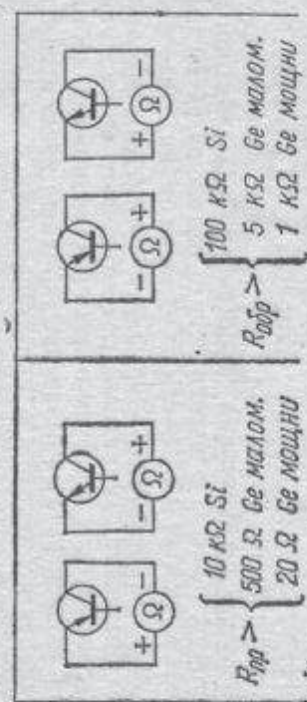
тъй като емитерният им преход няма рязко изразена еднопосочна проводимост.)

При установяване годността на транзисторите се препоръчва да се проверява и веригата емитер-колектор (и в двете посоки). Съ-



Фиг. 1

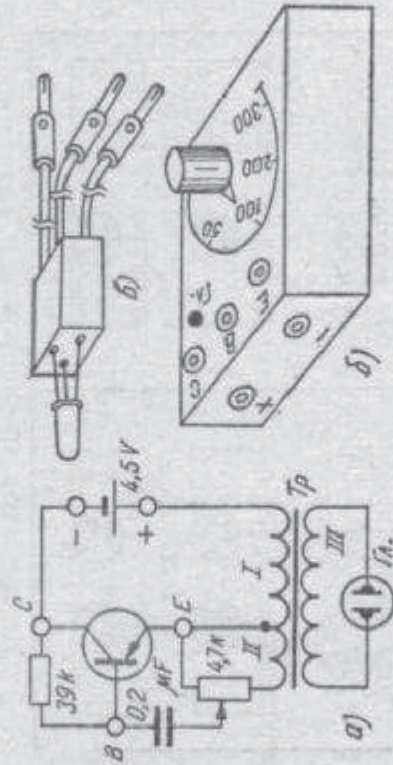
противленията, които трябва да имат изправните транзистори, са дадени на фиг. 2. При наличие на късо съединение между емитера и колектора (това е често срещан дефект при мощните транзистори) транзисторът е негоден за работа.



Фиг. 2

Проверката на транзисторите е по-сигурна, ако те се изпробват в генераторен режим. В радиолюбителски условия това може да стане с помощта на просто устройство, чиято схема и външен вид са

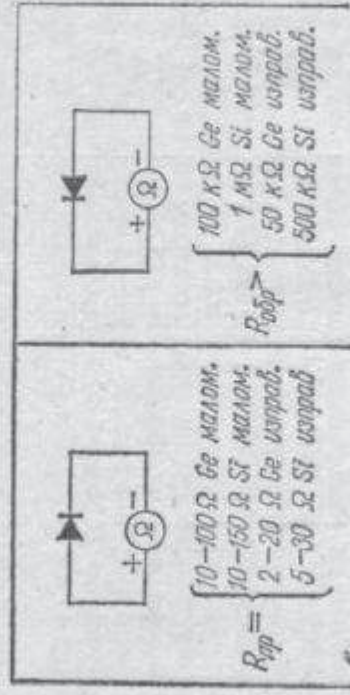
дадени на фиг. 3. С него може да се проверява годността на различни видове транзистори (маломощни, мощни, PNP, NPN), като едновременно с това се отчита и стойността на коефициента β с точност около 15—20%. По същество това е един блокинггенератор,



Фиг. 3

в който участва измерваният транзистор. Ако последният е изправен, възникват генерации, като променливият колекторен ток чрез трансформатора се повишава до напрежение 80—120 V, необходимо за запалване на глимлампата. Светенето на последната е указание, че транзисторът е годен за работа. Чрез потенциометъра може да се регулира напрежението на обратната връзка, подавано към базата, като при транзистори с по-голямо β запалването на глимлампата става по-рано. Отчитането на коефициента β става чрез въртене на потенциометъра отляво надясно, като се следят моментът на запалване на глимлампата. Измерваният транзистор се включва предварително в буксите E-B-C чрез самоделен куплунг (фиг. 3а). Кутията на устройството е пластмасова, с размери 90/60/30 mm. В нея се монтира трансформаторът, миниатюрната глимлампа с напрежение на запалване 80—100 V, жичният потенциометър 4,7k Ω , кондензаторът 0,2 μ F и резисторът 39 k Ω . На кутията се прави подходящ отвор, през който да се вижда глимлампата. Захранващата батерия се включва външно с оглед лесна промяна на поляритета. При измерване на транзистори от типа PNP батерията се включва така, както е показано на схемата. Когато се измерват транзистори от типа NPN, нейният поляритет трябва да се промени. Трансформаторът е миниатюрен (напр. от транзисторни приемници) със сечение

на ядрото 5x6 mm. Първо се навива намотка III, която съдържа 2000 навивки от емайлиран проводник с диаметър 0,07 mm. Върху нея се поставят два пласта хартия (или тиксо) за изолация. След това от емайлиран проводник с диаметър 0,15 mm се навиват намот-



Фиг. 4

ки I и II, като се прави извод. Намотка I съдържа 200 навивки, а намотка II — 100 навивки. Готовият уред се градуираща с помощта на няколко подбрани транзистора, чиито коефициент β е измерен предварително по друг начин. Ако е нужно да се „разредят“ деленията в началото на скалата, между потенциометъра и точката E (вж. фиг. 3 а) се включва резистор (напр. 1—5 k Ω), чиято точна стойност се подбира опитно. В това отношение радиолюбителите могат да проявят творчество, като използват други съцевини, друго съотношение на навивките и т. н.

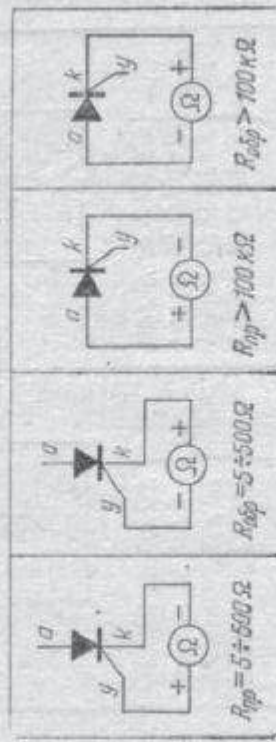
2.2. Проверка годността на маломощни и изправителни диоди

Полупроводниковите диоди (маломощни и изправителни) се проверяват най-лесно с омметър. Когато диодите са изправни, те имат еднопосочна проводимост и техните съпротивления са от порядъка на тези, дадени на фиг. 4. Ако даден диод и в двете посоки има нулево съпротивление или безкрайно голямо съпротивление, той е дефектен.

2.3. Проверка на годността на тиристори

Годността на тиристорите се проверява най-лесно също с омметър. Когато тиристорите са изправни, техните съпротивления са

като тези, дадени на фиг. 5. Обръщаме внимание, че PN-преходът между управляващия електрод и катода няма ярко изразена еднопосочна проводимост (умишлено е шунтиран за подобряване параметрите на тиристора). Най-честият дефект при тиристорите е късо съединение между анода и катода и между управляващия електрод и катода.



Фиг. 5.

3. ЗАМЯНА НА ТРАНЗИСТОРИ И ДИОДИ

3.1. Замяна на биполарни транзистори

В сравнение с радиолампите замяната на транзисторите е по-лесна. Това се дължи, от една страна, на сходството между всички транзистори, а от друга — на значителните им производствени толеранси.

След като сме сигурни, че даден транзистор е дефектен, най-добре е той да се замени с нов транзистор от същия тип, чийто изправност предварително сме проверили. При липса на такъв транзистор трябва да се търси подходящ еквивалент. Първо изискване е новият транзистор да има същата структура (PNP или NPN) и същия полупроводников материал (Ge или Si). След това се сравняват следните параметри, които трябва да бъдат или еднакви, или да се различават помежду си не повече от 10—20%:

- а) максимална мощност, разсейвана от колектора P_{Cmax} ;
- б) максимално допустимо колекторно напрежение U_{Cmax} (или U_{CEmax});
- в) максимално допустим колекторен ток I_{Cmax} ;
- г) коефициент на усилване β (или h_{21e});
- д) граничната честота f_T (или f_a) на новия транзистор трябва да бъде равна или по-голяма от тази на стария. Следователно ниско-

честотният транзистор може да се замени с високочестотен, ако останалите параметри са еднакви или близки. Обратната замяна обаче не е възможна.

3.2. Замяна на маломощни и изправителни диоди

При замяна на маломощни диоди първо изискване е новият диод да е от същия полупроводников материал (Ge или Si). След това се сравняват следните параметри, които трябва да бъдат или еднакви, или да се различават не повече от 10—20%:

- а) Максимално допустимо обратно напрежение U_{RMmax} или U_{Rmax} .
- б) Максимален ток в права посока I_{Fmax} или I_{FMmax} .

При замяна на импулсни и СВЧ диоди към тези параметри трябва да се прибавят и гранична честота, собствен капацитет, време на възстановяване и др.

При замяна на изправителни диоди трябва да се има пред вид следното:

- а) максималното обратно напрежение U_{RMmax} на новия диод да бъде равно или по-голямо от това на повредения;
- б) максималният изправен ток I_{Omax} на новия диод да бъде равен или по-голям с 10—50% от този на повредения;
- в) замяната на германиев със силициев диод е допустима, но обратното не се препоръчва;
- г) замяната на селенови стълбове и пакети с подходящи германиеви и силициеви изправителни диоди е възможна. Да се има предвид обаче, че диодите не търпят претоварване и при късо съединение (макар и за момент) те веднага излизат от строя, докато при селеновите пакети и стълбове това не е така.

Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB} \text{ max, V}$	$I_{C \text{ max, mA (A)}}$	$f_{T, \text{ MHz (kHz)}}$	$h_{21E, \beta}$	$P_{C \text{ max, mW (W)}}$	Плоты	Забелешка
AC105	Ge, p; D	-40	50	20*	40	60	1	мш
AC107	Ge, p; H	-1	5	2*	40	50	1	
AC108	Ge, p; D	-20	50	1,7*	45	60	2	
AC109	Ge, p; D	-20	50	1,7*	75	60	2	
AC110	Ge, p; D	-20	50	1,7*	110	60	2	
AC116	Ge, p; D	-30	200	(500)*	55-140	100	3	мш
AC117	Ge, p; D	-32	(1)	(500)*	110	180	3	
AC120	Ge, p; D	-20	300	(500)*	30	115	2	
AC121	Ge, p; D	-20	300	1,5	30-250	150	2	
AC122	Ge, p; D	-30	200	(500)*	85-300	90	3	
AC123	Ge, p; D	-45	200	(500)*	55-140	100	3	мш
AC124	Ge, p; D	-45	(1)	(400)*	60	180	3	
AC125	Ge, p; H	-32	200	1,7	100	150	2	
AC126	Ge, p; H	-32	200	2,3	100	150	2	
AC127	Ge, n; D	32	500	2,5	100	120	2	
AC128	Ge, p; H	-32	(1)	1,5	90	(1)	2	мш
AC128K	Ge, p; H	-32	(1)	1,5	50-250	(1)	2	
AC128/01	Ge, p; F	-32	(1)	1,5	60-100	700	2	
AC130	Ge, n; D	20	100	2	25	100	2	
AC132	Ge, p; D	-32	200	2	115	150	2	
AC141	Ge, n; I	32	(1)	3*	40-160	150	2	мш
AC141K	Ge, n; I	50	(1,2)	2*	40-160	150	2	
AC142	Ge, p; I	-32	(1,2)	1,5*	40-160	150	2	
AC150	Ge, p; D	-30	50	(500)*	55-140	60	3	
AC151	Ge, p; D	-32	200	1,5	30-250	150	2	
AC152	Ge, p; D	-32	500	1,5	30-150	150	2	мш
AC153	Ge, p; D	-32	(2)	1,5	50-250	(1)	2	
AC160	Ge, p; D	-15	10	2	55-140	30	3	
AC161	Ge, p; F	-15	100	2	75-250	30	2	
AC162	Ge, p; D	-32	200	1,7	80-170	150	2	
AC163	Ge, p; D	-32	200	1,7	130-300	150	2	мш
AC164	Ge, p; GB	-10	30	10*	50	40	2	
AC170	Ge, p; D	-32	200	1,7	80-170	90	3	
AC171	Ge, p; D	-32	200	2,3	130-300	90	3	
AC172	Ge, n; F	32	100	2,5	45-110	120	2	

Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB} \text{ max, V}$	$I_{C \text{ max, mA (A)}}$	$f_{T, \text{ MHz (kHz)}}$	$h_{21E, \beta}$	$P_{C \text{ max, mW (W)}}$	Плоты	Забелешка
AC175	Ge, n; D	25	200	1*	100-150	150	3	мш
AC176	Ge, n; H	32	(1)	3	50-250	(1)	2	
AC176K	Ge, n; H	32	(1)	3	50-250	(1)	2	
AC180	Ge, p; F	-32	(1,5)	4	50-250	300	2	
AC180K	Ge, p; F	-32	(1,5)	1	50-250	700	2	
AC181	Ge, n; F	32	(1)	3,5	50-250	300	2	мш
AC181K	Ge, n; F	32	(1)	3,5	50-250	700	3	
AC182	Ge, p; F	-32	150	4	50-250	130	2	
AC184	Ge, p; F	-32	500	3	50-250	165	2	
AC185	Ge, n; F	32	500	4	50-250	165	2	
AC187	Ge, n; H	25	(1)	5	70-500	(1)	2	мш
AC187K	Ge, n; D	25	(1)	5	100-500	(1)	2	
AC188	Ge, p; H	-25	(1)	1,5	100-500	(1)	2	
AC188K	Ge, p; D	-25	(1)	1,5	95-500	(1)	2	
AC191	Ge, p; D	-32	250	7	50	130	2	
AC192	Ge, p; I	-32	250	3	50	130	2	мш
AC193	Ge, p; I	-25	(1)	3	50	130	2	
AC193K	Ge, p; I	-25	(1)	3	50	280	2	
XC194	Ge, n; I	25	(1)	5	50	280	2	
AC230	Ge, p; I	-10	10	4	40	50	2	
AC240	Ge, p; GB	-10	10	4	40	50	2	мш
AC241	Ge, p; GB	-10	10	4	40	50	2	
AC242	Ge, p; GB	-10	10	4	40	50	2	
AC250	Ge, p; GB	-16	50	4	50	50	2	
AC251	Ge, p; GB	-16	50	4	50	50	2	
AC330	Ge, n; GB	24	10	1	50	50	2	мш
AC340	Ge, n; GB	24	10	1,5	50	50	2	
AC341	Ge, n; GB	24	10	2	50	50	2	
AC342	Ge, n; GB	24	10	2,5	50	50	2	
AC350	Ge, n; GB	32	50	1	50	50	2	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T,a}$, MHz (kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Покрѣ	Забелѣжка
AC502	Ge, p; YU	-16	50	1*	50	100	1	
AC503	Ge, p; YU	-16	50	3*	50	100	1	
AC504	Ge, p; YU	-16	50	3*	50	100	1	
AC508	Ge, p; YU	-16	50	4*	50	100	1	
AC509	Ge, p; YU	-16	50	4,4*	50	100	1	
AC515	Ge, p; YU	-25	50	2,5*	50	100	1	
AC516	Ge, p; YU	-25	50	3*	50	100	1	
AC517	Ge, p; YU	-30	50	2,5*	50	100	1	
AC518	Ge, p; YU	-30	50	3*	50	160	1	
AC519	Ge, p; YU	-30	50	2*	50	160	1	
AC520	Ge, p; YU	-30	50	2,5*	50	160	1	
AC521	Ge, p; YU	-30	50	3*	50	160	1	
AC523	Ge, p; YU	-30	50	2,5*	50	150	1	
AC524	Ge, p; YU	-45	50	2*	50	150	1	
AC525	Ge, p; YU	-45	50	2,5*	50	150	1	
AC526	Ge, p; YU	-45	50	3*	50	150	1	
AC527	Ge, p; YU	-45	50	3,3*	50	150	1	
AC530	Ge, p; YU	-24	10	1*	30	125	1	
AC540	Ge, p; YU	-24	10	(500)*	40	90	1	
AC541	Ge, p; YU	-24	10	(750)*	65	90	1	
AC542	Ge, p; YU	-24	10	(750)*	65	90	2	
AC548	Ge, p; YU	-26	150	1*	50	180	1	
AC549	Ge, p; YU	-26	300	2*	50	180	1	
AC550	Ge, p; YU	-32	200	1*	70	120	2	
AC551	Ge, p; YU	-32	200	1,5*	45-330	120	2	
AC552	Ge, p; YU	-60	200	1*	45-330	120	2	
AC553	Ge, p; YU	-20	300	1,5*	40-200	120	2	
AC554	Ge, p; YU	-24	300	1,5*	25-120	120	2	
AC555	Ge, p; YU	-24	300	2*	180	120	2	
AC556	Ge, p; YU	-25	(1)	1,5*	40-200	(1)	1	
AC556K	Ge, p; YU	-25	(1)	1,5*	100	(1)	3	
AC558	Ge, p; YU	-25	(1)	1,5*	40-350	(1)	1	
AC558K	Ge, n; YU	25	(1)	1,5*	40-350	(1)	3	
AC570	Ge, p; YU	-70	10	2*	50	150	1	
AC571	Ge, p; YU	-70	10	2,5*	50	150	1	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T,a}$, MHz (kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Покрѣ	Забелѣжка
AC572	Ge, p; YU	-70	500	3*	50	150	1	
AC573	Ge, p; YU	-70	500	3,3*	50	150	1	
AC574	Ge, p; YU	-70	500	4*	50	150	1	
AC577	Ge, p; YU	-70	500	2,5*	50	150	1	
AC598	Ge, p; YU	-105	200	1,4*	50	100	1	
ACY16	Ge, p; D	-40	400	(700)	60	800	3	
ACY17	Ge, p; GB	-70	500	(700)	50	250	1	
ACY18	Ge, p; GB	-50	500	1	50	250	1	
ACY19	Ge, p; GB	-50	500	(700)	50	250	1	
ACY20	Ge, p; D	-40	500	1	50	250	1	
ACY21	Ge, p; GB	-40	500	1,3	50	250	1	
ACY22	Ge, p; GB	-20	500	1,5	50	250	1	
ACY23	Ge, p; D	-32	200	500	40	115	3	
ACY24	Ge, p; D	-70	300	1,1*	50	200	4	
ACY27	Ge, p; D	-40	50	1,2*	50	200	4	
ACY28	Ge, p; D	-40	50	1,4*	50	200	4	
ACY29	Ge, p; D	-40	10	3*	50	200	4	
ACY30	Ge, p; D	-40	10	1*	50	200	4	
ACY31	Ge, p; GB	-40	10	1,5	50-150	(1)	3	
ACY32	Ge, p; D	-32	200	1,5	50-250	800	3	
ACY33	Ge, p; D	-32	(1)	(200)*	75-350	200	4	
ACY34	Ge, p; GB	-30	50	(300)*	50	200	4	
ACY35	Ge, p; GB	-30	50	(360)*	50	200	4	
ACY36	Ge, p; GB	-32	50	3*	75-200	150	1	
ACY38	Ge, p; F	-15	100	15	75-200	150	1	
ACY38W	Ge, p; F	-15	100	15	75-200	150	1	
ACY39	Ge, p; I	-110	500	(600)	50	250	1	
ACY40	Ge, p; GB	-32	500	(400)	50	250	1	
ACY41	Ge, p; GB	-32	500	1	50	250	1	
ACY44	Ge, p; GB	-50	500	1	50	250	1	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T, f_n , MHz (kHz)	h_{21E}, β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полка	Забелешка
ACY50	Ge, p; YU	-32	50	1*	50	165	1	
ACY51	Ge, p; YU	-32	50	1.5*	50	165	1	
ACY52	Ge, p; YU	-50	50	1*	50	165	1	
ACY55	Ge, p; YU	-32	300	2*	50	550	1	
ACZ10	Ge, p; YU	-70	50	1*	50	400	2	
AD103	Ge, p; D	-50	(15)	(200)*	>20	(22,5)	3	
AD104	Ge, p; D	-65	(10)	(200)*	>12	(22,5)	3	
AD105	Ge, p; D	-80	(8)	(200)*	>12	(22,5)	3	
AD130	Ge, p; D	-32	(3)	(400)*	>50	(30)	4	
AD131	Ge, p; D	-64	(3)	(400)*	>50	(30)	4	
AD132	Ge, p; D	-80	(3)	(400)*	50	(30)	4	
AD133	Ge, p; D	-50	(15)	(200)*	60	(30)	5	
AD134	Ge, p; D	-65	(10)	(200)*	60	(30)	5	
AD135	Ge, p; D	-80	(8)	(200)*	20	(30)	5	
AD136	Ge, p; D	-40	(10)	(300)*	60	(11)	1	
AD138	Ge, p; D	-40	(8)	(200)*	40	(30)	4	
AD138/50	Ge, p; D	-70	(8)	(200)*	40	(30)	4	
AD139	Ge, p; D	-32	(1)	(600)*	50	(11)	4	
AD140	Ge, p; GB	-55	(3)	(4,5)*	40	(25)	4	
AD142	Ge, p; I	-55	(10)	(450)*	30-200	(30)	4	
AD143	Ge, p; I	-32	(10)	450	30-200	(30)	4	
AD143	Ge, p; D	-32	(10)	450	50	(30)	4	
AD145	Ge, p; I	-20	(10)	450	50	(30)	4	
AD148	Ge, p; D	-32	(3,5)	450	50	(13)	4	
AD149	Ge, p; H	-50	(3,5)	300	50	(27)	4	
AD150	Ge, p; H	-32	(3,5)	450	50	(27)	4	
AD152	Ge, p; D	-45	(1)	200	50	(6)	4	
AD153	Ge, p; F	-40	(3)	500	50	(45)	4	
AD155	Ge, p; D	-25	(1)	500	120	(6)	4	
AD156	Ge, p; D	-40	(8)	500	100	(6)	4	
AD157	Ge, p; D	-32	(2)	1,5	100	(6)	4	
AD159	Ge, p; D	-40	(8)	300	48	(9)	1	
AD160	Ge, p; D	-40	(10)	300	45	(9)	1	
AD161	Ge, n; D	-32	(3)	3	50	(4)	4	AD162
AD162	Ge, p; D	-32	(3)	1,5	50	(6)	4	AD161



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T, f_n , MHz (kHz)	h_{21E}, β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полка	Забелешка
AD162U	Ge, p; H	-80	(1)	1,5	2-250	(6)	4	
AD163	Ge, p; D	-100	3	(350)	13-60	(30)	4	
AD164	Ge, p; D	-25	(1)	(400)*	110	(6)	4	
AD165	Ge, n; D	25	(1)	(500)*	110	(5,3)	4	
AD262	Ge, p; I	-35	4	(365)	40-180	(10)	4	
AD263	Ge, p; I	-60	4	(275)	25-180	(10)	4	
AD301	Ge, p; BG	-30	(3)	(200)	20-150	(30)	4	
AD302	Ge, p; BG	-40	(3)	(200)	20-150	(45)	4	
AD303	Ge, p; BG	-60	(3)	(200)	20-150	(45)	4	
AD304	Ge, p; BG	-80	(3)	(200)	20-150	(45)	4	
AD312	Ge, p; BG	-40	(6)	(250)	20-80	(45)	4	
AD313	Ge, p; BG	-60	(6)	(250)	20-80	(45)	4	
AD314	Ge, p; BG	-80	(6)	(25)	20-80	(45)	4	
AD315	Ge, n; YU	32	(2,5)	2*	20-50	(6)	4	
AD325	Ge, p; BG	-100	(10)	(100)	15-80	(45)	4	
AD412	Ge, p; YU	-24	(1)	(500)	5-200	(6)	4	
AD415	Ge, p; YU	-32	(2,5)	2	50-250	(6)	4	
AD430	Ge, p; YU	-16	(1,4)	(200)	40	(5)	4	
AD431	Ge, p; YU	-32	(2)	(200)	30-150	(5)	4	
AD432	-Ge, p; YU	-24	(1,5)	(200)	45	(6)	4	
AD436	Ge, p; YU	-40	(3)	(200)	15-60	(12)	4	
AD438	Ge, p; YU	-60	(3)	(200)	15-40	(10)	4	
AD439	Ge, p; YU	-80	(3)	(200)	15-50	(10)	4	
AD457	Ge, p; YU	-60	(5)	(200)	20-60	(10)	4	
AD465	Ge, p; YU	-40	(6)	(200)	20-90	(10)	4	
AD467	Ge, p; VU	-60	(6)	(200)	2-50	(10)	4	
AD469	Ge, p; YU	-80	(6)	(200)	20-60	(10)	4	
AD541	Ge, p; YU	-24	(8)	(50)	>20	(10)	4	
AD542	Ge, p; YU	-80	(8)	(50)	>10	(10)	4	
AD545	Ge, p; YU	-60	(12)	(50)	>10	(10)	4	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \beta}$, МГц (kHz)	h_{21E} , %	$P_{C\max}$, мВт (W)	Пакеты	Заделка
AD1202	Ge, p; H	-45	(3)*	(200)*	35	(8,1)	1	
AD1203	Ge, p; H	-60	(3)*	(200)*	35	(8,1)	1	
ADY22	Ge, p; D	-30	(10)	(250)*	15-50	(40)	2	
ADY23	Ge, p; D	-80	(10)	(250)*	20-60	(40)	2	
ADY24	Ge, p; D	-80	(10)	(250)*	50-100	(40)	2	
ADY25	Ge, p; D	-100	(7,5)	(250)*	20-60	(40)	2	
ADY26	Ge, p; D	-80	(25)	(100)	25	(100)	3	
ADY27	Ge, p; D	-32	(3,5)	(450)	30-100	(37,5)	1	
ADZ11	Ge, p; D	-50	(20)	(80)*	>15	(37,5)	3	
ADZ12	Ge, p; D	-80	(20)	(100)*	>15	(37,5)	3	
AF101	Ge, p; D	-20	20	14*	50	30	4	
AF102	Ge, p; D	-25	10	180	>20	50	5	
AF105	Ge, p; D	-25	50	55*	60	30	4	
AF106	Ge, p; D	-25	10	220	50	30	6	
AF107	Ge, p; D	-30	70	250	20	500	7	
AF108	Ge, p; D	-30	70	250	20	500	7	
AF109	Ge, p; D	-25	12	200	100	33	8	
AF109R	Ge, p; D	-20	10	260	50	60	6	
AF114	Ge, p; D	-20	10	75	150	50	5	
AF115	Ge, p; D	-20	10	75	150	50	5	
AF116	Ge, p; D	-20	10	75	150	50	5	
AF117	Ge, p; D	-20	10	75	40	50	5	
AF118	Ge, p; D	-70	30	175	180	200	5	
AF121	Ge, p; D	-25	10	270	75	70	9	
AF122	Ge, p; D	-20	10	275	60	30	8	
AF124	Ge, p; D	-20	10	75	150	50	5	
AF125	Ge, p; D	-20	10	75	150	60	6	
AF126	Ge, p; D	-20	10	75	150	60	6	
AF127	Ge, p; D	-20	10	75	150	60	6	
AF128	Ge, p; D	-9	10	6	70	12	10	
AF129	Ge, p; D	-20*	10	160*	75	30	8	
AF130	Ge, p; D	-20*	10	150*	75	30	8	
AF131	Ge, p; D	-20*	10	100*	35	30	8	
AF132	Ge, p; D	-20*	10	90*	50	30	8	
AF134	Ge, p; D	-25	10	55	110	60	6	



Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \beta}$, МГц (kHz)	h_{21E} , %	$P_{C\max}$, мВт (W)	Пакеты	Заделка
AF135	Ge, p; D	-25	10	50	100	60	6	
AF136	Ge, p; D	-25	10	40	80	60	6	
AF136T	Ge, p; H	-20	10	45	100	55	7	
AF137	Ge, p; D	-25	10	35	60	60	6	
AF137T	Ge, p; H	-20	10	35	100	55	7	
AF138	Ge, p; D	-25	10	40	100	60	6	
AF139	Ge, p; D	-20	10	500	50	60	6	
AF178	Ge, p; D	-25	10	180	>20	75	6	
AF179	Ge, p; F	-25	10	200	>30	95	6	
AF181	Ge, p; D	-30	20	170	>20	95	6	
AF185	Ge, p; D	-32	20	80	150	100	6	
AF186	Ge, p; GB	-25	15	900	>30	90	6	
AF187	Ge, p; F	-18	100	5	45	150	7	
AF188	Ge, p; F	-18	100	10	90	150	7	
AF189	Ge, p; F	-18	100	7*	45	150	7	
AF190	Ge, p; F	-18	100	13*	90	150	7	
AF192	Ge, n; F	20	100	20	20	150	8	
AF193	Ge, p; F	-20	10	40	100	120	7	
AF200	Ge, p; D	-25	10	5	85	225	9	
AF200U	Ge, p; D	-25	10	(50)	85	225	8	
AF201	Ge, p; H	-25	10	50	85	225	9	
AF201U	Ge, p; D	-25	10	(200)	85	225	8	
AF202	Ge, p; D	-25	30	50	85	225	9	
AF202S	Ge, p; D	-32	30	5	85	225	9	
AF239	Ge, p; H	-20	10	650	>30	60	6	CB4
AF239S	Ge, p; H	-15*	10	780	>30	60	6	CB4
AF240	Ge, p; D	-15*	10	500	25	60	6	CB4
AF256	Ge, p; D	-25	10	250	10-100	90	4	
AF260	Ge, p; YU	-15	10	3	25-150	75	8	
AF261	Ge, p; YU	-15	10	7	45-250	75	8	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T,a}$, MHz (kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
AF266	Ge, p; YU	-18	100	4,5*	5-150	125	1	свч
AF267	Ge, p; D	-20	10	780	>10	60	1	
AF271	Ge, p; YU	-18	10	30	20-300	55	1	
AF272	Ge, p; YU	-18	10	35	40-300	55	1	
AF275	Ge, p; YU	-18	10	35	20-300	55	1	
AF279	Ge, p; H	-20	10	780	>30	60	2	свч
AF279S	Ge, p; H	-20	10	820	>30	60	2	свч
AF280	Ge, p; H	-20	10	550	>30	60	2	свч
AF280S	Ge, p; H	-15*	10	55	>10	60	2	свч
AF289	Ge, p; D	-20	10	950	30	60	2	свч
AF306	Ge, p; D	-25	15	220	>10	60	3	
AF367	Ge, p; D	-15	10	550	10-200	60	2	свч
AF369	Ge, p; D	-20	10	550	50-200	60	2	свч
AF379	Ge, p; H	-15	20	1250	>25	100	2	свч
AFY10	Ge, p; D	-30	70	250	80	600	1	
AFY11	Ge, p; D	-30	70	300	60	600	1	
AFY12	Ge, p; D	-25	10	230	65	50	4	
AFY13	Ge, p; D	-25	50	50	100	60	4	
AFY14	Ge, p; D	-40	250*	60	120	100	4	
AFY15	Ge, p; D	-22	50	11	80	65	1	
AFY16	Ge, p; D	-30	10	500	80	60	4	
AFY18	Ge, p; D	-30	100	500	40-60	180	1	
AFY19	Ge, p; D	-32	150	350	40	125	1	
AFY29	Ge, p; D	-25	50	35	80	60	4	
AFY34	Ge, p; D	-40	20	3500	>10	35	5	
AFY37	Ge, p; D	-32	20	600	40	60	4	
AFY39	Ge, p; D	-32	30	500	85	225	4	
AFY40	Ge, p; D	-32	20	700	>10	82	4	
AFY40R	Ge, p; D	-20	10	600	50	82	4	
AFY42	Ge, p; D	-30	10	700	50	60	4	
AFZ10	Ge, p; D	-40	250*	35	140	150	6	
AFZ11	Ge, p; GB	-20	10	140	180	83	4	
AFZ12	Ge, p; D	-20	10	180	70	50	7	
AL100	Ge, p; I	-130	(10)	5	125	(50)	8	
AL101	Ge, p; I	-100	(10)	5	90	(50)	8	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T,a}$, MHz (kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
AL102	Ge, p; I	-100	(5)	4	40-250	(50)	8	
AL103	Ge, p; I	-100	(5)	3	40-250	(50)	8	
AL112	Ge, p; I	-35	(4)	4	20-220	(10)	8	
AL113	Ge, p; I	-60	(4)	3	40-220	(10)	8	
ALZ10	Ge, p; D	-50	250	40	90	150	6	
ASX11	Ge, p; BG	-30	250	7,5	>30	150	3	
ASX12	Ge, p; BG	-24	250	12	>30	150	3	
ASX13	Ge, p; BG	-18	250	25	>30	150	3	
ASY12	Ge, p; D	-32	600	1,5	30-40	135	1	
ASY12A	Ge, p; D	-24	600	1,5	30-40	135	1	
ASY13	Ge, p; D	-60	600	1,5	30-40	135	1	
ASY14	Ge, p; D	-80	250	1,5	20-100	75	1	
ASY24	Ge, p; D	-50	250*	22	90	65	1	
ASY24B	Ge, p; D	-35	250*	22	30-80	100	1	
ASY26	Ge, p; D	-30	200	4	30-80	100	1	
ASY27	Ge, p; D	-25	200	6	50-150	100	1	
ASY28	Ge, n; D	30	200	4	30-80	138	1	
ASY29	Ge, n; G	25	200	20	50-150	138	1	
ASY30	Ge, p; D	-50	250*	22	65	80	1	
ASY31	Ge, p; D	-25	100	4	30-80	75	6	
ASY32	Ge, p; D	-25	100	6	50-150	75	6	
ASY33	Ge, p; D	-30	200	2	20-200	150	1	
ASY34	Ge, p; D	-15	200	2	20-200	150	1	
ASY35	Ge, p; D	-30	200	2	30-200	150	1	
ASY36	Ge, p; D	-30	200	5	40-300	150	1	
ASY37	Ge, p; D	-30	200	10	60-250	150	1	
ASY48	Ge, p; D	-64	300	1,2	30-100	300	3	
ASY49	Ge, p; D	-100	100	(500)*	30-125	150	3	
ASY50	Ge, p; D	-20	100	(500)*	15-80	200	3	
ASY52	Ge, p; D	-60	100	(500)*	>30	150	3	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\ max}^{\circ}$, V	$I_{C\ max}^{\circ}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$\beta_{21E, \beta}$	$P_{C\ max}^{\circ}$, mW (W)	Плоть	Забелешка
ASY53	Ge, n; D	20	250	(500)*	15-80	150	1	
ASY54	Ge, p; D	-30	100	6*	15-95	200	1	
ASY55	Ge, p; D	-20	100	11*	25-125	200	1	
ASY56	Ge, p; D	-16	100	2	25-80	200	1	
ASY57	Ge, p; D	-16	100	3,7	30-80	200	1	
ASY58	Ge, p; D	-16	100	7	40-10	200	1	
ASY59	Ge, p; D	-16	100	12	60-150	200	1	
ASY6	Ge, p; D	-20	100	11*	25-125	200	1	
ASY61	Ge, n; D	30	250	5*	20-100	100	1	
ASY62	Ge, n; D	20	250	8*	25	100	1	
ASY70	Ge, p; D	-32	300	1,5	30-150	900	1	
ASY73	Ge, n; D	30	400	4	20	85	2	
ASY74	Ge, n; D	30	400	6	<50	85	2	
ASY75	Ge, n; D	30	400	10	<50	85	2	
ASY76	Ge, p; D	-40	500	0,9	20	160	2	
ASY77	Ge, p; D	-60	500	0,9	20	160	2	
ASY78T	Ge, p; D	-40	400	40	30-150	125	3	
ASY80	Ge, p; D	-40	500	0,9	40	160	2	
ASY81	Ge, p; F	-60	500	2	30-100	150	2	
ASY82	Ge, p; GB	-26	500	1,5	50	200	1	
ASY83	Ge, p; GB	-26	500	2,5	50	200	1	
ASY84	Ge, p; GB	-40	500	1,5	50	200	1	
ASY85	Ge, p; GB	-40	500	2,5	50	200	1	
ASY86	Ge, p; GB	-16	500	2	>50	200	1	
ASY87	Ge, p; GB	-16	500	4	>50	200	1	
ASY88	Ge, p; GB	-26	500	2	>50	200	1	
ASY89	Ge, p; GB	-26	500	4	>50	200	1	
ASY90	Ge, p; I	-40	250	5	>30	125	1	
ASY91	Ge, p; I	-25	250	5	>30	125	1	
ASZ10	Ge, p; D	-50	250	20	70	150	4	
ASZ15	Ge, p; D	-100	(8)	(200)	15-55	(20)	5	МНМ
ASZ16	Ge, p; D	-60	(8)	250	20-150	(20)	5	МНМ
ASZ17	Ge, p; D	-60	(8)	(220)	20-150	(20)	5	МНМ
ASZ18	Ge, p; D	-100	(8)	(220)	20-110	(20)	5	МНМ
ASZ20	Ge, p; GB	-40	25	100	30	83	4	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\ max}^{\circ}$, V	$I_{C\ max}^{\circ}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$\beta_{21E, \beta}$	$P_{C\ max}^{\circ}$, mW (W)	Плоть	Забелешка
ASZ21	Ge, p; D	-20	30	300	>50	80	2	
ASZ22	Ge, p; GB	-30	10	50	>50	100	4	
ASZ23	Ge, p; D	-24	10	30	30	50	4	
ASZ30	Ge, p; D	-50	250	20	40	30	1	
ASZ1015	Ge, p; H	-80	(6)	(250)	>20	(22)	5	МНМ
ASZ1016	Ge, p; H	-60	(6)	(250)	>25	(22)	5	МНМ
ASZ1017	Ge, p; H	-60	(6)	(250)	>25	(22)	5	МНМ
ASZ1018	Ge, p; H	-80	(6)	(250)	>30	(22)	5	МНМ
AT74	Ge, p; AUS	-20	300	1,5	40	200	1	
AU106	Ge, p; I	-320	(4)	2	15	(5)	5	МНМ
AU107	Ge, p; I	-200	(10)	2	35-120	(30)	5	МНМ
AU108	Ge, p; I	-100	(10)	2	35-200	(30)	5	МНМ
AU110	Ge, p; I	-140	(10)	2	20-90	(30)	5	
AU111	Ge, p; I	-320	(10)	2	15-80	(5)	5	
AU112	Ge, p; I	-320	(10)	2	15-40	(5)	5	
AU113	Ge, p; I	-250	(4)	2	15-80	(5)	5	
AUY10	Ge, p; D	-70	700	120	40	(6)	5	
AUY18	Ge, p; D	-64	(8)	(300)	20-60	(6)	1	
AUY19	Ge, p; D	-64	(3)	(350)	20-100	(16)	5	
AUY20	Ge, p; D	-80	(3)	(350)	20-100	(16)	5	
AUY21	Ge, p; D	-65	(10)	(300)	13-60	(16)	6	
AUY21A	Ge, p; J	-55	(10)	(300)	12-60	(36)	5	
AUY22	Ge, p; D	-80	(8)	(300)	13-60	(16)	6	
AUY22A	Ge, p; J	-80	(8)	(300)	13-60	(36)	5	
AUY28	Ge, p; D	-90	(5)	(250)	33	(30)	5	
AUY29	Ge, p; D	-50	(15)	(300)	20-100	(16)	6	
AUY30	Ge, p; F	-100	(10)	(500)	20-70	(45)	5	
AUY31	Ge, p; F	-60	(6)	(500)	20-70	(45)	5	
AUY32	Ge, p; F	-80	(3)	(500)	20-100	(45)	5	
AUY33	Ge, p; F	-60	(3)	(500)	20-100	(45)	5	



Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_{T, \alpha}$, МГц (kHz)	h_{21E} , р	P_{Cmax} , мВт (W)	Площадь	Забелешка
AUY34	Ge, p; D	-100	(3)	0,3	20	(12)	1	
AUY35	Ge, p; D	-70	(20)	2,5	20	(15)	1	
AUZ11	Ge, p; D	-50	(1)	3,5	18-60	(6)	1	
BC107	Si, n; D	50	100	150	>125	260	2	
BC107A	Si, n; D	50	100	150	>125	260	2	
BC107B	Si, n; D	50	100	150	240-500	260	2	
BC108	Si, n; D	30	100	150	125-900	250	2	
BC108A	Si, n; D	30	100	150	125-260	260	2	
BC108B	Si, n; D	30	100	150	240-500	260	2	
BC108C	Si, n; D	30	100	150	450-900	260	2	
BC109	Si, n; D	30	100	150	240-900	260	2	
BC109B	Si, n; D	30	100	150	450-900	260	2	
BC109C	Si, n; D	30	100	150	200-400	200	5	
BC113	Si, n; I	30	50	60	100-400	300	5	
BC115	Si, n; I	30	200	100	80-240	240	5	
BC116	Si, p; I	-45	600	200	40-160	300	3	
BC118	Si, n; D	45	100	200	40-120	800	3	
BC119	Si, n; D	60	(1)	40	75-900	100	4	
BC122	Si, n; D	30	75	250	30-60	300	5	
BC125	Si, n; D	30	600	40	30-120	300	5	
BC126	Si, p; D	-30	600	200	125-900	140	3	
BC130	Si, n; D	20	100	250	40-250	750	3	BC160
BC140	Si, n; D	80	(1)	50	30-90	300	3	BC161
BC141	Si, n; D	100	(1)	50	80-550	50	6	
BC145	Si, n; D	120	100	40	125-500	250	7	
BC146	Si, n; D	20	50	150	125-900	250	7	
BC147	Si, n; D	50	100	150	125-900	250	7	
BC148	Si, n; D	30	100	150	125-900	250	7	
BC149	Si, n; D	30	100	300	115	200	5	
BC153	Si, p; I	-40	100	200	75-260	250	7	
BC157	Si, p; D	-50	100	150	75-500	250	7	
BC158	Si, p; D	-30	100	150	125-500	250	7	
BC159	Si, p; D	-25	100	150	40-250	750	3	BC140
BC160	Si, p; D	-40	(1)	50	40-250	750	3	BC141
BC161	Si, p; D	-60	(1)	50	40-250	750	3	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_{T, \alpha}$, МГц (kHz)	h_{21E} , р	P_{Cmax} , мВт (W)	Площадь	Забелешка
BC167	Si, n; D	50	100	300	125-500	280	6	
BC168	Si, n; D	30	100	300	125-900	280	6	
BC169	Si, n; D	30	100	300	240-900	280	6	
BC170	Si, n; D	20	100	100	35-600	300	8	
BC171	Si, n; D	45*	100	250	125-500	300	8	
BC172	Si, n; D	25*	100	250	290-500	300	8	
BC174	Si, n; D	64*	100	250	170-290	300	8	
BC177	Si, p; H	-50	100	130	75-260	300	3	
BC178	Si, p; D	-30	100	100	75-500	300	3	
BC179	Si, p; D	-25	50	100	125-500	300	3	
BC182	Si, n; H	60	200	150	125-500	300	8	
BC183	Si, n; H	45	200	150	120-800	300	8	
BC184	Si, n; H	45	200	150	50-300	240	8	
BC190	Si, n; D	64*	100	250	170-290	250	3	
BC200	Si, p; D	-20	50	90	>60	50	9	
BC201	Si, p; D	-5	75	80	50-500	200	4	
BC202	Si, p; D	-30	75	80	75-900	200	4	
BC203	Si, p; D	-45	75	80	75-500	200	4	
BC207	Si, n; I	45	100	150	110-450	300	7	
BC208	Si, n; I	25	100	150	110-800	300	7	
BC209	Si, n; I	25	100	150	200-800	200	7	
BC211	Si, n; H	80	(1)	50	40-100	(4)	3	
BC211A	Si, n; H	100	(1)	50	40-100	(4)	3	
BC212	Si, p; H	-60	200	200	70-140	300	8	
BC213	Si, p; H	-45	200	200	120-800	300	8	
BC214	Si, p; H	-45	200	200	140-800	300	8	
BC237	Si, n; H	50	100	300	125-500	300	8	
BC238	Si, n; H	30	100	300	180-600	300	8	
BC239	Si, n; H	30	100	300	180-800	300	8	
BC250	Si, p; H	-20	100	180	35-600	300	3	

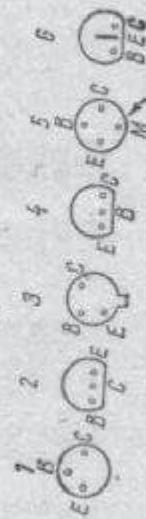


Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{21E} , В	P_{Cmax} , Вт (W)	Монтаж	Забелешка
BC251	Si, p; D	-45*	100	130	170-500	300	1	
BC252	Si, p; D	-20*	100	130	170-500	300	1	
BC253	Si, p; D	-20*	100	130	90-270	300	1	
BC255	Si, n; USA	100	30	50	>80	625	1	
BC256	Si, p; D	-64*	100	130	170-290	300	1	
BC257	Si, p; D	-50	100	130	75-260	220	2	
BC258	Si, p; D	-30	100	130	75-500	220	2	
BC259	Si, p; D	-25	100	130	125-500	220	2	
BC260	Si, p; D	-20	100	180	35-600	300	3	
BC261	Si, p; D	-45*	100	130	170-500	300	3	
BC262	Si, p; D	-25*	100	130	170-500	300	3	
BC263	Si, p; D	-25*	100	130	90-270	300	3	
BC266	Si, p; D	-64*	100	130	170-290	300	3	
BC298	Si, p; I	-25*	(1)	150	75-500	375	3	
BC300	Si, n; H	120	500	120	40-80	(6)	3	
BC301	Si, n; H	90	500	120	40-80	(6)	3	
BC302	Si, n; H	60	500	120	70-140	(6)	3	
BC303	Si, p; H	-85	500	75	120-240	(6)	3	
BC303	Si, p; I	-90	(1)*	130	100-240	(7)	3	
BC304	Si, p; H	-60	500	75	120-240	(6)	3	
BC307	Si, p; H	-50	100	200	170-500	300	4	
BC308	Si, p; H	-30	100	200	180-460	300	4	
BC309	Si, p; H	-25	100	200	90-270	300	4	
BC313	Si, p; H	-60	(1)	50	100-250	(4)	3	
BC313A	Si, p; H	-80	(1)	50	100-250	(4)	3	
BC327	Si, p; H	-50*	500	100	100-600	625	4	BC337
BC328	Si, p; H	-30*	500	100	50-600	625	4	BC338
BC337	Si, n; H	50*	500	100	100-600	625	4	BC327
BC338	Si, n; H	30*	500	100	100-600	625	4	BC328
BC340	Si, n; D	40	500	100	40-250	800	3	
BC341	Si, n; D	60	500	100	40-160	800	3	
BC360	Si, p; D	-40	500	250	40-250	800	3	
BC361	Si, p; D	-60	500	250	40-160	800	3	
BC368	Si, n; D	25	(1)	65	50-375	800	2	
BC369	Si, p; D	-25	(1)	65	50-375	800	2	

Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{21E} , В	P_{Cmax} , Вт (W)	Монтаж	Забелешка
BC393	Si, p; PL	-180	50	120	50-150	400	3	
BC408	Si, n; D	30	100	300	180	250	5	
BC413	Si, n; D	45	100	250	150	240	4	BC415
BC414	Si, n; D	50	100	250	90	240	4	BC416
BC415	Si, p; D	-45	100	200	220	300	4	BC413
BC416	Si, p; D	-50	100	200	90	240	4	BC414
BC431	Si, n; D	60*	800	100	60-240	500	4	
BC432	Si, p; D	-60*	800	100	60-240	500	4	
BC460	Si, p; I	-50	1	50	40-250	1	3	
BC516	Si, Dp; D	-40	400	220	30000	625	4	BC517
BC517	Si, Dn; D	40	400	220	30000	625	4	BC516
BC527	Si, n; PL	45	100	300	180	400	3	
BC528	Si, n; PL	20	100	300	180	400	3	
BC546	Si, n; D	80	100	300	110	500	4	BC556
BC547	Si, n; D	50	100	300	110	500	4	BC557
BC548	Si, n; D	30	100	300	110	500	4	BC558
BC549	Si, n; D	30	100	300	240	500	4	BC559
BC550	Si, n; D	50	100	300	290	500	4	BC560
BC556	Si, p; D	-80	100	150	110	500	4	BC546
BC557	Si, p; D	-50	100	150	110	500	4	BC547
BC558	Si, p; D	-30	100	150	110	500	4	BC548
BC559	Si, p; D	-30	100	300	180	500	4	BC549
BC560	Si, p; D	-50	100	300	290	500	4	BC550
BC617	Si, Dn; D	50	(1)	150	10000	625	4	
BC618	Si, Dn; D	80	(1)	150	4000	625	4	
BC627	Si, n; PL	45	100	300	180	300	6	
BC628	Si, n; PL	20	100	300	180	300	6	
BC635	Si, n; D	45*	(1)	130	25-250	800	2	BC636
BC636	Si, p; D	-45*	(1)	130	25-250	800	2	BC635
BC637	Si, n; D	60*	(1)	130	25-160	800	2	BC638

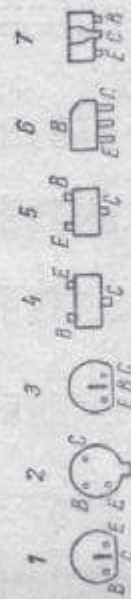


Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	h_{21E}, β	P_{Cmax} , mW (W)	Полоса	Забелешка
BC638	Si, p; D	-60*	(1)	130	25-160	800	1	BC637
BC639	Si, n; D	100*	(1)	130	25-160	800	1	BC640
BC640	Si, p; D	-100*	(1)	130	25-160	800	1	BC639
BC875	Si, Dn; D	60	(1)	200	>1000	800	1	BC876
BC876	Si, Dp; D	-60	(1)	200	>1000	800	1	BC875
BC877	Si, Dn; D	80	(1)	200	>1000	800	1	BC878
BC878	Si, Dp; D	-80	(1)	200	>1000	800	1	BC877
BC879	Si, Dn; D	100	(1)	200	>1000	800	1	BC880
BC880	Si, Dp; D	-100	(1)	200	>1000	800	1	BC879
BCAP07	Si, n; PL	45	100	150	>125	300	2	
BCAP08	Si, n; PL	20	100	150	>125	300	2	
BCAP09	Si, n; PL	20	100	150	>240	300	2	
BCAP11	Si, n; PL	80	150	300	40-250	800	2	
BCAP13	Si, p; PL	-60	150	50	40-250	800	2	
BCAP38	Si, n; PL	20	50	300	>100	300	3	
BCAP58	Si, p; PL	-30	50	150	65-240	300	3	
BCAP77	Si, p; PL	-50	100	150	65-240	300	3	
BCAP78	Si, p; PL	-30	100	150	65-480	300	2	
BCAP79	Si, p; PL	-25	100	150	>110	300	2	
BCE107	Si, n; PL	45	100	400	>180	150	4	
BCE108	Si, n; PL	20	100	400	>180	150	4	
BCE109	Si, n; PL	20	100	400	>290	150	4	
BCE177	Si, p; PL	-50	100	250	65-480	150	4	
BCE178	Si, p; PL	-30	100	250	65-850	150	4	
BCE179	Si, p; PL	-25	100	250	>250	150	4	
BCV26	Si, Dp; D	-40	500	200	>4000	150	5	BCV27
BCV27	Si, Dn; D	40	500	200	>4000	150	5	BCV26
BCV46	Si, Dp; D	-80	500	200	>2000	150	5	BCV47
BCV47	Si, Dn; D	80	500	200	>2000	150	5	BCV46
BCW46	Si, n; D	80	100	1	>125	200	6	
BCW60	Si, n; D	32*	200	250	80-500	310	5	
BCW60F	Si, n; D	32*	200	250	80-500	310	5	
BCW60R	Si, n; D	32*	200	250	80-500	310	5	
BCW61	Si, p; D	-32*	200	180	>140	310	5	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	h_{21E}, β	P_{Cmax} , mW (W)	Полоса	Забелешка
BCW61F	Si, p; D	-32*	200	180	>140	310	5	
BCW61R	Si, p; D	-32*	200	180	>140	310	5	
BCW65	Si, n; D	32*	800	100	>35	360	5	
BCW65R	Si, n; D	32	800	100	>35	360	5	
BCW86	Si, n; D	45	800	100	>35	360	5	
BCW66R	Si, n; D	450	800	100	>35	360	5	
BCW67	Si, p; D	-32	800	100	>75	360	5	
BCW67R	Si, p; D	-32	800	100	>75	360	5	
BCW68	Si, p; D	-45*	800	100	>75	360	5	
BCW68R	Si, p; D	-45*	800	100	>75	360	5	
BCX22	Si, n; D	125*	800	100	>63	450	2	
BCX23	Si, p; D	-125*	800	100	>63	450	2	
BCX24	Si, n; D	100*	800	100	>40	450	2	
BCX39	Si, p; D	-100	800	100	>63	450	2	
BCX41	Si, n; D	125	800	100	>25	350	5	
BCX41R	Si, n; D	125	800	100	>25	350	5	
BCX42	Si, p; D	-125	800	100	>30	350	5	
BCX42R	Si, p; D	-125	800	100	>30	350	5	
BCX51	Si, p; D	-45	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX52	Si, p; D	-60	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX53	Si, p; D	100	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX54	Si, n; D	45	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX55	Si, n; D	60	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX56	Si, n; D	100	(1)	50	>25	(3)	7	
BCX58	Si, n; D	32*	100	250	>80	450	3	BCX78
BCX59	Si, n; D	45*	100	250	>80	450	3	BCX79
BCX68	Si, n; D	20*	(1)	65	>50	(3)	7	BCX69
BCX69	Si, p; D	-20*	(1)	65	>50	(3)	7	BCX68
BCX70	Si, n; D	45*	200	250	>80	310	5	
BCX70R	Si, n; D	45*	200	250	>80	310	5	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (кГц)	h_{21E} , р	$P_{C\max}$, мВт (Вт)	Почка	Забелешка
BCX71	Si, p; D	-45	100	180	250	150	1	
BCX71R	Si, p; D	-45	200	180	140	310	1	
BCX73	Si, n; D	32*	800	100	>50	625	2	
BCX74	Si, n; D	45*	800	100	>50	625	2	
BCX75	Si, p; D	-32*	800	100	>50	625	2	
BCX76	Si, p; D	-45*	800	100	>50	625	2	
BCX78	Si, p; D	-32	100	200	>140	450	2	
BCX79	Si, p; D	-45	100	200	>140	450	2	
BCX94	Si, n; D	100*	800	100	>63	450	3	
BCY10	Si, p; D	-32	500	1,5	>24	260	4	
BCY30	Si, p; NL	-64	50	1,2	10-35	250	3	
BCY31	Si, p; D	-64	50	1,7	15-60	250	3	
BCY32	Si, p; NL	-64	50	2,5	20-70	250	3	
BCY33	Si, p; NL	-64	50	1,5	10-35	250	3	
BCY34	Si, p; NL	-64	50	2,4	15-60	250	3	
BCY38	Si, p; NL	-32	250	1,5	10-30	250	3	
BCY39	Si, p; NL	-64	250	1,5	10-50	250	3	
BCY40	Si, p; NL	-32	250	2,5	15-120	250	3	
BCY54	Si, p; NL	-50	250	2	12-70	250	3	
BCY56	Si, n; D	45	100	85	40-800	260	3	
BCY57	Si, n; D	25	100	100	100-800	260	3	
BCY58	Si, n; D	32	200	250	80-520	200	3	ИМП
BCY59	Si, n; D	45	200	250	80-520	200	3	ИМП
BCY65E	Si, n; D	60	100	250	78-350	(1)	3	ИМП
BCY66	Si, n; D	45*	50	250	40-630	(1)	3	BCY66
BCY67	Si, p; D	-45*	50	180	40-630	(1)	3	
BCY70	Si, p; NL	-50	200	250	>15	350	3	
BCY71	Si, p; NL	-45	200	300	>90	200	3	
BCY72	Si, p; NL	-25	200	200	>50	200	3	
BCY77	Si, p; D	-60*	100	180	>180	(1)	3	
BCY78	Si, p; D	-32	200	200	180	(1)	3	ИМП
BCY79	Si, p; D	-45	200	200	180	(1)	3	ИМП
BCY85	Si, n; D	100	200	300	100	300	2	
BCY86	Si, n; D	80	200	300	100	300	2	
BCY91	Si, p; D	-40	50	15	80	350	3	



Биполярни транзистори

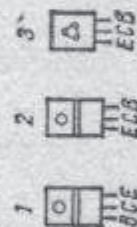
Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (кГц)	h_{21E} , р	$P_{C\max}$, мВт (Вт)	Почка	Забелешка
BCZ11	Si, p; D	-25	50	1,5*	35	210	4	
BCZ13	Si, p; D	-20	10	0,5	20	85	5	
BCZ14	Si, p; D	-20	10	0,5	60	85	5	
BD106	Si, n; GB	36	(2,5)	100	50	(11,5)	6	
BD107	Si, n; D	64	(2,5)	100	50	(11,5)	6	
BD109	Si, n; D	60	(3)	30	30	(15)	6	
BD115	Si, n; NL	245	150	145	20-60	(6)	3	BB
BD130	Si, n; D	100	(15)	1,1	20-70	(100)	3	BS
BD131	Si, n; NL	70	(3)	60	>40	(11)	7	
BD132	Si, p; CS	-45	(3)	60	>40	(11)	7	
BD133	Si, n; NL	90	(3)	60	>40	(11)	7	
BD135	Si, n; D	45	(1)	50	40-250	(6)	7	BD136
BD136	Si, p; D	-45	(1)	75	40-250	(6)	7	BD135
BD137	Si, n; D	60	(1)	50	25-160	(6)	7	BD138
BD138	Si, p; D	-60	(1)	75	25-160	(6)	7	BD137
BD139	Si, n; D	80	(1)	50	40-160	(6)	7	BD140
BD140	Si, p; D	-80	(1)	75	40-160	(6)	7	BD139
BD142	Si, n; I	50	(15)	1,3	20-250	(117)	6	
BD160	Si, n; NL	250	(5)	5	>20	(10)	6	BB
BD162	Si, n; I	40	(4)	1	40-180	(23)	6	
BD163	Si, n; I	60	(4)	1	20-180	(23)	6	
BD165	Si, n; H	45	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD166	Si, p; D	-45	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD167	Si, n; D	60	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD168	Si, p; D	-60	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD169	Si, n; D	80	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD170	Si, p; H	-80	(1,5)	3	>40	(20)	7	
BD181	Si, n; NL	55	(10)	5	20-70	(78)	6	
BD182	Si, n; NL	70	(15)	5	20-70	(117)	6	
BD183	Si, n; NL	85	(15)	5	20-70	(117)	6	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} V	I_{C}^{max} mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$ MHz (kHz)	h_{21E}^{*}	P_{C}^{max} mW (W)	Плотка	Забелешка
BD534	Si, p; I	-45	(4)	3	>20	(50)	1	BD533
BD535	Si, n; I	60	(4)	3	>20	(50)	1	BD536
BD536	Si, p; I	-60	(4)	3	>20	(50)	1	BD535
BD537	Si, n; I	80	(4)	3	>20	(50)	1	BD538
BD538	Si, p; I	-80	(4)	3	>20	(50)	1	BD537
BD611	Si, n; D	22	(4)	3	>40	(15)	2	BD612
BD612	Si, p; D	-22	(4)	3	>40	(15)	2	BD611
BD613	Si, n; D	32	(4)	3	>40	(15)	2	BD614
BD614	Si, p; D	-32	(4)	3	>40	(15)	2	BD613
BD615	Si, n; D	45	(4)	3	>30	(15)	2	BD616
BD616	Si, p; D	-45	(4)	3	>30	(15)	2	BD615
BD617	Si, n; D	60	(4)	3	>20	(15)	2	BD618
BD618	Si, p; D	-60	(4)	3	>20	(15)	2	BD617
BD619	Si, n; D	80	(4)	3	>15	(15)	2	BD620
BD620	Si, p; D	-80	(4)	3	>15	(15)	2	BD619
BD643	Si, Dn; D	45	(8)	1	>750	(62)	1	BD644
BD644	Si, Dp; D	-45	(8)	1	>750	(62)	1	BD643
BD645	Si, Dn; D	60	(8)	1	>750	(62)	1	BD646
BD646	Si, Dp; D	-60	(8)	1	>750	(62)	1	BD645
BD647	Si, Dn; D	80	(8)	1	>750	(62)	1	BD648
BD648	Si, Dp; D	-80	(8)	1	>750	(62)	1	BD647
BD649	Si, Dn; D	100	(8)	1	>750	(62)	1	BD650
BD650	Si, Dp; D	-100	(8)	1	>750	(62)	1	BD649
BD651	Si, Dn; D	120	(8)	1	>750	(62)	1	BD652
BD652	Si, Dp; D	-120	(8)	1	>750	(62)	1	BD651
BD663	Si, n; I	60	(10)	3	20-250	(75)	1	BD676
BD675	Si, Dn; D	45	(4)	1	>750	(40)	2	BD676
BD676	Si, Dp; D	-45	(4)	1	>750	(40)	2	BD675
BD677	Si, Dn; D	60	(4)	1	>750	(40)	2	BD678
BD678	Si, Dp; D	-60	(4)	1	>750	(40)	2	BD677
BD679	Si, Dn; D	80	(4)	1	>750	(40)	2	BD680
BD680	Si, Dp; D	-80	(4)	1	>750	(40)	2	BD679
BD681	Si, Dn; D	100	(4)	7	>750	(40)	3	BD682
BD682	Si, Dp; D	-100	(4)	7	>750	(40)	3	BD681
BD813	Si, n; NL	45	(2)	6	>30	(12)	2	

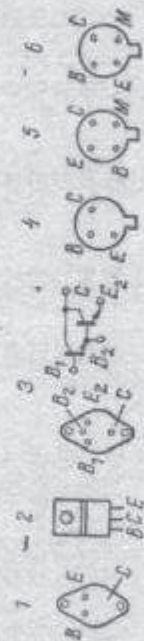
Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} V	I_{C}^{max} mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$ MHz (kHz)	h_{21E}^{*}	P_{C}^{max} mW (W)	Плотка	Забелешка
BD814	Si, p; NL	-45	(2)	6	>30	(12)	2	
BD815	Si, n; NL	60	(2)	6	>30	(12)	2	
BD816	Si, p; NL	-60	(2)	6	>30	(12)	2	
BD817	Si, n; NL	100	(2)	6	>30	(12)	2	
BD818	Si, p; NL	-100	(2)	6	>30	(12)	2	
BD819	Si, n; NL	120	(2)	6	>30	(12)	2	
BD820	Si, p; NL	-120	(2)	6	>30	(12)	2	
BD821	Si, n; NL	140	(2)	6	>30	(12)	2	
BD822	Si, p; NL	-140	(2)	6	>30	(12)	2	
BD825	Si, n; D	45	(1.5)	50	25-160	(8)	2	BD826
BD826	Si, p; D	-45	(1.5)	50	25-160	(8)	2	BD825
BD827	Si, n; D	60	(1.5)	50	25-100	(8)	2	BD828
BD828	Si, p; D	-60	(1.5)	50	25-100	(8)	2	BD827
BD829	Si, n; D	100	(1.5)	50	25-100	(8)	2	BD830
BD830	Si, p; D	-100	(1.5)	50	25-100	(8)	2	BD829
BD861	Si, Dn; D	45	(4)	1	>750	(15)	2	BD862
BD862	Si, Dp; D	-45	(4)	1	>750	(15)	2	BD861
BD863	Si, Dn; D	60	(4)	1	>750	(15)	2	BD864
BD864	Si, Dp; D	-60	(4)	1	>750	(15)	2	BD863
BD865	Si, Dn; D	80	(4)	1	>750	(15)	2	BD866
BD866	Si, Dp; D	-80	(4)	1	>750	(15)	2	BD865
BD875	Si, Dn; D	60	(1)	200	>1000	(9)	3	BD876
BD876	Si, Dp; D	-60	(1)	200	>1000	(9)	3	BD875
BD877	Si, Dn; D	80	(1)	200	>1000	(9)	3	BD878
BD878	Si, Dp; D	-80	(1)	200	>1000	(9)	3	BD877
BD879	Si, Dn; D	100	(1)	200	>1000	(9)	3	BD880
BD880	Si, Dp; D	-100	(1)	200	>1000	(9)	3	BD879
BD933	Si, n; NL	45	(3)	3	>30	(30)	1	
BD934	Si, p; NL	-45	(3)	3	>30	(30)	1	
BD935	Si, n; NL	60	(3)	3	>30	(30)	1	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
BDX62B	Si, Dp; NL	-100	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX62C	Si, Dp; NL	-120	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX63	Si, Dn; NL	80	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX63A	Si, Dn; NL	100	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX63B	Si, Dn; NL	120	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX63C	Si, Dn; NL	140	(8)	3	>1000	(90)	1	
BDX64	Si, Dp; NL	-60	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX64A	Si, Dp; NL	-80	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX64B	Si, Dp; NL	-100	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX64C	Si, Dp; NL	-120	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX65	Si, Dn; NL	80	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX65A	Si, Dn; NL	100	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX65B	Si, Dn; NL	120	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX65C	Si, Dn; NL	140	(12)	3	>1000	(117)	1	
BDX66	Si, Dp; NL	-60	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX66A	Si, Dp; NL	-80	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX66B	Si, Dp; NL	-100	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX66C	Si, Dp; NL	-120	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX67	Si, Dn; NL	80	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX67B	Si, Dn; NL	120	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX67C	Si, Dn; NL	140	(16)	3	>1000	(150)	1	
BDX70	Si, n; NL	70	(10)	3	20-80	(75)	2	
BDX71	Si, n; NL	70	(10)	3	20-80	(75)	2	
BDX72	Si, n; NL	80	(10)	3	20-80	(75)	2	
BDX73	Si, n; I	80	(10)	3	20-80	(75)	2	
BDX74	Si, n; I	45	(16)	3	20-80	(75)	2	
BDX75	Si, n; I	45	(16)	3	20-80	(75)	2	
BDX77	Si, n; NL	100	(8)	3	>30	(60)	2	
BDX78	Si, p; NL	-100	(8)	3	>30	(60)	2	
BDX91	Si, n; NL	60	(8)	3	>30	(90)	1	
BDX92	Si p; NL	-60	(8)	3	>30	(90)	1	
BDX93	Si n; NL	80	(8)	3	>30	(90)	1	
BDX94	Si p; NL	-80	(8)	3	>30	(90)	1	
BDX95	Si n; NL	100	(8)	3	>30	(90)	1	
BDX96	Si p; NL	-100	(8)	3	>30	(90)	1	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	β	$P_{C\max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
BDY11	Si, n; D	100	(2)	1	>12	(150)	1	ММ
BDY12	Si, n; D	60	(3)	70	55-120	(26)	1	ММ
BDY13	Si, n; D	80	(3)	7	55-120	(26)	1	ММ
BDY20	Si, n; NL	100	(15)	1	20-70	(115)	1	
BDY23	Si, n; PL	60	(8)	10	15-180	(87)	1	
BDY24	Si, n; PL	100	(8)	10	15-180	(87)	1	ВВ
BDY25	Si, n; PL	200	(8)	10	15-180	(87)	1	ВВ
BDY38	Si, n; NL	50	(6)	1	>30	(115)	1	
BDY60	Si, n; NL	120	(5)	100	>45	(15)	1	
BDY61	Si, n; NL	100	(5)	100	>45	(15)	1	
BDY73	Si, n; H	100	(15)	0,8	>50	(117)	1	
BDY87	Si, Dn; D	20	(8)	1,5	>1000	(35)	3	
BDY90	Si, n; NL	100*	(10)	3	>30	(40)	1	
BDY91	Si, n; NL	80*	(10)	3	>30	(40)	1	
BDY92	Si, n; NL	60*	(10)	3	>30	(40)	1	
BDY93	Si, n; NL	750	(3)	8	15-60	(30)	1	ВВ
BDY94	Si, n; NL	750	(3)	8	25-80	(30)	1	ВВ
BDY95	Si, n; NL	600	(3)	8	25-80	(30)	1	ВВ
BDY95	Si, n; NL	750	(10)	10	15-60	(40)	1	ВВ
BDY98	Si, n; NL	600	(10)	10	25-80	(40)	1	ВВ
BF108	Si, n; F	135	30	100	50	180	4	
BF109	Si, n; D	135	50	80	>20	520	4	
BF115	Si, n; D	50	30	230	40-165	145	5	
BF117	Si, n; D	140	100	80	>25	(1,3)	4	
BF120	Si, n; D	220*	50	100	>20	300	4	
BF137	Si, n; D	160	100	95	>25	680	4	
BF140	Si, n; F	135*	30	40*	>15	800	4	ВВ
BF155	Si, n; I	40	20	600	70	175	6	ВВ
BF167	Si, n; D	40	25	350	55	130	5	
BF173	Si, n; D	40	25	550	115	260	5	ВВ

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T\alpha}$, MHz (kHz)	$k_{21}E_{\alpha}$, %	$P_{C\max}$, mW (W)	Цепка	Забелешка
BF177	Si, n; H	100	40	120	>20	600	1	
BF178	Si, n; H	160	50*	120	>20	600	1	
BF179	Si, n; D	160	50	120	>20	600	1	
BF184	Si, n; D	30	30	260	70-250	145	1	
BF185	Si, n; D	30	30	200	33-140	145	1	
BF194	Si, n; D	30	30	260	115	300	2	
BF195	Si, n; D	30	30	300	67	300	2	
BF196	Si, n; D	40	25	400	>20	300	2	вч
BF198	Si, n; D	40	25	400	>25	500	3	вч
BF199	Si, n; D	40	25	550	>38	500	3	вч
BF200	Si, n; H	30	20	380	>15	150	4	
BF224	Si, n; H	45	50	450	>30	250	5	вч
BF225	Si, n; H	50	40	700	>30	250	5	свч
BF240	Si, n; H	40	25	430	67-220	300	3	вч
BF241	Si, n; H	40	25	400	36-125	300	3	
BF254	Si, n; D	30	30	260	115	220	3	
BF255	Si, n; D	30	30	200	67	220	3	
BF257	Si, n; H	160	100	90	80	750	1	
BF258	Si, n; H	250	100	110	80	750	1	
BF259	Si, n; H	300	100	90	80	750	1	
BF310	Si, n; D	30	25	580	>30	300	5	вч
BF311	Si, n; D	35	40	750	40-80	360	3	свч
BF314	Si, n; D	30	25	450	>30	300	5	вч
BF324	Si, p; D	-30	25	350	45-160	250	5	
BF362	Si, n; D	20	20	800	>20	120	7	свч
BF363	Si, n; D	20	20	600	>10	120	7	свч
BF414	Si, p; D	-40	25	560	80	300	5	вч
BF420	Si, n; D	300	25	60	>40	830	6	BF421
BF421	Si, p; D	-300	25	60	>40	830	6	BF420
BF422	Si, n; D	250	25	60	50	830	6	BF423
BF423	Si, p; D	-250	25	60	50	830	6	BF422
BF440	Si, p; D	-40	25	250	60-220	300	3	
BF441	Si, p; D	-40	25	250	30-125	300	3	
BF450	Si, p; D	-40	25	375	60	250	3	вч
BF451	Si, p; D	-40	25	325	>30	250	3	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T\alpha}$, MHz (kHz)	$k_{21}E_{\alpha}$, %	$P_{C\max}$, mW (W)	Цепка	Забелешка
BF457	Si, n; D	160	100	90	80	(6)	8	
BF458	Si, n; D	250	100	90	20-80	(6)	8	
BF459	Si, n; D	300	100	90	80	(6)	8	
BF469	Si, n; D	250	30	60	>50	(2)	8	BF470
BF470	Si, p; D	-250	30	60	>50	(2)	8	BF469
BF471	Si, n; D	300	30	60	>40	(2)	8	BF472
BF472	Si, p; D	-300	30	60	>40	(2)	8	BF471
BF479	Si, p; D	-30	50	1800	20	160	7	свч
BF502	Si, n; D	40	20	700	>30	500	3	вч
BF503	Si, n; D	40	20	750	>30	500	3	вч
BF504	Si, n; PL	30	50	95	>30	250	1	
BF505	Si, n; PL	30	50	95	>30	250	1	
BF505	Si, n; D	30	20	750	30	500	3	вч
BF506	Si, p; H	-40	30	500	>20	300	5	вч
BF506	Si, n; PL	45	50	95	>70	250	1	
BF506	Si, p; D	-35	30	550	>25	300	5	вч
BF507	Si, n; D	30	2	750	30	500	3	вч
BF509	Si, p; H	-40	30	750	20	300	5	вч
BF516	Si, p; I	-40	20	850	50	150	4	вч
BF550	Si, p; D	-40	25	375	50	150	9	
BF554	Si, n; D	30	30	260	115	150	9	
BF552	Si, n; D	30	20	600	20	250	5	вч
BF558	Si, p; D	-40	30	1100	60	220	9	свч
BF569	Si, p; D	-40	30	850	50	220	9	свч
BF579	Si, p; D	-20	30	1600	20	220	9	свч
BF599	Si, n; D	40	25	550	85	150	9	вч
BF606A	Si, p; D	-40	25	650	30	300	3	вч
BF622	Si, n; D	250	20	60	>50	(2)	10	BF623
BF623	Si, p; D	-250	20	60	>50	(2)	10	BF622
BF660	Si, p; D	-40	25	650	30	150	9	вч

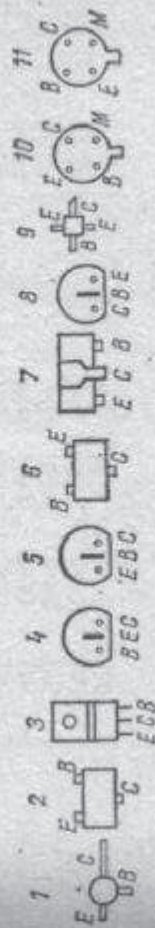


Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{FE} , β	$P_{C\max}$, Вт	Площадь	Заделка
BF679	Si, p; H	-40	30	880	>20	160	1	свч
BF679S	Si, p; H	-40	30	1100	>20	160	1	свч
BF680	Si, p; H	-40	30	750	>20	160	1	свч
BF676	Si, p; D	-30	20	950	60	200	2	свч
BF647	Si, p; D	-160	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF848	Si, p; D	-270	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF849	Si, p; D	-300	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF857	Si, n; D	160	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF858	Si, n; D	250	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF859	Si, n; D	300	100	90	>25	(1,8)	3	мвч
BF869	Si, n; D	250	30	60	>50	(1,6)	3	мвч
BF870	Si, p; D	-250	30	60	>50	(1,6)	3	мвч
BF871	Si, n; D	300	30	60	>40	(1,6)	3	мвч
BF872	Si, p; D	-300	30	60	>40	(1,6)	3	мвч
BF926	Si, p; D	-40	25	600	80	300	4	вч
BF939	Si, p; D	-30	20	750	50	350	5	вч
BF959	Si, n; D	30	30	1100	85	500	4	свч
BF967	Si, p; D	-30	20	950	60	160	1	свч
BF968	Si, p; D	-40	30	1100	60	160	1	свч
BF970	Si, p; D	-40	30	850	50	150	1	свч
BF970	Si, p; D	-30	50	1600	>20	160	1	свч
BF979S	Si, p; D	-30*	50	1600	>20	160	1	свч
BFE214	Si, n; PL	30	30	150	90	150	6	свч
BFE215	Si, n; PL	30	30	150	>35	150	6	свч
BFN16	Si, n; D	250	200	60	>25	(2)	7	BFN17
BFN17	Si, p; D	-250	200	60	>25	(2)	7	BFN16
BFN18	Si, p; D	-300	200	60	>25	(2)	7	BFN19
BFN19	Si, n; D	300	200	60	>25	(2)	7	BFN18
BFN20	Si, n; D	300	20	60	>40	(2)	7	BFN21
BFN21	Si, p; D	-300	20	6	>40	(2)	7	BFN20
BFN22	Si, n; D	250	25	60	>50	310	2	BFN23
BFN23	Si, p; D	-250	25	60	>50	310	2	BFN22
BFP22	Si, n; D	200	500	50	>25	625	8	BFP23
BFP23	Si, p; D	-200	500	50	>25	625	8	BFP22
BFQ17	Si, n; D	40	150	1200	>25	(1,5)	7	свч

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{FE} , β	$P_{C\max}$, Вт	Площадь	Заделка
BFQ19	Si, n; D	20	75	5000	50	550	7	свч
BFQ28	Si, n; D	20	15	5000	>20	200	9	свч
BFQ29	Si, n; D	20	30	4000	70	200	2	свч
BFQ41	Si, n; D	50	35	1000	40	(4)	9	свч
BFQ57	Si, n; D	25	35	6500	120	450	9	свч
BFQ58	Si, n; D	25	30	6500	120	450	9	свч
BFQ59	Si, n; D	27	35	4000	100	700	9	свч
BFQ60	Si, n; D	27	35	4000	100	700	9	свч
BFQ11A	Si, n; D	20	30	5000	>30	250	9	свч
BFQ14B	Si, n; D	20	30	6000	>30	250	9	свч
BFQ14C	Si, n; D	27	35	4300	>30	700	9	свч
BFQ15	Si, n; D	12*	20	3300	>30	200	10	свч
BFQ15A	Si, n; D	12*	30	4500	>25	200	10	свч
BFQ34	Si, n; D	12*	30	3000	>30	200	1	свч
BFQ34A	Si, n; D	12*	30	5000	>25	200	1	свч
BFQ35A	Si, n; D	12*	30	5000	>25	200	2	свч
BFQ63	Si, n; D	40	500	1000	>25	(3,5)	9	свч
BFQ64	Si, n; D	90	500	1000	>25	(3,5)	9	свч
BFQ65	Si, n; D	30	400	1200	>30	(5)	9	свч
BFQ90	Si, n; D	15	30	5000	>25	200	1	свч
BFQ91	Si, n; D	20*	50	5000	>30	250	1	свч
BFQ92	Si, n; D	15*	30	5000	>25	200	2	свч
BFQ93	Si, n; D	15*	50	5000	>25	200	2	свч
BFQ96	Si, n; D	20	90	5000	50	500	1	свч
BFS17	Si, n; D	25	25	1300	>20	200	2	свч
BFS17R	Si, n; D	25	25	1300	>30	200	2	свч
BFS18	Si, n; D	30	50	200	>35	150	2	ИМП
BFS18R	Si, n; D	30	30	200	>35	150	2	ИМП
BFS19	Si, n; D	30	30	260	65	150	2	ИМП
BFS19R	Si, n; D	30	30	260	65	150	2	ИМП



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	β	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плоть	Заделка
BFX48	Si, p; I	-30	100	550	>90	360	6	вч
BFX56	Si, n; D	60	400	700	>30	(2,2)	6	вч
BFX59	Si, n; D	30	100	900	>30	370	3	свч
BFX59F	Si, n; D	30	100	900	>30	370	3	свч
BFX60	Si, n; D	40	25	550	100	370	2	вч
BFX65	Si, p; D	-45	50	10	>40	360	6	мш
BFX89	Si, n; D	30	25	1200	>20	200	3	свч
BFY19	Si, n; D	30	100	400	>35	300	6	
BFY27	Si, n; D	70	50	250	>40	320	6	
BFY33	Si, n; H	50	500	100	>40	600	6	
BFY34	Si, n; H	75	500	100	>40	600	6	вч
BFY37	Si, n; D	25	100	270	>35	300	6	
BFY39	Si, n; D	45	100	150	>35	300	6	
BFY40	Si, n; D	60	800	60	>60	800	6	
BFY41	Si, n; D	120	600	60	>60	800	6	
BFY43	Si, n; D	140	100	60	>25	800	6	
BFY46	Si, n; H	75	500	120	>100	600	6	
BFY50	Si, n; D	80	(1)	100	>30	800	6	
BFY51	Si, n; D	60	(1)	110	>40	800	6	
BFY52	Si, n; D	40	(1)	120	>60	800	6	
BFY55	Si, n; D	80	(1)	60	>40	700	6	
BFY56A	Si, n; D	55*	(1)	60	>20	800	6	
BPY64	Si, p; I	-40	300	250	>60	700	6	
BFY68	Si, n; D	75	(1)	70	>100	700	6	
BFY80	Si, n; D	100	100	50	>30	260	6	
BFY85	Si, dn; D	45	100	50	>100	160	8	вч
BFY86	Si, dn; D	45	100	50	>180	160	8	свч
BFY88	Si, n; D	40	25	800	40	175	3	свч
BFY90	Si, n; D	30	(25)	1000	25	200	3	свч
BLW44	Si, n; D	50	(2)	1000	25	(4,3)	5	свч



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	β	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плоть	Заделка
BFS20	Si, n; D	30	25	450	85	150	1	вч
BFS20R	Si, n; D	30	25	450	85	150	1	вч
BFS55A	Si, n; D	20*	50	4500	>30	250	2	свч
BFS62	Si, n; D	40	25	580	>35	200	3	вч
BFT12	Si, n; D	25	150	1900	>25	700	4	свч
BFT65	Si, n; D	20*	50	9000	80	250	4	свч
BFT66	Si, n; D	20	30	4000	>30	200	2	свч
BFT67	Si, n; D	20	30	4000	>30	200	2	свч
BFT75	Si, n; D	20	50	5000	80	250	1	свч
BFT97	Si, n; D	20	30	4000	70	200	4	свч
BFT98	Si, n; D	20*	200	3000	>25	(2,2)	5	свч
BFT99	Si, n; D	20*	350	3000	>25	(4)	5	свч
BFW16	Si, n; D	40	150	1200	>25	700	6	свч
BFW16A	Si, n; D	40	150	1200	>25	(1,5)	6	свч
BFW20	Si, p; I	-50	50	100	>100	360	6	мш
BFW21	Si, p; I	-80	50	100	>100	360	6	мш
BFW22	Si, p; I	-45	50	100	>200	360	6	мш
BFW23	Si, p; I	-60	50	100	>250	360	6	мш
BFW30	Si, n; D	20	50	1600	>25	250	3	свч
BFW43	Si, p; I	-150	50	100	>40	400	6	вв
BFW44	Si, p; I	-150	50	100	>40	700	6	вв
BFW45	Si, n; NL	165	50	120	>20	(2,5)	6	
BFW63	Si, n; I	40	50	100	>25	150	3	
BFW64	Si, n; I	40	50	400	>30	150	3	
BFW68	Si, n; I	50	100	300	>50	360	6	
BFW92	Si, n; D	25	25	1900	>20	200	7	свч
BFW93	Si, n; D	18	50	1600	>25	200	7	свч
BFX17	Si, n; I	60	100	250	>20	800	6	
BFX18	Si, n; I	30	100	200	>20	175	3	
BFX19	Si, n; I	35	100	400	>20	200	3	
BFX20	Si, n; I	30	100	600	>20	260	3	свч
BFX21	Si, n; I	30	100	1000	>20	175	3	
BFX31	Si, n; I	30	100	100	>20	175	3	
BFX34	Si, n; NL	60	500	50	>40	800	6	
BFX45	Si, n; D	30	100	175	>90	125	6	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	β , K_{21}	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелюшка
BSS23	Si, n; D	45	(1)*	100	>20	500	1	
BSS27	Si, n; NL	45	(1)	50	>25	800	1	
BSS28	Si, n; NL	30	(1)	50	>30	800	1	
BSS29	Si, n; NL	30	(1)	50	>20	800	1	
BSS38	Si, n; NL	80	100	50	80	300	2	
BSS40	Si, n; NL	40	(1)*	50	>25	360	1	
BSS41	Si, n; NL	30	(1)*	50	>25	360	1	
BSS42	Si, n; D	120	(1.5)	100	>25	(1)	1	
BSS44	Si, p; I	-65	(5)*	80	>30	870	1	
BSS45	Si, n; D	85	(5)	50	>25	870	1	
BSS46	Si, p; D	-85	(5)*	70	>25	870	1	
BSS50	Si, n; NL	45	(1)	30	>50	800	1	
BSS51	Si, n; NL	60	(1)	50	>50	800	1	
BSS52	Si, n; NL	80	(1)	50	>50	800	1	
BSS59	Si, n; D	140	(1)*	100	>20	500	1	
BSS63	Si, p; D	-110	100	50	>30	200	3	вв
BSS64	Si, n; D	120	100	50	>30	200	3	вв
BSS68	Si, p; NL	-100	100	30	>60	300	2	
BSS79	Si, n; D	75	800	250	>40	350	3	нмч
BSS80	Si, p; D	-60	800	200	>40	350	3	нмч
BSS81	Si, n; D	75	800	250	>40	350	3	нмч
BSS82	Si, p; D	-60	800	200	>40	350	3	нмч
BSV15	Si, p; D	-40	(1)	50	>40	(3,2)	1	нч
BSV16	Si, p; D	-60*	(1)	50	>40	(5)	1	нч
BSV17	Si, p; D	-80*	(1)	50	>40	(5)	1	нч
BSV60	Si, n; D	45	(3)	50	>25	800	1	
BSV65	Si, n; D	20	150	280	>40	150	3	
BSV69	Si, n; D	45	(1)*	100	>20	500	1	
BSVP20	Si, n; PL	40	200	150	>30	240	4	
BSVP30	Si, n; PL	40	100	300	>30	240	4	
BSW19	Si, p; D	-35	100	150	>40	300	1	
BSW20	Si, p; D	-35	100	150	>40	300	5	
BSW22	Si, p; I	-25	200	300	>180	300	1	
BSW33	Si, n; D	40	100	175	>50	125	6	
BSW39	Si, n; D	100	(1)	50	>20	790	1	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	β , K_{21}	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелюшка
BSW40	Si, p; D	-100	(1)	50	>20	790	1	вв
BSW49	Si, n; F	40	(1)	200	>30	600	1	вв
BSW67	Si, n; I	120	(1.5)	80	>15	(5)	1	
BSW68	Si, n; I	150	(1.5)	80	>15	(5)	1	
BSW72	Si, p; D	-40	500	250	>40	200	5	
BSW73	Si, p; D	-75	500	250	100	200	5	
BSW74	Si, p; D	-75	500	250	>40	200	5	
BSW75	Si, p; D	-75	500	250	100	200	5	
BSW82	Si, n; D	40	500	250	>40	200	5	
BSW83	Si, n; D	40	500	250	100	200	5	
BSW84	Si, n; D	75	500	250	>40	200	5	
BSW85	Si, n; D	75	500	250	100	200	5	
BSW89	Si, n; D	35	100	200	>60	230	5	
BSX19	Si, n; D	40	500*	400	>20	350	1	
BSX20	Si, n; H	40	200	600	>40	360	1	
BSX22	Si, n; D	40	(1.5)	100	>35	800	1	
BSX24	Si, n; D	32	100	200	>35	900	1	
BSX32	Si, n; H	65	(1)	300	>60	800	1	
BSX39	Si, n; I	45	100	600	>15	360	1	
BSX45	Si, n; D	40*	(1)	50	>40	(5)	1	нмч
BSX46	Si, n; D	60*	(1)	50	>40	(5)	1	нмч
BSX47	Si, n; D	80*	(1)	50	>40	(5)	1	нмч
BSX48	Si, n; D	50	600	400	>23	(1)	1	
BSX49	Si, n; D	60	600	400	>23	(1)	1	
BSX53	Si, n; D	35	100	200	>65	130	1	
BSX62	Si, n; D	40*	(3)	70	>40	(5)	1	нмч
BSX63	Si, n; D	60*	(3)	70	>40	(5)	1	нмч
BSX68	Si, n; D	30	100	175	>50	125	7	
BSX69	Si, n; D	30	100	175	>50	125	7	
BSX80	Si, n; D	35	230	200	>50	150	8	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_{T, f_a} , МГц (кГц)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плоть	Заделка
BSX81	Si, n; D	35	100	200	>50	230	1	ИМП
BSXE92	Si, n; PL	40	200	400	>40	200	2	ИМП
BSXE93	Si, n; PL	40	200	500	>40	200	2	ИМП
BSXE94	Si, n; PL	40	200	400	>40	200	2	ИМП
BSXP59	Si, n; PL	70	200	300	>25	800	3	ИМП
BSXP60	Si, n; PL	70	200	300	>25	800	3	ИМП
BSXP61	Si, n; PL	70	200	300	>25	800	3	ИМП
BSXP65	Si, n; PL	60	200	150	100	500	3	ИМП
BSXP66	Si, n; PL	60	200	150	>40	500	3	ИМП
BSXP67	Si, n; PL	60	200	150	>20	500	3	ИМП
BSXP87	Si, n; PL	40	200	300	>30	360	3	ИМП
BSXP92	Si, n; PL	40	200	400	>30	360	3	ИМП
BSXP93	Si, n; PL	40	200	500	>40	360	3	ИМП
BSXP94	Si, n; PL	40	200	400	>50	360	3	ИМП
BSY17	Si, n; D	20	200	280	>20	(1)	3	ИМП
BSY18	Si, n; D	20	200	280	>40	(1)	3	ИМП
BSY19	Si, n; D	40	200	300	>30	280	3	ИМП
BSY21	Si, n; D	40	500	300	>30	260	3	ИМП
BSY34	Si, n; D	60	600	400	>23	(2,5)	3	ИМП
BSY38	Si, n; D	20	200	350	>30	300	3	ИМП
BSY39	Si, n; D	20	200	360	>40	300	3	ИМП
BSY40	Si, p; GB	-25	100	210	>50	300	3	ИМП
BSY41	Si, p; GB	-25	100	230	>50	300	3	ИМП
BSY44	Si, n; D	75	(1)	60	>40	700	3	ИМП
BSY45	Si, n; D	120	(1)	50	>40	700	3	ИМП
BSY46	Si, n; D	80	(1)	50	>40	700	3	ИМП
BSY51	Si, n; D	60	500	100	>30	800	3	ИМП
BSY53	Si, n; D	75	750	100	>30	800	3	ИМП
BSY58	Si, n; D	50	600	400	>23	(2,5)	3	ИМП
BSY59	Si, n; D	30*	800	100	>35	280	4	ИМП
BSY61	Si, n; D	25	200	200	>45	300	5	ИМП
BSY62	Si, n; D	25	200	200	>30	(1)	3	ИМП
BSY63	Si, n; D	40	200	300	>40	(1)	3	ИМП
BSYP04	Si, p; PL	-60	300	250	>40	600	3	ИМП
BSYP05	Si, p; PL	-60	300	250	100	600	3	ИМП

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_{T, f_a} , МГц (кГц)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плоть	Заделка
BSYP06	Si, p; PL	-60	200	200	>40	400	3	ИМП
BSYP07	Si, p; PL	-60	200	200	100	400	3	ИМП
BSYP62	Si, n; PL	25	100	200	>20	360	3	ИМП
BSYP63	Si, n; PL	40	100	200	>30	360	3	ИМП
BU104	Si, n; H	150*	(7)	10	>10	(85)	6	ВВ
BU104D	Si, n; H	150*	(7)	10	>7	(85)	6	ВВ
BU105	Si, n; NL	1500	(2,5)	7	>10	(10)	6	ВВ
BU108	Si, n; NL	1500	(2)	7	>10	(12)	6	ВВ
BU109	Si, n; H	120*	(10)	10	>20	(85)	6	ВВ
BU109D	Si, n; H	120*	(10)	10	>7	(85)	6	ВВ
BU125	Si, n; I	130	(5)	100	40	800	3	ВВ
BU125S	Si, n; I	250	(1,2)	1	>30	(1)	3	ВВ
BU126	Si, n; H	300*	(3)	21	>15	(30)	6	ВВ
BU126A	Si, n; NL	750	(3)	8	>15	(30)	6	ВВ
BU132	Si, n; NL	800	(1)	8	>25	(15)	6	ВВ
BU133	Si, n; NL	750	(3)	8	>15	(30)	6	ВВ
BU204	Si, n; NL	1300	(2,5)	7	>2	(10)	6	ВВ
BU205	Si, n; NL	1500	(2,5)	7	>2	(10)	6	ВВ
BU206	Si, n; NL	1700	(2,5)	7	>2	(10)	6	ВВ
BU207	Si, n; NL	1300	(5)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU207A	Si, n; NL	600*	(5)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU208	Si, n; NL	1500	(5)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU208A	Si, n; D	700*	(5)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU209	Si, n; NL	1700	(4)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU209A	Si, n; NL	800*	(4)	7	>2	(12)	6	ВВ
BU325	Si, n; H	375*	(6)	6	>15	(60)	6	ВВ
BU325A	Si, n; H	400*	(6)	6	>15	(60)	6	ВВ
BU406	Si, n; I	400	(7)	10	>20	(60)	7	ВВ
BU407	Si, n; I	330	(7)	10	>20	(60)	7	ВВ



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA(A)	f_T, f_a , MHz(kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW(W)	Полоса	Забелешка
BU426	Si, n; D	375*	(6)	6	30	(70)	1	BB
BU426A	Si, n; D	400*	(6)	6	30	(70)	1	BB
BU433	Si, n; NL	375*	(6)	3	30	(70)	1	BB
BU626	Si, n; D	400*	(10)	6	>10	(100)	2	BB
BUW70	Si, n; D	150*	(10)	6	40	(80)	2	BB
BUW71	Si, n; D	450*	(5)	6	>15	(100)	2	BB
BUW72	Si, n; D	450*	(10)	6	>15	(100)	2	BB
BUW84	Si, n; NL	400*	(2)	3	>30	(50)	3	BB
BUW85	Si, n; NL	450*	(2)	3	>30	(50)	3	BB
BUX28	Si, Dn; D	350*	(8)	6	>10	(80)	2	BB
BUX80	Si, n; D	400*	(10)	6	>30	(100)	2	BB
BUX81	Si, n; D	450*	(10)	6	>30	(100)	2	BB
BUX82	Si, n; D	400*	(6)	6	>30	(75)	2	BB
BUX83	Si, n; D	450*	(6)	6	>30	(75)	2	BB
BUX84	Si, n; D	400*	(2)	20	10-50	(40)	4	BB
BUX85	Si, n; D	450*	(2)	20	10-50	(40)	4	BB
BUX86	Si, n; D	400*	500	20	10-50	(20)	5	BB
BUX87	Si, n; D	450*	500	20	10-50	(20)	5	BB
BUY12	Si, n; H	210*	(10)	26	>10	(70)	2	BB
BUY12T	Si, n; H	200*	(10)	12	>10	(50)	2	BB
BUY47	Si, n; I	150	(10)	90	15-130	(1)	6	BB
BUY48	Si, n; I	200	(10)	90	15-130	(1)	6	BB
BUY49S	Si, n; I	250	(1,5)	80	40-80	(1)	6	BB
BUY54	Si, n; PL	30	(5)	10	20	(50)	2	MBq
BUY68	Si, n; I	100	(5)	100	40-250	800	6	BB
BUYP52	Si, n; PL	120	(5)	10	>20	(50)	2	MBq
BUYP53	Si, n; PL	80	(5)	10	>20	(50)	2	MBq
BUYP54	Si, n; PL	40	(5)	10	>20	(50)	2	MBq
BY18S	Si, n; I	400	(7)	50	20-40	(50)	2	MBq
BY100A	Si, n; I	150	(10)	100	20-100	(25)	2	MBq
EFT0321	Ge, p; R	-24	250	1,0*	20	200	7	
EFT035	Ge, p; R	-24	150	1,0*	20	200	7	
EFT121	Ge, p; R	-24	250	1,3*	20	200	7	
EFT122	Ge, p; R	-24	250	1,6*	20	200	7	
EFT123	Ge, p; R	-24	250	2,6*	20	200	7	



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA(A)	f_T, f_a , MHz(kHz)	h_{21E} , β	$P_{C\max}$, mW(W)	Полоса	Забелешка
EFT124	Ge, p; R	-24	500	1,0*	30	350	7	
EFT125	Ge, p; R	-24	500	2,0*	70	350	7	
EFT130	Ge, p; R	-24	500	1,0*	30	350	7	
EFT131	Ge, p; R	-24	500	2,0*	70	350	7	
EFT151	Ge, p; R	-24	150	1,2*	40	200	7	
EFT152	Ge, p; R	-24	150	1,6*	50	200	7	
EFT153	Ge, p; R	-24	150	2,4*	50	200	7	
EFT212	Ge, p; R	-30	(3)	(200)	40	(30)	2	
EFT213	Ge, p; R	-40	(3)	(200)	40	(30)	2	
EFT214	Ge, p; R	-60	(3)	(200)	40	(30)	2	
EFT238	Ge, p; R	-40	(5)	(200)*	30	(45)	2	
EFT239	Ge, p; R	-60	(6)	(200)*	30	(45)	2	
EFT240	Ge, p; R	-80	(6)	(200)*	30	(45)	2	
EFT250	Ge, p; R	-80	(3)	(200)	40	(30)	2	
EFT306	Ge, p; R	-15	100	2,5*	30	150	7	
FT305B	Ge, p; R	-12	100	3*	50	150	7	
EFT306C	Ge, p; R	-9	100	3*	50	150	7	
EFT307	Ge, p; R	-15	100	5,7*	40	150	7	
EFT307B	Ge, p; R	-12	100	7*	30	150	7	
EF307C	Ge, p; R	-9	100	7*	40	150	7	
EFT308	Ge, p; R	-15	100	10,3*	50	150	7	
EFT308B	Ge, p; R	-12	100	13*	30	150	7	
EFT308C	Ge, p; R	-9	100	13*	40	150	7	
EFT311	Ge, p; R	-18	250	1,3	40	130	7	
EFT312	Ge, p; R	-18	250	1,6	40	130	7	
EFT313	Ge, p; R	-18	250	2	40	130	7	
EFT317	Ge, p; R	-20	10	40	30	150	7	
EFT319	Ge, p; R	-20	10	35	40	150	7	
EFT320	Ge, p; R	-20	10	35	30	150	7	
EFT321	Ge, p; R	-24	250	1,3*	30	200	7	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , В	I_{C}^{max} , А	f_T , МГц (кГц)	h_{FE} , %	P_{C}^{max} , Вт (В)	Полная	Забелешки
EFT321B	Ge, p; R	-18	250	1,3*	20	200	—	—
EFT321C	Ge, p; R	-12	250	1,3*	30	200	—	—
EFT322	Ge, p; R	-24	250	1,6*	50	200	—	—
EFT322B	Ge, p; R	-18	250	1,6*	30	200	—	—
EFT322C	Ge, p; R	-12	250	1,6*	30	200	—	—
EFT323	Ge, p; R	-24	250	2,6*	80	200	—	—
EFT323B	Ge, p; R	-18	250	2,6*	5	200	—	—
EFT323C	Ge, p; R	-12	250	2,6*	50	200	—	—
EFT323D	Ge, p; R	-24	250	2,6*	40	200	—	—
EFT331	Ge, p; R	-32	250	1,3	50	130	—	—
EFT332	Ge, p; R	-32	250	1,6	40	130	—	—
EFT333	Ge, p; R	-32	250	2	40	130	—	—
EFT341	Ge, p; R	-48	250	1,3	50	130	—	—
EFT342	Ge, p; R	-48	250	1,6	30	130	—	—
EFT343	Ge, p; R	-48	250	2	50	130	—	—
EFT351	Ge, p; R	-24	150	1,2*	30	20	—	—
EFT351B	Ge, p; R	-18	150	1,2*	40	200	—	—
EFT351C	Ge, p; R	-12	150	1,2*	40	200	—	—
EFT352	Ge, p; R	-24	150	1,6*	50	200	—	—
EFT352B	Ge, p; R	-18	150	1,6*	50	200	—	—
EFT352C	Ge, p; R	-12	150	1,6*	40	200	—	—
EFT353	Ge, p; R	-24	150	2,4*	80	200	—	—
EFT353B	Ge, p; R	-18	150	2,4*	50	200	—	—
EFT353C	Ge, p; R	-12	150	2,4*	40	200	—	—
GC100	Ge, p; DDR	-15	15	1,1*	18-100	30	1	—
GC101	Ge, p; DDR	-15	15	2,1*	18-100	30	2	—
GC102	Ge, p; DDR	-15*	50	6	20-150	100	2	—
GC103	Ge, p; DDR	-9*	15	1,2	20-150	100	2	—
GC104	Ge, p; DDR	-9*	15	1,2	20-150	100	2	—
GC111	Ge, p; DDR	-80*	125	(200)	10-80	120	2	—
GC112	Ge, p; DDR	-80*	150	(300)	10-80	92	2	—
GC115	Ge, p; DDR	-20	125	(500)	10-22	120	2	—
GC116	Ge, p; DDR	-20	150	(500)	18-100	92	2	—
GC117	Ge, p; DDR	-25	150	1,2	18-100	92	2	—



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , В	I_{C}^{max} , А	f_T , МГц (кГц)	h_{FE} , %	P_{C}^{max} , Вт (В)	Полная	Забелешки
GC118	Ge, p; DDR	-25	150	1,2	45-220	92	2	—
GC120	Ge, p; DDR	-20	150	(500)	10-20	120	2	—
GC121	Ge, p; DDR	-25	250	(100)	20-220	92	2	—
GC122	Ge, p; DDR	-35	250	(100)	20-140	92	2	—
GC123	Ge, p; DDR	-70	250	(100)	20-140	92	2	—
GC216	Ge, p; DDR	-20	100	(500)	20-130	75	2	—
GC217	Ge, p; DDR	-20	100	(500)	30-150	75	2	—
GC221	Ge, p; DDR	-20	100	(500)	20-140	75	2	—
GC223	Ge, p; DDR	-66	100	(500)	20-180	75	2	—
GC300	Ge, p; DDR	-20	500	(100)	20-200	600	2	—
GC301	Ge, p; DDR	-32	(1)	(100)	20-220	600	2	—
GC500	Ge, p; CS	-24	300	(500)	50	550	3	—
GC501	Ge, p; CS	-24	300	1	95	550	3	—
GC502	Ge, p; CS	-32	300	1	95	550	3	—
GC503	Ge, p; CS	-7	5	1	20-45	10	4	—
GC504	Ge, p; CS	-7	5	1	30-65	10	4	—
GC505	Ge, p; CS	-7	5	1	50-120	10	4	—
GC506	Ge, p; CS	-7	5	1	30-55	10	4	—
GC507	Ge, p; CS	-32	125	1*	40-300	125	3	—
GC508	Ge, p; CS	-32	125	1*	125	125	3	—
GC509	Ge, p; CS	-60	125	1*	125	125	3	—
GC510	Ge, p; CS	-32	(1)	1	60-175	200	3	—
GC510K	Ge, p; CS	-32	(1)	1	100-175	300	5	—
GC511	Ge, p; CS	-25	1	1	100-500	200	5	—
GC511K	Ge, p; CS	-25	1	1	100-500	300	3	GC521K
GC512	Ge, p; CS	-25	(1)	(550)	>25	200	3	—
GC512K	Ge, p; CS	-25	(1)	(550)	>25	300	5	—
GC515	Ge, p; CS	-32	125	(300)*	40	125	3	—
GC516	Ge, p; CS	-32	125	(300)*	40	125	3	—
GC517	Ge, p; CS	-32	125	(400)*	40	125	3	—

Биполярни транзистори

Означе- ние	Тип, Страна- производитель	U_{GB}^{max} , V	I_{Cmax}^{max} , A	$f_{T_{max}}$, MHz	η_{GE} , %	P_{Cmax}^{max} , mW	Плотн	Забелешка
GC518	Ge, p; CS	32	125	(700)*	50	125	1	
GC519	Ge, p; CS	32	125	(700)*	50	125	1	
GS320	Ge, n; CS	32	(1)	1	60-175	200	1	
GC520K	Ge, n; CS	32	(1)	1	60-175	300	2	
GC521	Ge, n; CS	25	(1)	1	10-500	200	1	
GC521K	Ge, n; CS	25	(1)	1	100-500	300	2	GC511K
GC525	Ge, n; CS	15	125	1,2	50	120	1	
GC526	Ge, n; CS	32	125	1,2	40	130	1	
GC527	Ge, n; CS	32	125	1,4	30	130	1	
GCN53	Ge, n; CS	30	250	(700)	40	125	1	
GCN54	Ge, n; CS	48	250	(700)*	40	125	1	
GCN55	Ge, p; CS	32	125	1*	50	125	1	
GCN56	Ge, p; CS	60	125	1*	30	125	1	
GD100	Ge, p; DDR	20	(1,3)	(100)	20	(2)	3	
GD110	Ge, p; DDR	20	(1,3)	(200)	>20	(2)	3	
GD120	Ge, p; DDR	33	(1,3)	(200)	25	(2)	3	
GD130	Ge, p; DDR	66	(1,3)	(200)	25	(2)	3	
GD150	Ge, p; DDR	20	(3)	(100)	15	(4)	3	
GD160	Ge, p; DDR	20	(3)	(250)	18-56	(4)	3	
GD170	Ge, p; DDR	33	(3)	(250)	18-90	(4)	3	
GD175	Ge, p; DDR	50	(3)	(250)	18-90	(4)	3	
GD180	Ge, p; DDR	66	(3)	(250)	18-90	(4)	3	
GD190	Ge, p; DDR	30	(1,5)	(350)	30	(2)	3	
GD191	Ge, p; DDR	40	(1,5)	(350)	30	(2)	3	
GD192	Ge, p; DDR	50	(1,5)	(350)	30	(2)	3	
GD200	Ge, p; DDR	30	(6)	(200)	30	(12)	3	
GD210	Ge, p; DDR	60	(6)	(200)	30	(12)	3	
GD220	Ge, p; DDR	80	(6)	(200)	30	(12)	3	
GD240	Ge, p; DDR	30	(3)	(300)	18-140	(10)	3	
GD241	Ge, p; DDR	40	(3)	(300)	18-140	(10)	3	
GD242	Ge, p; DDR	50	(3)	(300)	18-140	(10)	3	
GD243	Ge, p; DDR	65	(3)	(300)	18-90	(10)	3	
GD244	Ge, p; DDR	75	(3)	(300)	18-90	(10)	3	
GD607	Ge, n; CS	32	(1)	1	50	(4)	3	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{GB}^{max} , В	I_{Gmax}^{max} , мА (А)	$f_{T_{\alpha}}$, МГц (кГц)	h_{FE} , %	P_{Gmax}^{max} , Вт	Плотн.	Защелка
GD608	Ge, n; CS	25	(1)	1	40	(4)	3	
GD617	Ge, p; CS	32	(1)	1	40	(4)	3	
GD618	Ge, p; CS	25	(1)	1	40	(4)	3	
GD619	Ge, p; CS	25	(1)	1	40	(4)	3	
GF100	Ge, p; DDR	15	15	5*	20-100	50	4	
GF105	Ge, p; DDR	15	15	10,5*	110	50	4	
GF108	Ge, p; DDR	9	15	6	20-120	100	4	
GF120	Ge, p; DDR	25	10	30	50	50	5	
GF121	Ge, p; DDR	25	10	50	50	50	5	
GF121b	Ge, p; DDR	25	10	50	40	50	5	
GF122	Ge, p; DDR	25	10	50	50	50	5	
GF122b	Ge, p; DDR	25	10	50	30	50	5	
GF125	Ge, p; DDR	25	10	60	40	50	5	
GF126	Ge, p; DDR	25	10	10	50	50	5	
GF128	Ge, p; DDR	25	10	100	50	50	5	
GF129	Ge, p; DDR	25	10	75	40	30	5	
GF130	Ge, p; DDR	25	10	75	60	50	5	
GF131	Ge, p; DDR	25	10	85	80	50	5	
GF132	Ge, p; DDR	25	10	85	40	50	5	
GF134	Ge, p; DDR	10	10	180	80*	30	5	
GF135	Ge, p; DDR	15	10	150	70	30	4	
GF136	Ge, p; DDR	15	10	150	70	30	4	
GF137	Ge, p; DDR	15	10	200	100	30	4	
GF138	Ge, p; DDR	15	10	200	80	30	4	
GF139	Ge, p; DDR	25	10	11	60	50	5	
GF140	Ge, p; DDR	25	70	200	50	180	4	
GF141	Ge, p; DDR	25	70	400	60	180	4	
GF142	Ge, p; DDR	25	70	200	60	180	4	
GF143	Ge, p; DDR	25	70	400	60	180	4	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA	f_T , MHz	β_{hFE}	$P_{C\max}$, W	Повторя	Забелешка
GF145	Ge, p; DDR	-20	10	600	10-30	50	2	
GF146	Ge, p; DDR	-20	10	500	20	60	2	
GF147	Ge, p; DDR	-20	10	650	10-50	60	2	
GF180	Ge, p; DDR	-25	10	11	20	50	1	
GF181	Ge, p; DDR	-25	10	100	20	50	1	
GF501	Ge, p; CS	-24	100	300	40	300	3	
GF502	Ge, p; CS	-24	100	300	40	300	3	
GF503	Ge, p; CS	-24	100	300	40	300	3	
GF504	Ge, p; CS	-28	100	300	40	300	3	
GF505	Ge, p; CS	-24	10	170	40	60	3	
GF506	Ge, p; CS	-24	10	170	40	60	3	
GF507	Ge, p; CS	-20	10	250	40	60	2	
GF514	Ge, p; CS	-32	10	90	40	60	1	
GF515	Ge, p; CS	-32	10	60	40	60	1	
GF516	Ge, p; CS	-32	10	60	40	60	1	
GF517	Ge, p; CS	-20	10	50	40	60	1	
GFY50	Ge, p; CS	-20	10	50	40	50	4	
GS100	Ge, p; DDR	-25	50	5	50	30	3	
GS109	Ge, p; DDR	-20	50	5	30-140	83	3	
GS110	Ge, p; DDR	-15*	300	5*	50	80	3	
GS111	Ge, p; DDR	-20	200	1	30-140	83	3	
GS112	Ge, p; DDR	-20	200	1	30-140	83	3	
GS121	Ge, p; DDR	-30	100	2	30-160	150	3	
GS122	Ge, p; DDR	-30	100	5	30-220	150	3	
GS501	Ge, n; CS	20	400	18	40	150	3	
GS502	Ge, n; CS	20	400	18	30	150	3	
GS504	Ge, n; CS	20	400	18	40	150	5	
GS506	Ge, n; CS	15	10	10	40	85	6	
GS507	Ge, n; CS	15	30	10	40-300	85	6	
FT103A	Ge, p; SU	-32	200	0,7	>30	150	7	
FT103B	Ge, p; SU	-45	200	0,7	>30	150	7	
FT103B	Ge, p; SU	-60	250	0,7	>30	150	7	
FT104A	Ge, n; SU	32	150	1	>30	150	7	
FT104B	Ge, n; SU	32	150	1,5	>30	150	7	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA	f_T , MHz	β_{hFE}	$P_{C\max}$, W	Повторя	Забелешка
FT104B	Ge, n; SU	32	150	2,2		150	7	
FT108A	Ge, p; SU	-10	50	0,5*	20-50	75	8	
FT108B	Ge, p; SU	-10	50	1*	35-80	75	8	
FT108B	Ge, p; SU	-10	50	1*	60-180	75	8	
FT108F	Ge, p; SU	-10	50	1*	110-330	75	8	
FT109A	Ge, p; SU	-10	20	1*	20-50	30	9	
FT109B	Ge, p; SU	-10	20	1*	35-80	30	9	
FT109B	Ge, p; SU	-10	20	1*	60-130	30	9	
FT109Г	Ge, p; SU	-10	20	1*	110-250	30	9	
FT109Д	Ge, p; SU	-10	20	3*	20-70	30	9	
FT109E	Ge, p; SU	-10	20	5*	50-100	30	9	
FT109Ж	Ge, p; SU	-10	20	1*	100	30	9	
FT109И	Ge, p; SU	-10	20	1*	20-80	30	9	
FT110A	Ge, p; SU	-15	20	0,1*	10	150	6	
FT111A	Ge, p; SU	-5	5	0,1*	10	50	7	
FT115A	Ge, p; SU	-20	30	1*	20-80	50	8	
FT115B	Ge, p; SU	-30	30	1*	20-80	50	8	
FT115B	Ge, p; SU	-20	30	1*	60-150	50	8	
FT115Г	Ge, p; SU	-30	30	1*	60-150	50	8	
FT115Д	Ge, p; SU	-20	30	1*	125-250	50	8	
FT203A	Ge, p; BG	-30	250	7,5	20	150	5	
FT203B	Ge, p; BG	-24	250	12	30	150	3	
FT203B	Ge, p; BG	-18	250	25	40	150	3	
FT204A	Ge, p; BG	-10	5	5	10-200	50	7	
FT301A	Ge, p; BG	-20	10	40	40	150	7	
FT301B	Ge, p; BG	-20	10	27	30	150	7	
FT301B	Ge, p; BG	-20	10	20	30	150	7	
FT301Г	Ge, p; BG	-20	10	65	30	150	7	
FT301Д	Ge, p; BG	-20	10	68	30	150	7	
FT301E	Ge, p; BG	-20	10	87	30	150	7	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\ max}$, V	$I_{C\ max}$, mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	h_{21E}, β	$P_{C\ max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
ГТ301Ж	Ge, p; BG	-20	10	100	30	150	1	
ГТ302А	Ge, p; BG	-32	10	50	30	120	1	
ГТ302Б	Ge, p; BG	-32	10	60	30	120	1	
ГТ302В	Ge, p; BG	-32	10	70	40	120	1	
ГТ302Г	Ge, p; BG	-32	10	85	40	120	1	
ГТ305А	Ge, p; SU	-15	40	140	25-40	75	3	
ГТ305Б	Ge, p; SU	-15	40	160	50-500	75	2	
ГТ305В	Ge, p; SU	-15	40	160	40-360	75	2	
ГТ308А	Ge, p; SU	-20	50	90	20-75	150	3	
ГТ308Б	Ge, p; SU	-20	50	120	50-120	150	3	
ГТ308В	Ge, p; SU	-20	50	120	80-200	150	3	
ГТ309А	Ge, p; SU	-12	10	120	20-70	50	2	
ГТ309Б	Ge, p; SU	-12	10	120	60-180	50	2	
ГТ309Г	Ge, p; SU	-12	10	80	20-70	50	2	
ГТ309Д	Ge, p; SU	-12	10	40	20-70	50	2	
ГТ309Е	Ge, p; SU	-12	10	40	60-180	50	2	
ГТ310А	Ge, p; SU	-12	10	160	20-70	20	4	
ГТ310Б	Ge, p; SU	-12	10	160	60-180	20	4	
ГТ310Г	Ge, p; SU	-12	10	120	20-70	20	4	
ГТ310Д	Ge, p; SU	-12	10	120	60-180	20	4	
ГТ310Е	Ge, p; SU	-12	10	80	50	150	5	
ГТ311А	Ge, n; SU	12	20	100	50	150	5	
ГТ311Б	Ge, n; SU	12	20	100	50	150	5	
ГТ311В	Ge, n; SU	12	20	100	50	150	5	
ГТ311Г	Ge, n; SU	12	20	100	40	150	5	
ГТ311Д	Ge, n; SU	12	20	100	40	150	5	
ГТ311Е	Ge, n; SU	12	50	250	15-80	150	5	
ГТ311Ж	Ge, n; SU	12	50	300	50-200	150	5	
ГТ311И	Ge, n; SU	12	50	450	100-300	150	5	
ГТ313А	Ge, p; SU	-15	10	300	20-250	100	5	
ГТ313Б	Ge, p; SU	-15	10	450	20-250	100	5	
ГТ320А	Ge, p; SU	-20	150	80	20-80	200	6	
ГТ320Б	Ge, p; SU	-20	150	120	50-160	200	6	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\ max}$, V	$I_{C\ max}$, mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	h_{21E}, β	$P_{C\ max}$, mW (W)	Полоса	Забелешка
ГТ320В	Ge, p; SU	-20	150	160	80-250	200	6	
ГТ321А	Ge, p; SU	-60	200	60	20-60	180	6	
ГТ321Б	Ge, p; SU	-60	200	60	40-120	160	6	
ГТ321В	Ge, p; SU	-60	200	60	80-200	160	6	
ГТ321Г	Ge, p; SU	-45	200	60	20-60	160	6	
ГТ321Д	Ge, p; SU	-45	200	60	40-120	160	6	
ГТ321Е	Ge, p; SU	-45	200	60	80-200	160	6	
ГТ322А	Ge, p; SU	-15	5	80	30-100	50	7	
ГТ322Б	Ge, p; SU	-15	5	80	50-120	50	7	
ГТ322В	Ge, p; SU	-15	5	50	20-120	50	7	
ГТ322Г	Ge, p; SU	-15	5	50	30	50	7	
ГТ322Д	Ge, p; SU	-15	5	50	30	50	7	
ГТ322Е	Ge, p; SU	-15	5	50	30	50	7	
ГТ323А	Ge, n; SU	20	(1)*	200	20-60	250	6	
ГТ323Б	Ge, n; SU	20	(1)*	200	40-120	250	6	
ГТ323В	Ge, n; SU	20	(1)*	300	80-200	250	6	
ГТ328А	Ge, p; SU	-15	10	400	20-200	50	7	
ГТ328Б	Ge, p; SU	-15	10	300	40-200	50	7	
ГТ328В	Ge, p; SU	-15	10	300	10-50	50	7	
ГТ329А	Ge, n; SU	10	15	120	15-300	20	8	
ГТ329Б	Ge, n; SU	10	15	1500	15-300	20	8	
ГТ329В	Ge, n; SU	10	15	2000	15-300	20	8	
ГТ329Г	Ge, n; SU	10	20	690	35-300	50	8	
ГТ330А	Ge, n; SU	10	20	1000	15-300	50	8	
ГТ330Д	Ge, n; SU	10	20	1500	10-400	50	8	
ГТ330Ж	Ge, n; SU	10	20	500	30-400	50	8	
ГТ330И	Ge, n; SU	10	20	1000	10-400	50	8	
ГТ338А	Ge, np; SU	-20	(1)*	(15)		100	6	
ГТ338Б	Ge, np; SU	-20	(1)*	(15)		100	6	
ГТ338В	Ge, np; SU	-20	(1)*	(15)		100	6	



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T, f_a , МГц (kHz)	R_{21E} , Ом	P_{Cmax} , мВт (Вт)	Площадь	Забелешка
ГТ341А	Ge, n; SU	10	10	1500	15-300	35	1	свч
ГТ341Б	Ge, n; SU	10	10	2000	15-300	35	1	свч
ГТ341В	Ge, n; SU	10	10	1500	15-300	35	1	свч
ГТ346А	Ge, p; SU	-15	10	700	10-200	40	2	
ГТ346Б	Ge, p; SU	-15	10	550	10-250	40	2	
ГТ346В	Ge, p; SU	-15	10	550	15-150	40	2	
ГТ362А	Ge, n; SU	5	10	2400	10-200	40	1	свч
ГТ362Б	Ge, n; SU	5	10	2400	10-250	40	1	свч
ГТ376А	Ge, p; SU	-7	10	1000	10-150	35	2	
ГТ402А	Ge, p; SU	-25	500	1*	30-80	600	3	ГТ404А
ГТ402Б	Ge, p; SU	-25	500	1*	60-150	600	3	ГТ404Б
ГТ402В	Ge, p; SU	-25	500	1*	30-80	600	3	
ГТ402Г	Ge, p; SU	-25	500	1*	60-150	600	3	
ГТ402Д	Ge, p; SU	-25	500	1*	30-80	600	3	
ГТ402Е	Ge, p; SU	-25	500	1*	30-80	600	3	
ГТ402Ж	Ge, p; SU	-40	500	1*	60-150	600	3	
ГТ403А	Ge, p; SU	-45	500	1*	60-150	600	3	
ГТ403Б	Ge, p; SU	-45	(1,25)	(8)*	20-60	600	4	
ГТ403В	Ge, p; SU	-60	(1,25)	(8)*	20-60	600	4	
ГТ403Г	Ge, p; SU	-60	(1,25)	(6)*	50-150	600	4	
ГТ403Д	Ge, p; SU	-60	(1,25)	(6)*	50-150	600	4	
ГТ403Е	Ge, p; SU	-60	(1,25)	(8)*	30-50	600	4	
ГТ403Ж	Ge, p; SU	-80	(1,25)	(8)*	20-60	600	4	
ГТ403И	Ge, p; SU	-80	(1,25)	(8)*	30-50	600	4	
ГТ403Ю	Ge, p; SU	-45	(1,25)	(8)*	30-60	600	4	
ГТ404А	Ge, n; SU	25*	500	1*	30-80	600	3	
ГТ404Б	Ge, n; SU	25*	500	1*	60-150	600	3	
ГТ404В	Ge, n; SU	40*	500	1*	30-80	600	3	
ГТ404Г	Ge, n; SU	40*	500	1*	60-150	600	3	
ГТ405А	Ge, p; SU	-25*	500	1	30-80	600	5	
ГТ405Б	Ge, p; SU	-25*	500	1	60-150	600	5	
ГТ405Г	Ge, p; SU	-40*	500	1	30-80	600	5	
ГТ612А	Ge, n; SU	12	120	500	>50	570	6	



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T, f_a , МГц (kHz)	R_{21E} , Ом	P_{Cmax} , мВт (Вт)	Площадь	Забелешка
ГТ701А	Ge, p; SU	-55*	(12)	(50)*	>10	(10)	7	
ГТ702А	Ge, p; BG	-30	(3)	(200)	30	(30)	8	
ГТ702Б	Ge, p; BG	-40	(3)	(200)	30	(45)	8	
ГТ702В	Ge, p; BG	-60	(3)	(200)	30	(45)	8	
ГТ702Г	Ge, p; BG	-80	(3)	(200)	30	(45)	8	
ГТ702Д	Ge, p; BG	-40	(6)	(250)	30	(45)	8	
ГТ702Е	Ge, p; BG	-60	(6)	(250)	30	(45)	8	
ГТ702Ж	Ge, p; BG	-80	(6)	(250)	30	(45)	8	
ГТ702З	Ge, p; BG	-100	(10)	(400)	30	(45)	8	
ГТ703А	Ge, p; SU	-30*	(3,5)	0,2*	30-70;	(15)	8	
ГТ703Б	Ge, p; SU	-30*	(3,5)	0,2*	50-100	(15)	8	
ГТ703В	Ge, p; SU	-30*	(3,5)	0,2*	30-70	(15)	8	
ГТ703Г	Ge, p; SU	-30*	(3,5)	0,2*	50-100	(15)	8	
ГТ703Д	Ge, p; SU	-40*	(3,5)	0,2*	20-45	(15)	8	
ГТ705А	Ge, n; SU	20	(3,5)	0,5	50-100	(15)	8	
ГТ705Б	Ge, n; SU	20	(3,5)	0,5	50-100	(15)	8	
ГТ705В	Ge, n; SU	20	(3,5)	0,5	30-70	(15)	8	
ГТ705Г	Ge, n; SU	20	(3,5)	0,5	50-100	(15)	8	
ГТ705Д	Ge, n; SU	20	(3,5)	0,5	90-250	(15)	8	
ГТ804А	Ge, n; SU	45*	(10)	10*	20-150	(15)	7	
ГТ804Б	Ge, n; SU	55*	(10)	10*	20-150	(15)	7	
ГТ804В	Ge, n; SU	75*	(10)	10*	20-150	(15)	7	
ГТ805А	Ge, p; SU	-75	(15)	10	10-100	(30)	7	
ГТ805Б	Ge, p; SU	-100	(15)	10	10-100	(30)	7	
ГТ805В	Ge, p; SU	-120	(15)	10	10-100	(30)	7	
ГТ806Г	Ge, p; SU	-50	(15)	10	10-100	(30)	7	
ГТ806Д	Ge, p; SU	-140	(15)	10	10-100	(30)	7	
ГТ810А	Ge, p; SU	-200	(10)	15	15	(15)	9	
ГТ905А	Ge, p; SU	-75	(3)	60	35-100	(6)	9	
ГТ905Б	Ge, p; SU	-60	(3)	60	50-100	(6)	9	

Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{CB\max}$, мА (А)	$f_{T,a}$, МГц (kHz)	β	$P_{C\max}$, мВт (W)	Полка	Заделка
ГТ906А	Ge, p; SU	-60	(3)	60	50-100	(6)	1	
ГТ1321	Ge, p; BG	-32	250	0,9	20-44	200	2	
ГТ1322	Ge, p; BG	-32	250	1,2	40-66	200	2	
ГТ1323	Ge, p; BG	-32	250	1,7	60-150	200	2	
ГТ1351	Ge, p; BG	-32	150	1	20-44	200	2	
ГТ1352	Ge, p; BG	-32	150	1,4	40-66	200	2	
ГТ1353	Ge, p; BG	-32	150	1,7	60-250	200	2	
ГТ2305	Ge, p; BG	-18	100	1,5	15-70	150	2	
ГТ2307	Ge, p; BG	-18	100	4	25-120	150	2	
ГТ2308	Ge, p; BG	-18	100	7	40-180	150	2	
ГТ4124	Ge, p; BG	-24	500	0,6	20-40	350	3	
ГТ4125	Ge, p; BG	-24	500	0,8	40-150	350	3	
ГТ4130	Ge, p; BG	-24	500	0,6	25-44	550	4	
ГТ4131	Ge, p; BG	-24	500	0,8	40-150	550	4	
ГТ4143	Ge, p; BG	-45	500	0,6	20-44	350	3	
ГТ4144	Ge, p; BG	-45	500	0,8	40-80	350	3	
ГТ4145	Ge, p; BG	-45	500	0,6	20-44	550	4	
ГТ4146	Ge, p; BG	-45	500	0,8	40-80	550	4	
ГТ4350	Ge, p; BG	-32	(1,5)	1	50-250	300	3	
ГТ4351	Ge, p; BG	-32	(1,5)	1	50-250	(1,5)	4	
ГТ4352	Ge, p; BG	-32	(1,5)	1	50-250	(2,5)	4	
ГТ7212	Ge, p; BG	-30	(3)	0,2	20-150	(30)	5	
ГТ7213	Ge, p; BG	-40	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7214	Ge, p; BG	-60	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7238	Ge, p; BG	-40	(6)	0,2	20-80	(40)	5	
ГТ7239	Ge, p; BG	-60	(6)	0,2	20-80	(40)	5	
ГТ7240	Ge, p; BG	-80	(6)	0,2	20-80	(40)	5	
ГТ7250	Ge, p; BG	-80	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7301	Ge, p; BG	-30	(3)	0,2	20-150	(30)	5	
ГТ7302	Ge, p; BG	-40	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7303	Ge, p; BG	-60	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7304	Ge, p; BG	-80	(3)	0,2	20-150	(40)	5	
ГТ7312	Ge, p; BG	-40	(6)	0,2	20-80	(40)	5	
ГТ7313	Ge, p; BG	-60	(6)	0,2	20-80	(40)	5	
ГТ7314	Ge, p; BG	-80	(6)	0,2	20-80	(40)	5	



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{CB\max}$, мА (А)	$f_{T,a}$, МГц (kHz)	β	$P_{C\max}$, мВт (W)	Полка	Заделка
ГТ7325	Ge, p; BG	-100	(10)	0,2	15-80	(40)	5	
HA7810	Si, p; CS	-10	100	1*	50-200	400	6	
HS646	Si, n; JP	20	20	650	50-200	120	7	
HS653B	Si, p; JP	-60	400	10	50-150	600	6	
HT400	Si, n; CS	20	50	40	50-200	300	6	
J623	Si, n; USA	15*	25	4*	40-150	150	6	
J624	Si, n; USA	30*	25	4*	50-200	150	6	
J625	Si, n; USA	60*	25	4*	50-200	150	6	
J627	Si, n; USA	30*	25	6*	40-160	150	6	
J629	Si, n; USA	15*	25	7*	50-200	150	6	
J630	Si, n; USA	30*	25	7*	50-200	150	6	
J631	Si, n; USA	60*	25	7*	50-200	150	6	
KC147	Si, n; CS	45	100	150	125-500	200	8	
KC148	Si, n; CS	20	100	150	125-900	200	8	
KC149	Si, n; CS	20	100	150	240-900	200	8	
KC507	Si, n; CS	45	100	150	125-500	300	6	
KC508	Si, n; CS	20	100	150	125-900	300	6	
KC509	Si, n; CS	20	100	150	240-900	300	6	
KC510	Si, Dn; CS	45	100	150	50-150	400	9	
KC809	Si, dn; CS	45	20	3	>50	500	9	
KC810	Si, dn; CS	45	20	3	>50	500	9	
KC811	Si, dn; CS	45	20	3	>50	500	9	
KCZ58	Si, dn; CS	45	100	50	>100	450	9	
KCZ59	Si, dn; CS	45	100	50	>50	450	9	
KD501	Si, n; CS	40*	(20)	2	>5	(150)	5	
KD502	Si, n; CS	60*	(20)	2	>5	(150)	5	
KD503	Si, n; CS	80*	(20)	2	>5	(150)	5	
KD601	Si, n; CS	40	(10)	10	>5	(35)	5	
KD602	Si, n; CS	110	(10)	(500)	>5	(35)	5	

Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{CB\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{FE} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Площба	Забелешка
KD605	Si, n; CS	40	(10)	2	≥ 10	(70)	1	
KD606	Si, n; CS	60	(10)	2	≥ 10	(70)	1	
KD607	Si, n; CS	80	(10)	2	≥ 10	(70)	1	
KD610	Si, Dn; CS	40	(10)	2	≥ 10	(35)	2	
KD615	Si, p; CS	-40*	(10)	2	≥ 30	(70)	1	
KD616	Si, p; CS	-60*	(10)	2	≥ 30	(70)	1	
KD617	Si, p; CS	-80*	(10)	2	≥ 30	(70)	1	
KF124	Si, n; CS	30	30	200	≥ 67	220	3	
KF125	Si, n; CS	30	30	230	≥ 37	220	3	
KF167	Si, n; CS	40	25	350	≥ 26	130	4	
KF173	Si, n; CS	40	25	550	≥ 38	200	4	
KF272	Si, p; CS	-40	20	900	≥ 40	150	5	
KF503	Si, n; CS	60*	50	150	100	700	6	
KF504	Si, n; CS	100*	50	150	≥ 80	700	6	
KF505	Si, n; CS	75	500	100	≥ 35	800	6	
KF507	Si, n; CS	40	500	100	≥ 35	800	6	
KF508	Si, n; CS	75	500	120	≥ 90	800	6	
KF517	Si, p; CS	-30	600	30	≥ 35	800	6	
KF517A	Si, p; CS	-30	600	30	≥ 35	800	6	
KF517B	Si, p; CS	-30	600	30	≥ 90	800	6	
KF524	Si, n; CS	30	30	350	≥ 67	145	4	
KF525	Si, n; CS	30	30	300	≥ 37	145	4	
KF521	Si, n; CS	40	400	600	≥ 20	(3.5)	6	
KF622	Si, n; CS	55	400	400	≥ 20	(5)	6	
KF630A	Si, n; CS	36	400	400	≥ 20	(5)	6	
KF630B	Si, n; CS	36	400	40	20	(5)	6	
KF630C	Si, n; CS	36	400	80	20	(5)	6	
KF630D	Si, n; CS	36	400	80	20	(5)	6	
KF630S	Si, n; CS	30	400	140	20	(5)	6	
KFY16	Si, p; CS	-75	600	90	35	800	6	KFY34
KFY18	Si, p; CS	-75	600	100	90	800	6	KFY46
KFY34	Si, n; CS	75	500	100	35	800	6	KFY16
KFY46	Si, n; CS	75	500	120	90	800	6	KFY18
KFZ57	Si, np; CS	± 60	500	90	50	450	7	
KFZ66	Si, dn; CS	60	500	70	30	800	8	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{CB\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{FE} , β	$P_{C\max}$, mW (W)	Площба	Забелешка
KFZ68	Si, n; CS	60	500	70	≥ 30	800	8	
KS500	Si, n; CS	25	200	200	≥ 20	300	6	
KS521	Si, n; CS	40	200	300	≥ 30	360	6	
KS534	Si, n; CS	60	600	250	≥ 10	800	6	
KS562	Si, n; CS	25	200	200	≥ 20	350	6	
KS562A	Si, n; CS	25	200	200	≥ 20	350	6	
KS562B	Si, n; CS	25	200	200	≥ 30	350	6	
KS563	Si, n; CS	40	200	300	≥ 30	350	6	
KS571	Si, n; CS	40	200	700	≥ 40	350	6	
KS572	Si, n; CS	40	200	450	≥ 40	200	6	
KS581	Si, n; CS	40	200	500	40	200	6	
KS582	Si, n; CS	12	30	250	35	200	6	
KSZ62	Si, n; CS	25	200	290	500	350	8	
KSZ62A	Si, n; CS	25	200	290	500	350	8	
KT9A	Si, n; CS	36	600*	160	50	(5)	6	
KT9B	Si, n; CS	36	600*	200	50	(5)	6	
KT9C	Si, n; CS	36	600*	300	50	(5)	6	
KT9D	Si, n; CS	36	600*	500	50	(5)	6	
KT11A	Si, n; CS	55	400	200	50	(5)	6	
KT11B	Si, n; CS	55	400	300	50	(5)	6	
KT11C	Si, n; CS	55	400	100	50	(5)	6	
KT21A	Si, n; CS	40	400	50	50	(3.5)	6	
KT21B	Si, n; CS	40	400	50	50	(3.5)	6	
KT21C	Si, n; CS	40	400	20	50	(3.5)	6	
KT104A	Si, p; SU	-30	50	5*	9-35	150	9	
KT104B	Si, p; SU	-15	50	5*	20-80	150	9	
KT104C	Si, p; SU	-15	50	5*	40-160	150	9	
KT104F	Si, p; SU	-30	50	5*	15-60	150	9	
KT118A	Si, Ep; SU	-15	50			100	10	
KT118B	Si, Ep; SU	-15	50			100	10	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	β_{21E}, β	$P_{C\max}$, mW (W)	Цепка	Забелешка
KT118B	Si, Ep; SU	-15	50	1	30	100	1	
KT118Г	Si, Ep; SU	-15	50	1	30	100	1	
KT120A	Si, p; SU	-60	10	1*	20-200	10	2	
KT120Б	Si, p; SU	-30	10	1*	20-200	10	2	
KT120В	Si, p; SU	-60	10	1*	20-200	10	2	
KT201A	Si, n; SU	20	20	10	20-60	150	3	
KT201Б	Si, n; SU	20	20	10	30-90	150	3	
KT201В	Si, n; SU	10	20	10	30-90	150	3	
KT201Г	Si, n; SU	10	20	10	70-120	150	3	
KT201Д	Si, n; SU	10	20	10	30-90	150	3	
KT202A	Si, p; SU	-15	10	5*	15-70	15	2	
KT202Б	Si, p; SU	-15	10	5*	40-160	15	2	
KT202В	Si, p; SU	-30	10	5*	15-70	30	2	
KT202Г	Si, p; SU	-30	10	5*	40-160	30	2	
KT203A	Si, p; SU	-60	10	5*	>9	150	3	
KT203Б	Si, p; SU	-30	10	5	30-100	150	3	
KT203В	Si, p; SU	-15	10	5	30-200	150	3	
KT208A	Si, n; SU	20	150	5*	20-60	200	3	
KT208Б	Si, n; SU	20	150	5*	40-120	200	3	
KT208В	Si, n; SU	20	150	5*	80-240	200	3	
KT208Г	Si, n; SU	30	150	5*	20-60	200	3	
KT208Д	Si, n; SU	30	150	5*	40-120	200	3	
KT208Е	Si, n; SU	30	150	5*	80-240	200	3	
KT208Ж	Si, n; SU	45	150	5*	20-60	200	3	
KT208И	Si, n; SU	45	150	5*	40-120	200	3	
KT208К	Si, n; SU	45	150	5*	80-240	200	3	
KT208Л	Si, n; SU	60	150	5*	20-60	200	3	
KT301	Si, n; SU	20	10	20	20-60	150	4	
KT301A	Si, n; SU	20	10	20	40-120	150	4	
KT301Б	Si, n; SU	30	10	20	10-32	150	4	
KT301В	Si, n; SU	30	10	20	20-60	150	4	
KT301Г	Si, n; SU	20	10	30	10-32	150	4	
KT301Д	Si, n; SU	20	10	30	20-60	150	4	
KT301Е	Si, n; SU	20	10	30	40-120	150	4	
KT301Ж	Si, n; SU	20	10	30	80-300	150	4	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	β_{21E}, β	$P_{C\max}$, mW (W)	Цепка	Забелешка
KT306A	Si, n; SU	150	30	300	20-60	75	5	
KT306Б	Si, n; SU	15	30	500	40-120	75	5	
KT306В	Si, n; SU	15	30	300	30-100	75	5	
KT306Г	Si, n; SU	15	30	500	40-200	75	5	
KT306Д	Si, n; SU	15	30	200	30-150	125	5	
KT307A	Si, n; SU	10	20	250	20	5	6	
KT307Б	Si, n; SU	10	20	250	30	5	6	
KT307В	Si, n; SU	10	20	250	40	5	6	
KT307Г	Si, n; SU	10	20	250	80	5	6	
KT312A	Si, n; SU	15	30	80	10-100	450	4	
KT312Б	Si, n; SU	30	30	120	25-100	450	4	
KT312В	Si, n; SU	15	30	120	50-280	450	4	
KT315A	Si, n; SU	30	30	200	20	50	7	
KT315Б	Si, n; SU	30	30	200	20-90	150	8	
KT315В	Si, n; SU	25*	100	250	20-90	150	8	
KT315Г	Si, n; SU	20*	100	250	70-350	150	8	
KT315Д	Si, n; SU	40*	100	250	20-90	150	8	
KT315Е	Si, n; SU	35*	100	250	70-350	150	8	
KT315Ж	Si, n; SU	25*	100	250	20-90	150	8	
KT315З	Si, n; SU	25*	100	250	50-350	150	8	
KT316A	Si, n; SU	10	30	600	20-60	60	3	
KT316Б	Si, n; SU	10	30	800	40-120	60	3	
KT316В	Si, n; SU	10	30	800	40-120	60	3	
KT316Г	Si, n; SU	10	30	600	20-100	60	3	
KT316Д	Si, n; SU	10	30	800	60-300	60	3	
KT317A	Si, n; SU	5	15	100	25-75	15	6	
KT317Б	Si, n; SU	5	15	100	35-120	15	6	
KT317В	Si, n; SU	5	15	100	80-250	15	6	
KT318A	Si, n; SU	20	20	430	30-90	30	6	
KT318Б	Si, n; SU	20	20	430	50-150	30	6	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \beta}$, МГц (кГц)	h_{FE} , %	$P_{C\max}$, мВт (W)	Почка	Забелешка
КТ318В	Si, n; SU	20	20	430	70-280	30	1	
КТ318Г	Si, n; SU	20	20	350	30-90	30	1	
КТ318Д	Si, n; SU	20	20	350	50-150	30	1	
КТ318Е	Si, n; SU	20	20	350	70-280	30	1	
КТ319А	Si, n; SU	5	15	100	15	5	1	
КТ319Б	Si, n; SU	5	15	100	25	5	1	
КТ319В	Si, n; SU	5	15	100	40	5	1	
КТ324А	Si, n; SU	10	20	800	20-60	15	1	
КТ324Б	Si, n; SU	10	20	800	40-120	15	2	
КТ324В	Si, n; SU	10	20	800	80-250	15	2	
КТ324Г	Si, n; SU	10	20	600	40-120	15	2	
КТ324Д	Si, n; SU	10	20	600	20-80	15	2	
КТ324Е	Si, n; SU	10	20	600	60-250	15	2	
КТ325А	Si, n; SU	15	30	800	60-90	225	3	
КТ325Б	Si, n; SU	15	30	600	70-210	225	3	
КТ325В	Si, n; SU	15	300	800	160-400	225	3	
КТ325Г	Si, n; SU	15	30	600	30-100	225	3	
КТ325Д	Si, n; SU	15	30	800	20-80	225	3	
КТ326А	Si, p; U	-20	50	400	20-70	250	3	
КТ326Б	Si, p; SU	-20	50	400	45-160	250	3	
КТ331А	Si, n; SU	15	5	250	20-60	15	4	
КТ331Б	Si, n; SU	15	5	250	40-120	15	4	
КТ331В	Si, n; SU	15	5	250	80-220	15	4	
КТ331Г	Si, n; SU	15	5	400	40-120	15	4	
КТ332А	Si, n; SU	15	5	250	20-60	15	4	
КТ322Б	Si, n; SU	15	5	250	40-120	15	4	
КТ332В	Si, n; SU	15	5	250	80-220	15	4	
КТ332Г	Si, n; SU	15	5	500	40-120	15	4	
КТ332Д	Si, n; SU	15	5	500	80-220	15	4	
КТ333А-В	Si, n; SU	10	20	450	30-280	15	5	
КТ333Г-Д	Si, n; SU	10	20	350	30-280	15	5	
КТ336А-В	Si, n; SU	10	20	250	20-120	15	5	
КТ336Г	Si, n; SU	10	20	450	20-60	15	5	
КТ336Д	Si, n; SU	10	20	450	40-120	15	5	
КТ336Е	Si, n; SU	10	20	450	50-130	15	5	

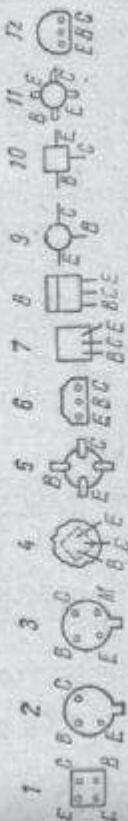


Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \beta}$, МГц (кГц)	h_{FE} , %	$P_{C\max}$, мВт (W)	Почка	Забелешка
КТ337А	Si, p; SU	-6	30	500	30-70	150	3	
КТ337Б	Si, p; SU	-6	30	600	50-75	150	3	
КТ337В	Si, p; SU	-6	30	600	70-120	150	6	
КТ339А	Si, n; SU	40	25	450	25	250	6	
КТ339Б	Si, n; SU	20	25	450	15	250	6	
КТ339В	Si, n; SU	40	25	250	25	250	6	
КТ339Г	Si, n; SU	20	25	450	40	250	6	
КТ339Д	Si, n; SU	20	25	250	15	250	6	
КТ340А	Si, n; SU	5	50	300	100-300	150	3	
КТ340Б	Si, n; SU	20	50	300	100	150	3	
КТ340В	Si, n; SU	15	50	300	35	150	3	
КТ340Г	Si, n; SU	15	75	300	35	150	3	
КТ340Д	Si, n; SU	15	50	300	40	150	3	
КТ342А	Si, n; SU	30*	50	300	100-250	250	3	
КТ342Б	Si, n; SU	25*	50	300	200-500	250	3	
КТ342В	Si, n; SU	20*	50	300	400-1000	250	3	
КТ342Г	Si, n; SU	15*	50	300	50-125	250	3	
КТ342Д	Si, n; SU	60*	50	300	60	250	3	
КТ342Е	Si, n; SU	10*	50	300	60	250	3	
КТ343А	Si, p; SU	-17*	50	300	30	150	3	
КТ343Б	Si, p; SU	-17*	50	300	50	150	3	
КТ343В	Si, p; SU	-9*	50	300	30	150	3	
КТ343Г	Si, p; SU	-17*	50	300	30	150	3	
КТ345А	Si, p; SU	-20	200	350	20-60	100	7	
КТ345Б	Si, p; SU	-20	200	350	50-85	100	7	
КТ345В	Si, p; SU	-20	200	350	70-105	100	7	
КТ347А	Si, p; SU	-15*	50	100	30-400	150	3	
КТ347Б	Si, p; SU	-9*	50	100	30-400	150	3	
КТ347В	Si, p; SU	-6*	50	100	50-400	150	3	
КТ348А	Si, n; SU	5	15	100	25-75	15	8	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \alpha}$, МГц (kHz)	$R_{21E, \rho}$	$P_{C\max}$, мВт (W)	Плотность	Заделка
КТ348Б	Si, n; SU	5	15	100	35-120	15	1	
КТ348В	Si, n; SU	5	15	100	80-250	15	1	
КТ349А	Si, p; SU	-20	40	300	20-80	200	2	
КТ349Б	Si, p; SU	-20	40	300	40-160	200	2	
КТ349В	Si, p; SU	-20	40	300	120-300	200	2	
КТ350	Si, p; SU	-20	100	500	15-150	200	2	
КТ350А	Si, p; SU	-20	100	500	15-150	200	2	
КТ351А	Si, p; SU	-20	100	200	20-80	200	2	
КТ351Б	Si, p; SU	-20	100	200	50-200	200	2	
КТ352А	Si, p; SU	-20	100	200	25-120	200	2	
КТ352Б	Si, p; SU	-20	200	200	70-300	200	3	
КТ354А	Si, n; SU	10	10	1500	50	30	4	свч
КТ354Б	Si, n; SU	10	10	1500	50	30	4	свч
КТ355А	Si, n; SU	15	30	1500	80-300	225	3	свч
КТ356А	Si, n; SU	10	40	1600	80-260	100	5	свч
КТ356Б	Si, n; SU	10	40	2000	80-320	100	5	свч
КТ357А	Si, p; SU	-6	40	300	20-100	100	6	
КТ357Б	Si, p; SU	-6	40	300	60-300	100	6	
КТ357В	Si, p; SU	-20	40	300	20-100	100	6	
КТ357Г	Si, p; SU	-20	40	300	60-300	100	6	
КТ358А	Si, n; SU	15	30	80	10-100	100	6	
КТ358Б	Si, n; SU	30	30	120	25-100	100	6	
КТ359А	Si, n; SU	10	20	300	50-280	100	6	
КТ359Б	Si, n; SU	10	20	300	30-90	15	1	
КТ359В	Si, n; SU	10	20	300	50-150	15	1	
КТ360А	Si, p; SU	-25	20	300	7-280	15	1	
КТ360Б	Si, p; SU	-20	20	400	40-120	10	7	
КТ360В	Si, p; SU	-20	20	400	80-240	10	7	
КТ361А	Si, p; SU	-25	20	250	20-90	150	8	
КТ361Б	Si, p; SU	-20	20	250	50-350	150	8	
КТ361Г	Si, p; SU	-35	20	250	50-350	150	8	
КТ361Д	Si, p; SU	-40	20	250	20-90	150	8	
КТ361Е	Si, p; SU	-35	20	250	50-350	150	8	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	$f_{T, \alpha}$, МГц (kHz)	$R_{21E, \rho}$	$P_{C\max}$, мВт (W)	Плотность	Заделка
КТ363А	Si, p; SU	-15	30	1200	20-70	150	2	свч
КТ363Б	Si, p; SU	-15	30	1500	40-120	150	2	свч
КТ364А	Si, p; SU	-25	200	250	20-70	30	7	
КТ364Б	Si, p; SU	-25	200	250	40-120	30	7	
КТ364В	Si, p; SU	-25	200	250	80-240	30	7	
КТ365А	Si, n; SU	15	10	1000	50	15	4	свч
КТ365Б	Si, n; SU	15	20	1000	50	25	4	свч
КТ365В	Si, n; SU	15	45	1000	40	50	4	свч
КТ367А	Si, n; SU	10	30	1500	40-330	100	9	свч
КТ368А	Si, n; SU	15	30	300	40	225	3	
КТ368Б	Si, n; SU	15	30	300	50	225	3	
КТ369А	Si, n; SU	45	250	200	20-100	50	4	
КТ369Б	Si, n; SU	45	250	200	40-200	50	4	
КТ370А	Si, p; SU	-15	15	1000	20-70	15	10	свч
КТ370Б	Si, p; SU	-15	15	1200	40-120	15	10	свч
КТ371А	Si, n; SU	10	30	3000	20	100	9	свч
КТ372А	Si, n; SU	15*	30	6000	20	50	11	свч
КТ372Б	Si, n; SU	15	10	3000	15	50	11	свч
КТ372В	Si, n; SU	15	10	2400	20	50	11	свч
КТ373А	Si, n; SU	30	50	300	100-250	150	6	
КТ373Б	Si, n; SU	25	50	300	200	150	12	
КТ373В	Si, n; SU	10	50	300	500	150	12	
КТ502А	Si, p; SU	-25*	300	5	40	500	12	
КТ502Б	Si, p; SU	-25*	300	5	80	500	12	
КТ502В	Si, p; SU	-40*	300	5	40	500	12	
КТ502Г	Si, p; SU	-40*	300	5	80	500	12	
КТ502Д	Si, p; SU	-60*	300	5	40	500	12	
КТ502Е	Si, p; SU	-80*	300	5	40	500	12	
КТ503А	Si, n; SU	25*	300	5	40	500	12	
КТ503Б	Si, n; SU	25*	300	5	80	500	12	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T, f_a , МГц (kHz)	R_{zE}, Ω	P_{Cmax} , мВт (Вт)	Класс	Забелешка
M3A	Ge, n; SU	15	50	1*	18-55	75	1	
M3B	Ge, n; SU	15	50	5*	20-60	75	1	
M3Г	Ge, n; SU	15	50	5*	40-120	75	1	
M3Д	Ge, n; SU	15	50	10*	40-160	75	1	
M4A	Ge, p; SU	-15	40	1*	20-75	75	1	
M4B	Ge, p; SU	-15	40	1*	50-120	75	1	
M4B	Ge, p; SU	-15	40	1*	90-200	75	1	
M4Г	Ge, p; SU	-15	40	1*	20-75	75	1	
M4Д	Ge, p; SU	-15	40	1*	50-120	75	1	
M4E	Ge, p; SU	-15	40	1*	90-200	75	1	
M5A	Ge, p; SU	-15	70	1*	20-50	75	1	
M5B	Ge, p; SU	-15	70	1*	35-80	75	1	
M5B	Ge, p; SU	-15	70	2*	60-130	75	1	
M5Г	Ge, p; SU	-15	70	3*	110-250	75	1	
M5Д	Ge, p; SU	-15	70	1*	20-50	75	1	
M10	Si, n; SU	20	10	1	20-60	150	1w2	
M10A	Si, n; SU	20	10	1	40-120	150	1w2	
M10B	Si, n; SU	30	10	1	10-32	150	1w2	
M10Г	Si, n; SU	30	10	1	20-60	150	1w2	
M10Г	Si, n; SU	20	10	1	10-32	150	1w2	
M10 Д	Si, n; SU	20	10	1	20-60	150	1w2	
M10E	Si, n; SU	20	10	1	40-120	150	1w2	
M10Ж	Si, n; SU	20	10	1	80	150	1w2	
MC104	Si, n; D	60	200	1	50	450	3	
MC105	Si, n; D	100	200	1	50	450	3	
MC106	Si, n; D	60	300	1	50	450	4	
MC107	Si, n; D	100	300	1	50	450	3	
ME209	Si, n; F	10	300	1	50	300	5	
ME214	Si, n; F	10	300	1	50	300	5	
ME900A	Si, n; USA	40	300	100	50	360	5	
ME901A	Si, n; USA	40	200	100	50	360	5	
ME1100	Si, n; USA	110	200	60	50	200	6	
ME1120	Si, n; USA	130	200	60	50	200	6	
MP4A	Ge, p; SU	-50*	(5)	0,15*	5	(20)	7	
MP4B	Ge, p; SU	-60*	(5)	0,15*	15-40	(20)	7	



Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	f_T, f_a , МГц (kHz)	R_{zE}, Ω	P_{Cmax} , мВт (Вт)	Класс	Забелешка
MP4B	Ge, p; SU	-35*	(5)	0,15*	10	(25)	7	
MP4Г	Ge, p; SU	-50*	(5)	0,15*	15-30	(25)	7	
MP4Д	Ge, p; SU	-50*	(5)	0,15*	30	(25)	7	
MP9A	Ge, n; SU	15*	20	0,5*	15-45	150	3	
MP10	Ge, n; SU	15*	20	0,5*	15-30	150	3	
MP10A	Ge, n; SU	15*	20	1*	15-30	150	3	
MP10B	Ge, n; SU	15*	20	1*	25-50	150	3	
MP11	Ge, n; SU	15*	20	2*	25-55	150	3	
MP11A	Ge, n; SU	15*	20	2*	25-100	150	3	
MP13	Ge, p; SU	-15*	20	0,5*	12	150	3	
MP13A	Ge, p; SU	-15*	20	0,5*	30	150	3	
MP13B	Ge, p; SU	-15*	20	1*	20-60	150	3	
MP14	Ge, p; SU	-15*	20	1*	20-40	150	3	
MP14A	Ge, p; SU	-30*	20	1*	20-40	150	3	
MP14B	Ge, p; SU	-30*	20	1*	30-60	150	3	
MP15	Ge, p; SU	-15*	20	2*	30-60	150	3	
MP15A	Ge, p; SU	-15*	20	2*	50-100	150	3	
MP16	Ge, p; SU	-15*	50	1*	20-30	200	3	
MP16A	Ge, p; SU	-15*	50	1*	30-50	200	3	
MP16B	Ge, p; SU	-15*	50	2*	45-100	200	3	
MP20	Ge, p; SU	-30*	300	1*	50-150	150	3	
MP20A	Ge, p; SU	-20*	300	2*	50-150	150	3	
MP20B ÷ BGe, p; SU		-20*	300	1,5*	80-200	150	3	
MP20Г ÷ EGe, p; SU		-30*	300	1,5*	50-150	150	3	
MP21	Ge, p; SU	-30*	300	1*	20-60	150	3	
MP21A	Ge, p; SU	-35*	300	1*	50-150	150	3	
MP21B	Ge, p; SU	-40*	300	0,5*	20-80	150	3	
MP21Г	Ge, p; SU	-35*	300	1,5*	20-100	150	3	
MP21Г	Ge, p; SU	-35*	300	1*	20-80	150	3	
MP21Д	Ge, p; SU	-30*	300	1*	60-200	150	3	

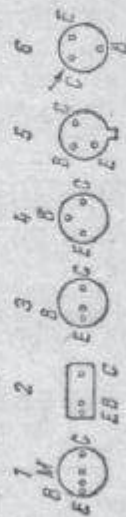
Символ	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_T \cdot f_\alpha$, МГц (kHz)	β_{21E} , p	P_{Cmax} , Вт (W)	Класс	Забелешка
МП111	Si, n, SU	20*	20	0,5*	10-25	150	1	
МП111А	Si, n, SU	10*	20	0,5*	10-30	150	1	
МП111Б	Si, n, SU	20*	20	0,5*	15-45	150	1	
МП112	Si, n, SU	10*	20	0,5*	15-45	150	1	
МП113	Si, n, SU	10*	20	1*	15-45	150	1	
МП113А	Si, n, SU	10*	20	1*	35-105	150	1	
МП114	Si, p, SU	-60*	10	0,1*	9	150	1	
МП115	Si, p, SU	-30*	10	0,1*	9-45	150	1	
МП116	Si, p, SU	-15*	10	0,1*	15-100	150	1	
МГТ108	Ge, p, SU	-10*	50	1*	75	75	1	
МГТ108А	Ge, p, SU	-10	50	0,5*	20-50	75	1	
МГТ108Б	Ge, p, SU	-10	50	0,5*	20-50	75	1	
МГТ108В	Ge, p, SU	-10	50	1*	60-130	75	1	
НКТ72	Ge, p, GB	-15	10	6,2*	50	75	1	
НКТ73	Ge, p, GB	-15	10	2,5*	50	75	1	
НКТ271	Ge, p, GB	-15	500	1*	40	200	1	
НКТ274	Ge, p, GB	-15	250	1*	40	200	1	
НКТ275	Ge, p, GB	-15	250	1*	40	200	1	
НКТ773	Ge, n, GB	15	300	1*	40	150	1	
НКТ774	Ge, n, GB	15	300	1*	40	150	1	
ОС10	Ge, p, GB	-4*	20	1*	40	200	1	
ОС11	Ge, p, GB	-4*	20	1*	50	200	1	
ОС13	Ge, p, F	-10*	10	(500)*	80	65	2	
ОС14	Ge, p, F	-12*	30	(350)*	70	130	2	
ОС15	Ge, p, D	-24*	(2)	3*	50	(2)	3	
ОС16	Ge, p, D	-32*	(1,5)	(200)*	35	(4)	4	
ОС18	Ge, p, GB	-24*	(1)	0,2*	44	(30)	1	
ОС19	Ge, p, GB	-16*	(3)	(200)*	70	(24)	5	
ОС20	Ge, p, GB	-100	(10)	(250)*	60	(30)	5	



Символ	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_T \cdot f_\alpha$, МГц (kHz)	β_{21E} , p	P_{Cmax} , Вт (W)	Класс	Забелешка
МП21Е	Ge, p, SU	-35*	300	0,7*	30-150	150	1	
МП25	Ge, p, SU	-40*	400*	0,2*	10-25	200	1	
МП25А	Ge, p, SU	-40*	400*	0,2*	20-50	200	1	
МП25Б	Ge, p, SU	-40*	400*	0,5*	30-80	200	1	
МП26	Ge, p, SU	-70*	400*	0,2*	10-25	200	1	
МП26А	Ge, p, SU	-70*	400*	0,2*	20-50	200	1	
МП26Б	Ge, p, SU	-70*	400*	0,5*	30-80	200	1	
МП35	Ge, n, SU	15*	20	0,5*	10-125	150	1	
МП36А	Ge, n, SU	15*	20	1*	15-45	150	1	
МП37	Ge, n, SU	15*	20	1*	15-30	150	1	
МП37А	Ge, n, SU	30*	20	1*	15-30	150	1	
МП37Б	Ge, n, SU	30*	20	1*	25-50	150	1	
МП38	Ge, n, SU	15*	20	2*	23-55	150	1	
МП38А	Ge, n, SU	15*	20	2*	45-150	150	1	
МП39	Ge, p, SU	-15*	150*	0,5*	12-20	150	1	
МП39Б	Ge, p, SU	-10*	150*	0,5*	20-60	150	1	
МП40	Ge, p, SU	-10*	150*	1*	20-40	150	1	
МП40А	Ge, p, SU	-30*	150*	1*	20-40	150	1	
МП41	Ge, p, SU	-10*	150*	1*	30-60	150	1	
МП41А	Ge, p, SU	-10*	150*	1*	50-100	150	1	
МП42	Ge, p, SU	-15*	150*	1*	20-35	200	1u2	
МП42А	Ge, p, SU	-15*	150*	1*	30-50	200	1u2	
МП42Б	Ge, p, SU	-15*	150*	1*	45-100	200	1u2	
МП101	Si, n, SU	20*	20	0,5*	10-25	150	1u2	
МП101А	Si, n, SU	10*	10	0,5*	10-30	150	1u2	
МП101Б	Si, n, SU	20*	20	0,5*	15-45	150	1u2	
МП101В	Si, n, SU	20	20	0,5*	15-30	150	1u2	
МП102	Si, n, SU	10*	20	1*	15-45	150	1u2	
МП102Б	Si, n, SU	10*	20	0,5*	15-45	150	1u2	
МП103	Si, n, SU	10*	20	1*	15-45	150	1u2	
МП103А	Si, n, SU	10*	20	1*	30-75	150	1u2	
МП103Б	Si, n, SU	10*	20	0,5*	30-75	150	1u2	
МП104	Si, p, SU	-60*	10	0,1*	9	150	1u2	
МП105	Si, p, SU	-30*	10	0,1*	9	150	1u2	
МП106	Si, p, SU	-15*	10	0,5*	20	150	1u2	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	K_{21E} , %	P_{Cmax} , mW (W)	Полная	Забелешка
OC123	Ge, p, GB	-50*	(1)*	1,5	160	300	1	
OC130	Ge, p, D	-20*	10	(300)*		50	2	
OC139	Ge, n, GB	20	250	3,5*	45	100	3	
OC140	Ge, n, GB	20	400	4,5*	75	100	3	
OC141	Ge, n, GB	20	200	9	150	130	3	
OC160	Ge, n, GB	20	50	10	100	60	3	
OC169	Ge, p, D	-20	10	70	100	50	1	
OC170	Ge, p, D	-20	10	70	100	50	1	
OC171	Ge, p, D	-20	10	70	100	50	1	
OC201	Si, p, D	-25	50	4*	30	250	4	
OC202	Si, p, GB	-15		(750)*	70	250	4	
OC203	Si, p, GB	-60		1*	15	250	4	
OC204	Si, p, GB	-32	250	1,5*	24	310	4	
OC205	Si, p, GB	-60	250	1,5*	24	310	4	
OC206	Si, p, GB	-32	250	(850)	40	310	4	
OC207	Si, p, GB	-50	250	(450)		310	3	
OC302	Ge, p, D	-15*	50	(600)*		67	3	
OC303	Ge, p, D	-15*	50	(750)*	26	67	4	
OC304	Ge, p, D	-15*	50	(900)*		67	4	
OC305	Ge, p, D	-8*	50	(900)*		67	4	
OC306	Ge, p, D	-32	50	(900)*		67	4	
OC307	Ge, p, D	-32	250	(700)*	25,50	75	5	
OC308	Ge, p, D	-35	250	(600)*	25,50	75	5	
OC309	Ge, p, D	-60	250	(500)*	25	75	5	
OC318	Ge, p, D	-15	300	(600)*	65	135	5	
OC320	Ge, p, D	-15*	35	(25)*		45	5	
OC330	Ge, p, D	-15*	35	(25)*	24	45	6	
OC331	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	70	30	6	
OC340	Ge, p, D	-15*	35	1,1*	40	45	6	
OC341	Ge, p, D	-7*	30	1,2*		30	6	
OC342	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	65	30	4	
OC343	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	100	30	4	
OC350	Ge, p, D	-5*	35	2*	150	45	4	
OC351	Ge, p, D	-5*	30	2*	160	30	4	
OC360	Ge, p, D	-15*	35	2*	20	45	4	

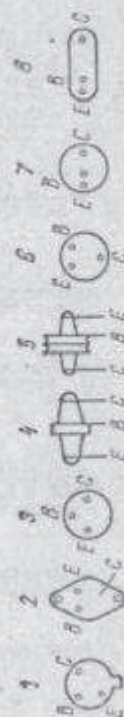


Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	K_{21E} , %	P_{Cmax} , mW (W)	Полная	Забелешка
OC361	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	40	30	4	
OC362	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	65	30	4	
OC363	Ge, p, D	-7*	30	1,2*	100	30	4	
OC364	Ge, p, D	-7*	30	2,5*	85	30	4	
OC390	Ge, p, D	-15	40	4,5*	40	65	4	
OC400	Ge, p, D	-15	40	7*	75	65	4	
OC410	Ge, p, D	-15	40	12*	110	65	4	
OC430	Si, p, D	-10	50	(600)*	15	200	5	
OC430K	Si, p, D	-10	50	(600)*	15	250	5	
OC443	Si, p, D	-25	50	1*	30	200	5	
OC443K	Si, p, D	-25	50	1*	30	250	5	
OC445	Si, p, D	-50	50	(600)*	15	200	5	
OC445K	Si, p, D	-50	50	(600)*	15	250	5	
OC449	Si, p, D	-60	50	1*	20	200	5	
OC449K	Si, p, D	-60	50	1*	15	250	5	
OC450K	Si, p, D	-75	50	(800)*	15	200	5	
OC450K	Si, p, D	-75	50	(800)*	15	250	5	
OC460	Si, p, D	-10	50	1,2*	15	200	5	
OC460K	Si, p, D	-10	50	1,2*	15	250	5	
OC463	Si, p, D	-10	50	4*	50	200	5	
OC466K	Si, p, D	-10	50	4*	50	250	5	
OC467	Si, p, D	-25	50	1,5*	40	200	5	
OC467K	Si, p, D	-25	50	1,5*	40	250	5	
OC468	Si, p, D	-10	50	2,5*	60	200	5	
OC468K	Si, p, D	-10	50	2,5*	60	250	5	
OC469	Si, p, D	-32	50	1*	15	200	5	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелешка
OC893	Ge, p; DDR	-15*	70	150	20	180	1	
OC920	Si, p; DDR	-10*	50	2,3*	20	250	1	
OC921	Si, p; DDR	-33*	50	1,9*	20	250	1	
OC922	Si, p; DDR	-66*	50	1*	20	250	1	
OC923	Si, p; DDR	-10*	50	4,2*	20	250	1	
OC1016	Ge, p; H	-32	(1,5)	0,2*	16-40	(13)	2	
OC1044	Ge, p; H	-15	5	15*	100	50	3	
OC1045	Ge, p; H	-15	5	6*	50	50	3	
OC1070	Ge, p; H	-32	10		20	75	3	
OC1071	Ge, p; H	-32	10		30	75	3	
OC1072	Ge, p; H	-32	50	(350)*	30	75	3	
OC1074	Ge, p; H	-20	300	1,5*	100	75	3	
OC1075	Ge, p; H	-32	10	1*	90	75	3	
OC1076	Ge, p; H	-32	125	(350)*	30	75	3	
OC1077	Ge, p; H	-60	125	(350)*	30	75	3	
OC1079	Ge, p; SU	-26*	300	1*	60	550	3	
П1А ÷ Д	Ge, p; SU	-20	5	(100)*	10	50	4	
П1Е	Ge, p; SU	-20*	5	(465)*	10	50	4	
П1Ж	Ge, p; SU	-20*	5	1*	10	50	4	
П1И	Ge, p; SU	-20*	5	1,6*	10	50	4	
П2А	Ge, p; SU	-100*	10	(100)*	20	250	4	
П2Б	Ge, p; SU	-50*	25	(100)*	20	250	4	
П3А	Ge, p; SU	-50*	150	(100)*	20	(3,5)	5	
П3Б	Ge, p; SU	-50*	450	(100)*	20	(3,5)	5	
П3В	Ge, p; SU	-50*	250	(100)*	20	(3,5)	5	
П4А	Ge, p; SU	-60	(5)	0,1*	>5	(20)	6	
П4Б	Ge, p; SU	-70	(5)	0,1*	15-40	(25)	6	
П4В	Ge, p; SU	-40	(5)	0,1*	10	(25)	6	
П4Г	Ge, p; SU	-60	(5)	0,1*	15-30	(25)	6	
П4Д	Ge, p; SU	-60	(5)	0,1*	>30	(25)	6	
П4А9	Ge, p; SU	-50	(5)	0,15*	5	(20)	6	
П4Б9	Ge, p; SU	-60	(5)	0,15*	15-40	(25)	6	
П4В9	Ge, p; SU	-35	(5)	0,15*	10	(25)	6	
П4Г9	Ge, p; SU	-50	(5)	0,15*	15-30	(25)	6	



Биполярни транзистори

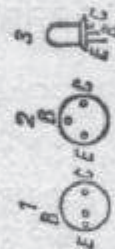
Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелешка
П4Д9	Ge, p; SU	-60*	(5)	(150)*	30	(25)	6	
П5А	Ge, p; SU	-10*	10	(100)*	>15	25	7	
П5Б	Ge, p; SU	-10*	10	(300)*	>20	25	7	
П5В	Ge, p; SU	-10*	10	(300)*	>50	25	7	
П5Г	Ge, p; SU	-10*	10	(300)*	>50	25	7	
П5Д	Ge, p; SU	-10*	10	(300)*	>24	25	7	
П5Е	Ge, p; SU	-10*	10	(300)*	>24	25	7	
П6А	Ge, p; SU	-10*	10	(100)*	>12	150	7	
П6Б	Ge, p; SU	-10*	10	(500)*	>15	150	7	
П6В	Ge, p; SU	-10*	10	(500)*	>19	150	7	
П6Г	Ge, p; SU	-10*	10	1*	>49	150	7	
П6Д	Ge, p; SU	-10*	10	(500)*	>19	150	7	
П7	Ge, p; SU	-6,5*	45	(200)		45	7	
П8	Ge, n; SU	15*	20	(500)*	15	150	7	
П9	Ge, n; SU	15*	20	(500)*		150	7	
П9А	Ge, n; SU	15*	20	1*	30	150	7	
П10	Ge, n; SU	15*	20	1*	22	150	7	
П10А	Ge, n; SU	30*	20	1*	35	150	7	
П10Б	Ge, n; SU	30*	20	1*	35	150	7	
П11	Ge, n; SU	15*	20	2*	35	150	7	
П11А	Ge, n; SU	15*	20	2*	140	150	7	
П12	Ge, p; SU	-6*	5	5*	30	30	8	
П12А	Ge, p; SU	-6*	5	5*	30	30	8	
П13	Ge, p; SU	-15*	20	(500)*	25	150	7	
П13А	Ge, p; SU	-15*	20	(500)*	33	150	7	
П13Б	Ge, p; SU	-15*	20	1*	50	150	7	
П14	Ge, p; SU	-15*	20	1*	40	150	7	
П14А	Ge, p; SU	-30*	20	1*	40	150	7	
П14Б	Ge, p; SU	-30*	20	1*	100	150	7	
П15	Ge, p; SU	-15*	20	2*	40	150	7	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_T \cdot f_a$, MHz (kHz)	$R_{HE} \cdot \omega$	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелешки
П15А	Ge, p; SU	-15*	20	2*	>100	150	1	
П16	Ge, p; SU	-15*	50	2*	20-35	200	1	
П16А	Ge, p; SU	-15*	50	2*	30-50	200	1	
П16Б	Ge, p; SU	-15*	50	2*	45-100	200	1	
П17	Ge, p; SU	-15*	50	0,2	10	150	1 и 2	
П17А	Ge, p; SU	-15*	50	0,2*	15	150	1 и 2	
П17Б	Ge, p; SU	-15*	50	0,2*	30	150	1 и 2	
П18	Ge, p; SU	-15*	50	0,2*	10	150	1 и 2	
П18А	Ge, p; SU	-15*	50	0,2*	15	150	1 и 2	
П18Б	Ge, p; SU	-15*	50	0,2*	30	150	1 и 2	
П19	Ge, p; SU	-6*	30	5*	40	30	3	
П20А	Ge, p; SU	-20*	300	1,5*	60	150	1	
П20Б	Ge, p; SU	-20*	300	2*	30	150	1	
П21	Ge, p; SU	-30*	500	1,5*	30	150	1	
П21А	Ge, p; SU	-30*	500	1,5*	60	150	1	
П21Б	Ge, p; SU	-30*	300	1,5*	50	150	1	
П21Г	Ge, p; SU	-35*	300	1*	40	150	1	
П21Д	Ge, p; SU	-30*	300	1*	40	150	1	
П21Е	Ge, p; SU	-35*	300	(700)*	30	150	1	
П22	Ge, p; SU	-20*	10	1*	20	100	1	
П23	Ge, p; SU	-30*	10	3*	20	100	1	
П25	Ge, p; SU	-60*	400	(200)*	10-25	200	1	
П25А	Ge, p; SU	-60*	400	(200)*	20-50	200	1	
П25Б	Ge, p; SU	-60*	400	(200)*	45	200	1	
П26	Ge, p; SU	-100*	400	(200)*	10-25	200	1	
П26А	Ge, p; SU	-100*	400	(200)*	30	200	1	
П26Б	Ge, p; SU	-100*	400	(500)*	30-80	200	1	
П27	Ge, p; SU	-5*	6	1*	>20	30	2	
П27А	Ge, p; SU	-5*	6	1*	>20	30	2	
П28	Ge, p; SU	-5	6	5*	>20	30	2	
П29	Ge, p; SU	-12	100*	5*	>25	30	2	
П29А	Ge, p; SU	-12	100*	5*	40-100	30	2	
П30	Ge, p; SU	-12	100*	10*	80-180	30	2	
П31	Ge, p; SU	-12*	100	4,5*	60	30	2	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_T \cdot f_a$, MHz (kHz)	$R_{HE} \cdot \omega$	$P_{C\max}$, mW (W)	Цоколя	Забелешки
П31А	Ge, p; SU	-12*	100	4,5*	30	30	2	
П32	Ge, p; SU	-12*	100	9*	30	30	2	
П33	Ge, p; SU	-15*	50	1*	20	100	2	
П34	Ge, p; SU	-15*	50	1*	20	100	2	
П35	Ge, n; SU	15*	20	(500)*	20	150	1	
П36А	Ge, n; SU	15*	20	1*	20	150	1	
П37	Ge, n; SU	15*	20	1*	20	150	1	
П37А	Ge, n; SU	30*	20	1*	20	150	1	
П37Б	Ge, n; SU	30*	20	1*	20	150	1	
П38	Ge, p; SU	-15*	20	1*	20	150	1	
П38А	Ge, p; SU	-15*	20	2*	25	150	1	
П39	Ge, p; SU	-10*	20	(500)*	12	150	1	
П39Б	Ge, p; SU	-10*	20	(500)*	20-60	150	1	
П40	Ge, p; SU	-10*	20	1*	20-80	150	1	
П40А	Ge, p; SU	-30*	20	1*	20-80	150	1	
П41	Ge, p; SU	-10*	20	1*	30-100	150	1	
П41А	Ge, p; SU	-10*	20	1*	50-120	150	1	
П42	Ge, p; SU	-15*	150	1*	20-35	200	1	
П42А	Ge, p; SU	-15*	150	1*	30-50	200	1	
П42Б	Ge, p; SU	-15*	150	1*	45-100	200	1	
П101	Si, n; SU	20	20	(500)*	>15	150	2	
П101А	Si, n; SU	10*	20	(500)*	>15	150	2	
П101Б	Si, n; SU	20*	20	(500)*	>20	150	2	
П102	Si, n; SU	10*	20	1*	25	150	2	
П103	Si, n; SU	10*	20	1*	30	150	2	
П103А	Si, n; SU	10*	20	1*	>12	150	2	
П104	Si, p; SU	-60*	10	(500)*	>12	150	2	
П105	Si, p; SU	-30*	10	(600)*	>20	150	2	
П106	Si, p; SU	-30*	10	1*	>20	150	2	
П108	Si, n; SU	10*	20	1		150	2	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , V	I_{C}^{max} , mA (A)	f_{T} , MHz (kHz)	h_{21E} , P	P_{C}^{max} , mW (W)	Пакет	Забелешка
П108А	Si, n; SU	10*	20	1*	20	150	2	
П109	Si, n; SU	10*	20	2	20	150	2	
П110	Si, n; SU	10*	21	3	20	150	2	
П201	Ge, p; SU	-30*	(2,5)	0,1*	20	(10)	1	
П201А	Ge, p; SU	-30*	(2,0)	0,2*	40	(10)	1	
П201В	Ge, p; SU	-30*	(2,0)	0,2*	40	(10)	1	
П202	Ge, p; SU	-30*	(1,5)	0,1*	20	(10)	1x2	
П202А	Ge, p; SU	-55*	(2,5)	0,1*	20	(10)	1x2	
П202Б	Ge, p; SU	-55*	(2)	0,1*	20	(10)	1x2	
П203	Ge, p; SU	-55*	(2,5)	0,2*	20	(10)	1x2	
П203А	Ge, p; SU	-55*	(2)	0,2*	20	(10)	1x2	
П207	Ge, p; SU	-40*	(25)	0,1*	15	(100)	3	
П207А	Ge, p; SU	-40*	(25)	0,1*	17,40	(100)	3	
П208	Ge, p; SU	-60*	(25)	0,3*	>15	(100)	3	
П208А	Ge, p; SU	-60*	(25)	0,2*	>15	(100)	3	
П209	Ge, p; SU	-40*	(12)	0,1*	15-40	(60)	3	
П209А	Ge, p; SU	-40*	(12)	0,1*	>15	(60)	3	
П210	Ge, p; SU	-50*	(12)	0,1*	>15	(60)	3	
П210А	Ge, p; SU	-55*	(12)	0,1*	>15	(60)	3	
П210Б	Ge, p; SU	-40*	(12)	0,1*	>10	(60)	3	
П211	Ge, p; SU	-50	400	1*	50-150	750	4	
П212	Ge, p; SU	-50	400	1*	20-60	750	4	
П212А	Ge, p; SU	-70	400	1*	50-150	750	4	
П213	Ge, p; SU	-40*	(5)	0,15*	20-50	(10)	5	
П213А	Ge, p; SU	-30*	(5)	0,15*	20	(10)	5	
П213Б	Ge, p; SU	-30*	(5)	0,15*	>20	(10)	5	
П214	Ge, p; SU	-55*	(5)	0,15*	20-60	(10)	5	
П214А	Ge, p; SU	-55*	(5)	0,15*	50-150	(10)	5	
П214Б	Ge, p; SU	-55*	(5)	0,15*	20-150	(10)	5	
П214В	Ge, p; SU	-55*	(5)	0,15*	20	(10)	5	
П214Г	Ge, p; SU	-55*	(5)	(100)*	>20	(10)	5	
П215	Ge, p; SU	-80	(5)	(150)*	20-150	(10)	5	
П216	Ge, p; SU	-40	(7,5)	(100)*	>20	(30)	5	
П216А	Ge, p; SU	-40	(7,5)	(100)*	20-80	(30)	5	
П216Б	Ge, p; SU	-35	(7,5)	(100)*	10	(24)	5	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , V	I_{C}^{max} , mA (A)	f_{T} , MHz (kHz)	h_{21E} , P	P_{C}^{max} , mW (W)	Пакет	Забелешка
П216В	Ge, p; SU	-35	(7,5)	(100)*	30	(24)	5	
П216Г	Ge, p; SU	-50	(7,5)	(100)*	5	(24)	5	
П216Д	Ge, p; SU	-50	(7,5)	(100)*	15-30	(30)	5	
П217	Ge, p; SU	-60	(7,5)	(100)*	15	(30)	5	
П217А	Ge, p; SU	-60	(7,5)	(100)*	20-60	(30)	5	
П217Б	Ge, p; SU	-60	(7,5)	(100)*	20	(30)	5	
П217В	Ge, p; SU	-60	(7,5)	(100)*	15-40	(24)	5	
П217Г	Ge, p; SU	-60	(7,5)	(100)*	15-40	(24)	5	
П302	Si, p; SU	-35	500	0,2*	10-50	(7)	3	
П303	Si, p; SU	-50	500	0,1*	6-40	(10)	3	
П303А	Si, p; SU	-60	500	0,1*	6-40	(10)	3	
П304	Si, p; SU	-80	500	0,05*	5-50	(10)	3	
П305	Si, p; SU	-60	400	0,05*	7-30	(10)	3	
П305А	Si, p; SU	-80	400	0,05*	5-50	(10)	3	
П307	Si, n; SU	80	30	20	16-50	250	6	
П307А	Si, n; SU	80	30	20	30-90	250	6	
П307Б	Si, n; SU	60	30	20	50-150	250	6	
П307В	Si, n; SU	60	30	20	50-150	250	6	
П307Г	Si, n; SU	80	15	20	16-50	250	6	
П308	Si, n; SU	120	15	20	30-90	250	6	
П309	Si, n; SU	120	30	20	16-50	250	2	
П401	Ge, p; SU	-10*	20	30	50	100	7	
П402	Ge, p; SU	-10*	20	50	98	100	7	
П403	Ge, p; SU	-10*	20	100	50	100	7	
П403А	Ge, p; SU	-10*	20	180	50	100	7	
П404	Ge, p; SU	-4,5*	15	15*	50	10	8	
П404А	Ge, p; SU	-4,5*	4	15*	50	10	8	
П405	Ge, p; SU	-4,5*	4	30*	50	10	8	
П405А	Ge, p; SU	-4,5*	4	30*	50	10	8	
П406	Ge, p; SU	-6*	5	10*	50	30	7	



Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	K_{21E} , %	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плотность	Забелешка
П407	Ge, p; SU	-6*	5	20*	100	30	1	
П408	Ge, p; SU	-6*	5	10*		20	2х3	
П409	Ge, p; SU	-6*	5	20*		30	2х3	
П410	Ge, p; SU	-6*	20	200*	30-45	100	4	
П410А	Ge, p; SU	-6*	20	400*	100-300	100	4	
П411	Ge, p; SU	-6*	20	400*	30-45	100	4	
П411А	Ge, p; SU	-6*	20	400*	100-300	100	4	
П412	Ge, p; SU	-4,5	5	30*	20-50	10	2	
П413	Ge, p; SU	-4,5	5	30	20-50	10	2	
П414	Ge, p; SU	-10*	10	60*	45	100	5	
П414А	Ge, p; SU	-10*	10	60*	100	100	5	
П414Б	Ge, p; SU	-10*	10	60*	140	100	5	
П415	Ge, p; SU	-10*	10	120*	45	100	5	
П415А	Ge, p; SU	-10*	10	120*	100	100	5	
П415Б	Ge, p; SU	-10*	10	120*	140	100	5	
П416	Ge, p; SU	-15	25	50	25-80	100	1	
П416А	Ge, p; SU	-15	25	80	60-125	100	1	
П416Б	Ge, p; SU	-15	25	80	90-200	100	1	
П417	Ge, p; SU	-10	10	200*	24-100	50	1	
П417А	Ge, p; SU	-10	10	200*	65-200	50	1	
П418	Ge, p; SU	-10	10	400*	8-70	50	6	
П418Г	Ge, p; SU	-10	10	400*	8-70	50	6	
П418Д	Ge, p; SU	-10	10	400*	8-70	50	6	
П418Е	Ge, p; SU	-10	10	400*	60-170	50	6	
П418Ж	Ge, p; SU	-10	10	400*	60-170	50	6	
П418	Ge, p; SU	-10	10	200*	60-170	50	6	
П418К	Ge, p; SU	-10	10	200*	60-170	50	6	
П418Л	Ge, p; SU	-10	10	200*	8-70	50	6	
П418	Ge, p; SU	-10	10	200*	8-70	50	6	
П420	Ge, p; SU	-10*	10	30*	>12	50	4	
П421	Ge, p; SU	-10*	10	30*	>15	50	4	
П422	Ge, p; SU	-10*	10	60*	30-100	50	1	
П422А	Ge, p; SU	-10*	10	60*	>15	50	1	
П423	Ge, p; SU	-10*	10	120*	30-100	50	1	
П423А	Ge, p; SU	-10*	10	120*	>15	50	1	



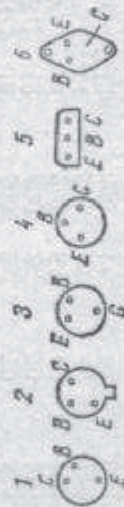
Биполярни транзистори

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	K_{21E} , %	$P_{C\max}$, Вт (W)	Плотность	Забелешка
П501	Si, p; SU	-20*	10	10*	18	150	1	
П501А	Si, p; SU	-20*	10	10*	>20	150	1	
П502	Si, p; SU	-20*	10	30*	>9	150	1	
П502А	Si, p; SU	-20*	10	30*	>20	150	1	
П502Б	Si, p; SU	-20*	10	30*	>9	150	1	
П502В	Si, p; SU	-20*	10	30*	20	150	1	
П503	Si, p; SU	-20*	10	60*	10	150	1	
П503А	Si, p; SU	-20*	10	60*	20	150	1	
П504	Si, n; SU	-30*	10	2,5*	10-35	150	6	
П504А	Si, n; SU	-30*	10	2,5*	25-80	150	6	
П505	Si, n; SU	-30*	10	4,7*	40	150	6	
П505А	Si, n; SU	-30*	10	4,7*	20	150	6	
П601	Si, p; SU	-25*	(1)*	20*	20	(1)	7	ММ
П601А	Si, p; SU	-30*	(1)*	20*	40	(1)	7	ММ
П601АИ	Si, p; SU	-30*	(1,5)*	20*	40	(3)	7	ММ
П601Б	Si, p; SU	-25*	(1)*	20*	80	(1)	7	ММ
П601БИ	Si, p; SU	-30*	(1,5)*	20*	80	(3)	7	ММ
П601И	Si, p; SU	-25*	(1,5)*	20*	20	(3)	7	ММ
П602	Si, p; SU	-30*	(1)*	20*	40	(1)	7	ММ
П602А	Si, p; SU	-25*	(1)*	20*	80	(1)	7	ММ
П602АИ	Si, p; SU	-25*	(1,5)*	30*	80	(3)	7	ММ
П602И	Si, p; SU	-30*	(1,5)*	30*	40	(3)	7	ММ
П604	Si, p; SU	-45*	500	10*	10-30	400	7	
П604А-Б	Si, p; SU	-45*	500	10*	25-100	400	7	
П605	Si, p; SU	-45	(1,5)*	30	20-60	(3)	7	
П605А	Ge, p; SU	-45	(1,5)*	30	40-120	(3)	7	
П606	Ge, p; SU	-35	(1,5)*	30	20-60	(3)	7	
П606А	Ge, p; SU	-35	(1,5)*	30	40-120	(3)	7	
П607	Si, n; SU	-25	300	60	20-80	(1,5)	7	
П607А	Si, n; SU	-25	300	60	60-200	(1,5)	7	



Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , f_{β} , МГц (kHz)	h_{21E} , p	$P_{C\max}$, мВт (W)	Полка	Забелешка
П608	Si, n; SU	30	300	90	40-140	(1,5)	1	
П608А	Si, n; SU	30	300	90	80-240	(1,5)	1	
П608Б	Si, n; SU	50	300	90	40-120	(1,5)	1	
П609	Si, n; SU	30	300	120	40-120	(1,5)	1	
П609А	Si, n; SU	30	300	120	80-240	(1,5)	1	
П609Б	Si, n; SU	50	300	120	80-240	(1,5)	1	
П701	Si, n; SU	40	500	12,5	10-40	(10)	1	
П701А	Si, n; SU	60	500	12,5	15-60	(10)	1	
П701Б	Si, n; SU	35	500	12,5	20-100	(10)	1	
П702	Si, n; SU	60	(2)	4	25	(40)	1	
П702А	Si, n; SU	60	(2)	4	10	(40)	1	
SA310	Si, p; USA	-30	50	10	20	150	2	
SA495	Si, p; GB	-25*	50	20	20	150	3	
SA496	Si, p; GB	-10*	50	11	20	150	3	
SAC40	Si, p; GB	-15*	50	10	20	150	4	
SAC42	Si, p; GB	-25	50	10	20	150	4	
SAC44	Si, p; GB	-5	50	4	20	150	3	
SC100	Si, p; DDR	-10*	50	2,3*	20	250	2	
SC103	Si, p; DDR	-10*	50	4,2*	20	250	2	
SC104	Si, p; DDR	-10*	50	6*	20	250	2	
SC105	Si, p; DDR	-6,6*	50	12*	20	250	2	
SC106	Si, p; DDR	-10*	50	10*	20	250	2	
SC107	Si, p; DDR	-25*	50	10*	20	250	2	
SC108	Si, p; DDR	-10*	50	20	40	250	2	
SC109	Si, p; DDR	-9*	50	20	40	250	2	
SC110	Si, n; DDR	20	250	40	40	600	2	
SC111	Si, n; DDR	30	200	60	40	600	2	
SC112	Si, n; DDR	20	100	60	40	600	2	
SC206	Si, n; DDR	20	100	300	18-1120	200	5	
SC207	Si, n; DDR	20	100	300	28-1120	200	5	
SC236	Si, n; DDR	30	100	200	56-560	200	5	
SC237	Si, n; DDR	50	100	200	56-560	200	5	
SC238	Si, n; DDR	30	100	200	56-1120	200	5	

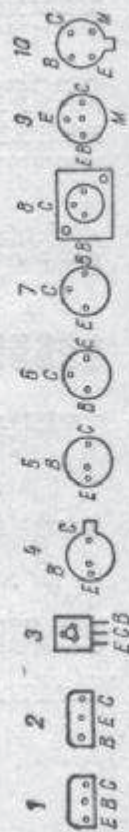


Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , f_{β} , МГц (kHz)	h_{21E} , p	$P_{C\max}$, мВт (W)	Полка	Забелешка
SC239	Si, n; DDR	30	100	200	112-1120	200	5	
SD100	Si, n; DDR	28	(3)	15	50	(62)	6	
SD101	Si, n; DDR	30	(3)	15	50	(62)	6	
SD102	Si, n; DDR	50	(3)	15	50	(62)	6	
SD168	Si, n; DDR	300*	(3)	1	<10	(12)	6	ва
SF021	Si, n; DDR	20	500	60	20	600	2	
SF022	Si, n; DDR	33	500	60	20	600	2	
SF023	Si, n; DDR	66	500	60	20	600	2	
SF024	Si, n; DDR	100	500	60	20	600	2	
SF025	Si, n; DDR	120	500	60	20	600	2	
SF111	Si, n; DDR	20	200	40	20	400	2	
SF112	Si, n; DDR	30	200	40	20	400	2	
SF113	Si, n; DDR	60	200	40	20	400	2	
SF114	Si, n; DDR	100	200	40	20	400	2	
SF115	Si, n; DDR	80	200	40	20	400	2	
SF121	Si, n; DDR	20	100	130	18-1120	600	2	
SF122	Si, n; DDR	33	100	130	18-1120	600	2	
SF123	Si, n; DDR	66	100	130	18-1120	600	2	
SF126	Si, n; DDR	33	500	100	18-1120	600	2	
SF127	Si, n; DDR	66	500	100	18-1120	600	2	
SF128	Si, n; DDR	100	500	100	18-1120	600	2	
SF129	Si, n; DDR	120	500	100	18-560	600	2	
SF131	Si, n; DDR	20	50	330	18-1120	300	2	
SF132	Si, n; DDR	40	50	270	18-1120	300	2	
SF136	Si, n; DDR	20	200	300	18-1120	300	2	
SF137	Si, n; DDR	40	200	300	18-1120	300	2	
SF138	Si, n; DDR	40	200	200	50	300	2	
SF140	Si, n; DDR	40	25	350	50	300	2	
SF150	Si, n; DDR	160	50	80	28-140	630	2	
SF215	Si, n; DDR	20	100	400	28-560	200	5	

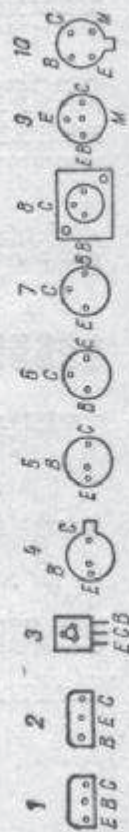
Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{21E} , β	P_{\max} , mW (W)	Пов'язка	Забеліжка
SF216	Si, n; DDR	40	100	400	28-560	200	1	
SF225	Si, n; DDR	40	25	100	>40	200	2	
SF235	Si, n; DDR	40	25	400	>40	200	1	
SF240	Si, n; DDR	40	25	600	>40	160	2	
SF245	Si, n; DDR	40	25	780	30-300	200	2	
SF357	Si, n; DDR	160	100	90	25	(6)	3	ВВ
SF358	Si, n; DDR	250	100	90	25	(6)	3	ВВ
SF359	Si, n; DDR	300	100	90	25	(6)	3	ВВ
SFT101+3	Ge, p; F	-24	100	(600)*	50	100	4	
SFT106	Ge, p; F	-12	50	3*	40	80	5	
SFT107	Ge, p; F	-12	50	6*	40	80	5	
SFT108	Ge, p; F	-12	50	6*	40	80	5	
SFT113	Ge, p; F	-30	(3)	(250)*	20	(25)	6	
SFT114	Ge, p; F	-60	(3)	(250)*	20	(25)	6	
SFT115	Ge, p; F	-40	10	30*	40	120	5	
SFT116	Ge, p; F	-25	10	30*	50	120	5	
SFT117	Ge, p; F	-25	10	30*	50	120	4	
SFT118	Ge, p; F	-25	10	30*	50	120	4	
SFT119	Ge, p; F	-25	10	30*	50	120	5	
SFT120	Ge, p; F	-25	10	30*	50	120	5	
SFT121	Ge, p; F	-12*		1,3*	30	150	5	
SFT122	Ge, p; F	-12*	250*	1,6*	30	150	5	
SFT123	Ge, p; F	-12*	250*	2,6*	30	150	5	
SFT124	Ge, p; F	-12	500*	1*	50	350	7	
SFT124	Ge, p; BG	-24	500	1	30	350	6	
SFT124B	Ge, p; BG	-18	500	1	30	350	6	
SFT124C	Ge, p; BG	-12	500	1	30	350	6	
SFT125	Ge, p; F	-12	500*	2*	60	350	7	
SFT125	Ge, p; BG	-24	500	2	70	350	6	
SFT125P	Ge, p; F	-30	500	2*	60	350	7	
SFT125B	Ge, p; BG	-18	500	2	70	350	6	
SFT125C	Ge, p; BG	-12	500	2	70	350	6	
SFT126	Ge, p; F	-24	250	5*	40	150	5	
SFT128	Ge, p; F	-24	250	10*	40	150	5	
SFT130	Ge, p; F	-12	500*	1*	50	550	7	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{21E} , β	P_{\max} , mW (W)	Пов'язка	Забеліжка
SFT130	Ge, p; BG	-24	500	1	30	550	8	
SFT130C	Ge, p; BG	-12	500	1	30	550	8	
SFT131	Ge, p; F	-12	500*	2*	60	550	7	
SFT131	Ge, p; BG	-24	500	1,8	70	550	8	
SFT131C	Ge, p; BG	-12	500	1,8	70	550	8	
SFT131P	Ge, p; F	-30	550	2*	60	550	7	
SFT135	Ge, p; F	-25	10	30*	30	120	8	
SFT136	Ge, p; F	-35	250	2,5*	30	150	8	
SFT141	Ge, p; F	-45	250	1*	30	200	5	
SFT142	Ge, p; F	-45	250	1,2*	40	200	5	
SFT143	Ge, p; F	-45	500	1*	50	350	7	
SFT144	Ge, p; F	-45	500	1,8*	55	350	7	
SFT145	Ge, p; F	-45	500	1*	30	550	7	
SFT146	Ge, p; F	-45	500	1,8*	60	550	7	
SFT151	Ge, p; F	-12	150	(700)*	30	150	5	
SFT152	Ge, p; F	-12	150	(900)*	40	150	5	
SFT153	Ge, p; F	-12	150	1,1*	40	150	5	
SFT154	Ge, p; F	-35	250	7*	40	150	4	
SFT155	Ge, p; F	-35	10	100*	40	120	5	
SFT162	Ge, p; USA	-70	10	70	50	240	9	
SFT163	Ge, p; F	-15	10	120	40	120	9	
SFT170	Ge, p; F	-30	25	250	40	65	10	
SFT171	Ge, p; USA	-30	25	250	50	100	10	
SFT172	Ge, p; USA	-30	25	250	50	100	10	
SFT173	Ge, p; USA	-30	25	250	50	100	10	
SFT174	Ge, p; USA	-30	25	250	20	100	10	
SFT184	Ge, n; USA	15	100	5	40	150	10	
SFT185	Ge, p; F	-30	100	3	40	150	10	
SFT186	Si, n; USA	140	150	180	30	800	10	
SFT187	Ge, n; F	135	150	100	30	800	10	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	η_{21E}, ρ	P_{Cmax} , mW (W)	Цоколя	Забелешка
SFT187A	Si, n, F	135	100	70	40	800	1	
SFT190	Ge, p, F	-65*	(3)	(400)	50	(30)	2	
SFT191	Ge, p, F	-50	(1)	(200)	50	(20)	2	
SFT192	Ge, p, F	-45*	(3)	(200)*	50	(30)	2	
SFT206	Ge, p, F	-18	250	5,5	40	200	1	
SFT207	Ge, p, F	-18	250	7,5	50	200	1	
SFT208	Ge, p, F	-15	250	12	50-200	150	1	
SFT211	Ge, p, F	-80	(6)	(500)	40	(30)	2	
SFT212	Ge, p, USA	-30	(3)	(200)*	40	(45)	2	
SFT212	Ge, p, BG	-30	(3)	(300)	40	(30)	2	
SFT213	Ge, p, F	-40	(3)	(200)*	40	(45)	2	
SFT213	Ge, p, BG	-40	(3)	(300)	40	(45)	2	
SFT214	Ge, p, F	-60	(3)	(500)	40	(45)	2	
SFT214	Ge, p, BG	-60	(3)	(300)	40	(45)	2	
SFT221	Ge, p, F	-30	250	1,3*	30	225	1	
SFT222	Ge, p, F	-30	250	2*	50	225	1	
SFT223	Ge, p, F	-30	250	3*	80	225	1	
SFT226	Ge, p, USA	-40	250	5,5	25	150	1	
SFT227	Ge, p, F	-30	250	7,5	35	150	1	
SFT228	Ge, p, F	-24	250	12	50	150	1	
SFT229	Ge, p, F	-18	250	15	75	150	1	
SFT232	Ge, p, F	-40	(3)	(700)	40	500	1	
SFT233	Ge, p, F	-60	(3)	(700)	40	500	1	
SFT234	Ge, p, F	-80	(3)	(700)	40	450	1	
SFT234A	Ge, p, F	-80	(1)	(200)	50	450	1	
SFT235	Ge, p, F	-100	(3)	(700)	40	500	1	
SFT237	Ge, p, F	-15	100	3*	100	150	1	
SFT238	Ge, p, F	-40	(6)	(300)*	30	(45)	2	
SFT239	Ge, p, F	-60	(6)	(300)*	30	(45)	2	
SFT240	Ge, p, F	-100	(10)	(500)	30	(45)	2	
SFT241	Ge, p, F	-45	500	1,6*	45	225	1	
SFT242	Ge, p, F	-45	500	2,5*	70	225	1	
SFT243	Ge, p, F	-60	500	2*	30-100	225	1	
SFT244	Ge, p, F	-80	400	1	40	225	1	
SFT245	Ge, p, F	-100	400	1	40	225	1	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CBmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T, f_{α} , MHz (kHz)	η_{21E}, ρ	P_{Cmax} , mW (W)	Цоколя	Забелешка
SFT250	Ge, p, F	-80	(3)	(500)*	40	(45)	2	
SFT251	Ge, p, F	-30	150	1,3*	30	225	1	
SFT252	Ge, p, F	-30	150	2*	30	225	1	
SFT253	Ge, p, F	-30	150	3*	80	225	1	
SFT259	Ge, n, F	20	250	3	20	150	1	
SFT260	Ge, n, F	20	250	9	25	150	1	
SFT261	Ge, n, F	20	250	13	30	150	1	
SFT264	Ge, p, F	-30	(15)	(300)*	45	(87)	3	
SFT265	Ge, p, F	-40	(15)	(300)*	20-70	(87)	3	
SFT266	Ge, p, F	-60	(15)	(300)*	20-70	(87)	3	
SFT267	Ge, p, F	-80	(15)	(300)*	20-70	(87)	3	
SFT268	Ge, p, F	-100	(15)	(300)*	20-70	(87)	3	
SFT288	Ge, p, F	-24	500	16*	40	150	1	
SFT289	Ge, p, F	-30	500	15*	30	150	1	
SFT298	Ge, n, F	30	500	15	35	150	1	
SFT306	Ge, p, F	-18	10	3*	28	150	4	ИМП
SFT306	Ge, p, BG	-18	100	1,5	28	150	4	ИМП
SFT306A	Ge, p, BG	-12	100	1,5	28	150	4	ИМП
SFT306C	Ge, p, BG	-9	100	1,5	28	150	4	ИМП
SFT307	Ge, p, F	-18	10	7*	40	150	4	ИМП
SFT307	Ge, p, BG	-18	100	6	40	150	4	ИМП
SFT307A	Ge, p, BG	-12	100	6	40	150	4	ИМП
SFT307C	Ge, p, BG	-9	100	6	40	150	4	ИМП
SFT308	Ge, p, F	-18	10	13*	70	150	4	ИМП
SFT308	Ge, p, BG	-18	100	10	70	150	4	ИМП
SFT308A	Ge, p, BG	-12	100	10	70	150	4	ИМП
SFT308C	Ge, p, BG	-9	100	10	70	150	4	ИМП
SFT315	Ge, p, F	-40	10	30	80	120	5	
SFT316	Ge, p, F	-20	10	70	120	120	5	
SFT317	Ge, p, F	-20	10	40	100	150	4	



Фиг. 41

Биполярни транзистори

Означения	Тип. Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	$f_{T, \alpha}$, MHz (kHz)	$K_{21E, \beta}$	P_{Cmax} , mW (W)	Почка	Забелешка
SFT1317	Ge, p; BG	-20	10	40	100	150	1	
SFT1319	Ge, p; F	-20	10	20	40-100	150	1	
SFT1319	Ge, p; BG	-20	10	30	40-100	150	1	
SFT1320	Ge, p; F	-20	10	35	80	150	1	
SFT1320	Ge, p; BG	-20	10	35	80	150	1	
SFT1321	Ge, p; F	-32	500	1,3*	55	200	1	
SFT1321	Ge, p; BG	-24	250	(500)	30	200	1	
SFT1321B	Ge, p; BG	-18	250	(900)	30	200	1	
SFT1321C	Ge, p; BG	-12	250	(900)	30	200	1	
SFT1322	Ge, p; F	-24	250	1,6*	60	200	1	
SFT1322	Ge, p; BG	-24	250	1,2	50	200	1	
SFT1322B	Ge, p; BG	-18	250	1,2	50	200	1	
SFT1322C	Ge, p; BG	-12	250	1,2	50	200	1	
SFT1323	Ge, p; F	-24	250	2,6*	85	200	1	
SFT1323	Ge, p; BG	-24	250	1,7	85	200	1	
SFT1323B	Ge, p; BG	-18	250	1,7	85	200	1	
SFT1323C	Ge, p; F	-32	500	2	100	150	1	
SFT1337	Ge, p; F	-15	100	3*	100	185	1	
SFT1337A	Ge, p; I	-24	150	7			1	
SFT1343	Ge, p; I	-70	150	1,2*		250	1	
SFT1351	Ge, p; F	-32	150	1,2*	30	200	1	
SFT1351	Ge, p; BG	-24	150	1	33	200	1	
SFT1351B	Ge, p; BG	-18	150	1	33	200	1	
SFT1351C	Ge, p; BG	-12	150	1	33	200	1	
SFT1352	Ge, p; F	-32	150	1,6*	50	200	1	
SFT1352	Ge, p; BG	-24	150	1,4	57	200	1	
SFT1352B	Ge, p; BG	-18	150	1,4	57	200	1	
SFT1352C	Ge, p; BG	-12	150	1,4	57	200	1	
SFT1353	Ge, p; F	-32	150	2,5*	80	200	1	
SFT1353	Ge, p; BG	-24	150	1,7	92	200	1	
SFT1353B	Ge, p; BG	-18	150	1,7	92	200	1	
SFT1353C	Ge, p; BG	-12	150	1,7	92	200	1	
SFT1353D	Ge, p; I	-32	150	2,4	92	250	1	
SFT1354	Ge, p; F	-20	10	80	120	120	2	

Биполярни транзистори

Означения	Тип. Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	$f_{T, \alpha}$, MHz (kHz)	$K_{21E, \beta}$	P_{Cmax} , mW (W)	Почка	Забелешка
SFT1357	Ge, p; F	-20	10	85	120	120	2	
SFT1357P	Ge, p; F	-30	10	80	180	120	2	
SFT1358	Ge, p; F	-20	10	110*	120	120	2	
SFT1367	Ge, p; F	-32	(1)	4	50-250	650	1	
SFT1373	Ge, n; I	12	300	3,5	60	250	1	
SFT1377	Ge, n; F	32	(1)	4	50	650	1	
SFT1440	Si, n; F	80	(1)	150	30	(12)	3	
SFT1443	Si, n; F	80	500	125	40	(6)	4	
SFT1443A	Si, n; F	80	(1)	180	30	(12)	3	
SFT1445	Si, n; F	80	100	200	50	800	4	
SFT1449	Si, n; F	60	(10)	100	30	(100)	5	
SFT1449A	Si, n; F	60	(10)	100	30	(150)	5	
SFT1713	Si, n; I	25	200	150	50	300	4	
SFT1714	Si, n; F	25	200	150	50	300	4	
SFT1714A	Si, n; F	50	200	150	50	300	4	
SFT1715	Si, n; F	25	200	150	40	300	4	
SFT1715A	Si, n; F	50	200	150	40	300	4	
SFT1918	Si, dn; F	15*	50	600	50	300	6	
SFT1918A	Si, dn; F	15*	50	600	50	300	6	
SFT1918B	Si, dn; F	15*	50	600	50	300	6	
SL112	Si, n; DDR	30	400	40	40	(10)	7	
SL113	Si, n; DDR	60	400	40	40	(10)	7	
SL114	Si, n; DDR	100	400	40	40	(10)	7	
SP8400	Si, n; I	120		80*	50	600	4	
SP8401	Si, n; I	100		96*	50	600	4	
SP8402	Si, n; I	100	50	20	50	600	4	
SP8568	Si, dn; I	45	50	60	40	300	6	
SS101	Si, p; DDR	-33*	50	1,9*	30	250	4	
SS102	Si, p; DDR	-66*	50	1*	50	250	4	
SS106	Si, n; DDR	25	200	450	18-560	300	4	



Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_T \cdot f_a$, МГц (kHz)	h_{FE} , %	P_{Cmax} , мВт (W)	Плотность	Заделка
SS108	Si, n; DDR	40	300	480	18-560	300	1	1
SS109	Si, n; DDR	40	200	450	18-280	300	1	1
SS120	Si, n; DDR	60	600	50	40	800	1	1
SS125	Si, n; DDR	30	500	30	30	600	1	1
SS126	Si, n; DDR	60	500	30	30	600	1	1
SS200	Si, n; DDR	70	30	>32	>32	150	2	2
SS201	Si, n; DDR	100	30	>32	>32	150	2	2
SS202	Si, n; DDR	120	30	>32	>32	150	2	2
SS216	Si, n; DDR	20	100	350	18-280	200	2	2
SS218	Si, n; DDR	20	100	350	18-280	200	2	2
SS219	Si, n; DDR	20	100	350	18-280	200	2	2
SSX16	Si, n; DDR	20	100	350	30	200	2	2
SSX18	Si, n; DDR	20	100	350	30	200	2	2
SSX19	Si, n; DDR	20	100	350	30	200	2	2
SSY20	Si, n; DDR	60	600	700	8-140	700	1	1
STC1015	Si, n; USA	30	(7.5)	2.5	30	(150)	4	4
STC1016	Si, n; USA	30	(7.5)	2.5	40	(150)	4	4
STC1400	Si, n; USA	60	(5)	2.5	30	(150)	4	4
SU161	Si, n; DDR	350	(3)*	4	>2	(10)	3	3
SU165	Si, n; DDR	300	(3)*	1	>5	(10)	3	3
T11	Ge, p; PL	-10	10	(200)*	25	25	5	5
T12	Ge, p; PL	-10	10	(200)*	25	25	5	5
T13	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T14	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T15	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T16	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T17	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T18	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	25	25	5	5
T143	Ge, p; BG	-45	500	1	>20	350	6	6
T144	Ge, p; BG	-45	500	2	>20	350	6	6
T145	Ge, p; BG	-45	500	1	>20	550	6	6
T146	Ge, p; BG	-45	500	1.8	>20	550	6	6
T151	Ge, p; PL	-10	10	(500)*	50	25	3	3
T238	Ge, p; BG	-40	(6)	(350)	>20	(45)	3	3
T239	Ge, p; BG	-60	(6)	(350)	>20	(45)	3	3

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , В	I_{Cmax} , мА (А)	$f_T \cdot f_a$, МГц (kHz)	h_{FE} , %	P_{Cmax} , мВт (W)	Плотность	Заделка
T240	Ge, p; BG	-80	(6)	(350)	>20	(45)	3	3
T241	Ge, p; BG	-32	500	(700)	>20	150	7	7
T242	Ge, p; BG	-45	200	(700)	>20	150	7	7
T243	Ge, p; BG	-60	250	(700)	>20	150	7	7
T250	Ge, p; BG	-80	(3)	(300)	>20	(45)	3	3
T316	Ge, p; BG	-20	10	(600)*	>20	120	7	7
T316H	Ge, p; BG	-32	10	50	>20	120	7	7
T317	Ge, p; BG	-20	10	40	>20	150	7	7
T319	Ge, p; BG	-20	10	45	>20	150	7	7
T320	Ge, p; BG	-20	10	20	>20	150	7	7
T321N	Ge, n; BG	32	150	1	>20	150	7	7
T322N	Ge, n; BG	32	150	1.5	>20	150	7	7
T323N	Ge, n; BG	32	150	2.2	>20	150	7	7
T328	Ge, p; BG	-40	(6)	(300)*	>20	(45)	3	3
T329	Ge, p; BG	-60	(6)	(300)*	>20	(45)	3	3
T354	Ge, p; BG	-20	10	68	>20	150	7	7
T354H	Ge, p; BG	-32	10	60	>20	120	7	7
T357	Ge, p; BG	-20	10	87	>20	150	7	7
T357H	Ge, p; BG	-32	10	70	>20	120	7	7
T358	Ge, p; BG	-20	10	100	>20	150	7	7
T358H	Ge, p; BG	-32	10	85	>20	120	7	7
TC11	Ge, p; PL	-15	10	1*	30	50	5	5
TC12	Ge, p; PL	-15	10	1*	30	50	5	5
TC13	Ge, p; PL	-15	10	1*	30	50	5	5
TC14	Ge, p; PL	-15	10	1*	30	50	5	5
TC15	Ge, p; PL	-15	10	1*	30	50	5	5
TF65	Ge, p; D	-16	50	1*	20-150	60	7	7
TF65/30	Ge, p; D	-32	50	1*	40	60	7	7

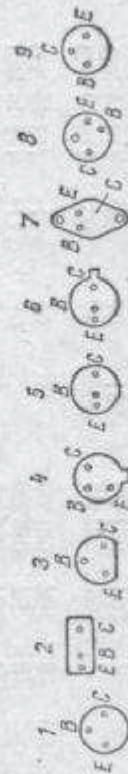


Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{FE} , β	P_{Cmax} , mW (W)	Плоть	Забелешка
TF66	Ge, p; D	-15	300*	1*	30-150	150	1	
TF66/30	Ge, p; D	-32	300	1*	30-100	150	1	
TF66/60	Ge, p; D	-64	300	1*	50	100	1	
TF70	Ge, n; D	30	25	(250)*	50	200	2	
TF71	Ge, n; D	30	25	(400)*	50	200	2	
TF72	Ge, n; D	30	25	(500)*	40	100	2	
TF75	Ge, p; D	-6,5	125		40	200	2	
TF77	Ge, p; D	-16	600*		40	500	2	
TF77/30	Ge, p; D	-32	600*		30	500	2	
TF78	Ge, p; D	-16	600	(700)*	20-150	(2)	1	
TF78/30	Ge, p; D	-32	600	(700)*	20-150	(2)	1	
TF78/60	Ge, p; D	-64	600	(700)*	20-100	(2)	1	
TF80/30	Ge, p; D	-32	(3)	(250)*	>20	(3)	1	
TF80/60	Ge, p; D	-64	(3)	(250)*	>20	(3)	1	
TF80/80	Ge, p; D	-80	(3)	(250)*	>13	(3)	1	
TF85	Ge, p; D	-6,5	(1,25)	1*	20	(4)	1	
TF90/30	Ge, p; D	-32*	(15)	(500)*	20	(7)	3	
TF90/60	Ge, p; D	-64*	(15)	(500)*	20	(7)	3	
TF251	Si, n; D	5	20	(500)*	20	500	1	
TF252	Si, n; D	10	20	1*	20	500	1	
TF260	Si, n; D	100	300	1*	30	600	4	
TG1	Ge, p; PL	-15	50	(300)*	20	50	5	
TG2	Ge, p; PL	-15	10	1,5	20-80	75	4	
TG3	Ge, p; PL	-15	10	(300)*	20	75	4	
TG3A	Ge, p; PL	-15	10	3	75-130	75	4	
TG3F	Ge, p; PL	-15	10	2	50	75	4	
TG4	Ge, p; PL	-15	10	2	20-50	75	4	
TG5	Ge, p; PL	-30	10	1,5	25-80	75	4	
TG5E	Ge, p; PL	-15	10	(600)	50	75	4	
TG6	Ge, p; PL	-30	10	(800)*	50	50	5	
TG8	Ge, p; PL	-60	30	1,7	40	75	4	
TG9	Ge, p; PL	-15	125	1,5*	40	75	6	
TG10	Ge, p; PL	-15	5	3*	30-120	50	5	
TG11	Ge, p; PL	-15	125	2	40	50	6	

Биполярни транзистори

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	h_{FE} , β	P_{Cmax} , mW (W)	Плоть	Забелешка
TG20	Ge, p; PL	-15	5	7*	>20	50	1	
TG27	Ge, p; PL	-15	10	40	>20	50	5	
TG37	Ge, p; PL	-15	10	40	>20	50	5	
TG38	Ge, p; PL	-15	10	20	>20	50	5	
TG39	Ge, p; PL	-15	10	20	>20	50	5	
TG40	Ge, p; PL	-15	10	20	>20	50	5	
TG41	Ge, p; PL	-25	10	150	>10	50	4	
TG50	Ge, p; PL	-30	150	1,2	15-120	175	4	
TG51	Ge, p; PL	-60	150	1,2	15-120	175	4	
TG52	Ge, p; PL	-30	150	1,2	15-120	175	4	
TG53	Ge, p; PL	-15	150	1,2	30-120	175	4	
TG55	Ge, p; PL	-30	150	1,2	30-120	175	4	
TG60	Ge, p; PL	-30	(1,5)	(100)*	20-100	(1)	7	
TG70	Ge, p; PL	-30	(1,5)	(100)*	16-120	(5)	7	
TG71	Ge, p; PL	-20	(1,5)	(100)*	16-120	(5)	7	
TG72	Ge, p; PL	-60	(1,5)	(100)*	16-120	(5)	7	
THP45	Ge, p; F	-15	(3)	(200)*	20-200	(12)	8	
THP46	Ge, p; F	-30	(3)	(200)*	20-100	(12)	8	
THP47	Ge, p; F	-60	(3)	(200)*	20-100	(12)	8	
THP50	Ge, p; F	-15	(2,5)	(200)	30	(5)	8	
THP51	Ge, p; F	-30	(2,5)	(200)*	30	(5)	8	
THP52	Ge, p; F	-60	(2,5)	(200)*	30	(5)	8	
THP79	Ge, n; F	6*	20	100*	50	30	9	
THP80	Ge, n; F	6*	20	40	50	50	9	
THP81	Ge, n; F	6*	20	20*	50	50	9	
TZ5	Ge, p; PL	-10	10	2*	50	25	5	
TZ6	Ge, p; PL	-10	10	2*	50	25	5	
TZ7	Ge, p; PL	-10	10	(700)*	50	25	5	



Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , f_a , MHz (kHz)	$R_{21, E, B}$	P_{Cmax} , mW (W)	Цоколя	Забелешка
TZ8	Ge, p; PL	-10	10	2*	20	25	1	
TZ9	Ge, p; PL	-10	10	2*	20	25	1	
TZ10	Ge, p; PL	-10	10	2*	20	25	1	
TZ11	Ge, p; PL	-10	10	2*	20	25	1	
XC703	Si, n; GB	-60	(1.5)	1.5*	>15	(4)	2	
XC713	Si, n; GB	60	(3)	1.2*	>15	(15)	3	
ZDT40	Si, dn; GB	45	500	290	30	300	4	
ZDT44	Si, dn; GB	60	500	290	30	300	4	
ZT20	Si, n; GB	20	50	110	18-24	350	3	
ZT33	Si, n; GB	120	(1)	60	40	(1)	3	
ZT2857	Si, n; GB	30	20	1000	50	200	5	
INU40	Ge, p; CS	-10	3	(100)*		20	1	
INU70	Ge, p; CS	-10	3	(100)*		30	1	
IT101	Ge, p; SU	-15*	10	2*	30-60	50	3	
IT101A	Ge, p; SU	-15*	10	2*	20-40	50	3	
IT102	Ge, p; SU	-5*	6	1*	20	30	3	
IT102A	Ge, p; SU	-5*	6	1*	20	30	3	
IT115A	Ge, p; SU	-50	100	1*	20-60	50	6	
IT115B	Ge, p; SU	-50	100	1*	50-150	50	6	
IT115B	Ge, p; SU	-70	100	1*	20-60	50	6	
IT115Г	Ge, p; SU	-70	100	1*	50-150	50	6	
IT303A	Ge, n; SU	10*	10	20	15-60	10	7	
IT303B	Ge, n; SU	10*	10	20	30-80	10	7	
IT303B	Ge, n; SU	10*	10	20	60-150	10	7	
IT303Г	Ge, n; SU	10*	10	20	15-50	10	7	
IT303Д	Ge, n; SU	10*	10	20	30-80	10	7	
IT303E	Ge, n; SU	10*	10	20	60-160	10	7	
IT305A	Ge, p; SU	-15*	40		25-80	75	8	
IT305B	Ge, p; SU	-15*	40		60-180	75	8	
IT305B	Ge, p; SU	-15*	40		40-120	75	8	
IT308A	Ge, p; SU	-20	50	90*	25-75	150	7	
IT308B	Ge, p; SU	-20	50	120*	50-120	150	7	
IT308Г	Ge, p; SU	-20	50	120*	80-150	150	7	
IT311A	Ge, n; SU	12*	50	>300	100-300	150	9	



Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	U_{CEmax} , V	I_{Cmax} , mA (A)	f_T , f_a , MHz (kHz)	$R_{21, E, B}$	P_{Cmax} , mW (W)	Цоколя	Забелешка
IT311B	Ge, n; SU	12*	50	>300	30-180	150	9	
IT311B	Ge, n; SU	12*	50	>300	15-50	150	9	
IT311Г	Ge, n; SU	12*	50	>450	30-80	150	9	
IT311Д	Ge, n; SU	12*	50	>600	60-180	150	9	
IT311K	Ge, n; SU	12*	50	>450	60-180	150	9	
IT311Л	Ge, n; SU	12*	50	>600	150-300	150	9	
IT313A	Ge, p; SU	-12*	50	>300	20-250	100	9	
IT313B	Ge, p; SU	-12*	50	>400	20-80	100	9	
IT313B	Ge, p; SU	-12*	50	>330	60-250	100	9	
IT321A	Ge, p; SU	-50	200	60	20-60	160	7	
IT321B	Ge, p; SU	-50	200	60	40-120	160	7	
IT321Г	Ge, p; SU	-50	200	60	80-200	160	7	
IT321Д	Ge, p; SU	-50	200	60	20-60	160	7	
IT321E	Ge, p; SU	-50	200	60	40-120	160	7	
IT329A	Ge, n; SU	10	20	1200	15-300	50	10	
IT329B	Ge, n; SU	10	20	1680	15-300	50	10	
IT329B	Ge, n; SU	10	20	990	15-300	50	10	
IT335A	Ge, p; SU	-20	150	300	40-70	200	7	
IT335B	Ge, p; SU	-20	150	300	60-100	200	7	
IT335B	Ge, p; SU	-20	150	300	40-70	200	7	
IT335Г	Ge, p; SU	-20	150	300	60-100	200	7	
IT335Д	Ge, p; SU	-20	150	300	50-100	200	7	
IT403A	Ge, p; SU	-45	1250	(8)	20-60	(1)	8	
IT403B	Ge, p; SU	-45	1250	(8)	50-150	(1)	8	
IT403B	Ge, p; SU	-60	1250	(8)	20-60	(1)	8	
IT403Г	Ge, p; SU	-60	1250	(8)	20-150	(1)	8	
IT403Д	Ge, p; SU	-60	1250	(8)	20-150	(1)	8	
IT403E	Ge, p; SU	-60	1250	(8)	30	(1)	8	
IT403Ж	Ge, p; SU	-80	1250	(8)	20-60	(1)	8	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, mW (W)	Класс	Забелешка
1T403P	Ge, p; SU	-80	1250	(80)	50-150	(1)	1	
1T806A	Ge, p; SU	-75	(20)	10*	10	(30)	2	
1T806B	Ge, p; SU	-100	(20)	10*	10	(30)	2	
1T806B	Ge, p; SU	-120	(20)	10*	10	(30)	2	
1T806F	Ge, p; SU	-80	20	10	10	30	2	
2N34	Ge, p; USA	-40	100	(400)*	75	150	3	
2N37	Ge, p; USA	-20	8	(600)*	30	50	3	
2N38	Ge, p; USA	-20	8	(500)*	15	50	3	
2N43	Ge, p; USA	-45	300	1.3*	53	240	4	
2N44	Ge, p; USA	-45	300	1*	31	240	4	
2N45	Ge, p; USA	-45	50	1*	12	150	5	
2N77	Ge, p; USA	-25	15	(700)*	55	35	5	
2N101	Ge, p; USA	-30	(1,5)	(10)*	40	(1)	6	
2N104	Ge, p; USA	-30	50	(700)*	44	150	4	
2N105	Ge, p; USA	-25	15	(750)*	55	35	5	
2N106	Ge, p; USA	-25	10	(800)*	45	100	3	
2N107	Ge, p; USA	-12	10	1*	19	50	4	
2N108	Ge, p; USA	-20	15	1*	30	50	7	
2N109	Ge, p; USA	-35	150	5*	75	165	4	
2N114	Ge, p; USA	-30	200	20*	75	130	3	
2N138	Ge, p; USA	-20	150	1,2*	44	150	3	
2N141	Ge, p; USA	-30*	800	(400)*		(4)	6	
2N143	Ge, p; USA	-30*	800	(400)*		(4)	6	
2N174	Ge, p; USA	-80	(15)		25-50	(50)	8	
2N175	Ge, p; USA	-10	2	(850)*	65	20	4	
2N186	Ge, p; USA	-25	200	(800)*	24	100	4	
2N187	Ge, p; USA	-25	200	(800)*	36	100	4	
2N189	Ge, p; USA	-25*	200	(800)*	21	200	4	
2N190	Ge, p; USA	-25*	200	1*	36	200	4	
2N204	Ge, p; USA	-30*	100	(400)*		100	7	
2N207	Ge, p; USA	-12	20	2*	100	85	7	
2N213	Ge, p; USA	-40	100	3*	150	180	3	
2N215	Ge, p; USA	-30	50	(700)*	44	150	7	
2N217	Ge, p; USA	-25	70	(350)*	75	150	7	
2N218	Ge, p; USA	-16	105	13	48	35	7	

Биполярни транзистори

Означения	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, V	$I_{C\max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	$h_{21E, \beta}$	$P_{C\max}$, mW (W)	Класс	Забелешка
2N219	Ge, p; USA	-16	15	10*	75	80	7	
2N235	Ge, p; USA	-40*	(3)	(7)*		(25)	9	
2N270	Ge, p; USA	-25	75	25	70	250	5	
2N301	Ge, p; USA	-40	(1,5)		30	(11)	9	
2N316	Ge, p; USA	-20	500	12*	30	150	5	
2N333	Si, n; USA	45	25	8*	15	150	5	
2N335	Si, n; USA	45	25	11*	63	150	5	
2N336	Si, n; USA	45	25	13*	200	150	5	
2N356	Ge, n; USA	20	500	3	30	100	5	
2N363	Ge, p; USA	-32	100	1,5*	50	170	5	
2N375	Ge, p; USA	-80	(3)		55	(90)	9	
2N393	Ge, p; USA	-6	50	50	50	25	6	
2N404	Ge, p; USA	-25	100	13*	>30	150	5	
2N406	Ge, p; USA	-20	35	(650)*	35	150	7	
2N408	Ge, p; USA	-20	70	6,7*	75	150	7	
2N410	Ge, p; USA	-13	15	6,8*	48	80	7	
2N412	Ge, p; USA	-13	15	16,5	75	80	7	
2N414	Ge, p; USA	-30	200	7*	60	170	5	
2N422	Ge, p; USA	-35	200	(800)*	50	150	5	
2N458	Ge, p; USA	-80	(5)		30	(50)	9	
2N464	Ge, p; USA	-45	100	1*	26	170	5	
2N483	Ge, p; USA	-12	20	5,5*	60	150	5	
2N486	Ge, p; USA	-12	10	12*	100	150	5	
2N514	Ge, p; USA	-40	(25)	(430)	20-60	(150)	9	
2N537	Ge, p; USA	-30	100	750	50	250	5	
2N591	Ge, p; USA	-32	20	(700)*	70	50	7	
2N614	Ge, p; USA	-20	150	3*		125	5	
2N618	Ge, p; USA	-80	(3)		90	(90)	9	
2N633	Ge, p; USA	-32	100	1,5*	60	170	5	
2N679	Ge, n; USA	25	200	3	30	150	5	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , V	U_{CE}^{max} , V	I_C^{max} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	K_{21E} , p	$P_{C^{max}}$, mW (W)	Покрък	Забелѣжка
2N706	Si, n; USA	25		100	320*	45	300	1	
2N708	Si, n; USA	40		200	480*	50	360	1	
2N743	Si, n; USA	20		200	400	40	300	1	
2N915	Si, n; USA	70		250	250	>40	360	1	
2N918	Si, n; USA	30		50	600	20-50	200	2	
2N930	Si, n; USA	45		30	30	100	300	1	
2N976	Ge, p; USA	15		100	250	80	100	1	
2N1015	Si, n; USA	30*		(7.5)	50	14	(150)	3	
2N1132	Si, p; USA	50		600	60	40	600	1	
2N1175	Ge, p; USA	35		200	4.2*	90	200	1	
2N1264	Ge, p; USA	20		50	10	50	50	4	
2N1305	Ge, p; USA	30		300	5*	40-200	150	1	
2N1485	Si, n; USA	60		(3.5)	1.25*	35-100	(25)	1	
2N1524	Ge, p; USA	24		10	33*	60	80	1	
2N1565	Si, n; USA	80		50	60	40-100	600	1	
2N1613	Si, n; USA	75		500	80	40-120	800	1	
2N1711	Si, n; USA	75		(1)	70	100-300	800	1	
2N1983	Si, n; USA	50		(1)	40	90	600	1	
2N1984	Si, n; USA	50		(1)	40	45	600	1	
2N1990	Si, n; USA	100		(1)	40	>20	600	1	
2N2142	Ge, p; USA	30		(3)	5	70	(63)	5	
2N2147	Ge, p; USA	75		(5)	4	50	(12.5)	5	
2N2148	Ge, p; USA	60		(5)	4	40	12.5	5	
2N2192	Si, n; USA	60		(1)	50	100-300	800	1	
2N2195	Si, n; USA	45		(1)	50	>20	600	1	
2N2218	Si, n; H	60		800	250	>40	(3)	1	ИМП
2N2218A	Si, n; H	75		800	250	>40	(3)	1	ИМП
2N2219	Si, n; H	60		800	250	>100	(3)	1	ИМП
2N2219A	Si, n; H	75		800	300	>100	(3)	1	ИМП
2N2220	Si, n; D	60		800	250	100	500	1	ИМП
2N2221	Si, n; H	60		800	250	80	(1.8)	1	ИМП
2N2221A	Si, n; H	75		800	250	80	(1.8)	1	ИМП
2N2222	Si, n; H	60		800	250	100	(1.8)	1	ИМП
2N2222A	Si, n; USA	60		800	250	100	500	1	ИМП
2N2222A	Si, n; H	75		800	250	100	(1.8)	1	ИМП

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	U_{CB}^{max} , V	U_{CE}^{max} , V	I_C^{max} , mA (A)	f_T , MHz (kHz)	K_{21E} , p	$P_{C^{max}}$, mW (W)	Покрък	Забелѣжка
2N2358	Si, n; H	40		200	400	50	360	1	
2N2359	Si, n; USA	40		500	800	100	360	1	
2N2369A	Si, n; H	40		200	500	100	360	1	
2N2371	Si, p; USA	15		50	1	80	200	6	
2N2552	Si, p; USA	40		(3)	225	50	(20)	6	
2N2562	Ge, p; USA	80		(3.5)	(250)	20-60	(20)	6	
2N2613	Ge, p; USA	30		50	4*	40	120	1	
2N2650	Si, n; USA	140*		(2)	800*	6.5-18	(8.7)	1	
2N2712	Si, n; USA	18		100	200	50	200	1	
2N2805	Si, dp; USA	25		30	60	50	250	7	
2N2894	Si, p; USA	12		400	400	40-150	360	1	
2N2904	Si, p; USA	60		600	200	40-120	600	1	
2N2905	Si, p; USA	60		600	200	100-300	600	1	
2N2907	Si, p; USA	60		600	200	10-300	400	1	
2N2924	Si, n; F	25		100	200	155	200	8	
2N2925	Si, n; F	25		100	200	215	200	8	
2N2926	Si, dn; F	18		100	200	36-215	200	7	
2N3017	Si, n; USA	100		(5)	200	60-150	(3.3)	6	
2N3053	Si, n; USA	60		700	100	50-250	(1)	1	
2N3055	Si, n; USA	100		(15)	0.8	20-100	(115)	5	
2N3179	Si, p; USA	40		(5)	1	10-30	(85)	6	
2N3241	Si, n; USA	25*		100	60	20	500	1	
2N3242	Si, n; USA	25*		200	60	50	500	1	
2N3375	Si, n; USA	65		(1.5)	350	45	(12)	6	
2N3393	Si, n; USA	25		100	140	90-180	200	9	
2N3402	Si, n; USA	25		500	120	160	560	1	
2N3439	Si, n; USA	350		(1)	15	40-160	(1)	1	
2N3478	Si, n; USA	30		50	750	50	200	2	
2N3553	Si, n; USA	30		50	600	70	200	1	
2N3567	Si, n; USA	80		500	60	40	300	10	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\ max}$, V	$I_{C\ max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	h_{21E} , °	P_{max} , mW (W)	Цепка	Забелешка
2N3632	Si, n; USA	65	(3)	250	50	(23)	1	
2N3638	Si, p; USA	-25	300	100	60	300	2	
2N3643	Si, n; USA	60	500	250	40	350	2	
2N3646	Si, p; USA	-40	200	350	50	200	2	
2N3702	Si, p; USA	-40	200	100	40-120	360	3	
2N3704	Si, n; USA	50	800	100	20-40	360	3	
2N3707	Si, n; USA	30	30	80	>40	360	3	
2N3719	Si, p; USA	-40	(3)	60	25-180	(6)	4	
2N3748	Si, n; USA	80	(5)	40	40-120	(30)	1	
2N3812	Si, dp; USA	-60	50	30	50	250	5	
2N3866	Si, n; USA	55	400	500	50	(5)	4	
2N3902	Si, n; USA	400	(2,5)	200	40	(100)	6	
2N3903	Si, n; USA	60	200	250	>50	310	2	
2N3904	Si, n; USA	60	200	300	>50	310	7	
2N3907	Si, p; USA	-40	200	250	50-150	310	7	
2N4002	Si, n; USA	100	(30)	30	20-80	(100)	1	
2N4036	Si, p; USA	-90	(1)	60	50	(5)	4	
2N4058	Si, p; USA	-30	30	50	>100	360	3	
2N4074	Si, n; USA	40	300	50	60	400	4	
2N4124	Si, n; USA	30	200	250	40	310	7	
2N4126	Si, p; USA	-25	200	250	30	310	7	
2N4236	Si, p; USA	-80	(1)	3	60	(1)	4	
2N4357	Si, p; USA	-240	100	40	45	400	4	
2N4866	Si, n; USA	140	(90)	10	50	(350)	8	
2N4921	Si, n; USA	40	(1)	3	70	(30)	9	
2N4976	Si, n; USA	55	400	1	80	(5)	10	
2N5059	Si, n; USA	250	150	30	60	(1)	4	
2N5109	Si, n; USA	40	400	1200	40-120	(3,5)	4	
2NU72	Ge, p; CS	-24	(1,5)	(100)	10	(4)	6	
2NU73	Ge, p; CS	-24	(3,5)	(150)	10	(12)	6	
2NU74	Ge, p; CS	-50	(15)	(150)	20-60	(50)	6	
2SA12	Ge, p; JP	-16	15	8*	60	80	2	
2SA15	Ge, p; JP	-16	15	12*	60	80	2	
2SA29	Ge, p; JP	-18	5	15*	50	55	2	
2SA33	Ge, p; JP	-20	25	6*	65	100	2	



Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\ max}$, V	$I_{C\ max}$, mA (A)	$f_{T, f_{\alpha}}$, MHz (kHz)	h_{21E} , °	P_{max} , mW (W)	Цепка	Забелешка
2SA42	Ge, p; JP	-45	15	6*	45	80	2	
2SA49	Ge, p; JP	-18	5	9*	70	60	2	
2SA52	Ge, p; JP	-18	5	7*	70	60	2	
2SA53	Ge, p; JP	-18	5	5*	49	60	2	
2SA56	Ge, p; JP	-15*	50	300	40	300	2	
2SA60	Ge, p; JP	-18*	5	55*	70	55	2	
2SA70	Ge, p; JP	-20	10	70*	150	100	12	
2SA72	Ge, p; JP	-18*	5	40*	49	55	11	
2SA73	Ge, p; JP	-18*	5	35*	49	55	11	
2SA75	Ge, p; JP	-20*	50	30*	70	120	11	
2SA76	Ge, p; JP	-18*	5	130*	70	55	11	
2SA80	Ge, p; JP	-20	10	60*	100	80	11	
2SA86	Ge, p; JP	-45*	5	50*	80	225	11	
2SA93	Ge, p; JP	-18*	5	45*	49	55	11	
2SA101	Ge, p; JP	-40	10	15*	30	60	2	
2SA107	Ge, p; JP	-6	10	20*	40	35	11	
2SA112	Ge, p; JP	-20	10	20*	45	80	11	
2SA115	Ge, p; JP	-34	10	20*	60	50	11	
2SA123	Ge, p; JP	-15	2	100*	24	15	12	
2SA126	Ge, p; JP	-12	50	300	40	300	4	
2SA136	Ge, p; JP	-6	15	10*	75	80	2	
2SA153	Ge, p; JP	-15*	4	30*	60	65	4	
2SA154	Ge, p; JP	-15*	4	50*	20	20	4	
2SA157	Ge, p; JP	-15*	4	55*	50	65	4	
2SA159	Ge, p; JP	-15*	4	55*	50	65	4	
2SA160	Ge, p; JP	-15*	4	55*	60	20	4	
2SA161	Ge, p; JP	-20	15	500*	13	50	4	
2SA175	Ge, p; JP	-18*	5	85*	80	55	11	
2SA180	Ge, p; JP	-15	10	12*	70	50	2	
2SA181	Ge, p; JP	-15	10	8*	47	50	2	

Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{21E} , %	$P_{C\max}$, мВт (Вт)	Плотка	Заделка
2SA201	Ge, p; JP	-15	15	8*	49	100	1	
2SA202	Ge, p; JP	-15	15	12*	70	100	1	
2SA203	Ge, p; JP	-15	15	5*	31	100	1	
2SA215	Ge, p; JP	-15	2	120	40	15	1	
2SA229	Ge, p; JP	-20	5	400	10	75	2	
2SA230	Ge, p; JP	-20	5	400	10	75	2	
2SA235	Ge, p; JP	-20	10	135	80	80	3	
2SA241	Ge, p; JP	-20*	5	230	100	50	4	
2SA250	Ge, p; JP	-100	10	50*	100	180	1	
2SA289	Ge, p; JP	-20	10	600*	60	80	4	
2SA290	Ge, p; JP	-20	10	700*	120	80	4	
2SA308	Ge, p; JP	-20	5	450	250	83	4	
2SA321	Ge, p; JP	-20	10	25*	50	50	3	
2SA350	Ge, p; JP	-20	10	45*	90	80	1	
2SA353	Ge, p; JP	-25	10	30*	70	80	1	
2SA354	Ge, p; JP	-25	10	30*	70	80	1	
2SA362	Se, p; JP	-30	30	150*	50	100	5	
2SA374	Ge, p; JP	-34	300	300	50	(1,5)	6	
2SA398	Ge, p; JP	-30	200	7,5*	40	250	6	
2SA433	Ge, p; JP	-18	5	34	60	55	3	
2SA517	Ge, p; JP	-18	10	55*	90	55	1	
2SB23	Ge, p; JP	-15	10		70	40	1	
2SB52	Ge, p; JP	-30	200	3*	83	200	6	
2SB54	Ge, p; JP	-30	150	1*	150	80	1	
2SB56	Ge, p; JP	-30	150	1*	80	150	1	
2SB73	Ge, p; JP	-10	2	(700)*	65	20	1	
2SB75	Ge, p; JP	-25	100	2*	45	150	1	
2SB77	Ge, p; JP	-25	100	2*	70	150	1	
2SB80	Ge, p; JP	-25	(1)	(600)*	70	(4)	7	
2SB84	Ge, p; JP	-60	(3)	(400)*	70	(12)	7	
2SB94	Ge, p; JP	-25	150	1*	150	150	1	
2SB111	Ge, p; JP	-25	50	1*	45	100	1	
2SB146	Ge, p; JP	-30	(1)		75	(10)	7	
2SB156	Ge, p; JP	-16	300	1,3*	>30	150	1	

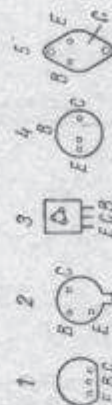


Биполярни транзистори

Означеніе	Тип, Страна-производитель	$U_{CB\max}$, В	$I_{C\max}$, мА (А)	f_T , МГц (kHz)	h_{21E} , %	$P_{C\max}$, мВт (Вт)	Плотка	Заделка
2SB158	Ge, p; JP	-7	5	(700)*	55	10	8	
2SB166	Ge, p; JP	-30	100	1	100	180	9	
2SB171	Ge, p; JP	-30	10	(500)*	50	125	1	
2SB172	Ge, p; JP	-32	125	1*	50	125	1	
2SB176	Ge, p; JP	-32	125	1,4*	100	125	1	
2SB181	Ge, p; JP	-60	500	1,5*	70	(5,5)	8	
2SB185	Ge, p; JP	-25	50	1,5*	45	150	1	
2SB187	Ge, p; JP	-25	50	1*	100	150	1	
2SB189	Ge, p; JP	-25	250	1*	75	250	1	
2SB199	Ge, p; JP	-20	300	(800)*	80	250	4	
2SB202	Ge, p; JP	-32	400	(500)*	100	250	1	
2SB213	Ge, p; JP	-100	(20)	2*	40	(80)	6	
2SB220	Ge, p; JP	-30	200	2*	50	225	6	
2SB233	Ge, p; JP	-130	(6)	2*	>100	(54)	6	
2SB248	Ge, p; JP	-40	(5)	(350)*	60	(54)	7	
2SB282	Ge, p; JP	-80	(6)	(250)*	60	(30)	7	
2SB304	Ge, p; JP	-30	500	1*	80	225	1	
2SB312	Ge, p; JP	-140	(8)	(170)*	60	(43)	7	
2SB324	Ge, p; JP	-32	500	1,5	75	200	1	
2SB370	Ge, p; JP	-25	500	1,5	90	200	1	
2T3107	Si, n; BG	45	100	150	120-460	300	6	
2T3108	Si, n; BG	25	100	150	120-800	300	6	
2T3109	Si, n; BG	25	100	150	180-800	300	6	
2T3167	Si, n; BG	45	100	150	100-460	200	10	
2T3168	Si, n; BG	25	100	150	100-460	200	10	
2T3169	Si, n; BG	25	100	150	180-850	200	10	
2T3237	Si, n; BG	50	100	150	100-460	150	10	
2T3238	Si, n; BG	30	100	150	100-850	150	10	
2T3239	Si, n; BG	30	100	150	180-850	150	10	
2T3402	Si, n; BG	20	10	60	40-150	30	6n10	

Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}^*$ V	$I_{C\max}^*$ mA (A)	$f_{T,a}^*$ MHz (kHz)	h_{FE}^*	$P_{C\max}^*$ mW (W)	Полка	Заделка
2T3422	Si, n; BG	20	10	60	40-150	30	1 и 2	
2T3501	Si, n; BG	20	10	120	20-150	250	2	
2T3502	Si, n; BG	20	10	120	20-150	250	2	
2T3511	Si, n; BG	20	100	120	20-200	200	1	
2T3512	Si, n; BG	20	100	120	150-450	200	1	
2T3531	Si, n; BG	120	30	90	30-180	250	2	
2T3532	Si, n; BG	100	30	90	30-180	250	2	
2T3603	Si, n; BG	20	150	300	10-200	250	2	
2T3604	Si, n; BG	20	200	300	15-280	200	1	
2T3605	Si, n; BG	20	200	300	15-280	200	1	
2T3606	Si, n; BG	20	100	300	15-280	200	1	
2T3607	Si, n; BG	20	100	300	15-280	200	1	
2T3608	Si, n; BG	40	200	300	15-280	200	1	
2T3609	Si, n; BG	40	200	300	15-280	200	1	
2T3633	Si, n; BG	20	150	300	15-200	250	2	
2T3671	Si, n; BG	25	100	600	20-160	150	2	
2T3841	Si, p; BG	-15	200	300	15-790	150	2	
2T3850	Si, p; BG	-110	100	50	30	150	2	
2T3851	Si, p; BG	-70	10	50	30	150	2	
2T6551	Si, n; BG	75	500	200	26-470	800	2	
2T6552	Si, n; BG	60	500	70	26-470	800	2	
2T6554	Si, n; BG	60	500	200	8-140	800	2	
2T6555	Si, n; BG	60	600	200	8-71	700	2	
2T6602	Si, n; BG	20	300	300	10-200	350	2	
2T6631	Si, n; BG	40	300	300	10-200	350	2	
2T6632	Si, n; BG	20	300	300	10-200	350	2	
2T6821	Si, p; BG	-60	500	60	>25	600	2	
2T9135	Si, n; BG	45	(1)	150	>25	(8)	3	
2T9136	Si, p; BG	-45	(1)	60	>25	(8)	3	
2T9137	Si, n; BG	60	(1)	150	>25	(8)	3	
2T9138	Si, p; BG	-60	(1)	60	>25	(8)	3	
2T9139	Si, n; BG	100	(1)	150	>25	(8)	3	
2T9140	Si, p; BG	-100	(1)	60	>25	(8)	3	
3NU40	Ge, p; CS	-20		0,2*		20	4	



Биполярни транзистори

Означение	Тип, Страна-производитель	$U_{CE\max}^*$ V	$I_{C\max}^*$ mA (A)	$f_{T,a}^*$ MHz (kHz)	h_{FE}^*	$P_{C\max}^*$ mW (W)	Полка	Заделка
3NU70	Ge, p; CS	-20		0,2*	20	50	4	
3NU72	Ge, p; CS	-32	(1,5)	(100)	>10	(4)	5	
3NU73	Ge, p; CS	-32	(3,5)	(150)	>10	(12)	5	
3NU74	Ge, p; CS	-50	(15)	(150)	50-130	(50)	5	
4NU72	Ge, p; CS	-48	(1,5)	(100)	10	(4)	5	
4NU73	Ge, p; CS	-48	(3,5)	(150)	10	(12)	5	
4NU74	Ge, p; CS	-60	(15)	(150)	20-60	(50)	5	
5NU72	Ge, p; CS	-60	(1,5)	(100)	10	(4)	5	
5NU73	Ge, p; CS	-60	(3,5)	(150)	10	(12)	5	
5NU74	Ge, p; CS	-60	(15)	(150)	50-130	(50)	5	
6NU73	Ge, p; CS	-70	(3,5)	(150)	10	(12)	5	
6NU74	Ge, p; CS	-90	(15)	(150)	20-60	(50)	5	
7NU73	Ge, p; CS	-80	(3,5)	(150)	10	(12)	5	
7NU74	Ge, p; CS	-90	(15)	(150)	50-130	(50)	5	
101NU70	Ge, n; CS	10	3	(200)*	12	30	4	
101NU71	Ge, n; CS	30	250	(700)*	50	125	4	
102NU70	Ge, n; CS	20	5	(500)*	16	50	4	
102NU71	Ge, n; CS	30	250	(700)*	120	125	4	
103NU70	Ge, n; CS	20	5	500	20-100	50	4	
103NU71	Ge, n; CS	48	250	(700)*	30-200	125	4	
104NU70	Ge, n; CS	20	5	(500)*	20-100	50	4	
104NU71	Ge, n; CS	20	250	(700)*	70	125	4	
105NU70	Ge, n; CS	32	10	1*	20-40	125	4	
106NU70	Ge, n; CS	32	10	1,2*	30-75	125	4	
107NU70	Ge, n; CS	32	10	1,5*	65-130	125	4	
152NU70	Ge, n; CS	10	5	2,5*	20-100	50	4	
153NU70	Ge, n; CS	10	5	1*	10-40	50	4	
154NU70	Ge, n; CS	10	5	2,5	20-100	50	4	
155NU70	Ge, n; CS	15	5	6*	25-125	80	4	
156NU70	Ge, n; CS	15	5	15*	45-225	80	4	

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (W)	Монтаж
A 130	PN, n; USA	30	10	-30	5,0	-4	150	1
A 191	PN, n; USA	30	10	-30	5,0	-4	150	1
A 192	PN, n; USA	30	30	-30	5,0	-8	300	1
A 193	PN, n; USA	30	30	-30	4,0	-6	300	1
A 194	PN, n; USA	25	15	-25	5,0	-4	150	2
A 195	PN, n; USA	25	15	-25	3,0	-4	150	2
A 196	PN, n; USA	25	15	-25	7,0	-4	150	2
A 197	PN, n; USA	30	15	-30	5,0	-10	200	2
A 198	PN, n; USA	30	15	-30	8,0	-6	200	2
A 199	PN, n; USA	30	20	-30	7,0	-5	200	2
A 205	PN, n; USA	30	15	-30	9,0	-7	200	2
A 330	MOS, n-co6; USA	25	30*	± 35	6,0	-5	300	3
A 392	MOS, n-co6; USA	30	50*	± 30	7,0	-5	150	3
BC 264	PN, n; USA	30	2-12,0	-30	2-6	$>(-0,5)$	200	4
BC 264A	PN, n; USA	30	2-4,5	-30	$>2,5$	$>(-0,5)$	200	4
BC 264B	PN, n; USA	30	3,5-6,5	-30	$>3,0$	$>(-0,5)$	200	4
BC 264C	PN, n; USA	30	5,0-8,0	-30	$>3,5$	$>(-0,5)$	200	4
BC 264D	PN, n; USA	30	7,0-12,0	-30	$>4,0$	$>(-0,5)$	200	4
BF 244A	PN, n; USA	30	2-6	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	4
BF 244B	PN, n; USA	30	6-15	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	4
BF 244C	PN, n; USA	30	12-25	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	5
BF 245A	PN, n; USA	30	2-6,5	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	5
BF 245B	PN, n; USA	30	6-15	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	5
BF 245C	PN, n; USA	30	12-25	-30	3-6,5	$-(1+8)$	300	5
BF 256A	PN, n; USA	30	3-7	-30	4,5	$-(1+8)$	300	5
BF 256B	PN, n; USA	30	6-13	-30	$>4,5$	$-(1+8)$	300	5
BF 256C	PN, n; USA	30	11-18	-30	$>4,5$	$-(1+8)$	300	5
BF 320	PN, p; USA	15	10	-15	2,9	$+8,0$	200	5
BF 346	PN, n; USA	15	2,3	-15	2,3	-3	360	5
BF 348	PN, n; USA	40	25	-40	10,5	-4	250	5
BF 800	PN, n; USA	25	25	-25	0,5	-6	36	1
BF 801	PN, n; USA	25	25	-25	0,5	-6	36	1
BF 802	PN, n; USA	25	25	-25	0,5	-6	36	1
BF 805	PN, n; USA	30	30	-30	0,4	-6	300	1
BF 806	PN, n; USA	30	30	-30	0,4	-5	300	1



Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (W)	Монтаж
BF 808	PN, n; USA	20			1,1	-6	120	1
BF 810	PN, n; USA	30			4,5	-6	300	1
BF 811	PN, n; USA	30			4,5	-6	300	1
BF 815	PN, n; USA	30			2-6	-6	300	1
BF 816	PN, n; USA	30			2-6	-6	300	1
BF 817	PN, n; USA	25			2-10	-5	300	1
BF 818	PN, n; USA	25			2-10	-5	300	1
BF 819	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 810	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 811	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 812	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 813	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 814	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 815	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 816	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 817	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 818	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 819	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 820	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 821	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 822	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 823	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 824	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 825	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 826	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 827	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 828	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 829	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 830	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 831	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 832	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 833	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 834	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 835	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 836	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 837	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 838	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 839	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 840	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 841	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 842	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 843	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 844	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 845	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 846	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 847	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 848	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 849	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 850	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 851	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 852	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 853	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 854	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 855	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 856	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 857	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 858	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 859	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 860	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 861	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 862	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 863	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 864	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 865	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 866	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 867	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 868	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 869	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 870	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 871	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 872	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 873	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 874	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 875	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6
BF 876	PN, n; USA	30			1	-1,7	250	6

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\ max}$, В	I_{DSS} , мА (°C)	$U_{GS\ max}$, В	$S_{m\ 21S}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\ max}$ (Вт)	Пояска
BFS77	PN, n; USA	30 50	30	-30	6	-7	360	1
BFS78	PN, n; USA	30 50	30	-30	8	-4	360	1
BFS79	PN, n; USA	30 50	30	-30	7	-2,4	360	1
BFS80	PN, n; USA	30 10	30	-30	6	-4,2	300	2
BFT10	MOS, n-соед; USA	40 4-20*	30	-40	13	-7	300	3
BFT11	MOS, p-соед; USA	-25 4-20*	30	-25	10	+10	300	2
BFW10	PN, n; D	30 10	30	-30	3,5	-8	300	2
BFW11	PN, n; D	30 10	30	-30	3,5	-6	300	2
BFW12	PN, n; D	30 5	30	-30	2	-2,5	150	2
BFW13	PN, n; D	30 5	30	-30	1	-1,2	150	2
BFW27	MOS, p-инд; D	-30 25*	30	-40	0,7	-4,5	200	2
BFW54	PN, n; USA	50 10	50	-50	4,75	-6	300	1
BFW55	PN, n; USA	50 10	50	-50	4,75	-6	300	1
BFW56	PN, n; USA	50 10	50	-50	4,75	-6	300	1
BFW61	PN, n; D	25 10	25	-25	2	-8	300	2
BFW96	MOS, n-инд; GB	30 50*	30	-30	1,3	+2,5	200	2
BFWP21	MOS, n-соед; PL	20 15*	20	-20	1,5	-5	100	2
BFX63	MOS, n-соед; F	30 50*	30	-30	2,5	-1,5	250	4
BFX78	MOS, n-соед; I	15 16*	15	-25	9	-2	375	1
BFX82	MOS, p-соед; I	-25 17*	25	-25	6	+5	300	1
BFX83	MOS, p-соед; I	-25 6,8*	25	-25	3,5	+9	300	1
BSV20	MOS, p-инд; I	-30 200*	30	-50	4,6	-6	400	5
BSV20A	MOS, p-соед; I	-30 200*	30	-50	4,6	+6	400	5
BSV28	MOS, n-соед; GB	30 50*	30	-30	4,0	-4	200	1
BSV34	dMOS, p-инд; I	-30 200	30	-50	2,0	-6	600	6
BSV34A	dMOS, p-инд; I	-30 200*	30	-50	2,0	-6	600	6
BSV38	PN, n; USA	25 10	25	-25	2,5	-7	300	7
BSV38P	PN, n; USA	25 10	25	-25	2,5	-7	150	8
BSV39	PN, n; USA	25 10	25	-25	2,7	-3,5	300	7
BSV39P	PN, n; USA	25 10	25	-25	2,7	-3,4	150	8
BSV78	PN, n; D	40 50	40	-40	3,5	-7,4	350	1
BSV79	PN, n; D	40 50	40	-40	3,5	-6	350	1
BSV80	PN, n; D	40 50	40	-40	3,7	-3	350	1
BSV81	MOS, n-соед; D	30 50*	30	-15	6	-4	200	4

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\ max}$, В	I_{DSS} , мА (°C)	$U_{GS\ max}$, В	$S_{m\ 21S}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\ max}$ (Вт)	Пояска
BSW30	MOS, p-инд; I	-30 500*	30	-25	3,8	-6	400	5
BSW31	MOS, p-инд; I	-30 500*	30	-25	5,6	-6	400	5
BSW95	MOS, p-инд; I	-30 50*	30	-20	0,6	-6	350	5
BSW95A	MOS, p-инд; I	-30 50*	30	-20	0,5	-6	350	5
BSW930	MOS, p-инд; PL	-25 500*	30	-20	1,0	-9	250	9
BSX34	dMOS, p-инд; I	-30 200*	30	-25	3,0	-6	300	6
BSX82	MOS, n-инд; F	30 50*	30	-30	2,5	+4,5	250	4
BSX83	MOS, p-соед; I	-30 3,5*	30	-25	0,6	+6	350	5
BSX84	MOS, p-соед; I	-30 6,5*	30	-25	0,8	+6	350	5
BSX85	dMOS, p-соед; I	-30 12	30	-25	4,2	+6	300	6
CM601	PN, n; USA	15 70	15	-15	10-30	-15	300	2
CM602	PN, n; USA	30 70	30	-30	10-30	-15	300	2
CM656	PN, n; USA	30 30	30	-30	5-15	-7	300	2
CM647	PN, n; USA	30 50	30	-30	5-15	-10	300	2
CP650	PN, n; USA	30 300-1200	30	-25	75-150	-10	300	10
CP651	PN, n; USA	30 100-500	30	-20	50-100	-10	300	10
CP652	PN, n; USA	30 100-500	30	-20	50-100	-10	300	10
F10049	dMOS, p-инд; USA	-30 200*	30	-25	2,0	-6	300	6
F1100	MOS, p-инд; USA	-30 35*	30	-40	0,45	-6	350	5
F11000	MOS, p-инд; BG	-20 7*	20	+20	2	-5	200	11
F11001	MOS, p-инд; BG	-20 7*	20	+20	2	-5	200	11
KF520	MOS, n-соед; CS	30 30*	30	-70	0,3	-30	300	11
KF551	MOS, n-соед; CS	30 30*	30	-50	1	-10	300	11
KF552	dMOS, p-инд; CS	-10 15*	30	-30	1,5	-4	100	12
KFZ52	dMOS, n-инд; CS	30 20*	30	-70	0,3	30	200	12
KП101F	PN, p; SU	-10 0,1-2	10	10	0,15	5	200	13
KП101Д	PN, p; SU	-10 0,3-5	10	10	0,3	10	200	13
KП101E	PN, p; SU	-10 0,3-5	10	10	0,3	10	200	13
KП102E	PN, p; SU	-15 0,55	10	10	0,47	2,8	200	14
KП102Ж	PN, p; SU	-15 0,4-10	10	10	0,6	4	200	14



Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_m, \mu A/V$	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (W)	Позиция
КП102И	PN, p-SU	15	0,7-1,8	10	0,67	5,5	200	1
КП102К	PN, p-SU	-15	3	10	0,88	7,5	200	1
КП102Л	PN, p-SU	-15	6	10	0,97	10	200	1
КП103Е	PN, p-SU	-10	0,3-0,7	15	0,6	0,4-1,5	200	2
КП103Ж	PN, p-SU	-10	0,5-1,2	15	1,4	0,5-2,2	200	2
КП103И	PN, p-SU	-10	1,0-2,1	15	1,7	0,8-3,0	200	2
КП103К	PN, p-SU	-10	1,7-3,8	15	2,4	1,4-4,0	200	2
КП103Л	PN, p-SU	-10	3,0-6,6	15	2,8	2,0-6,0	200	2
КП103М	PN, p-SU	-10	5,4-12	15	3,2	2,8-7,0	200	2
КП201Е	PN, p-SU	-10	0,3-0,65	15	>0,4	1,5	60	3
КП201Ж	PN, p-SU	-10	0,55-1,2	15	>0,7	2,2	60	3
КП201И	PN, p-SU	-10	1,0-2,1	15	>0,8	3,0	60	3
КП201К	PN, p-SU	-10	1,7-3,8	15	>1,4	4,0	60	3
КП201Л	PN, p-SU	-10	3,0-6,0	15	>1,8	6,0	60	3
КП301А-Б	MOS, p-инд; SU	-20	7-30*	± 30	1-3	-4,2	200	4
КП302А	PN, n-SU	20	3-24	-10	5,0	-5	300	5
КП302Б	PN, n-SU	20	18-43	-10	7,0	-7	300	5
КП302В	PN, n-SU	20	10-33	-12	4,0	-10	300	5
КП303А	PN, n-SU	25	0,5-2,5	-30	1-4	-(0,5-3)	200	5
КП303Б	PN, n-SU	25	0,5-2,5	-30	1-4	-(0,5-3)	200	5
КП303В	PN, n-SU	25	1,5-5	-30	2-5	-(1-4)	200	5
КП303Г	PN, n-SU	25	3-12	-30	3-7	-8	200	5
КП303Д	PN, n-SU	25	3-9	-30	2,6	-8	300	5
КП303Е	PN, n-SU	25	5-20	-30	4	-8	200	5
КП303Ж	PN, n-SU	25	0,3-3	-30	1-4	-(0,3-3)	200	5
КР303И	PN, n-SU	25	1,5-5	-30	2-5	-(1-4)	200	5
КП304А	MOS, p-инд; SU	-25	30	-30	4,0	-5	200	6
КП305Д	MOS, n-сое; SU	15	15*	± 15	7,8	-6	150	7
КП305Е	MOS, n-сое; SU	15	15*	± 15	6,0	-6	150	7
КП305Ж	MOS, n-сое; SU	15	15*	± 15	7,8	-6	150	7
КП305И	MOS, n-сое; SU	15	15*	± 15	7,2	-6	150	7
КП301А	MOS, n-сое; SU	50	(1)*	± 30	40-60	-(10-20)	(30)	8
КП301Б	MOS, n-сое; SU	70	(1)*	± 30	40-60	-(5-20)	(20)	8
КП302А	MOS, n-сое; SU	50	200*	± 30	10	-(1-2)	(3,5)	8
КП302Б	MOS, n-сое; SU	50	200*	± 30	10	-(1-2)	(3,5)	8

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_m, \mu A/V$	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (W)	Позиция
КП902В	MOS, n-сое; SU	50	200*	± 30	10	-(1-2)	(3,5)	8
КП903А	PN, n-SU	30	50	-30	50	-10	(3)	8
КП903Б	PN, n-SU	30	100	-30	85	-10	(3)	8
КП903В	PN, n-SU	30	200	-30	80	-10	(3)	8
КП904А	MOS, n-сое; SU	85	(5)*	± 30	400	-(1-5)	(50)	8
КПС104А	dPN, n-SU	25	0,1-0,8	-20	0,35	0,2-1	45	9
КПС104Б	dPN, n-SU	25	0,1-0,8	-20	0,35	0,2-1	45	9
КПС104В	dPN, n-SU	25	0,3-1,5	-20	0,65	0,4-2	45	9
КПС104Г	dPN, n-SU	25	1,1-3	-20	1	1-3	45	9
КПС104Д	dPN, n-SU	25	1-3	-20	1	1-3	45	9
ЛДФ603	PN, n; USA	20	30	-20	5,0	-4	360	10
ЛДФ604	PN, n; USA	20	30	-20	5,5	-4	360	10
ЛДФ605	PN, n; USA	20	30	-20	7,5	-4	360	10
ЛДФ691	PN, n; USA	30	20	-30	4,7	-10	360	10
ЛДФ692	PN, n; USA	30	20	-30	4,7	-5	360	10
ЛДФ693	PN, n; USA	30	20	-30	4,7	-3	300	10
М100	MOS, n-инд; USA	20	15	-20	1,0	-10	360	4
М101	MOS, n-инд; USA	20	50	-20	6	-5	300	4
М103	MOS, p-инд; USA	-30	50	-20	6	-5	200	4
М104	MOS, p-инд; USA	-30	50	± 30	2-4	-6	225	7
М106	dMOS, p-инд; USA	-30	50	± 20	2-5	-6	500	11
М511	MOS, p-инд; USA	-30	50	± 25	1,0	-6	225	12
МРФ102	PN, n; USA	25	20	-25	4,2	-8	200	12
МРФ103	PN, n; USA	25	5	-25	3,0	-6	200	12
МРФ104	PN, n; USA	25	9	-25	3,5	-6	200	12
МРФ105	PN, n; USA	25	16	-25	4,0	-8	200	12
МРФ107	PN, n; USA	25	30	-25	6,0	-6	200	12
МРФ161	PN, p; USA	-40	20	40	7,5	8	310	12
НКТ80111	PN, n; GB	20	18	-20	1,87	-6,0	100	4
НКТ80113	PN, n; GB	12	15	-12	2,0	-4,5	100	4



Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, Вт	Класс
NKT80212	PN, n; GB	25	40	-10	0,75	-0,7	360	1
NKT80216	PN, n; GB	25	40	-10	3,0	-3,5	360	1
SFF103	MOS, p-co6; F	-25	50	± 25	1,0	3,0	200	2
SFF121	MOS, p-co6; F	-20	20	± 25	0,70	3,5	200	2
SFF601	MOS, n-co6; F	40	10	± 50	2,5	-3	150	2
SFF603	MOS, n-co6; F	40	10	± 50	0,35	-20	150	2
SFF604	MOS, n-co6; F	30	10	± 50	2,5	-5	150	2
SM101	MOS, n-co6; DDR	20	15	-10 \div 5	0,5	-15	100	2
SM102	MOS, n-co6; DDR	20	20	-10 \div 5	0,8	-10	100	2
SM103	MOS, n-co6; DDR	20	15	-10 \div 5	1,7	-7,5	150	3
SM104	MOS, n-co6; DDR	20	15	-15 \div 5	1,3	-5,5	150	3
SMY50	MOS, p-инд; DDR	-31	25	± 31	3,6	-3	225	4
SMY51	dMOS, p-инд; DDR	-31	25	± 31	3,6	-2	200	5
SMY52	MOS, p-инд; DDR	-31	60	± 31	12,5	-3	300	4
SMY60	dMOS, p-инд; DDR	-25	20	± 30	> 2	$> 2,8$	240	6
TIS14	PN, n; USA	30	10	-30	4,5	-6,5	300	2
TIS26	PN, n; USA	50	10	-50	4,0	-6	300	7
TIS34	PN, n; USA	30	10	-30	4,5	-4,5	300	8
TIS58	PN, n; USA	15	25	-25	2,7	-15	200	8
TIS59	PN, n; USA	15	25	-25	2,7	-15	360	8
TIS70	PN, n; USA	25	20	-25	3,5	-2,7	360	8
TIS73	PN, n; USA	30	50	-30	2,0	-10	360	8
TIS74	PN, n; USA	30	100	-30	1,5	-6,0	360	8
TIS75	PN, n; USA	30	80	-30	3,0	-4,0	360	8
TIS78	PN, n; USA	300	10	-75	1,9	-10	360	8
2N2498	PN, p; USA	-10	15	20	2,2	6	500	2
2N2844	PN, p; USA	-30	10	30	1,4	1,7	300	2
2N3086	PN, n; USA	-40	15	-15	1,2	-10	400	2
2N3112	PN, p; USA	-20	10	20	0,62	4	300	2
2N3278	PN, p; USA	-26	10	25	0,2	8	225	2
2N3331	PN, p; USA	-20	10	20	3,0	8	300	2
2N3332	PN, p; USA	-20	10	20	1,6	6	300	2
2N3366	PN, n; USA	40	20	-40	0,62	-6,5	300	1
2N3377	PN, p; USA	-30	100	30	1,5	5	150	9
2N3383	PN, p; USA	-30	100	30	9,25	5	150	9

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, Вт	Класс
2N3386	PN, p; USA	-30	100	30	11,25	9,5	300	2
2N3387	PN, p; USA	-30	100	30	11,25	9,5	150	9
2N3454	PN, n; USA	50	20	-50	0,35	-3,3	300	1
2N3459	PN, n; USA	50	20	-50	3,75	-3,4	300	10
2N3573	PN, p; USA	-25	10	25	0,2	2	50	2
2N3578	PN, p; USA	-20	20	20	2,35	4	300	2
2N3608	MOS, p-инд; USA	-25	10	± 25	0,85	-6	350	11
2N3686	PN, n; USA	25	1,2	-50	1,5	-1,8	60	1
2N3796	MOS, n-co6; USA	25	20	± 10	1,35	-4	200	2
2N3819	PN, n; USA	25	20	-25	4,25	-8	360	8
2N3823	PN, n; USA	30	10	-30	4,5	-8	300	1
2N3922	PN, n; USA	50	10	-50	4,5	-3	250	12
2N3966	MOS, n-co6; USA	30	2	± 30	3	-5,0	300	1
2N3967	PN, n; USA	30	10	-30	2	-5	300	1
2N3993	PN, p; USA	-25	10	25	9,0	9,5	300	2
2N4065	MOS, p-инд; USA	-30	20	± 25	0,6	-6,0	175	11
2N4091	PN, n; USA	40	30	-40	2,5	-10	(1,8)	1
2N4092	PN, n; USA	40	15	-40	2,5	-7,0	(1,8)	1
2N4093	PN, n; USA	40	8	-40	2,5	-5,0	(1,8)	1
2N4119	PN, n; USA	40	50	-40	0,21	-6,0	300	1
2N4224	PN, n; USA	30	20	-30	4,25	-8,0	300	11
2N4351	MOS, n-co6; USA	25	30	± 15	1,0	-0,5	300	2
2N4557	PN, n; USA	40	50	-40	1,2	-6,0	360	1
2N4860	PN, n; USA	30	50	-30	1,2	-6,0	360	1
2N5104	PN, n; USA	25	30	-25	5,5	-4,0	300	1
2N5398	PN, n; USA	25	40	-25	7,7	-6,0	300	1
2N5402	PN, p; USA	-40	20	40	4,0	9,0	310	8
2N5516	dPN, n; USA	40	20	-40	2,5	-4,0	250	7
2N5546	dPN, n; USA	50	30	-50	3,75	-4,5	250	7
2N5558	PN, n; USA	30	20	-30	1,4	-4	250	1



Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, \varphi 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (Вт)	Комп.
2N5566	dPN, n; USA	30	15	-30	4,0	-6,0	300	1
2N5594	PN, n; USA	40	15	-50	4,5	-2,0	300	2
2N5648	PN, n; USA	30	20	-50	0,6	-2,4	300	3
2N5653	PN, n; USA	30	20	-30	2,0	-3	310	4
2N5668	PN, n; USA	30	15	-25	4,0	-4	310	4
2N5669	PN, n; USA	30	15	-25	4,25	-6	310	4
2N5670	PN, n; USA	30	20	-25	5,25	-8	310	4
2N5716	PN, n; USA	40	15	-40	0,6	-3	200	4
2N5717	PN, n; USA	40	15	-40	1,0	-5	200	4
2N5718	PN, n; USA	40	20	-40	1,25	-8	200	4
2П102А	PN, p; SU	-15	0,5	10	0,3	2,5	200	5
2П102Б	PN, p; SU	-15	0,9	10	0,3	4	200	5
2П102В	PN, p; SU	-15	1,6	10	0,4	5,5	200	5
2П102Г	PN, p; SU	-15	2,8	10	0,5	7,5	200	5
2П102Д	PN, p; SU	-15	3,5	10	0,7	9	200	5
2П103А	PN, p; SU	-10	1,2	15	2,1	2,2	200	6
2П103Б	PN, p; SU	-10	2,1	15	2,6	3,0	200	6
2П103В	PN, p; SU	-10	3,8	15	3,5	4,0	200	6
2П103Г	PN, p; SU	-10	6,6	15	4,0	6,6	200	6
2П103Д	PN, p; SU	-10	12	15	4,4	7,0	200	6
2П301А	Mos, p-инд; SU	-20	5	±30	1,0	-3,5	200	3
2П301Б	MOS, p-инд; SU	-20	8	±30	1,0	-4,5	200	3
2П302А	PN, n; SU	20	12	-10	5,0	-5	200	2
2П302Б	PN, n; SU	20	18	-10	7,0	-7	200	2
2П302В	PN, n; SU	20	33	-12	5,0	-10	200	2
2П303А	PN, n; SU	25	2	-30	3	-2	200	2
2П303Б	PN, n; SU	25	2	-30	3	-2	200	2
2П303В	PN, n; SU	25	3	-30	4	-3	200	2
2П303Г	PN, n; SU	25	10	-30	6	-8	200	2
2П303Д	PN, n; SU	25	8	-30	5	-8	200	2
2П303Е	PN, n; SU	25	16	-30	4	-8	200	2
2П304А	MOS, p-инд; SU	25	30	±30	4	-5	200	7
2П305А	MOS, n-сб; SU	15	15	±15	7,8	-6	150	8
2П305Б	MOS, n-сб; SU	15	15	±15	6,0	-6	150	8
2П305В	MOS, n-сб; SU	15	15	±15	7,8	-6	150	8

Полевые транзисторы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{DS\max}$, В	I_{DSS} , мА (А)	$U_{GS\max}$, В	$S_{m, \varphi 215}$, мА/В	U_p , В	$P_{D\max}$, мВт (Вт)	Комп.
2П305Г	MOS, n-сб; SU	15	15	±15	7,2	-6	150	8
2SK16	PN, n; JP	20	10	-20	3,0	-3	100	3
2SK16H	PN, n; JP	15	10	-20	3,0	-2,7	100	3
2SK17	PN, n; JP	30	10	-20	0,7	-6	100	9
2SK19	PN, n; JP	20	10	-18	7,0	-5,5	200	9
3N128	MOS, n-сб; USA	20	50	±8	4,10	-6	100	10
3N139	MOS, n-сб; USA	35	50	±10	3,8	-6	150	10
3N143	PN, n; USA	20	50	-8	3,8	-8	400	10
3N151	dMOS, p-инд; USA	-30	25	±30	2,0	-2	162	1
3N154	MOS, n-сб; USA	20	50	±8	7,5	-8	400	10
3N157	MOS, p-инд; USA	-35	30	±25	2,5	-3,2	300	3
3N170	MOS, n-инд; USA	25	30	±35	1,0	2	800	3
3N188	dMOS, p-сб; USA	-40	50	±40	2,7	5	300	1
3N191	dMOS, p-сб; USA	-40	50	±40	2,7	5	300	1
3SK11	MOS, n-сб; JP	20	10	±2	0,75	-8	100	2
3SK12	MOS, n-сб; JP	20	10	±2	0,75	-8	100	2
3SK22	PN, n; JP	20	10	-18	7,0	-5,5	200	2
3SK29	MOS, n-сб; JP	20	10	±30	0,3	-5,0	80	2
3SK30	PN, n; JP	25	10	-15	7,5	-6,0	200	10
3SK30A	PN, n; JP	25	10	-18	7,5	-6,0	200	10
3SK33	MOS, n-сб; JP	25	20	±30	4,0	-4,0	200	10
3SK37	PN, n; JP	15	20	-20	1,5	-3,0	100	11
40467A	MOS, n-сб; USA	20	50	±1	9,5	-8,0	400	10
40468	MOS, n-сб; USA	20	20	±8	7,5	-6,0	100	10
40468A	MOS, n-сб; USA	20	25	±1	7,5	-5,0	375	10
40559	MOS, n-сб; USA	20	20	±8	4,8	-6,0	100	10
40559A	MOS, n-сб; USA	20	25	±1	4,8	-7,0	375	10
41004	PN, p; F	-30	30	35	3,9	4,0	350	11



МОС тетроды (двухэмиттоты полевые транзисторы)

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{DSmax} , В	I_{Dmax} , мА	U_{G1Smax} , В	U_{G2Smax} , В	V_{ZIS} , мА В	U_p , В	P_{Dmax} , мВт	Плотность
A498	MOS, n-co6; USA	30	20	± 10	± 10	10	-5	200	1
BF350	MOS, n-co6; USA	15	50	± 10	± 10	10	-5	360	1
BF351	MOS, n-co6; USA	24	50	± 15	± 10	14	-5	360	1
BF352	MOS, n-co6; USA	24	50	± 10	± 10	14	-2	360	1
BF353	MOS, n-co6; USA	24	50	± 10	± 10	12	-3	360	1
BF354	MOS, n-co6; USA	24	50	± 10	± 10	12	-3	360	1
BF360	MOS, n-co6; D	20	30	± 6	± 6	12	-1	200	2
BF361	MOS, n-co6; D	20	30	± 6	± 6	15	-1,5	200	2
BF384	MOS, n-co6; D	25	50	± 6	± 6	15	-3	300	1
BF328	MOS, n-co6; D	20	20	± 50	± 6	8-15	$\sqrt{-5}$	200	1
BSV22	MOS, n-co6; D	30	50	± 30	± 6	5-12	$\sqrt{-5}$	200	1
KF521	MOS, n-co6; CS	20	10	± 20	± 20	2,5	-3	100	3
KП306A	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	3-8	-1+0	150	1
KП306B	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	3-8	-1+0	150	1
KП306B	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	3-8	-1+0	150	1
KП350A	MOS, n-co6; SU	15	30	± 15	± 15	6	$\sqrt{-6}$	200	1
KП350B	MOS, n-co6; SU	15	30	± 15	± 15	6	$\sqrt{-6}$	200	1
2П306A	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	5	-1	150	1
2П306B	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	5	-5	150	1
2П303B	MOS, n-co6; SU	20	20	± 20	± 20	5	-1	150	1
2П350A	MOS, n-co6; SU	15	30	± 15	± 15	6	$\sqrt{-6}$	200	1
2П350B	MOS, n-co6; SU	15	30	± 15	± 15	6	$\sqrt{-6}$	200	1
2П350B	MOS, n-co6; SU	15	30	± 15	± 15	6	$\sqrt{-6}$	200	1
3N141	MOS, n-co6; USA	20	50	± 8	± 8	12	-4	400	1
3N159	MOS, n-co6; USA	20	50	± 8	± 8	10	-4	400	1
3SK20H	MOS, n-co6; JP	20	10	± 20	± 20	13	-3,5	100	3
3SK40	MOS, n-co6; JP	20	10	± 7	± 7	8	-3	100	3
40600	MOS, n-co6; USA	20	50	± 8	± 8	10	-2	400	1
40673	MOS, n-co6; USA	20	15	± 4	± 4	12	-4	330	1



Единородин транзисторы (двухбазовые диоды)

Описание	Тип, Страна-производитель	R_{BB} , кОм	η , %	I_{AS} , мА	I_p , мА	P_{max} , мВт	Плотность
BB11A	Si, p; F	3,2	0,90	2,0	12	300	1
BB14	Si, p; F	9,1	0,82	4,0	12	300	1
BRV56A	Si, n; D	6	0,7	0,01	0,2	300	2
BRV56B	Si, n; D	6	0,7	0,01	1,0	300	2
BRV56C	Si, n; D	6	0,7	0,05	3,0	300	2
BSV57A	Si, n; D	9,1	0,75	4,0	6	300	3
BSV57B	Si, n; D	4+9	0,8	4,0	6	300	3
D5E37	Si, n; USA	12	0,85	4,0	25	300	1
D5E44	Si, p; USA	9,1	0,82	4,0	5	300	1
D5K1	Si, p; USA	8,2	0,62	2,0	5	300	1
KT117A	Si, n; SU	4,9	0,5-0,7	1	20	300	4
KT117B	Si, n; SU	4,9	0,55-0,9	1	20	300	4
KT117B	Si, n; SU	8-12	0,5-0,7	1	20	300	4
KT117T	Si, n; SU	8-12	0,55-0,9	1	20	300	4
KT119A	Si, n; SU	4-12	0,5-0,65	1-6	0,5-5	60	5
KT119B	Si, n; USA	4-12	0,6-0,75	1-6	0,5-5	60	5
TIS43	Si, p; USA	9,1	0,82	10,0	5	360	3
2N491	Si, p; USA	6,8	0,68	8,0	20	450	1
2N2160	Si, p; USA	12,0	0,80	8,0	25	450	1
2N2646	Si, p; USA	9,1	0,75	4,0	25	300	1
2N3980	Si, p; USA	8,0	0,90	1,0	2	360	1
2T117A	Si, n; SU	7,5	0,70	1	20	300	6
2T117B	Si, n; SU	7,5	0,85	1	20	300	6
2T117B	Si, n; SU	9,0	0,70	1	20	300	6
2T117T	Si, n; SU	9,0	0,85	1	20	300	6



Маломощни и изправителни диоди

Означение	Тип, Препоръчителна температура на прозвояване	$U_{RM\max}$ В	$U_{R\max}$ В	I_{Dmax} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	I_{RM} мА	U_F В
AA103	Ge, ун.; YU	70	10	10	10	0,02	2,5
AA110	Ge, ун.; YU	22	10	15	10	0,07	1,7
AA111	Ge, дет.; D	30	10	10	10	0,005	1
AA112	Ge, ун.; H	20	5	30	30	0,012	1,5
AA113	Ge, ун.; H	65	60	25	25	0,18	1,6
AA116	Ge, ун.; H	30	20	30	30	0,14	1,5
AA117	Ge, ун.; H	115	90	50*	50*	0,28	1,8
AA118	Ge, ун.; H	115	90	50*	50*	0,25	1,5
AA119	Ge, ун.; H	45	30	35	35	0,35	2,2
AA132	Ge, ун.; H	110	100	50*	50*	0,12	1,8
AA133	Ge, ун.; D	140	200	150*	150*	0,05	1
AA134	Ge, ун.; D	70	50	150*	150*	0,07	1
AA135	Ge, ун.; H	30	20	150*	150*	0,03	0,7
AA136	Ge, ун.; H	60	50	150*	150*	0,03	0,8
AA137	Ge, ун.; H	40	30	20	20	0,05	1,5
AA138	Ge, дет.; D	25	10	25	25	0,02	0,9
AA139	Ge, ун.; H	20	20	200*	200*	0,1	0,5
AA140	Ge, ун.; YU	150	50	10	10	0,06	1,9
AA603A-Г	GaAs, свч.; SU	20	15	270			
AA703A	GaAs, свч.; SU	8,5					
AA703Б	GaAs, свч.; SU	8,5					
AA705A	GaAs, свч.; SU	10		320			
AA705Б	GaAs, свч.; SU	10		280			
AA712	GaAs, свч.; SU	100		300			
AA713	Ge, ун.; GB	100	115	10	10	0,001	0,4
AA714	Ge, ун.; D	25	400	400		0,01	0,5
AA714	Ge, ун.; D	100		200			
AA732	Ge, ун.; D	30	10	150*	150*	0,005	1
AA710	Ge, ун.; H	30	26	30	30	0,008	0,5
AA712	Ge, ун.; D	30	30	500*	500*	0,008	0,2
AA715	Ge, ун.; D	100	100	250*	250*	0,01	0,3
AA717	Ge, ун.; D	75	75	250*	250*	0,3	0,3
AA760	Ge, ун.; YU	10	130	10	10	0,001	0,3
AA770	Ge, ун.; YU	10	130	10	10	0,001	0,3
AA780	Ge, ун.; YU	25	150	10	10	0,002	0,3
AA781	Ge, ун.; YU	25	250	10	10	0,001	0,3

Маломощни и изправителни диоди

Означение	Тип, Препоръчителна температура на прозвояване	$U_{RM\max}$ В	$U_{R\max}$ В	I_{Dmax} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	I_{RM} мА	U_F В
AD110A	GaAs, имп.; SU		30		10	0,005	1,5
AD112A	GaAs, имп.; SU	50		300		0,1	3
AD116A	GaAs, имп.; SU		10		30*	0,002	1,5
AD116Б	GaAs, имп.; SU		10		30*	0,002	1,5
AY102	Ge, имп.; I	320	175		(10)*	0,15	0,7
AY106	Ge, имп.; I	200	110		(10)*	0,15	0,7
AY170	Ge, имп.; YU	260		500		0,1*	
AY260	Ge, имп.; YU	220		(5)		0,6*	
AY338	Ge, имп.; YU	80		100		15*	
AY350	Ge, имп.; YU	160		20		2*	
B-50	Si, имп.; BG	100 ÷ 1000		50		20*	1,5
B-200	Si, имп.; BG	100 ÷ 1000		200		20*	1,5
BA100	Si, ун.; D		60	90	10	0,05	0,6
BA103	Si, дет.; D		6	200	100	0,001	1,0
BA104	Si, дет.; D		100	190	100	0,001	1,1
BA105	Si, дет.; D		300	150	100	0,001	1,2
BA108	Si, дет.; D		50	190	100	0,001	1,1
BA147	Si, ун.; D		15		50	0,001	1,0
BA152	Si, имп.; PL	15			100	0,01	1,1
BA152P	Si, имп.; PL	35			100	0,01	1,2
BA157	Si, имп.; H	400		400	(2)*	0,005	1,3
BA158	Si, имп.; H	600		400	(2)*	0,005	1,0
BA159	Si, имп.; H	1000		400	(2)*	0,005	1,0
BA243	Si, имп.; H		20		100*	0,1	1,0
BA244	Si, имп.; H		20		100*	0,1	1,0
BA2P95	Si, имп.; PL	50			450	0,05	1,0
BA2P94	Si, имп.; PL	50			80	0,05	1,0
BA2P95	Si, имп.; PL	75			80	0,05	1,0
BA2P85	Si, имп.; PL	50			80	0,05	1,0
BA2Y14	Si, ун.; D	500	450		500	0,001	0,8
BA2Y15	Si, ун.; D	650	600		500	0,001	0,8
BA2Y16	Si, ун.; D	800	700		500	0,001	0,8
BA2Y23	Si, ун.; D		1000	5*	80	0,001	3,0
BA2Y25	Si, ун.; D		2000	50	80	0,001	3,0
BA2Y38	Si, ун.; D		50	225	225	0,001	1,1

Маломощные и излучающие диоды

Обозначение	Тип, структура, материал	U_{RMmax} , В	U_{Kmax} , В	I_{max} , мА (А)	I_{FMmax} , мА (А)	I_{RM} , мА	$U_{E, V}$
ДОГ18	Ge; ун.; PL	70		16		0,1	1
ДОГ19	Ge; ун.; PL	70		16		0,5	1
ДОГ20	Ge; ун.; PL	70		16		0,8	1
ДОГ21	Ge; ун.; PL	100		16		0,5	1
ДОГ22	Ge; ун.; PL	100		16		0,8	1
ДОГ31	Ge; дет.; PL	30		16		0,5	1
ДОГ31	Ge; ун.; PL	10		16		0,2	1
ДОГ52	Ge; ун.; PL	10		16		0,2	1
ДОГ53	Ge; ун.; PL	30		16		0,1	1
ДОГ54	Ge; ун.; PL	30		16		0,5	1
ДОГ55	Ge; ун.; PL	50		16	50*	0,05	1
ДОГ56	Ge; ун.; PL	100		16	50*	0,05	1
ДОГ57	Ge; ун.; PL	75		16	50*	0,05	1
ДОГ57 А	Ge; ун.; PL	50		16	50*	0,05	1
ДОГ58	Ge; ун.; PL	30		16	50*	0,05	1
ДОГ61	Ge; дет.; PL	30		16	50*	0,05	1
ДОГ62	Ge; дет.; PL	50		16	50*	0,05	1
ДОГ63	Ge; дет.; PL	50		16	50*	0,05	1
ДР300	Si; изпр.; R	50		300			1
ДР301	Si; изпр.; R	100		300			1
ДР302	Si; изпр.; R	200		284			1
ДР303	Si; изпр.; R	300		264			1
ДР304	Si; изпр.; R	400		248			1
ДР305	Si; изпр.; R	500		230			1
ДР306	Si; изпр.; R	600		212			1
Д1А	Ge; ун.; SU	20	10	50*		<0,25	1
Д1Б	Ge; ун.; SU	30	25	50*		<0,25	1
Д1В	Ge; ун.; SU	30	25	75*		<0,25	1
Д1Г	Ge; ун.; SU	50	50	50*		<0,25	1
Д1Д	Ge; ун.; SU	75	75	50*		<0,25	1
Д1Е	Ge; ун.; SU	100	100	55*		<0,25	1
Д1Ж	Ge; ун.; SU	100	100	35*		<0,25	1
Д1А	Ge; ун.; SU	7	7	150		0,25	1
Д1Б	Ge; ун.; SU	10	10	50*		0,10	1
Д1В	Ge; ун.; SU	30	30	78*		0,25	1

Маломощные и излучающие диоды

Обозначение	Тип, структура, материал	U_{RMmax} , В	U_{Kmax} , В	I_{max} , мА (А)	I_{FMmax} , мА (А)	I_{RM} , мА	$U_{E, V}$
Д2Г	Ge; ун.; SU	50		50*		0,25	1
Д2Д	Ge; ун.; SU	50		50*		0,25	1
Д2Е	Ge; ун.; SU	100		50*		0,25	1
Д2Ж	Ge; ун.; SU	150		25*		0,25	1
Д2И	Ge; ун.; SU	100		50*		0,25	1
Д7А	Ge; изпр.; SU	50		300		0,1	1
Д7Б	Ge; изпр.; SU	100		300		0,1	1
Д7В	Ge; изпр.; SU	150		300		0,1	1
Д7Г	Ge; изпр.; SU	200		300		0,1	1
Д7Д	Ge; изпр.; SU	300		300		0,1	1
Д7Е	Ge; изпр.; SU	350		300		0,1	1
Д7Ж	Ge; изпр.; SU	400		300		0,1	1
Д9А	Ge; ун.; SU	10		78*		<0,25	1
Д9Б	Ge; ун.; SU	10		125*		<0,25	1
Д9В	Ge; ун.; SU	30		62*		<0,25	1
Д9Г	Ge; ун.; SU	30		98*		<0,25	1
Д9Д	Ge; ун.; SU	30		98*		<0,25	1
Д9Е	Ge; ун.; SU	50		62*		<0,25	1
Д9Ж	Ge; ун.; SU	100		48*		<0,25	1
Д9И	Ge; ун.; SU	30		98*		<0,25	1
Д9К	Ge; ун.; SU	30		98*		<0,25	1
Д9Л	Ge; ун.; SU	100		48*		<0,25	1
Д9М	Ge; ун.; SU	30		98*		<0,25	1
Д10	Ge; дет.; SU	10		50*		<0,1	1
Д10А	Ge; дет.; SU	10		50*		<0,2	1
Д10Б	Ge; дет.; SU	10		50*		<0,2	1
Д11	Ge; ун.; SU	30		60*		<0,1	1
Д12	Ge; ун.; SU	50		60*		<0,07	1
Д12А	Ge; ун.; SU	50		60*		<0,05	1
Д13	Ge; ун.; SU	75		60*		<0,05	1
Д14	Ge; ун.; SU	100		60*		<0,007	1
Д14А	Ge; ун.; SU	100		60*		<0,07	1
Д15	Ge; ун.; SU	30		20*		<0,3	1
Д16	Ge; ун.; SU	50		30*		<0,5	1
Д18	Ge; ампл.; SU	20		16		<0,05	1

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, Препоръчана температура на прогонване	$U_{RM\max}$ V	$U_{RM\max}$ V	$I_{0\max}$ mA (A)	$I_F\max$ mA (A)	$F_{M\max}$ mA (A)	I_{RM} mA	U_F V
Д19	Ge; ун.; SU	40	40	16	45	<0,1	<0,1	1
Д19А	Ge; ун.; SU	20	20	16	60	<0,1	<0,1	1
Д19Б	Ge; ун.; SU	20	20	16	45	<0,1	<0,1	1
Д20	Ge; имп.; SU	10	10	20	10	<0,05	<0,05	1
Д201	Si; ун.; SU	100	75	100*	100*	<0,01	<0,01	2
Д201А	Si; ун.; SU	100	75	100*	100*	<0,01	<0,01	1
Д202	Si; ун.; SU	75	50	100*	100*	<0,01	<0,01	2
Д202А	Si; ун.; SU	75	50	100*	100*	<0,01	<0,01	1
Д203	Si; ун.; SU	30	30	100*	100*	<0,03	<0,03	2
Д203А	Si; ун.; SU	30	30	100*	100*	<0,03	<0,03	1
Д204	Si; ун.; SU	100	75	30	2	<0,01	<0,01	2
Д204А	Si; ун.; SU	100	75	30	1	<0,01	<0,01	1
Д205	Si; ун.; SU	75	50	30	2	<0,01	<0,01	2
Д205А	Si; ун.; SU	75	50	30	1	<0,01	<0,01	1
Д206	Si; ун.; SU	30	30	30	2	<0,03	<0,03	2
Д206А	Si; ун.; SU	30	30	30	1	<0,03	<0,03	1
Д207	Si; ун.; SU	30	30	30	10	<0,01	<0,01	1
Д208	Si; ун.; SU	50	50	10	10	0,001	0,001	1
Д209	Si; ун.; SU	30	30	30	1	0,001	0,001	1
Д209А	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Б	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209В	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Г	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Д	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Е	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Ж	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209З	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209И	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209К	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1
Д209Л	Si; ун.; SU	30	30	30	10	0,001	0,001	1

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, Препоръчана температура на прогонване	$U_{RM\max}$ V	$U_{RM\max}$ V	$I_{0\max}$ mA (A)	$I_F\max$ mA (A)	$F_{M\max}$ mA (A)	I_{RM} mA	U_F V
Д209	Si; изпр.; SU	400	400	100	100	0,05	0,05	1
Д210	Si; изпр.; SU	500	500	100	100	0,05	0,05	1
Д211	Si; изпр.; SU	600	600	100	100	0,05	0,05	1
Д214	Si; изпр.; SU	100	100	(10)	(10)	3	3	1,25
Д214А	Si; изпр.; SU	100	100	(10)	(10)	3	3	1,25
Д214Б	Si; изпр.; SU	100	100	(5)	(5)	3	3	1,5
Д215	Si; изпр.; SU	200	200	(10)	(10)	3	3	1,25
Д215А	Si; изпр.; SU	200	200	(10)	(10)	3	3	1,25
Д215Б	Si; изпр.; SU	200	200	(5)	(5)	3	3	1,25
Д217	Si; изпр.; SU	800	800	100	100	0,05	0,05	0,7
Д218	Si; изпр.; SU	1000	1000	100	100	0,05	0,05	0,7
Д219А	Si; имп.; SU	70	70	50	500*	0,001	0,001	1
Д220	Si; имп.; SU	50	50	50	500*	0,001	0,001	1
Д220А	Si; имп.; SU	70	70	50	500*	0,001	0,001	1
Д220Б	Si; имп.; SU	100	100	50	500*	0,001	0,001	1
Д221	Si; изпр.; SU	400	400	400	400	0,5	0,5	1
Д222	Si; изпр.; SU	600	600	400	400	0,5	0,5	1
Д223	Si; имп.; SU	5	5	50	500*	0,001	0,001	1
Д223А	Si; имп.; SU	100	100	50	500*	0,001	0,001	1
Д223Б	Si; имп.; SU	150	150	50	500*	0,001	0,001	1
Д226	Si; изпр.; SU	400	400	300	300	0,03	0,03	1
Д226А	Si; изпр.; SU	300	300	300	300	0,03	0,03	1
Д226Б	Si; изпр.; SU	400	400	300	300	0,1	0,1	1
Д226В	Si; изпр.; SU	300	300	300	300	0,1	0,1	1
Д226Г	Si; изпр.; SU	200	200	300	300	0,1	0,1	1
Д226Д	Si; изпр.; SU	100	100	300	300	0,1	0,1	1
Д226Е	Si; изпр.; SU	300	300	300	300	0,1	0,1	1
Д229А,Г	Si; изпр.; SU	200	200	400	400	0,05	0,05	1
Д229Б,Е	Si; изпр.; SU	400	400	400	400	0,05	0,05	1
Д229В	Si; изпр.; SU	100	100	400	400	0,05	0,05	1
Д229Д	Si; изпр.; SU	300	300	400	400	0,05	0,05	1
Д229Ж	Si; изпр.; SU	100	100	700	700	0,05	0,05	1
Д229И	Si; изпр.; SU	200	200	700	700	0,05	0,05	1
Д229К	Si; изпр.; SU	300	300	700	700	0,05	0,05	1
Д229Л	Si; изпр.; SU	400	400	700	700	0,05	0,05	1

Маломощные и исправительные диоды

Обозначение	Тип, материал, назначение, структура, производство	U_{RM}^{max} В	U_{R}^{max} В	I_{0}^{max} мА (А)	I_{F}^{max} мА (А)	F_{RM}^{max} мА (А)	r_{RM} мА	r_{RM} мА	U_{F} В
Д230А	Si; изпр.; SU	200		300			0,05		1
Д230Б	Si; изпр.; SU	400		300			0,05		1
Д231	Si; изпр.; SU	300		(10)			3		1
Д231А	Si; изпр.; SU	300		(10)			3		1
Д231Б	Si; изпр.; SU	300		(5)			3		1,5
Д232	Si; изпр.; SU	400		(10)			3		1
Д232А	Si; изпр.; SU	400		(10)			3		1
Д232Б	Si; изпр.; SU	400		(5)			3		1,5
Д233	Si; изпр.; SU	500		(10)			3		1
Д233Б	Si; изпр.; SU	500		(5)			3		1,5
Д234Б	Si; изпр.; SU	600		(5)			3		1,5
Д237А	Si; изпр.; SU	200		300			0,05		1
Д237Б	Si; изпр.; SU	400		300			0,05		1
Д237В	Si; изпр.; SU	600		300			0,05		1
Д242	Si; изпр.; SU	100		(5)			3		1
Д242А	Si; изпр.; SU	100		(10)			3		1
Д242Б	Si; изпр.; SU	100		(2)			3		1
Д243	Si; изпр.; SU	200		(5)			3		1
Д243А	Si; изпр.; SU	200		(10)			3		1
Д243Б	Si; изпр.; SU	200		(2)			3		1
Д244	Si; изпр.; SU	50		(5)			3		1
Д244А	Si; изпр.; SU	50		(10)			3		1
Д244Б	Si; изпр.; SU	50		(2)			3		1
Д245	Si; изпр.; SU	300		(10)			3		1,25
Д245А	Si; изпр.; SU	300		(10)			3		1,25
Д245Б	Si; изпр.; SU	300		(5)			3		1,5
Д246	Si; изпр.; SU	400		(10)			3		1,25
Д246А	Si; изпр.; SU	400		(10)			3		1
Д246Б	Si; изпр.; SU	400		(5)			3		1,5
Д247	Si; изпр.; SU	500		(10)			3		1,25
Д247Б	Si; изпр.; SU	500		(5)			3		1,5
Д248Б	Si; изпр.; SU	600		(5)			3		1,5
Д302	Ge; изпр.; SU	200		(1)			0,8		0,30
Д302А	Ge; изпр.; SU	200		(1)			1,2		0,30
Д303	Ge; изпр.; SU	150		(3)			1,0		0,35

Маломощные и исправительные диоды

Обозначение	Тип, материал, назначение, структура, производство	U_{RM}^{max} В	U_{R}^{max} В	I_{0}^{max} мА (А)	I_{F}^{max} мА (А)	F_{RM}^{max} мА (А)	r_{RM} мА	r_{RM} мА	U_{F} В
Д303А	Ge; изпр.; SU	150		(3)			1,2		0,35
Д304	Ge; изпр.; SU	100		(5)			3		0,30
Д305	Ge; изпр.; SU	50		(10)			3		0,30
Д310	Ge; ун.; SU	20		250	500*		0,02		
Д311	Ge; изпр.; SU	30		40	500*		0,1		
Д311А	Ge; изпр.; SU	30		80	600*		0,1		
Д311Б	Ge; изпр.; SU	30		20	250*		0,1		
Д312	Ge; изпр.; SU	100		50	500*		0,1		
Д312А	Ge; изпр.; SU	75		50	500*		0,1		
Д312Б	Ge; изпр.; SU	100		50	500*		0,1		
Д1001	Ge; стьлб.; SU	2000		100			0,15		6,5
Д1001А	Ge; дв. стьлб.; SU	2000		2×1000			0,15		3,5
Д1002	Ge; стьлб.; SU	2000		300			0,3		7,5
Д1002А	Ge; дв. стьлб.; SU	2×1000		2×300			0,3		4,0
Д1003А	Ge; дв. стьлб.; SU	2×500		2×300			0,3		2,0
Д1004	Si; стьлб.; SU	2000		100			0,1		5,0
Д1005А	Si; стьлб.; SU	4000		50			0,1		5,0
Д1005Б	Si; стьлб.; SU	5000		100			0,1		10
Д1006	Si; стьлб.; SU	6000		100			0,1		10
Д1007	Si; стьлб.; SU	8000		75			0,1		10
Д1008	Si; стьлб.; SU	10000		50			0,1		10
Д1009	Si; стьлб.; SU	2000		100			0,1		7
Д1009А	Si; дв. стьлб.; SU	2×1000		2×100			0,1		3,5
Д1010	Si; стьлб.; SU	2000		300			0,1		11
Д1010А	Si; дв. стьлб.; SU	2×1000		2×300			0,1		5,5
Д1011А	Si; дв. стьлб.; SU	2×500		2×300			0,1		5,5
Д1121	Ge; изпр.; SU	50		300			0,1		
Д1122	Ge; изпр.; SU	100		300			0,1		
Д1123	Ge; изпр.; SU	150		300			0,1		
Д1124	Ge; изпр.; SU	200		300			0,1		
Д1125	Ge; изпр.; SU	300		300			0,1		
Д1126	Ge; изпр.; SU	350		300			0,1		
Д1127	Ge; изпр.; SU	400		300			0,1		
ЕFR105	Ge; ун.; R	30		40	90		<0,1		
ЕFR106	Ge; ун.; R	25		30	90		<0,1		

Маломощни и изправителни диоди

Означење	Тип, Пред- стављено	U_{RM}^{max} V	U_{R}^{max} V	I_0^{max} mA (A)	I_{FM}^{max} mA (A)	I_{RM} mA	U_F V
GA100	Ge; ун.; DDR	25	20	20	20	0,10	1
GA101	Ge; ун.; DDR	50	40	15	15	0,04	1
GA102	Ge; ун.; DDR	70	60	12	12	0,04	1
GA103	Ge; ун.; GDR	90	80	10	10	0,015	1
GA104	Ge; ун.; DDR	115	110	10	10	0,015	1
GA105	Ge; ун.; DDR	26	20	20	20	0,10	1
GA106	Ge; ун.; DDR	35	30	20	20	0,04	1
GA107	Ge; ун.; DDR	90	80	20	20	0,008	1
GA108	Ge; ун.; DDR	90	80	20	20	0,006	1
GA201	Ge; ун.; CS	15	15	5	5	0,2	1
GA202	Ge; ун.; CS	30	30	5	5	0,1	1
GA203	Ge; ун.; CS	60	60	20	20	0,025	1
GA204	Ge; ун.; CS	120	120	5	5	0,025	1
GA205	Ge; ун.; CS	15	15	5	5	0,1	1
GA501	Ge; изпр.; CS	7	7	20	10	0,020	0,3
GAY60	Ge; изпр.; DDR	25	20	75	75	0,5	1
GAZ51	Ge; ун.; CS	25	25	50	400*	0,01	0,5
GY099	Ge; изпр.; DDR	12	12	100	350*	0,1	
GY100	Ge; изпр.; DDR	24	24	100	350*	0,1	
GY101	Ge; изпр.; DDR	40	40	100	350*	0,1	
GY102	Ge; изпр.; DDR	75	75	100	350*	0,1	
GY103	Ge; изпр.; DDR	100	100	100	350*	0,1	
GY104	Ge; изпр.; DDR	150	150	100	350*	0,05	
GY105	Ge; изпр.; DDR	200	200	100	350*	0,05	
GY109	Ge; изпр.; DDR	12	12	(1)	(3)*	0,2	
GY110	Ge; изпр.; DDR	24	24	(1)	(3)*	0,2	
GY111	Ge; изпр.; DDR	40	40	(1)	(3)*	0,2	
GY112	Ge; изпр.; DDR	75	75	(1)	(3)*	0,2	
GY113	Ge; изпр.; DDR	100	100	(1)	(3)*	0,2	
GY114	Ge; изпр.; DDR	150	150	(1)	(3)*	0,2	
GY115	Ge; изпр.; DDR	20	20	(1)	(3)*	0,2	
GY116	Ge; изпр.; DDR	300	300	(1)	(3)*	0,2	
GY117	Ge; изпр.; DDR	350	350	(1)	(3)*	0,2	
GY118	Ge; изпр.; DDR	400	400	(1)	(3)*	0,2	
GY120	Ge; изпр.; DDR	20	20	(10)	(32)	2	

Маломощни и изправителни диоди

Означење	Тип, Пред- стављено	U_{RM}^{max} V	U_{R}^{max} V	I_0^{max} mA	I_{FM}^{max} mA (V)	I_{RM} mA	U_F V
GY121	Ge; изпр.; DDR	40	40	(10)	(32)*	2	1
GY122	Ge; изпр.; DDR	65	65	(10)	(32)*	2	1
GY123	Ge; изпр.; DDR	100	100	(10)	(32)*	2	1
GY124	Ge; изпр.; DDR	180	180	(10)	(32)*	2	1
GY125	Ge; изпр.; DDR	200	200	(10)	(32)*	2	1
GA401A ÷ B	Ge; свч; SU	20	20	50		0,1	1
GA402A ÷ Г	Ge; свч; SU	15	15	20		0,1	1
GA501A ÷ И	Ge; свч; SU	19	19	30		0,1	1
GA504A	Ge; свч; SU	50	50	5		0,1	0,45
ГД107А	Ge; ун.; SU	20	20	5		0,1	0,45
ГД107Б	Ge; ун.; SU	15	15	5		0,1	0,45
ГД402А	Ge; ун.; SU	15	15	5		0,1	0,45
ГД402Б	Ge; ун.; SU	15	15	5		0,1	0,45
ГД403А	Ge; дет.; SU	5	5	5		0,1	0,45
ГД403Б	Ge; дет.; SU	5	5	5		0,1	0,45
ГД403В	Ge; дет.; SU	5	5	5		0,1	0,45
ГД404АР	Ge; дет.; SU	3	3	20		0,1	0,5
ГД507А	Ge; имп.; SU	8	8	10		0,1	0,6
ГД508А	Ge; имп.; SU	8	8	10		0,1	0,6
ГД508Б	Ge; имп.; SU	8	8	10		0,1	0,6
ГД511А	Ge; имп.; SU	12	12	15		0,1	0,6
ГД511Б	Ge; имп.; SU	12	12	15		0,1	0,6
ГД511В	Ge; имп.; SU	12	12	15		0,1	0,6
ГД2115	Ge; изпр.; BG	30	30	(8)	(15)*	7	0,7
ГД2135	Ge; изпр.; BG	100	100	(6)	(15)	7	0,7
ГД2136	Ge; изпр.; BG	50	50	(7)	(15)*	7	0,7
ГД4104	Ge; ун.; BG	30	25	40	90*	0,4	1,5
ГД4106	Ge; ун.; BG	40	25	30	90*	0,2	1,4
ГД4107	Ge; ун.; BG	15	10	20	60*	0,1	1,7
ГД4108	Ge; ун.; BG	115	100	30	90*	0,2	1,5
ГД4110	Ge; ун.; BG	45	45	30	100*	0,3	1,5
ГД4111	Ge; ун.; BG	25	25	30	90*	0,1	1,5
ГД4112	Ge; ун.; BG	40	24	20	70*	0,2	2,5
ГД4114	Ge; ун.; BG	70	60	30	90*	0,2	1,5
ГД4115	Ge; ун.; BG	45	45	30	100*	0,3	1,5

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, тип- назначение, Сравн.-про- исполнителя	$U_{RM\ max}$, V	$U_{R\ max}$, V	$I_{g\ max}$, mA (A)	$I_{F\ max}$, mA (A)	$I_{FM\ max}$, mA (A)	I_R, I_{RM} , mA	U_F , V
KA136	Si; вып.; CS		25		100		0,01	—
KA206	Si; вып.; CS		50	15	75		0,05	—
KA206S	Si; вып.; CS		50	15	75		0,05	—
KA206T	Si; вып.; CS		35		100		0,001	—
KA207	Si; вып.; CS		100	15	75		0,005	—
KA220/05	Si; вып.; CS	720		500	(5)*		350	—
KA221	Si; вып.; CS	35		150	750*		0,002	—
KA222	Si; вып.; CS	35		300	750*		0,002	—
KA223	Si; вып.; CS	25		100	750*		0,002	—
KA224	Si; вып.; CS	25		200	750*		0,002	—
KA225	Si; вып.; CS	50		150	750*		0,002	—
KA236	Si; вып.; CS		50		100		0,001	—
KA261	Si; вып.; CS	50		100	500*		0,001	—
KA262	Si; вып.; CS	115		100	500*		0,001	—
KA263	Si; вып.; CS	215		100	500*		0,001	—
KA264	Si; вып.; CS	115		100	500*		0,001	—
KA290	Si; вып.; CS		2		25		0,5	0,5
KA501	Si; вып.; CS	55	50	50			0,3	—
KA502	Si; вып.; CS	125	115	50			0,3	—
KA503	Si; вып.; CS	225	215	50			0,3	—
KA504	Si; вып.; CS	125	115	50			0,3	—
KA509A + B	Si; вып.; SU	200		100				—
KA510A + E	Si; вып.; SU	30		200				—
KL102A	Si; вып.; SU	250		100			0,5*	—
KL102B	Si; вып.; SU	300		100			0,5*	—
KL103A	Si; вып.; SU	50		100			1*	—
KL103B	Si; вып.; SU	50		100			1*	—
KL104A	Si; вып.; SU	300		10			1*	—
KL104B	Si; вып.; SU	400		300				—
KL105B	Si; вып.; SU	600		300				—
KL105Г	Si; вып.; SU	800		300				—
KL109A	Si; вып.; SU	100		300				—
KL109Б	Si; вып.; SU	300		300				—
KL109B	Si; вып.; SU	600		300				—
KL202A	Si; вып.; SU	50		5				0,9

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, тип- назначение, Сравн.-про- исполнителя	$U_{RM\ max}$, V	$U_{R\ max}$, V	$I_{g\ max}$, mA (A)	$I_{F\ max}$, mA (A)	$I_{FM\ max}$, mA (A)	I_R, I_{RM} , mA	U_F , V
KL202Б	Si; вып.; SU	50		(3,5)				0,9
KL202В	Si; вып.; SU	100		(5)				0,9
KL202Г	Si; вып.; SU	100		(3,5)				0,9
KL202Д	Si; вып.; SU	200		(5)				0,9
KL202Е	Si; вып.; SU	200		(3,5)				0,9
KL202Ж	Si; вып.; SU	300		(5)				0,9
KL202И	Si; вып.; SU	300		(3,5)				0,9
KL202К	Si; вып.; SU	400		(5)				0,9
KL202Л	Si; вып.; SU	400		(3,5)				0,9
KL220M	Si; вып.; SU	500		(5)				0,9
KL202Н	Si; вып.; SU	500		(3,5)				0,9
KL202Р	Si; вып.; SU	600		(5)				0,9
KL202С	Si; вып.; SU	600		(3,5)				0,9
KL203A	Si; вып.; SU	600		(10)				—
KL203Б	Si; вып.; SU	800		(5)				—
KL203В	Si; вып.; SU	800		(10)				—
KL203Г	Si; вып.; SU	1000		(5)				—
KL203Д	Si; вып.; SU	1000		(10)				—
KL204A	Si; вып.; SU	400		(1)				1,4
KL204Б	Si; вып.; SU	200		(1)				1,4
KL204В	Si; вып.; SU	50		(1)				1,4
KL205A	Si; вып.; SU	500		500				—
KL205Б	Si; вып.; SU	400		500				—
KL205В	Si; вып.; SU	300		500				—
KL205Г	Si; вып.; SU	200		500				—
KL205Д	Si; вып.; SU	100		500				—
KL205Е	Si; вып.; SU	500		300				—
KL205Ж	Si; вып.; SU	600		500				—
KL205И	Si; вып.; SU	700		500				—
KL205К	Si; вып.; SU	100		700				—
KL205Л	Si; вып.; SU	200		700				—
KL206A	Si; вып.; SU	400		(10)				1,2
KL206Б	Si; вып.; SU	500		(10)				1,2
KL206В	Si; вып.; SU	500		(10)				1,2
KL208A	Si; вып.; SU	100		(1,5)				—

Описание	Тип, Пред-назначение, Страна-произ-водитель	U_{RMmax} V	U_{Rmax} V	I_{0max} mA (A)	I_{Fmax} mA (A)	I_{FMmax} mA (A)	I_{RM} mA	U_F V
КД522Б	Si; нмр.; SU	50	50	50	—	—	0,005	—
КД1100	Si; изпр.; BG	50	50	300	—	—	0,1	—
КД1101	Si; изпр.; BG	100	100	300	—	—	0,1	—
КД1102	Si; изпр.; BG	200	200	300	—	—	0,1	—
КД1103	Si; изпр.; BG	300	300	300	—	—	0,1	—
КД1104	Si; изпр.; BG	400	400	300	—	—	0,1	—
КД1105	Si; изпр.; BG	500	500	300	—	—	0,1	—
КД1106	Si; изпр.; BG	600	600	300	—	—	0,1	—
КД1107	Si; изпр.; BG	100	100	200	—	—	0,05	—
КД1108	Si; изпр.; BG	300	300	200	—	—	0,05	—
КД1109	Si; изпр.; BG	400	400	200	—	—	0,05	—
КД1110	Si; изпр.; BG	600	600	200	—	—	0,05	—
КД1111	Si; изпр.; BG	800	800	200	—	—	0,05	—
КД1112	Si; изпр.; BG	1000	1000	200	—	—	0,05	—
КД1113	Si; изпр.; BG	100	100	300	—	—	0,05	—
КД1114	Si; изпр.; BG	300	300	300	—	—	0,05	—
КД1115	Si; изпр.; BG	400	400	300	—	—	0,05	—
КД1116	Si; изпр.; BG	600	600	300	—	—	0,05	—
КД1117	Si; изпр.; BG	800	800	300	—	—	0,05	—
КД1118	Si; изпр.; BG	1000	1000	300	—	—	0,05	—
КД2001	Si; изпр.; BG	100	100	(10)	—	—	3	1,2
КД2002	Si; изпр.; BG	100	100	(10)	—	—	3	1,2
КД2003	Si; изпр.; BG	100	100	(5)	—	—	3	1,5
КД2004	Si; изпр.; BG	200	200	(10)	—	—	3	1,5
КД2005	Si; изпр.; BG	200	200	(10)	—	—	3	1,5
КД2006	Si; изпр.; BG	200	200	(5)	—	—	3	1,5
КД2007	Si; изпр.; BG	300	300	(10)	—	—	3	1,5
КД2008	Si; изпр.; BG	300	300	(10)	—	—	3	1,5
КД2009	Si; изпр.; BG	300	300	(5)	—	—	3	1,5
КД2010	Si; изпр.; BG	400	400	(10)	—	—	3	1,5
КД2011	Si; изпр.; BG	400	400	(10)	—	—	3	1,5
КД2012	Si; изпр.; BG	400	400	(5)	—	—	3	1,5
КД2013	Si; изпр.; BG	500	500	(10)	—	—	3	1,5
КД2014	Si; изпр.; BG	500	500	(5)	—	—	3	1,5
КД2015	Si; изпр.; BG	600	600	(5)	—	—	3	1,5

Описание	Тип, Пред-назначение, Страна-произ-водитель	U_{RMmax} V	U_{Rmax} V	I_{0max} mA (A)	I_{Fmax} mA (A)	I_{FMmax} mA (A)	I_{RM} mA	U_F V
КД209А	Si; изпр.; SU	400	400	700	—	—	—	1
КД209Б	Si; изпр.; SU	600	600	700	—	—	—	1
КД209В	Si; изпр.; SU	800	800	700	—	—	—	1
КД210А	Si; изпр.; SU	800	800	(10)	—	—	—	0,8
КД210Б	Si; изпр.; SU	800	800	(10)	—	—	—	0,8
КД210В	Si; изпр.; SU	1000	1000	(10)	—	—	—	0,8
КД210Г	Si; изпр.; SU	1000	1000	(10)	—	—	—	0,8
КД401А	Si; дет.; SU	30	30	30	92*	—	0,005	1
КД401Б	Si; дет.; SU	30	30	30	92*	—	0,005	1
КД407А	Si; ун.; SU	24	24	50	500*	—	0,001	—
КД409А	Si; ун.; SU	24	24	50	500*	—	0,001	—
КД410А	Si; изпр.; SU	1000	1000	50	—	—	—	2
КД410Б	Si; изпр.; SU	600	600	50	—	—	—	2
КД411А	Si; ун.; SU	700	700	800	—	—	—	1,4
КД411Б	Si; ун.; SU	600	600	800	—	—	—	1,4
КД411В	Si; ун.; SU	500	500	800	—	—	—	1,4
КД411Г	Si; ун.; SU	400	400	800	—	—	—	2
КД503А	Si; нмр.; SU	30	30	20	200*	—	0,01	1
КД503Б	Si; нмр.; SU	30	30	20	200*	—	0,01	1,2
КД504А	Si; нмр.; SU	40	40	80	—	—	0,002	1,2
КД509А	Si; нмр.; SU	70	70	100	(1,5)*	—	0,005	1,1
КД510А	Si; нмр.; SU	70	70	200	—	—	0,005	1,1
КД512А	Si; нмр.; SU	15	15	20	—	—	0,005	1,1
КД513А	Si; нмр.; SU	50	50	100	—	—	0,005	1,1
КД514А	Si; нмр.; SU	10	10	10	—	—	0,005	1
КД518А	Si; нмр.; SU	20	20	100	(0,5)*	—	0,005	0,57
КД519А	Si; нмр.; SU	30	30	30	—	—	0,005	1,1
КД519Б	Si; нмр.; SU	30	30	30	—	—	0,005	1,1
КД520А	Si; нмр.; SU	15	15	20	—	—	0,001	1
КД521А	Si; нмр.; SU	75	75	50	—	—	0,5	1
КД521Б	Si; нмр.; SU	60	60	50	—	—	0,5	1
КД521В	Si; нмр.; SU	30	30	50	—	—	0,5	1
КД521Г	Si; нмр.; SU	30	30	50	—	—	0,5	1
КД521Д	Si; нмр.; SU	12	12	50	—	—	0,5	1
КД522А	Si; нмр.; SU	30	30	100	—	—	0,002	1,1

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, Пред-назначе-ние, Страна-про-изводитель	U_{Rmax} В	U_{Rmax} В	I_{0max} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	I_{RM} мА (А)	U_F В
КД2016А	Si; изпр.: BG	100		(1)		0,03	1,1
КД2016Б	Si; изпр.: BG	200		(1)		0,03	1,1
КД2016В	Si; изпр.: BG	300		(1)		0,03	1,1
КД2016Г	Si; изпр.: BG	400		(1)		0,03	1,1
КД2016Д	Si; изпр.: BG	500		(1)		0,03	1,1
КД2016Е	Si; изпр.: BG	600		(1)		0,03	1,1
КД2016Ж	Si; изпр.: BG	700		(1)		0,03	1,1
КД2016З	Si; изпр.: BG	800		(1)		0,03	1,1
КД2016И	Si; изпр.: BG	900		(1)		0,03	1,1
КД2016К	Si; изпр.: BG	1000		(1)		0,03	1,1
КД216Л	Si; изпр.: BG	1200		(1)		0,03	1,1
КД2016М	Si; изпр.: BG	1500		(1)		0,03	1,1
КД2017А	Si; изпр.: BG	65	50	(2)		0,7	1,4
КД2017Б	Si; изпр.: BG	130	100	(2)		0,7	1,4
КД2017В	Si; изпр.: BG	260	200	(2)		0,7	1,4
КД2017Г	Si; изпр.: BG	390	300	(2)		0,7	1,4
КД2018А	Si; изпр.: BG	65	50	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Б	Si; изпр.: BG	130	100	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018В	Si; изпр.: BG	260	200	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Г	Si; изпр.: BG	390	300	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Д	Si; изпр.: BG	520	400	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Е	Si; изпр.: BG	650	500	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Ж	Si; изпр.: BG	780	600	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018З	Si; изпр.: BG	910	700	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018И	Si; изпр.: BG	1040	800	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018К	Si; изпр.: BG	1300	1000	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018Х	Si; изпр.: BG	65	50	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018БХ	Si; изпр.: BG	130	100	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ВХ	Si; изпр.: BG	260	200	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ГХ	Si; изпр.: BG	390	300	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ДХ	Si; изпр.: BG	520	400	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ЕХ	Si; изпр.: BG	650	500	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ЖХ	Si; изпр.: BG	780	600	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ЗХ	Si; изпр.: BG	910	700	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2018ИХ	Si; изпр.: BG	1040	800	(6)	(20)*	0,2	2,3

Маломощни и изправителни диоды

Описание	Тип, Пред-назначе-ние, Страна-про-изводитель	U_{Rmax} В	U_{Rmax} В	I_{0max} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	I_{RM} мА (А)	U_F В
КД2018КХ	Si; изпр.: BG	1300	1000	(6)	(20)*	0,2	2,3
КД2019А	Si; изпр.: BG	65	50	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019Б	Si; изпр.: BG	130	100	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019В	Si; изпр.: BG	260	200	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019Г	Si; изпр.: BG	390	300	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019Д	Si; изпр.: BG	520	400	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019АХ	Si; изпр.: BG	65	50	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019БХ	Si; изпр.: BG	130	100	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019ВХ	Si; изпр.: BG	260	200	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019ГХ	Si; изпр.: BG	390	300	(10)	(50)*	0,5	1,2
КД2019ДХ	Si; изпр.: BG	520	400	(10)	(50)	0,5	1,2
КД2020	Si; изпр.: BG	100	500	500		0,05	1
КД2021	Si; изпр.: BG	300	500	500		0,05	1
КД2022	Si; изпр.: BG	400	500	500		0,05	1
КД2023	Si; изпр.: BG	600	500	500		0,05	1
КД2024	Si; изпр.: BG	800	500	500		0,05	1
КД2025	Si; изпр.: BG	1000	500	500		0,05	1
КД4521	Si; изпр.: BG	22	20	45	45	0,001	1,2
КД4522	Si; изпр.: BG	43	40	45	45	0,001	1,2
КД4523	Si; изпр.: BG	63	60	45	45	0,001	1,2
КДС111А	Si; изпр.: SU	300	200	200			1,2
КДС111Б	Si; изпр.: SU	300	200	200			1,2
КДС111В	Si; изпр.: SU	300	200	200			1,2
КУ130/80	Si; изпр.: CS	100	80	300	(10)*	0,1	1
КУ130/150	Si; изпр.: CS	180	150	300	(10)*	0,01	1
КУ130/300	Si; изпр.: CS	360	300	300	(10)*	0,01	1
КУ130/600	Si; изпр.: CS	720	600	300	(10)*	0,01	1
КУ130/900	Si; изпр.: CS	1100	900	300	(10)*	0,01	1
КУ130/1000	Si; изпр.: CS	1250	1000	300	(10)*	0,01	1
КУ132/80	Si; изпр.: CS	100	80	800	(40)*	0,01	1,1
КУ132/150	Si; изпр.: CS	180	150	800	(40)*	0,01	1,1
КУ132/300	Si; изпр.: CS	360	300	800	(40)*	0,01	1,1
КУ132/600	Si; изпр.: CS	720	600	800	(40)*	0,01	1,1
КУ132/900	Si; изпр.: CS	1100	900	800	(40)*	0,01	1,1
КУ132/1000	Si; изпр.: CS	1250	1000	800	(40)*	0,01	1,1

Маломощные и исправительные диоды

Символ	Тип, Пред- назначение, Спра- вительный	U_{Rmax} В	U_{Rmax} В	I_{0max} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	$I_{R, I_{RM}}$ мА (А)	U_F В
KY132/1250	Si; изпр.; CS	1400	1250	800	(40)*	0,01	1,1
KY189	Si; изпр.; CS	850		(4)	(75)*	0,01	1,3
KY190	Si; изпр.; CS	650		(4)	(75)*	0,01	1,3
KY193	Si; изпр.; CS	200		(6)	(75)*	0,01	1,3
KY194	Si; изпр.; CS	400		(6)	(75)*	0,01	1,3
KY195	Si; изпр.; CS	800		(6)	(75)*	0,01	1,3
KY196	Si; изпр.; CS	100		(1,2)	(70)*	0,01	1,3
KY197	Si; изпр.; CS	200		(1,2)	(70)*	0,01	1,3
KY198	Si; изпр.; CS	400		(1,2)	(70)*	0,01	1,3
KY199	Si; изпр.; CS	800		(1,2)	(70)*	0,01	1,3
KY299	Si; изпр.; CS	1250		300	(3)*	0,05	1,1
KY701F	Si; изпр.; CS	100	80	700	(30)*	0,05	1,1
KY702F	Si; изпр.; CS	180	150	700	(30)*	0,05	1,1
KY703F	Si; изпр.; CS	360	300	700	(30)*	0,05	1,1
KY704F	Si; изпр.; CS	720	600	700	(30)*	0,05	1,1
KY705F	Si; изпр.; CS	1100	900	700	(30)*	0,05	1,1
KY706F	Si; изпр.; CS	1250	1000	700	(30)*	0,05	1,1
KY708	Si; изпр.; CS	100	90	(10)	(80)*	0,06	1,1
KY710	Si; изпр.; CS	200	180	(10)	(80)*	0,06	1,1
KY711	Si; изпр.; CS	300	270	(10)	(80)*	0,06	1,1
KY712	Si; изпр.; CS	400	360	(10)	(80)*	0,06	1,1
KY715	Si; изпр.; CS	100	90	(20)	(140)*	0,1	1,1
KY717	Si; изпр.; CS	200	180	(20)	(140)*	0,1	1,1
KY718	Si; изпр.; CS	300	270	(20)	(140)*	0,1	1,1
KY719	Si; изпр.; CS	400	360	(20)	(140)*	0,1	1,1
KY721F	Si; изпр.; CS	100	80	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY722F	Si; изпр.; CS	180	150	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY723F	Si; изпр.; CS	360	300	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY724F	Si; изпр.; CS	720	600	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY725F	Si; изпр.; CS	1100	900	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY726F	Si; изпр.; CS	1250	1000	(1)	(30)*	0,05	1,1
KY106A	Si; стьлб; SU	4000		10			25
KY106B	Si; стьлб; SU	6000		10			25
KY106B	Si; стьлб; SU	8000		10			25
KY106Г	Si; стьлб; SU	10000		10			25

Маломощные и исправительные диоды

Символ	Тип, Пред- назначение, Спра- вительный	U_{Rmax} В	U_{Rmax} В	I_{0max} мА (А)	I_{Fmax} мА (А)	$I_{R, I_{RM}}$ мА (А)	U_F В
KY106Д	Si; стьлб; SU	12000					25
KY201A	Si; стьлб; SU	2000					3
KY201B	Si; стьлб; SU	4000					3
KY201B	Si; стьлб; SU	6000					6
KY201Г	Si; стьлб; SU	8000					6
KY201Г	Si; стьлб; SU	10000					6
KY201Г	Si; стьлб; SU	15000					10
KY401B	Si; мост; SU	500					2,5
KY401B	Si; мост; SU	400					2,5
KY402A	Si; мост; SU	600					2,5
KY402B	Si; мост; SU	500					2,5
KY402B	Si; мост; SU	400					2,5
KY402Г	Si; мост; SU	300					2,5
KY402Д	Si; мост; SU	200					2,5
KY402E	Si; мост; SU	100					2,5
KY402Ж	Si; мост; SU	600					2,5
KY402И	Si; мост; SU	600					2,5
KY403A	Si; дв. мост; SU	600					2,5
KY403B	Si; дв. мост; SU	500					2,5
KY403B	Si; дв. мост; SU	400					2,5
KY403Г	Si; дв. мост; SU	300					2,5
KY403Д	Si; дв. мост; SU	200					2,5
KY403E	Si; дв. мост; SU	100					2,5
KY403Ж	Si; дв. мост; SU	600					2,5
KY403И	Si; дв. мост; SU	500					2,5
KY404A	Si; дв. мост; SU	600					2,5
KY404B	Si; дв. мост; SU	500					2,5
KY404B	Si; дв. мост; SU	400					2,5
KY404Г	Si; дв. мост; SU	300					2,5
KY404Д	Si; дв. мост; SU	200					2,5
KY404E	Si; дв. мост; SU	100					2,5
KY404Ж	Si; дв. мост; SU	600					2,5
KY404И	Si; дв. мост; SU	500					2,5
KY405A	Si; мост; SU	600					2,5
KY405B	Si; мост; SU	500					2,5

Маломощные и исправительные диоды

Обозначение	Тип, пред- назначение, Страна-произ- водитель	U_{RM}^V	$I_{0\max}^V$ (А)	I_{PM}^{\max} (А)	I_{RM}^V (А)	U_F^V
OA1154Q	Ge; вып.; Н	55	50	30	0,1	1,6
OA1160	Ge; дет.; D	15	15	10	0,02	1
OA1161	Ge; вып.; Н	130	130	20	0,2	2,3
OA1161	Ge; дет.; D	130	20	5,5	0,08	1
OA1172	Ge; дет.; D	30	10	5,5	0,07	1
OA1180	Ge; вып.; Н	30	20	150*	0,02	0,7
OA1182	Ge; вып.; Н	100	80	150*	0,02	0,8
OA1182D	Ge; вып.; Н	60	50	150*	0,03	0,8
OA1186	Ge; вып.; Н	80	50	150*	0,03	0,7
OA1188	Ge; вып.; Н	70	60	150*	0,03	0,7
OY100	Ge; вып.; DDR	20	100	350*	0,1*	
OY101	Ge; вып.; DDR	50	100	350*	0,1*	
OY102	Ge; вып.; DDR	100	100	350*	0,1*	
OY103	Ge; вып.; DDR	150	100	350*	0,1*	
OY104	Ge; вып.; DDR	200	100	350*	0,1*	
OY110	Ge; вып.; DDR	20	(1)	(3)*	0,1*	
OY111	Ge; вып.; DDR	50	(1)	(3)*	0,1*	
OY112	Ge; вып.; DDR	100	(1)	(3)*	0,1*	
OY113	Ge; вып.; DDR	150	(1)	(3)*	0,1*	
OY114	Ge; вып.; DDR	200	(1)	(3)*	0,1*	
OY120	Ge; вып.; DDR	20	(10)	(32)*	1*	
OY121	Ge; вып.; DDR	40	(10)	(32)*	1*	
OY122	Ge; вып.; DDR	65	(10)	(32)*	1*	
OY123	Ge; вып.; DDR	100	(10)	(32)*	1*	
OY124	Ge; вып.; DDR	150	(10)	(32)*	1*	
OY125	Ge; вып.; DDR	200	(10)	(32)*	1*	
OY914	Si; вып.; D	400	(1)	(5)*	0,5*	1
OY915	Si; вып.; D	500	(1)	(5)*	0,5*	1
OY916	Si; вып.; D	600	(1)	(5)*	0,5*	1
OY917	Si; вып.; D	700	(1)	(5)*	0,5*	1
SA301	Si; вып.; DDR	25	20	100	0,1	1,2
SA403	Si; вып.; DDR	30	25	30	0,04	0,8
SA404	Si; вып.; DDR	20	15	20	0,06	0,8
SA412	Si; вып.; DDR	20	20	100	0,001	1
SA418	Si; вып.; DDR	80	80	100	0,001	1,2

Маломощные и исправительные диоды

Обозначение	Тип, пред- назначение, Страна-произ- водитель	U_{RM}^V	$I_{0\max}^V$ (А)	I_{PM}^{\max} (А)	I_{RM}^V (А)	U_F^V
SAL41	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<1,7
SAL43	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<1,7
SAL45	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<1,7
SAM43	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<0,8
SAM44	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<0,5
SAM63	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<0,8
SAM64	Si; блок; DDR	20	15	20	0,06	<0,5
SAY12	Si; вып.; DDR	200	200	300	0,1	<1
SAY16	Si; вып.; DDR	200	200	300	0,1	<1
SAY17	Si; вып.; DDR	115	115	175	0,1	<1
SAY18	Si; вып.; DDR	25	75	115	0,07	<1
SAY20	Si; вып.; DDR	15	50	75	0,05	<1
SAY30	Si; вып.; DDR	25	30	30	0,04	<0,8
SAY32	Si; вып.; DDR	25	25	50	0,04	<1
SAY40	Si; вып.; DDR	15	20	20	0,06	<0,8
SAY42	Si; вып.; DDR	15	15	30	0,06	1
SAY73	Si; вып.; DDR	75	50	600*	0,001	1
SFD104	Ge; вып.; BG	25	40	40	0,06	1
SFD105	Ge; вып.; BG	25	30	30	0,06	1,6
SFD107	Ge; вып.; BG	15	20	20	0,06	1,6
SFD108	Ge; вып.; BG	115	100	30	0,004	1,2
SFD110	Ge; вып.; BG	45	30	35	0,004	1,2
SFD111	Ge; вып.; BG	25	25	30	0,04	1,4
SFD112	Ge; вып.; BG	40	20	20	0,004	1,2
SFD115	Ge; вып.; BG	45	30	30	0,004	1,2
SFR115	Ge; вып.; BG	30	(9)	(15)*	7	0,5
SFR135	Ge; вып.; BG	100	(6,5)	(15)*	7	0,5
SFR136	Ge; вып.; BG	50	(7)	(15)*	7	0,5
SY100	Si; вып.; DDR	75	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY101	Si; вып.; DDR	100	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY102	Si; вып.; DDR	200	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY103	Si; вып.; DDR	300	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY104	Si; вып.; DDR	400	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY105	Si; вып.; DDR	500	(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY106	Si; вып.; DDR	600	(1)	(6)*	0,01*	1,2

Обозначение	Тип, страна-изготовитель	$U_{RM\ max}$ В	U_{max} В	$I_{0\ max}$ мА (А)	$I_{FM\ max}$ мА (А)	I_{RM} мА	U_F В
SY202	Si; изпр.; DDR	200		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY203	Si; изпр.; DDR	300		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY204	Si; изпр.; DDR	400		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY205	Si; изпр.; DDR	500		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY206	Si; изпр.; DDR	600		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY207	Si; изпр.; DDR	700		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY208	Si; изпр.; DDR	800		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY210	Si; изпр.; DDR	1000		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY221	Si; изпр.; DDR	100		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY222	Si; изпр.; DDR	200		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY223	Si; изпр.; DDR	300		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY224	Si; изпр.; DDR	400		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY225	Si; изпр.; DDR	500		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY226	Si; изпр.; DDR	600		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY227	Si; изпр.; DDR	700		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY228	Si; изпр.; DDR	800		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY230	Si; изпр.; DDR	1000		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY320/0,75	Si; изпр.; DDR	75		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
SY320/1	Si; изпр.; DDR	100		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
SY320/2	Si; изпр.; DDR	200		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
SY320/3	Si; изпр.; DDR	300		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
SY320/4	Si; изпр.; DDR	400		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
SY320/5	Si; изпр.; DDR	500		(0,8)	(8)*	0,1	1,2
ZS20	Si; изпр.; USA	100	100	100		0,005	
ZS25	Si; изпр.; USA	200	100	100		0,005	
ZS32A	Si; изпр.; USA	200	500	500	500	<0,001	1
ZS34B	Si; изпр.; USA	400	500	500	500	0,005	1,1
ZS78	Si; изпр.; USA	800	500	500	500	0,005	1,2
IN34	Ge; изпр.; USA	60	50	50	5	0,05	1
IN34A	Ge; изпр.; USA	75	30	30	5	0,5	1
IN42	Ge; изпр.; USA	50	11,5	12		0,006	1,5
IN58	Ge; изпр.; USA	100	50	4		0,8	1
IN60	Ge; изпр.; USA	25	50	0,05		0,03	0,25
IN72	Ge; изпр.; USA	5	25	0,8		0,8	0,5
IN87	Ge; изпр.; USA	25	25	5		0,03	1

Обозначение	Тип, страна-изготовитель	$U_{RM\ max}$ В	U_{max} В	$I_{0\ max}$ мА (А)	$I_{FM\ max}$ мА (А)	I_{RM} мА	U_F В
SY107	Si; изпр.; DDR	700		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY108	Si; изпр.; DDR	800		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY110	Si; изпр.; DDR	1000		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY120	Si; изпр.; DDR	75		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY121	Si; изпр.; DDR	100		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY122	Si; изпр.; DDR	200		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY123	Si; изпр.; DDR	300		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY124	Si; изпр.; DDR	400		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY125	Si; изпр.; DDR	500		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY126	Si; изпр.; DDR	600		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY127	Si; изпр.; DDR	700		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY128	Si; изпр.; DDR	800		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY130	Si; изпр.; DDR	1000		(1)	(6)*	0,01*	1,2
SY160	Si; изпр.; DDR	50		(10)	(80)*	3*	0,6
SY162	Si; изпр.; DDR	200		(10)	(80)*	3*	0,6
SY164	Si; изпр.; DDR	400		(10)	(80)*	3*	0,6
SY166	Si; изпр.; DDR	600		(10)	(80)*	3*	0,6
SY170	Si; изпр.; DDR	100		(25)	(250)*	8*	1
SY170/1	Si; изпр.; DDR	100		(17)	(100)*	8	1
SY170/2	Si; изпр.; DDR	200		(17)	(100)*	8	1
SY171	Si; изпр.; DDR	100		(25)	(250)*	8*	1
SY171/1	Si; изпр.; DDR	100		(17)	(100)*	8	1
SY171/2	Si; изпр.; DDR	200		(17)	(100)*	8	1
SY172	Si; изпр.; DDR	200		(25)	(250)*	8*	1
SY173	Si; изпр.; DDR	200		(25)	(250)*	8*	1
SY180/1	Si; изпр.; DDR	70		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/2	Si; изпр.; DDR	140		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/4	Si; изпр.; DDR	280		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/6	Si; изпр.; DDR	420		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/8	Si; изпр.; DDR	560		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/10	Si; изпр.; DDR	700		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/12	Si; изпр.; DDR	840		(16)	(250)*	5	1,3
SY180/14	Si; изпр.; DDR	980		(16)	(250)*	5	1,3
SY200	Si; изпр.; DDR	75		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2
SY201	Si; изпр.; DDR	100		(0,7)	(5)*	0,01*	1,2

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, преграда- излучение, Страна-произ- водител	$U_{RM\max}$ В	$U_{R\max}$ В	$I_{0\max}$ мА (А)	$I_{F\max}$ мА (А)	$I_{FM\max}$ мА (А)	$I_{R, RM}$ мА	$U_{F, V}$
IN101	Ge; ул.; USA	200	200	30	10	10	0,01	1
IN128	Ge; ул.; USA	40	40	30	3	3	0,01	1
IN145	Ge; ул.; USA	30	30	40	4	4	0,2	1
IN195	Si; ул.; USA	40	40	80	2	2	0,08	2
IN270	Ge; ул.; USA	100	100	80	200	200	0,1	1
IN295A	Si; ул.; USA	40	40	30	18	18	0,2	1
IN301A	Si; ул.; USA	65	65	100	100	100	<0,001	1,1
IN486	Si; ул.; USA	225	225	20	4	4	<0,001	1,5
IN625	Si; ул.; USA	20	20	400	400	400	<0,001	1
IN649	Si; ул.; USA	600	600	100	100	100	0,025	1
IN771	Ge; ул.; USA	5	5	75	10	10	<0,001	1,5
IN815	Si; ул.; USA	90	90	75	10	10	0,005	1
IN914	Si; ул.; USA	75	75	60	30	30	<0,001	1
IN916	Si; ул.; USA	80	80	50	10	10	0,005	1
IN934	Si; ул.; USA	50	50	10	10	10	0,001	1
IN3063	Si; ул.; USA	100	100	10	10	10	0,001	1
IN3064	Si; ул.; USA	100	100	10	10	10	0,001	1
IN4001	Si; ул.; USA	200	200	10	10	10	0,005	1,3
IN4002	Si; ул.; USA	400	400	10	10	10	0,005	1,3
IN4003	Si; ул.; USA	600	600	10	10	10	0,005	1,3
IN4004	Si; ул.; USA	800	800	10	10	10	0,005	1,3
IN4005	Si; ул.; USA	1000	1000	10	10	10	0,005	1,3
IN4006	Si; ул.; USA	1300	1300	10	10	10	0,005	1,3
IN4007	Si; ул.; USA	25	25	75	10	10	0,001	1
IN4148	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4149	Si; ул.; D	100	100	75	10	10	0,001	1
IN4150	Si; ул.; D	75	75	50	200	200	0,001	1
IN4151	Si; ул.; D	35	35	25	200	200	0,001	1
IN4151	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4154	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4154	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4446	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4447	Si; ул.; D	100	100	75	200	200	0,5	1

Маломощни и изправителни диоди

Описание	Тип, преграда- излучение, Страна-произ- водител	$U_{RM\max}$ В	$U_{R\max}$ В	$I_{0\max}$ мА (А)	$I_{F\max}$ мА (А)	$I_{FM\max}$ мА (А)	$I_{R, RM}$ мА	$U_{F, V}$
IN4448	Si; ул.; H	100	100	75	200	200	0,5	1
IN4449	Si; ул.; H	100	100	75	200	200	0,5	1
IS34	Ge; ул.; JP	40	40	80	4	4	0,35	1
IS50	Ge; ул.; JP	40	40	80	4	4	0,07	1
IS78	Ge; ул.; JP	40	40	80	4	4	0,01	1
IS218	Si; ул.; JP	250	250	100	10	10	0,001	1
2Д102А	Si; ул.; SU	75	75	100	100	100	0,001	1,2
2Д103А	Si; ул.; SU	100	100	100	100	100	0,001	1
2Д106А	Si; ул.; SU	800	800	100	100	100	0,001	1,5
2Д108А	Si; ул.; SU	1000	1000	100	100	100	0,001	1,5
2Д108Б	Si; ул.; SU	100	100	100	100	100	0,001	1,5
2Д201А	Si; ул.; SU	100	100	100	100	100	0,001	1
2Д201Б	Si; ул.; SU	200	200	100	100	100	0,001	1
2Д201В	Si; ул.; SU	200	200	100	100	100	0,001	1
2Д201Г	Si; ул.; SU	200	200	100	100	100	0,001	1
2Д503А	Si; ул.; SU	30	30	20	200	200	0,004	1
2Д503Б	Si; ул.; SU	30	30	20	200	200	0,004	1
2Д504А	Si; ул.; SU	40	40	16	100	100	0,05	1
2Д4331	Si; ул.; BG	32	32	45	150	150	0,001	1
2Д5321	Si; ул.; BG	16	16	45	150	150	0,001	1
2Д5323	Si; ул.; BG	53	53	45	150	150	0,001	1
2Д5601	Si; ул.; BG	22	22	45	250	250	0,001	1
2Д5602	Si; ул.; BG	43	43	45	250	250	0,001	1
2Д5603	Si; ул.; BG	70	70	45	250	250	0,001	1
2Д5605	Si; ул.; BG	22	22	45	250	250	0,001	1
2Д5606	Si; ул.; BG	43	43	45	250	250	0,001	1
2Д5607	Si; ул.; BG	70	70	45	250	250	0,001	1
2Д5612	Si; ул.; BG	85	85	45	250	250	0,001	1
2Д5613	Si; ул.; BG	103	103	45	250	250	0,001	1
2Д5614	Si; ул.; BG	115	115	45	250	250	0,001	1
2Ц101А	Si; ул.; SU	700	700	10	10	10	0,001	8,3
2Ц102А	Si; ул.; SU	800	800	100	100	100	0,001	1,5
2Ц102Б	Si; ул.; SU	1000	1000	100	100	100	0,001	1,5
2Ц102В	Si; ул.; SU	1200	1200	100	100	100	0,001	1,6
2Ц103А	Si; ул.; SU	2000	2000	10	10	10	0,001	10

Маломощии и направителни диоди

Описание	Тип, материал, значение, страна-произв.	$U_{RM\ max}$, В	U_{Kmax} , В	$I_{0\ max}$, мА (А)	$I_{F\ max}$, мА (А)	$I_{RM\ max}$, мА (А)	$I_{R, I_{RM}}$, мА	U_F , В
1NP70	Ge; изпр.; CS	36		300			3*	
2NP70	Ge; изпр.; CS	60		300			2*	
3NP70	Ge; изпр.; CS	110		300			1,5*	
4NP70	Ge; изпр.; CS	210		300			1*	
5NP70	Ge; изпр.; CS	160		300			1,3*	
6NP70	Ge; изпр.; CS	260		300			0,7*	
11NP70	Ge; изпр.; CS	36		500			3*	
13NP70	Ge; изпр.; CS	110		500			1,5*	
15NP70	Ge; изпр.; CS	160		500			1,3*	
20NP70	Ge; изпр.; CS	18		(3)			30*	
21NP70	Ge; изпр.; CS	30		(3)			20*	
23NP70	Ge; изпр.; CS	100		(3)			10*	
24NP70	Ge; изпр.; CS	150		(3)			8*	
30NP70	Ge; изпр.; CS	18		(5)			25*	
31NP70	Ge; изпр.; CS	30		(5)			18*	
32NP70	Ge; изпр.; CS	50		(5)			13*	
32NP75	Si; изпр.; CS	84		(0,5)	(5)*		0,01*	
33NP70	Ge; изпр.; CS	100		(5)	(5)*		9*	
33NP75	Si; изпр.; CS	157		(0,5)	(5)*		0,01*	
34NP70	Ge; изпр.; CS	150		(5)	(5)*		7*	
34NP75	Si; изпр.; CS	262		(0,5)	(5)*		0,01*	
35NP70	Ge; изпр.; CS	200		(5)	(5)*		5*	
35NP75	Si; изпр.; CS	420		(0,5)	(5)*		0,01*	
36NP75	Si; изпр.; CS	735		(0,5)	(5)*		0,01*	
35NP75	Si; изпр.; CS	1266		(0,5)	(5)*		0,01*	
40NP70	Ge; изпр.; CS	18		(10)	(10)		20*	
41NP70	Ge; изпр.; CS	30		(10)	(10)		15*	
42NP70	Ge; изпр.; CS	50		(10)	(10)		11*	
43NP70	Ge; изпр.; CS	100		(10)	(10)		8*	
44NP70	Ge; изпр.; CS	150		(10)	(10)		6*	
45NP70	Ge; изпр.; CS	200		(10)	(10)		4*	
46NP75	Si; изпр.; CS	735		(1)	(10)*		0,01*	
81NP71	Ge; изпр.; CS	42		(20)	(20)		15*	
82NP71	Ge; изпр.; CS	84		(20)	(20)		20*	
83NP71	Ge; изпр.; CS	157		(20)	(20)		8*	

Ценерови диоди

Описание	Тип, страна-произв.	U_Z , В	$I_{Z\ min}$, мА	$I_{Z\ max}$, мА	$P_{\ max}$, Вт	$TRR_{Z, 25^\circ C}$, %/°C	$\alpha, \%$
BZX83C6V2	Si; нем.; D	5,8—6,6	3	16	<10	0,1	
BZX83C9V1	Si; нем.; D	8,5—9,6	3	12	<10	0,1	
BZX83C12	Si; нем.; D	11,4—12,7	3	9	<20	0,1	
BZX97C6V2	Si; нем.; D	5,8—6,6	3	16	<10	0,1	
BZX97C9V1	Si; нем.; D	8,5—9,6	3	12	<10	0,1	
BZX97C12	Si; нем.; D	11,4—12,7	3	9	<20	0,1	
BZY10C6V2	Si; нем.; D	5,8—6,6	3	138	<4	+0,05	
BZY10C9V1	Si; нем.; D	8,5—9,6	3	96	<4	+0,06	
BZY10C12	Si; нем.; D	11,4—12,7	3	71	<7	+0,07	
BZY97C5V6	Si; нем.; D	5,2—6,0	3	208	<2	+0,02	
BZY97C6V2	Si; нем.; D	5,8—6,6	3	200	<2	+0,04	
BZY97C9V1	Si; нем.; D	8,5—9,6	3	134	<4	+0,06	
BZY97C12	Si; нем.; D	11,4—12,7	3	100	<7	+0,08	
D219C	Si; стаб.; SU	1,0	5	50	<20	0,05	
D220C	Si; стаб.; SU	1,0	5	50	<20	0,05	
D223C	Si; стаб.; SU	1,0	5	50	<20	0,05	
D808	Si; нем.; SU	7—8,5	3	33	12	+0,07	
D809	Si; нем.; SU	8—9,5	3	29	18	+0,08	
D810	Si; нем.; SU	9—10,5	3	26	25	+0,09	
D811	Si; нем.; SU	10—12	3	23	30	+0,095	
D813	Si; нем.; SU	11,5—14	3	20	35	+0,095	
D814A	Si; нем.; SU	7—8,5	5	40	6	+0,07	
D814B	Si; нем.; SU	8—9,5	5	36	10	+0,08	
D814B	Si; нем.; SU	9—10,5	6	32	12	+0,09	
D814Г	Si; нем.; SU	10—12	6	29	15	+0,095	
D814Д	Si; нем.; SU	11,5—14	6	24	18	+0,095	
D815A	Si; нем.; SU	5,6	50	1400	40	+0,045	
D815AП	Si; нем.; SU	5,6	50	1400	40	+0,045	
D815B	Si; нем.; SU	6,8	50	1150	30	+0,05	
D815BП	Si; нем.; SU	6,8	50	1150	30	+0,05	
D815B	Si; нем.; SU	8,2	50	950	16	+0,07	
D815BП	Si; нем.; SU	8,2	50	950	16	+0,07	
D815Г	Si; нем.; SU	10	25	800	30	+0,08	
D815ГП	Si; нем.; SU	10	25	800	30	+0,08	
D815Д	Si; нем.; SU	12	25	650	40	+0,09	

Центровые диоды

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_Z, V	$I_{Z_{min}}, mA$	$I_{Z_{max}}, mA$	I_A, A	$TKU, Z, \% / ^\circ C$	P_D, W
Д815ДП	Si; нем.; SU	12	25	650	40	+0,09	8
Д815Е	Si; нем.; SU	15	25	550	50	+0,01	8
Д815ЕП	Si; нем.; SU	15	25	550	60	+0,01	8
Д815Ж	Si; нем.; SU	18	25	450	50	+0,11	8
Д815ЖП	Si; нем.; SU	18	25	450	60	+0,11	8
Д815И	Si; нем.; SU	4,7	50	1400	40	+0,055	8
Д815ИП	Si; нем.; SU	4,7	50	1400	40	+0,056	8
Д816А	Si; нем.; SU	22	10	230	78	+0,12	8
Д816АП	Si; нем.; SU	22	10	230	10	+0,12	8
Д816Б	Si; нем.; SU	27	10	180	10	+0,12	8
Д816БП	Si; нем.; SU	27	10	180	12	+0,12	8
Д816В	Si; нем.; SU	33	10	150	10	+0,12	8
Д816ВП	Si; нем.; SU	33	10	150	15	+0,12	8
Д816Г	Si; нем.; SU	39	10	130	12	+0,12	8
Д816ГП	Si; нем.; SU	39	10	130	18	+0,12	8
Д816Д	Si; нем.; SU	47	10	110	15	+0,12	8
Д816ДП	Si; нем.; SU	47	10	110	22	+0,12	8
Д817А	Si; нем.; SU	56	5	90	35	+0,14	8
Д817АП	Si; нем.; SU	56	5	90	52	+0,14	8
Д817Б	Si; нем.; SU	68	5	75	40	+0,14	8
Д817БП	Si; нем.; SU	68	5	75	60	+0,14	8
Д817В	Si; нем.; SU	82	5	60	45	+0,14	8
Д817ВП	Si; нем.; SU	82	5	60	67	+0,14	8
Д817Г	Si; нем.; SU	100	5	50	50	+0,14	8
Д817ГП	Si; нем.; SU	100	5	50	75	+0,14	8
Д818А	Si; нем.; SU	9	3	33	16	$\pm 0,02$	0,3
Д818Б	Si; нем.; SU	9	3	33	18	-0,02	0,3
Д818В	Si; нем.; SU	9	3	33	18	$\pm 0,01$	0,3
Д818Г	Si; нем.; SU	9	3	33	18	$\pm 0,005$	0,3
Д818Д	Si; нем.; SU	9	3	33	18	$\pm 0,002$	0,3
Д818Е	Si; нем.; SU	9	3	33	18	$\pm 0,001$	0,3
КС107А	Si; таб.; SU	0,7	1	100	7	-0,03	0,3
КС133А	Si; нем.; SU	3,5—3,7	3	81	65		0,3
КС139А	Si; нем.; SU	4,1—4,3	3	70	60		0,3
КС147А	Si; нем.; SU	4,1—5,2	3	58	56		0,3

Центровые диоды

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_Z, V	$I_{Z_{min}}, mA$	$I_{Z_{max}}, mA$	I_A, A	$TKU, Z, \% / ^\circ C$	P_D, W
КС156А	Si; нем.; SU	5—6,3	3	55	37	+0,05	0,3
КС162А	Si; нем.; SU	5,8—6,6	3	22	33		0,3
КС168А	Si; нем.; SU	6,2—7,3	3	45	19	$\pm 0,06$	0,3
КС168Б	Si; нем.; SU	6,3—7,3	3	20	28	$\pm 0,05$	0,3
КС168В	Si; нем.; SU	6,8	3	20	28	$\pm 0,05$	0,15
КС170А	Si; нем.; SU	6,7—7,3	3	20	20	$\pm 0,01$	0,15
КС175А	Si; нем.; SU	7—8	3	18	18		0,3
КС182А	Si; нем.; SU	7,6—8,8	3	17	16		0,3
КС191А	Si; нем.; SU	8,5—9,7	3	15	14		0,3
КС191М	Si; нем.; SU	9,1	5	15	18	$\pm 0,005$	0,15
КС191Н	Si; нем.; SU	9,1	5	15	18	$\pm 0,002$	0,15
КС191П	Si; нем.; SU	9,1	5	15	18	$\pm 0,001$	0,15
КС191Р	Si; нем.; SU	9,1	5	15	18	$\pm 0,001$	0,15
КС191С	Si; нем.; SU	9,1	3	18	20	$\pm 0,005$	0,2
КС191Т	Si; нем.; SU	9,1	3	18	20	$\pm 0,001$	0,2
КС191У	Si; нем.; SU	9,1	3	18	20	$\pm 0,001$	0,2
КС191Ф	Si; нем.; SU	9,1	3	18	20	$\pm 0,001$	0,2
КС196А	Si; нем.; SU	9,6	3	20	18	+0,5	0,3
КС196Б	Si; нем.; SU	9,6	3	20	18	+0,25	0,3
КС196В	Si; нем.; SU	9,6	3	20	18	+0,25	0,3
КС196Г	Si; нем.; SU	9,6	3	20	18	+0,05	0,3
КС210Б	Si; нем.; SU	9,3—10,7	3	14	35		0,3
КС211Б	Si; нем.; SU	11—12,6	3	33	15	+2	0,3
КС211В	Si; нем.; SU	8,9—11	3	33	15	+2	0,3
КС211Г	Si; нем.; SU	9,3—12,6	3	33	15	+1	0,3
КС211Д	Si; нем.; SU	9,3—12,6	3	33	15	+0,5	0,3
КС213Б	Si; нем.; SU	12,1—13,9	3	10	25		0,3
КС433А	Si; нем.; SU	3,3	3	190	25		1
КС439А	Si; нем.; SU	3,9	3	175	18		1
КС447А	Si; нем.; SU	4,7	3	160	10		1
КС456А	Si; нем.; SU	5,6	3	140	5		1
КС488А	Si; нем.; SU	6,8	3	120	25		1
КС482А	Si; нем.; SU	8,2	3	96	25	+0,06	1
КС510А	Si; нем.; SU	10	3	79	25	+0,08	1
КС512А	Si; нем.; SU	12	3	67	25	+0,08	1

Центрови диоди

Означеније	Тип, Страна-произвођач	U_Z , V	$I_{Z\min}$, mA	$I_{Z\max}$, mA	P_d , W	TKU_Z , %/°C	P_d , W
KC515A	Si; нем.; SU	15	3	53	1	+0,09	1
KC515F	Si; нем.; SU	13	3	31	1	+0,005	1
KC518A	Si; нем.; SU	18	3	45	1	+0,09	1
KC320B	Si; нем.; SU	20	3	22	0,5	$\pm 0,01$	0,5
KC522A	Si; нем.; SU	22	3	37	1	+0,01	1
KC524F	Si; нем.; SU	24	3	19	0,5	$\pm 0,005$	0,5
KC527A	Si; нем.; SU	27	3	30	1	+0,1	1
KC531B	Si; нем.; SU	31	3	15	0,5	$\pm 0,005$	0,5
KC533A	Si; нем.; SU	33	3	17	0,6	+0,1	0,6
KC539F	Si; нем.; SU	39	3	17	0,7	$\pm 0,001$	0,7
KC547B	Si; нем.; SU	47	3	10	0,5	$\pm 0,01$	0,5
KC568B	Si; нем.; SU	68	3	10	0,7	$\pm 0,001$	0,7
KC582F	Si; нем.; SU	82	3	8	0,7	$\pm 0,01$	0,7
KC596B	Si; нем.; SU	96	3	7	0,7	$\pm 0,01$	0,7
KC620A	Si; нем.; SU	120	5	42	5	+0,2	5
KC630A	Si; нем.; SU	130	5	38	5	+0,2	5
KC650A	Si; нем.; SU	150	3	33	5	+0,2	5
KC680A	Si; нем.; SU	180	3	28	5	+0,2	5
KI620AP	Si; нем.; SU	120	5	42	5	+0,2	5
KI630AP	Si; нем.; SU	130	5	38	5	+0,2	5
KI650AP	Si; нем.; SU	150	5*	33	5	+0,2	5
KI680AP	Si; нем.; SU	180	5	28	5	+0,2	5
KZ140	Si; нем.; CS	2,8—3,2	5	90	0,28	$\pm 0,07$	0,28
KZ141	Si; нем.; CS	4,8—5,4	5	55	0,28	$\pm 0,07$	0,28
KZ260/5V1	Si; нем.; CS	4,8—5,4	10	260	1,4	$\pm 0,005$	1,4
KZ260/5V6	Si; нем.; CS	5,2—6	10	230	1,4	$\pm 0,05$	1,4
KZ260/6V2	Si; нем.; CS	5,8—6,6	10	210	1,4	$\pm 0,04$	1,4
KZ260/6V8	Si; нем.; CS	6,4—7,2	10	195	1,4	$\pm 0,07$	1,4
KZ260/7V5	Si; нем.; CS	7—7,9	10	178	1,4	$\pm 0,07$	1,4
KZ260/8V2	Si; нем.; CS	7,7—8,8	10	160	1,4	$\pm 0,08$	1,4
KZ260/9V1	Si; нем.; CS	8,5—9,6	10	145	1,4	$\pm 0,08$	1,4
KZ260/10	Si; нем.; CS	9,4—10,6	10	132	1,4	$\pm 0,09$	1,4
KZ260/11	Si; нем.; CS	10,4—11,6	10	120	1,4	$\pm 0,1$	1,4
KZ260/12	Si; нем.; CS	11,4—12,7	10	110	1,4	$\pm 0,1$	1,4
KZ260/13	Si; нем.; CS	12,4—14,1	10	100	1,4	$\pm 0,1$	1,4

Центрови диоди

Означеније	Тип, Страна-произвођач	U_Z , V	$I_{Z\min}$, mA	$I_{Z\max}$, mA	P_d , W	TKU_Z , %/°C	P_d , W
KZ260/15	Si; нем.; CS	13,8—15,8	10	90	1,4	+0,1	1,4
KZ260/16	Si; нем.; CS	15,3—17,1	10	82	1,4	+0,1	1,4
KZ260/18	Si; нем.; CS	16,8—19,1	10	73	1,4	+0,1	1,4
KZ703	Si; нем.; CS	6—7,8	20	320	10		10
KZ704	Si; нем.; CS	7—9,2	20	270	10		10
KZ705	Si; нем.; CS	8—10,2	20	240	10		10
KZ706	Si; нем.; CS	9,4—11,6	20	210	10		10
KZ707	Si; нем.; CS	10,6—13,2	20	190	10		10
KZ708	Si; нем.; CS	12—14,8	20	170	10		10
KZ709	Si; нем.; CS	13,6—16,8	20	150	10		10
KZ710	Si; нем.; CS	15,2—19	20	135	10		10
KZ711	Si; нем.; CS	16,8—21	20	120	10		10
KZ712	Si; нем.; CS	19—23,6	20	105	10		10
KZ713	Si; нем.; CS	21,6—26,6	20	95	10		10
KZ714	Si; нем.; CS	24,2—29,8	20	85	10		10
KZ715	Si; нем.; CS	27—33	20	75	10		10
KZ721	Si; нем.; CS	5,8—7,8	5	36	0,28		0,28
KZ722	Si; нем.; CS	7—9,4	5	30	0,28		0,28
KZ723	Si; нем.; CS	8,6—11,8	5	23	0,28		0,28
KZ724	Si; нем.; CS	10,2—14	5	20	0,28		0,28
KZ799	Si; нем.; CS	28,2—31,8	5	250	1,25		1,25
KZZ71	Si; нем.; CS	5,8—7,5	5	36	0,28		0,28
KZZ72	Si; нем.; CS	7—8,5	5	33	0,28		0,28
KZZ73	Si; нем.; CS	8—9,5	5	30	0,28		0,28
KZZ74	Si; нем.; CS	9—10,5	5	26	0,28		0,28
KZZ75	Si; нем.; CS	10—12	5	23	0,28		0,28
KZZ76	Si; нем.; CS	11,2—14	5	20	0,28		0,28
SZ501	Si; нем.; DDR	0,75	5	250	1,5		1,5
SZ504	Si; нем.; DDR	5,15	5	175	1		1
SZ505	Si; нем.; DDR	6,4	5	160	1		1
SZ506	Si; нем.; DDR	6,9	5	130	1		1
SZ507	Si; нем.; DDR	7,5	5	115	1		1
SZ508	Si; нем.; DDR	8,25	5	110	1		1
SZ509	Si; нем.; DDR	9,05	5	100	1		1
SZ510	Si; нем.; DDR	10	5	90	1		1

Ценероан диоды

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_z, V	I_{zm}, mA	I_{zmax}, mA	θ, P, dB	$TKU, Z, \%$	P_D, W
SZ511	Si; нем.; DDR	11	5	80	7		1
SZ512	Si; нем.; DDR	12	5	75	7		1
SZ513	Si; нем.; DDR	13,2	5	65	11		1
SZ515	Si; нем.; DDR	14,8	5	60	11		1
SZ516	Si; нем.; DDR	16	5	55	15		1
SZ518	Si; нем.; DDR	17,9	5	50	15		1
SZ520	Si; нем.; DDR	19,9	5	45	15		1
SZ522	Si; нем.; DDR	21,9	5	40	15		1
SZ555	Si; нем.; DDR	5,9	5	145	7		1
690/0,75	Si; нем.; DDR	0,65-0,85	10	1000	2		1
SZ600/5,1	Si; нем.; DDR	4,8-5,4	10	185	2	-0,01	1
SZ600/5,6	Si; нем.; DDR	5,4-6	10	165	1	+0,02	1
SZ600/6,2	Si; нем.; DDR	5,8-6,6	10	150	1	+0,03	1
SZ600/6,8	Si; нем.; DDR	6,4-7,2	10	139	1	+0,03	1
SZ600/7,5	Si; нем.; DDR	7,0-7,9	10	125	1	+0,04	1
SZ600/8,2	Si; нем.; DDR	7,7-8,8	10	115	1	+0,05	1
SZ600/9,1	Si; нем.; DDR	8,5-9,5	10	105	2	+0,06	1
SZ600/10	Si; нем.; DDR	9,4-10,6	10	95	2	+0,07	1
SZ600/11	Si; нем.; DDR	10,4-11,6	10	85	4	+0,07	1
SZ600/12	Si; нем.; DDR	11,4-12,7	10	80	4	+0,07	1
SZ600/13	Si; нем.; DDR	12,4-14,1	10	70	5	+0,07	1
SZ600/15	Si; нем.; DDR	13,8-15,7	10	65	5	+0,07	1
SZ600/16	Si; нем.; DDR	15,2-17,1	10	60	6	+0,07	1
SZ600/18	Si; нем.; DDR	16,8-19,1	10	55	6	+0,07	1
SZ600/20	Si; нем.; DDR	18,8-21,2	10	50	6	+0,08	1
SZ600/22	Si; нем.; DDR	20,8-23,3	10	45	6	+0,08	1
SZ600/24	Si; нем.; DDR	22,8-25,6	10	40	8	+0,08	1
SZ600/26	Si; нем.; DDR	24,8-28,1	10	35	8	+0,08	1
SZ600/28	Si; нем.; DDR	26,8-30,1	10	30	10	+0,08	1
SZ600/30	Si; нем.; DDR	28,8-32,1	10	25	10	+0,08	1
SZ600/32	Si; нем.; DDR	30,8-34,1	10	20	10	+0,08	1
SZ600/34	Si; нем.; DDR	32,8-36,1	10	15	10	+0,08	1
SZ600/36	Si; нем.; DDR	34,8-38,1	10	10	10	+0,08	1
SZ600/38	Si; нем.; DDR	36,8-40,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/40	Si; нем.; DDR	38,8-42,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/42	Si; нем.; DDR	40,8-44,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/44	Si; нем.; DDR	42,8-46,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/46	Si; нем.; DDR	44,8-48,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/48	Si; нем.; DDR	46,8-50,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/50	Si; нем.; DDR	48,8-52,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/52	Si; нем.; DDR	50,8-54,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/54	Si; нем.; DDR	52,8-56,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/56	Si; нем.; DDR	54,8-58,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/58	Si; нем.; DDR	56,8-60,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/60	Si; нем.; DDR	58,8-62,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/62	Si; нем.; DDR	60,8-64,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/64	Si; нем.; DDR	62,8-66,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/66	Si; нем.; DDR	64,8-68,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/68	Si; нем.; DDR	66,8-70,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/70	Si; нем.; DDR	68,8-72,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/72	Si; нем.; DDR	70,8-74,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/74	Si; нем.; DDR	72,8-76,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/76	Si; нем.; DDR	74,8-78,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/78	Si; нем.; DDR	76,8-80,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/80	Si; нем.; DDR	78,8-82,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/82	Si; нем.; DDR	80,8-84,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/84	Si; нем.; DDR	82,8-86,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/86	Si; нем.; DDR	84,8-88,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/88	Si; нем.; DDR	86,8-90,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/90	Si; нем.; DDR	88,8-92,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/92	Si; нем.; DDR	90,8-94,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/94	Si; нем.; DDR	92,8-96,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/96	Si; нем.; DDR	94,8-98,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/98	Si; нем.; DDR	96,8-100,1	10	5	10	+0,08	1
SZ600/100	Si; нем.; DDR	98,8-102,1	10	5	10	+0,08	1

Ценероан диоды

Обозначение	Тип, Страна-производитель	U_z, V	I_{zm}, mA	I_{zmax}, mA	θ, P, dB	$TKU, Z, \%$	P_D, W
SZX 19/5,1	Si; нем.; DDR	4,8-5,4	5	46	75	-0,05	0,25
SZX 19/5,6	Si; нем.; DDR	5,2-6	5	40	60	-0,03	0,25
SZX 19/6,2	Si; нем.; DDR	5,8-6,6	5	37	35	-0,02	0,25
SZX 19/6,8	Si; нем.; DDR	6,4-7,2	5	34	8	-0,01	0,25
SZX 19/7,5	Si; нем.; DDR	7-7,9	5	31	7	+0,02	0,25
SZX 19/8,2	Si; нем.; DDR	7,7-8,7	5	27	7	+0,03	0,25
SZX 19/9,1	Si; нем.; DDR	8,5-9,6	5	25	10	+0,04	0,25
SZX 19/10	Si; нем.; DDR	9,4-10,6	5	23	15	+0,05	0,25
SZX 19/11	Si; нем.; DDR	10,4-11,6	5	21	20	+0,05	0,25
SZX 19/12	Si; нем.; DDR	11,4-12,8	5	19	20	+0,06	0,25
SZX 19/13	Si; нем.; DDR	12,5-14	5	17	30	+0,07	0,25
SZX 19/15	Si; нем.; DDR	13,8-15,5	5	16	35	+0,07	0,25
SZX 19/16	Si; нем.; DDR	15,3-17	5	14	40	+0,08	0,25
SZX 19/18	Si; нем.; DDR	16,8-19	5	12	50	+0,08	0,25
SZX 19/20	Si; нем.; DDR	18,8-21	5	11	80	+0,08	0,25
SZX 19/22	Si; нем.; DDR	20,8-23	5	10	80	+0,08	0,25
SZX 19/24	Si; нем.; DDR	22,8-25,6	5	9	80	+0,08	0,25
SZX 21/1	Si; нем.; DDR	0,73-0,83	5	200	8	-0,18	0,25
SZX 21/5,1	Si; нем.; DDR	4,8-5,4	5	43	60	-0,05	0,25
SZX 21/5,6	Si; нем.; DDR	5,3-6	5	40	40	-0,02	0,25
SZX 21/6,2	Si; нем.; DDR	5,8-6,6	5	37	10	-0,01	0,25
SZX 21/6,8	Si; нем.; DDR	6,4-7,2	5	34	8	-0,01	0,25
SZX 21/7,5	Si; нем.; DDR	7-7,9	5	31	7	+0,02	0,25
SZX 21/8,2	Si; нем.; DDR	7,7-8,7	5	27	7	+0,03	0,25
SZX 21/9,1	Si; нем.; DDR	8,5-9,6	5	25	10	+0,04	0,25
SZX 21/10	Si; нем.; DDR	9,4-10,6	5	23	15	+0,05	0,25
SZX 21/11	Si; нем.; DDR	10,4-11,6	5	21	20	+0,05	0,25
SZX 21/12	Si; нем.; DDR	11,4-12,8	5	19	20	+0,06	0,25
SZX 21/13	Si; нем.; DDR	12,6-14	5	17	25	+0,06	0,25
SZX 21/15	Si; нем.; DDR	13,8-15,5	5	16	30	+0,07	0,25
SZX 21/16	Si; нем.; DDR	15,3-17	5	14	40	+0,07	0,25
SZX 21/18	Si; нем.; DDR	16,8-19	5	12	55	+0,07	0,25
SZX 21/20	Si; нем.; DDR	18,8-21	5	11	55	+0,07	0,25
SZX 21/22	Si; нем.; DDR	20,8-23	5	10	55	+0,07	0,25
SZX 21/24	Si; нем.; DDR	22,8-25,6	5	9	80	+0,07	0,25

Центровые диоды

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$U_{\Sigma}, \text{В}$	$I_{\Sigma \text{ min}}, \text{мА}$	$I_{\Sigma \text{ max}}, \text{мА}$	$P, \text{Вт}$	$TKU, \%, \text{В} \cdot \text{С}$	$P, \text{Вт}$
ЗА250/1	Si; нем.; DDR	0,72	3	48	0,25	-0,28	0,25
ЗА250/5	Si; нем.; DDR	5,1	3	40	0,25	+0,05	0,25
ЗА250/6	Si; нем.; DDR	5,9	3	40	0,25	-0,110	0,25
ЗА250/7	Si; нем.; DDR	7,9	3	31	0,25	+0,057	0,25
ЗА250/8	Si; нем.; DDR	8,9	3	28	0,25	+0,069	0,25
ЗА250/10	Si; нем.; DDR	9,9	3	25	0,25	+0,072	0,25
ЗА250/11	Si; нем.; DDR	11	3	22	0,25	+0,08	0,25
ЗА250/12	Si; нем.; DDR	12	3	20	0,25	+0,082	0,25
ЗА250/14	Si; нем.; DDR	14,5	3	17	0,25	+0,091	0,25
ЗА250/18	Si; нем.; DDR	18,4	3	13	0,25	+0,107	0,25
ЗА250/20	Si; нем.; DDR	22,5	3	12	0,25	+0,08	0,25
2С107А	Si; таб.; SU	0,6-0,7	1	100		+0,02	
2С113А	Si; таб.; SU	1,1-1,5	1	120		+0,03	
2С119А	Si; таб.; SU	1,7-2,1	5	50		+0,02	
2С133А	Si; нем.; SU	3,0-3,7	3	81	0,3		
2С139А	Si; нем.; SU	3,5-4,3	3	70	0,3		
2С147А	Si; нем.; SU	4,1-5,2	3	58	0,3		
2С156А	Si; нем.; SU	5,0-6,3	3	55	0,3		
2С168А	Si; нем.; SU	6,2-7,5	3	45	0,3		
2С920А	Si; нем.; SU	120	3	42	5		
2С930А	Si; нем.; SU	130	3	38	5		
2С950А	Si; нем.; SU	150	3	33	5		
2С980А	Si; нем.; SU	180	3	28	5		
1N270	Si; нем.; CS	5,5	5	230	1,25		
2N270	Si; нем.; CS	6,5	5	200	1,25		
3N270	Si; нем.; CS	7,5	5	180	1,25		
4N270	Si; нем.; CS	8,5	5	170	1,25		
5N270	Si; нем.; CS	9,9	5	130	1,25		
6N270	Si; нем.; CS	12,2	5	110	1,25		
7N270	Si; нем.; CS	15,0	5	90	1,25		
7FE1A-C	Ge; таб.; SU	0,6-0,8	1	10		+0,02	
7FE2A-C	Ge; таб.; SU	1,3-1,6	1	10		+0,05	
7FE3A-C	Ge; таб.; SU	2,1-2,4	1	10		+0,07	
8N270	Si; нем.; CS	18,1	5	70	1,25		

Варикапы

Обозначение	Тип, Страна-производитель	$C_{\Sigma}, \text{пФ}$	$C_{\Sigma}, \text{пФ}$	$C_{\Sigma}, \text{пФ}$	ϵ	$U_{\Sigma}, \text{В}$	$I_{\Sigma}, \text{мА}$
ВА243	Si; D	1,8/1	0,8/15	2-3		20	0,1
ВА244	Si; D	1,8/1	0,8/15	2-3		20	0,1
BB121A	Si; D	17/1	2,3/25	5-7		30	0,1
BB121B	Si; D	18/1	2,6/25	5-7		30	0,1
BB122	Si; D	20/1	2,8/25	5-7		30	0,1
BB139	Si; D	29/3	4,5/25	5-7	280	30	0,1
BB141A	Si; D	16/1	2,2/25	4-6		30	0,1
BB141B	Si; D	19/1	2,3/25	4-6		30	0,1
BB142	Si; D	17/1	2,5/25	4-6		30	0,1
Д901А	Si; SU	27/4	7/60	4	25	80	1
Д901Б	Si; SU	27/4	8/60	3	30	80	1
Д901Г	Si; SU	33/4	7/60	4	25	80	1
Д901Д	Si; SU	39/4	7/60	4	25	80	1
Д901Е	Si; SU	39/4	8/60	3	30	80	1
Д902	Si; SU	9/4	4/25	2,5	30	25	10
КА201	Si; CS	15-30/4		1,5		20	
КА202	Si; CS	25-50/4		1,5		20	
КА204	Si; CS	3-6/4		2,5		30	
КА213А	Si; CS	35-40/4		2,5		32	
КА213Б	Si; CS	40-46/3		2,5		32	
КА213С	Si; CS	38-42/3		2,5		32	
КА213Д	Si; CS	32-37/3		2,5		32	
КА213Е	Si; CS	43-48/3		2,5		32	
KB101A	Si; SU	200/0,8		150	4	1	
KB102A	Si; SU	14-23/4		2,5		45	1
KB102Б	Si; SU	19-30/4		2,5		45	1
KB102В	Si; SU	25-40/4		2,5		45	1
KB102Г	Si; SU	19-30/4		2,5		45	1
KB102Д	Si; SU	19-30/4		3,5		80	1
KB103A	Si; SU	18-32/4		50	80	10	
KB103Б	Si; SU	28-48/4		40	80	10	
KB104A	Si; SU	90-120/4		100		5	
KB104Б	Si; SU	106-144/4		100		5	
KB104В	Si; SU	128-192/4		100		5	

Описание	Тем. Среда- проникновения	$C_{\text{пр}}, V$	$C_{\text{пр}}, V$	$\frac{C}{C_0}$	Q	V, λ	V, λ
KB104Г	Si; SU	93—143/4			100		5
KB104Д	Si; SU	128—192/4			100	80	5
KB104Е	Si; SU	95—143/4			150	45	5
KB105А	Si; SU	400—600/4		3,8	500	90	50
KB105А	Si; CS	17/1		4		28	
KB105В	Si; CS	17/1		5		28	
KB105Б	Si; SU	400—600/4		3,8	500	50	50
KB105Г	Si; CS	17/1		5		28	
KB106А	Si; SU	20—50/4			40	120	20
KB106Б	Si; SU	20—50/4			60	90	20
KB107А	Si; SU	1—40/4			20	9	100
KB107Б	Si; SU	10—40/6			20	13	100
KB107Б	Si; SU	30—65/1			20	9	100
KB107Г	Si; SU	30—65/6			20	13	100
KB109А	Si; SU	2—3/3		5	300	25	0,5
KB109Б	Si; SU	2—23/3		5	300	25	0,5
KB109Б	Si; SU	8—17/3		5	160	25	0,5
KB109Г	Si; CS	26—32/3		5,5		28	
KB109Г	Si; SU	8—17/3		4	160	25	0,6
KB110А	Si; SU	12—18/4			300	45	1
KB110Б	Si; SU	14—21/4			300	45	1
KB110Б	Si; SU	17—26/4			300	45	1
KB110Г	Si; SU	12—18/4			150	45	1
KB110Д	Si; SU	14—21/4			150	45	1
KB110Е	Si; SU	17—26/4			150	45	1
KB115А	Si; SU	100—700/0				20	
KB115Б	Si; SU	100—700/0				20	
KB115Б	Si; SU	100—700/0				20	
KBBC11А	Si; d; SU	33/4		2,1	200	30	1
KBBC11Б	Si; d; SU	33/4		2,1	150	30	1
ОА900	Si; DDR	50/1	15/20			25	
SAZ12	Si; DDR	1—5/6	15/20			25	
SAZ13	Si; DDR	1—5/6				25	

Тунестни диодни

Обозначение	Тип, Справочная	I_{max} , mA	U_{p} , V	I_{max} при	$U_{\text{p}} - U_{\text{a}}$	C_D , pF	U_{Fmax} , V
АН101А	GaAs; SU	1±0,25	0,16	5		4	0,5-0,6
АН101В	GaAs; SU	1±0,25	0,16	5		2-3	0,5-0,6
АН101В	GaAs; SU	2±0,3	0,16	6		5	0,5-0,6
АН101Д	GaAs; SU	2±0,3	0,16	6		3,5-10	0,5-0,6
АН101Е	GaAs; SU	5±0,5	0,18	6		8	0,5-0,6
АН101Н	GaAs; SU	5±0,5	0,18	6		4,5-13	0,5-0,6
АН201А	GaAs; SU	10±1	0,18	10		8	0,5-0,6
АН201В	GaAs; SU	10±1	0,18	10		5-15	0,5-0,6
АН201В	GaAs; SU	10±1	0,18	10		5-15	0,5-0,6
АН201Г	GaAs; SU	20±2	0,20	10		10	0,5-0,6
АН201Е	GaAs; SU	20±2	0,20	10		6-20	0,5-0,6
АН201Ж	GaAs; SU	50±5	0,26	10		15	0,5-0,6
АН201И	GaAs; SU	50±5	0,26	10		10-30	0,5-0,6
АН201К	GaAs; SU	100±10	0,33	10		20	0,5-0,6
АН201Л	GaAs; SU	100±10	0,33	10		10-15	0,5-0,6
АН301А	GaAs; SU	1,6-2,4	0,18	8	0,65		
АН301Б	GaAs; SU	4,5-5,5	0,18	8	0,85-1,15		
АН301В	GaAs; SU	4,5-5,5	0,18	8	1,0-1,3		
АН301Г	GaAs; SU	9-11	0,18	8	0,8		
АН402Б	GaAs; SU	0,1	0,18			0,4	0,6
АН402Г	GaAs; SU	0,1	0,18			8	0,6
АН402Е	GaAs; SU	0,2	0,18			8	0,6
АН402И	GaAs; SU	0,4	0,18			10	0,6
ГЕ110	GaAs; CS	10±1		5		30	
ГЕ111	GaAs; CS	1±0,2		5		4,5	
ГЕ112	GaAs; CS	2±0,2		5		7	
ГЕ113	GaAs; CS	3±0,4		5		8,5	
ГЕ114	GaAs; CS	4±0,4		5		10	
ГЕ120	GaAs; CS	10±1		5		30	
ГЕ121	GaAs; CS	1±0,2		5		4,5	
ГЕ122	GaAs; CS	2±0,2		5		7	
ГЕ123	GaAs; CS	3±0,4		5		8	
ГЕ124	GaAs; CS	4±0,4		5		10	
ГЕ130	GaAs; CS	10±1		5		30	
ГЕ131	GaAs; CS	1±0,2		5		4,5	

Туннельни диоди

Описание	Тип, Страна-производитель	I_{\max} , мА	U_p , В	I_{\max} I_{\min}	$U_p - U_n$, В	C_D , пФ	U_{\max} , В
ГЕ132	GaAs; CS	2±0,2		5		7	
ГЕ133	GaAs; CS	3±0,4		5		8,5	
ГЕ134	GaAs; CS	4±0,4		5		10	
ГН103А	Ge; SU	13—1,7	0,1	4		0,7—1,6	0,4
ГН103Б	Ge; SU	1,3—1,7	0,1	4		0,7—1,6	0,4
ГН103В	Ge; SU	1,3—1,7	0,1	4		0,7—1,6	0,4
ГН103Г	Ge; SU	1,3—1,7	0,1	4		0,7—1,6	0,4
ГН104А	Ge; SU	4,5—5,1	0,07	5			
ГН104Б	Ge; SU	4,9—5,5	0,07	5			
ГН104В	Ge; SU	9,1—10	0,08	5	0,45		
ГН104Г	Ge; SU	9,8—11	0,08	5	0,45		
ГН104Д	Ge; SU	1,2		7	0,4		
ГН104Е	Ge; SU	0,8					
ГН104Ж	Ge; SU	0,1					
ГН104З	Ge; SU	1,5±0,2	0,1	4		1,9	0,6
ГН104И	GaAs; SU	1,5±0,2	0,1	4		1,9	0,6
ГН104К	GaAs; SU	1,5±0,2	0,1	4		1,1	0,6
ГН104Л	GaAs; SU	1,5±0,2	0,1	4		1,0	0,6
ГН104М	GaAs; SU	1,5±0,2	0,1	4		0,9	0,6
ГН104Н	GaAs; SU	1,5±0,2	0,1	4		0,8	0,6
ГН104О	GaAs; SU	1,7—17	0,1	3—6	0,2		
ГН104П	Ge; SU	1,7—17	0,1	3—6	0,2		
ГН104Р	Ge; SU	1,7—17	0,1	3—6	0,2		
ГН104С	Ge; SU	1,7—17	0,1	3—6	0,2		
ГН104Д	Ge; SU	1,7—17	0,1	3—6	0,2		
ГН104Е	GaAs; SU	2—10	0,1	3—10	0,45		
ГН104Б	GaAs; SU	2—10	0,1	3—10	0,45		
ГН104В	GaAs; SU	2—10	0,1	3—10	0,45		
ГН104Г	GaAs; SU	2—10	0,1	3—10	0,45		
ГН104Д	GaAs; SU	2—10	0,1	3—10	0,45		

Светодиоды

Описание	Тип, Страна-производитель	Цвет	Мощность, мВт	I_{\max} , мА	U_{\max} , В	U_{RM} , В	P_{\max} (при ток I_{\max} , мА), мВт
АЛ102А	GaP; SU	красный	5	10	3,2	2	
АЛ102Б	GaP; SU	красный	40	20	4,5	2	
АЛ102В	GaP; SU	зеленый	20	20	4,5	2	
АЛ102Г	GaP; SU	красный	10	10	3,0	2	1/50
АЛ103А	GaAs; SU	инф. красный	52	52	1,6	2	
АЛ103Б	GaAs; SU	инф. красный	52	52	1,6	2	0,6/50
АЛ106А	GaP; SU	инф. красный	120	120	1,7		0,2/100
АЛ106Б	GaP; SU	инф. красный	120	120	1,7		0,4/100
АЛ106В	GaP; SU	инф. красный	120	120	1,7		0,6/100
АЛ107А	GaAs; SU	инф. красный	100	100	2,0		6/100
АЛ107Б	GaAs; SU	инф. красный	100	100	2,0		10/100
АЛ108А	GaAs; SU	инф. красный	110	110	1,35	2	1,5/100
АЛ109А	GaAs; SU	инф. красный	22	22	1,2		0,2/20
АЛ301А	GaP; SU	красный	10	11	3,0		
АЛ301Б	GaP; SU	красный	20	11	3,8		
ДН1А	GaP; SU	красный	20	3	2,5		
ДН1Б	GaP; SU	зеленый	20	5	2,5		
ДН1В	GaP; SU	красный	20	5	2,5		
ДН1Г	GaP; SU	зеленый	20	10	3,0		
ДН1Д	GaP; SU	красный	20	10	3,0		
ДН1Е	GaP; SU	зеленый	30	30	3,5		
ДН1Ж	GaP; SU	зеленый	30	30	3,5		
ДН1И	GaP; SU	красный	60	30	5,0		
ДН1К	GaP; SU	красный	60	30	5,0		
КЛ101А	SiC; SU	желтый	10	10	5,5	3	
КЛ101Б	SiC; SU	желтый	15	20	5,5	3	
КЛ101В	SiC; SU	желтый	20	40	5,5	3	
ЛQ100	SiC; CS	красный	20	70	2		17

Тиристоры

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{RM}^A , В	$I_{o max}^A$, мА (А)	I_{FM}^{max} , мА (А)	I_{GT} , мА	P_{max}^A , Вт
Д235А	Si, тип.: SU	40	(2)	(10)	150	(4)
Д235Б	Si, тип.: SU	80	(2)	(10)	150	(4)
Д235В	Si, тип.: SU	40	(2)	(10)	150	(4)
Д235Г	Si, тип.: SU	80	(2)	(10)	150	(4)
Д238А	Si, тип.: SU	50	(10)	(30)	350	(20)
Д238Б	Si, тип.: SU	100	(10)	(30)	350	(20)
Д238В	Si, тип.: SU	150	(10)	(30)	350	(20)
Д238Г	Si, тип.: SU	50	(10)	(30)	350	(20)
Д238Д	Si, тип.: SU	100	(10)	(30)	350	(20)
Д238Е	Si, тип.: SU	150	(10)	(30)	350	(20)
КН102А	Si, тип.: SU	10	50/20*	(2)		
КН102Б	Si, тип.: SU	10	7/28*	(2)		
КН102В	Si, тип.: SU	10	10/40*	(2)		
КН102Г	Si, тип.: SU	10	14/56*	(2)		
КН102Д	Si, тип.: SU	10	20/80*	(2)		
КН102Ж	Si, тип.: SU	10	30/120*	(2)		
КН102И	Si, тип.: SU	10	50/150*	(2)		
КТ110	Si, тип.: CS	750	30	(15)	40	(20)
КТ501	Si, тип.: CS	50	(1)	(15)	10	(20)
КТ502	Si, тип.: CS	100	(1)	(15)	10	(20)
КТ503	Si, тип.: CS	200	(1)	(15)	10	(20)
КТ504	Si, тип.: CS	300	(1)	(15)	10	(20)
КТ505	Si, тип.: CS	400	(1)	(15)	10	(20)
КТ506	Si, тип.: CS	400	(1)	(15)	1-2	(20)
КТ701	Si, тип.: CS	50	(15)	(120)	40	(30)
КТ702	Si, тип.: CS	100	(15)	(120)	40	(30)
КТ703	Si, тип.: CS	200	(15)	(120)	40	(30)
КТ704	Si, тип.: CS	300	(15)	(120)	40	(30)
КТ705	Si, тип.: CS	400	(15)	(120)	40	(30)
КТ706	Si, тип.: CS	500	(15)	(120)	40	(30)
КТ707	Si, тип.: CS	600	(15)	(120)	40	(30)
КТ708	Si, тип.: CS	700	(15)	(120)	40	(30)
КТ710	Si, тип.: CS	50	(3)	(40)	15	(20)
КТ711	Si, тип.: CS	100	(3)	(40)	15	(20)
КТ712	Si, тип.: CS	200	(3)	(40)	15	(20)

Тиристоры

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{RM}^A , В	$I_{o max}^A$, мА (А)	I_{FM}^{max} , мА (А)	I_{GT} , мА	P_{max}^A , Вт
КТ713	Si, тип.: CS	300	(3)	(40)	15	(20)
КТ714	Si, тип.: CS	400	(3)	(40)	15	(20)
КУ101А	Si, тип.: SU	10	75	(1)	15	150
КУ101Б	Si, тип.: SU	50	75	(1)	15	150
КУ101Г	Si, тип.: SU	80	75	(1)	15	150
КУ101Е	Si, тип.: SU	150	75	(1)	15	150
КУ103А	Si, тип.: SU	150			40	150
КУ103Б	Si, тип.: SU	150			40	150
КУ103В	Si, тип.: SU	300			40	150
КУ103Г	Si, тип.: SU	250			40	150
КУ103Е	Si, тип.: SU	250			40	150
КУ201А	Si, тип.: SU	25	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Б	Si, тип.: SU	25	(2)	(10)	200	(4)
КУ201В	Si, тип.: SU	50	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Г	Si, тип.: SU	50	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Д	Si, тип.: SU	100	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Е	Si, тип.: SU	100	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Ж	Si, тип.: SU	200	(2)	(10)	200	(4)
КУ201И	Si, тип.: SU	200	(2)	(10)	200	(4)
КУ201К	Si, тип.: SU	300	(2)	(10)	200	(4)
КУ201Л	Si, тип.: SU	300	(2)	(10)	200	(4)
КУ202А	Si, тип.: SU	25	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Б	Si, тип.: SU	25	(10)	(30)	300	(20)
КУ202В	Si, тип.: SU	50	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Г	Si, тип.: SU	50	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Д	Si, тип.: SU	100	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Е	Si, тип.: SU	100	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Ж	Si, тип.: SU	200	(10)	(30)	300	(20)
КУ202И	Si, тип.: SU	200	(10)	(30)	300	(20)
КУ202К	Si, тип.: SU	300	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Л	Si, тип.: SU	300	(10)	(30)	300	(20)
КУ202М	Si, тип.: SU	400	(10)	(30)	300	(20)
КУ202Н	Si, тип.: SU	400	(10)	(30)	300	(20)
КУ203А	Si, тип.: SU	50	(10)	(30)	350	(20)
КУ203Б	Si, тип.: SU	100	(10)	(30)	350	(20)

Тиристоры

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{RM}^{max} , В	U_{FM}^{max} , В	$I_{o\max}$, мА (А)	I_{FM}^{max} , мА (А)	I_{GT} , мА	P_{max} , Вт (W)
KY203B	Si; тип.; SU	150	150	(10)		350	(20)
KY203Г	Si; тип.; SU	200	200	(10)		350	(20)
KY203Д	Si; тип.; SU	50	50	(10)		350	(20)
KY203E	Si; тип.; SU	100	100	(10)		350	(20)
KY203Ж	Si; тип.; SU	150	150	(10)		350	(20)
KY203И	Si; тип.; SU	200	200	(10)		350	(20)
KY204A	Si; тип.; SU	50	50	(2)		600	(8)
KY204B	Si; тип.; SU	100	100	(2)		600	(8)
KY204B	Si; тип.; SU	200	200	(2)		600	(8)
KY208A	Si; тип.; SU	100	100		(30)	500	(10)
KY208B	Si; тип.; SU	200	200		(30)	500	(10)
KY208Г	Si; тип.; SU	300	300		(30)	500	(10)
KY210A	Si; тип.; SU	400	400		(30)	500	(10)
KY210B	Si; тип.; SU	600	600	(8)		(4)	
KY210B	Si; тип.; SU	500	500		(80)	(4)	
KY210B	Si; тип.; SU	400	400	(8)	(80)	(4)	
ST103/1	Si; тип.; DDR	100	100	(3)	(15)	20	(15)
ST103/2	Si; тип.; DDR	200	200	(3)	(15)	20	(15)
ST103/3	Si; тип.; DDR	300	300	(3)	(15)	20	(15)
ST103/4	Si; тип.; DDR	400	400	(3)	(15)	20	(15)
ST103/5	Si; тип.; DDR	500	500	(3)	(15)	20	(15)
ST103/6	Si; тип.; DDR	600	600	(3)	(15)	20	(15)
ST108/0,5	Si; тип.; DDR	50	50	(6)	(50)	100	(30)
ST108/1	Si; тип.; DDR	100	100	(6)	(50)	100	(30)
ST108/2	Si; тип.; DDR	200	200	(6)	50	100	(30)
ST108/3	Si; тип.; DDR	300	300	(6)	(50)	100	(30)
ST108/4	Si; тип.; DDR	400	400	(6)	(50)	100	(30)
ST108/5	Si; тип.; DDR	500	500	(6)	(50)	100	(30)
ST108/6	Si; тип.; DDR	600	600	(6)	(50)	100	(30)
ST0,8/50T	Si; тип.; H	50	50	(1)	(15)	10	(0,8)
T0,8N/100T	Si; тип.; H	100	100	(1)	(15)	10	(0,8)
T0,8N/200T	Si; тип.; H	200	200	(1)	(15)	10	(0,8)
T0,8N/300T	Si; тип.; H	300	300	(1)	(15)	10	(0,8)
T0,8N/400T	Si; тип.; H	400	400	(1)	(15)	10	(0,8)
T3N/50T	Si; тип.; H	50	50	(2)	(45)	10	(3)

Тиристоры

Описание	Тип, Страна-производитель	U_{RM}^{max} , В	U_{FM}^{max} , В	$I_{o\max}$, мА (А)	I_{FM}^{max} , мА (А)	I_{GT} , мА	P_{max} , Вт (W)
T3N/100T	Si; тип.; H	100	100	(3)	(45)	10	(3)
T3N/200T	Si; тип.; H	200	200	(3)	(45)	10	(3)
T3N/300T	Si; тип.; H	300	300	(3)	(45)	10	(3)
T3N/400T	Si; тип.; H	400	400	(3)	(45)	10	(3)
T7-0,25A	Si; тип.; BG	25	25	(7)	(50)	100	(4)
T7-0,25	Si; тип.; BG	25	25	(7)	(50)	100	(4)
T7-0,5A	Si; тип.; BG	50	50	(7)	(50)	100	(4)
T7-0,5	Si; тип.; BG	50	50	(7)	(50)	100	(4)
T7-1A	Si; тип.; BG	100	100	(7)	(50)	100	(4)
T7-1	Si; тип.; BG	100	100	(7)	(50)	100	(4)
T7-2A	Si; тип.; BG	200	200	(7)	(50)	100	(4)
T7-2	Si; тип.; BG	200	200	(7)	(50)	100	(4)
T7-3A	Si; тип.; BG	300	300	(7)	(50)	100	(4)
T7-3	Si; тип.; BG	300	300	(7)	(50)	100	(4)
T7-4A	Si; тип.; BG	400	400	(7)	(50)	100	(4)
T7-4	Si; тип.; BG	400	400	(7)	(50)	100	(4)
T15N/50T	Si; тип.; H	50	50	(15)	(120)	40	(15)
T15N/100T	Si; тип.; H	100	100	(15)	(120)	40	(15)
T15N/200T	Si; тип.; H	200	200	(15)	(120)	40	(15)
T15N/300T	Si; тип.; H	300	300	(15)	(120)	40	(15)
T15N/400T	Si; тип.; H	400	400	(15)	(120)	40	(15)

 SOT-25(1) E B C	 SOT-23(1) B C	 SOT-106 B C	 TO-72(1) E B C M	 SOT-128 E C B
 SOT-25(2) B E C	 SOT-23(2) E B C	 SOT-18 E B C M	 TO-72(2) E B C M	 SOT-78 B C E
 SOT-89(1) E C B	 TM-1 C B E	 TO-1 E B C	 SOT-93 B C E	 TOP-3 B C E
 SOT-89(2) B C E	 SOT-54(1) B E C	 TO-60 E B C	 SOT-32(1) B C E	 SOT-32(2) E C B
 SOT-48 B E C	 SOT-54(2) E B C	 C-83 E B C	 SOT-82 B C E	 C-6 E B C
 SOT-37 E B C	 SOT-54(3) B C E	 MO-002AE E ₁ B ₁ C ₁ E ₂ B ₂ C ₂	 TO-39 E B C	 TO-18 E B C
 TO-50 E B C	 SOT-42 B C E	 C-16 E B C	 SOT-9 E B C	 TO-3 E B C
 SOT-120 E B C	 SOT-54(4) C B E	 TO-66 E B C	 TO-3 E B C	 TO-3 E B C
 SOT-122 E B C	 SOT-54(4) C B E	 TO-66 E B C	 TO-3 E B C	 TO-3 E B C